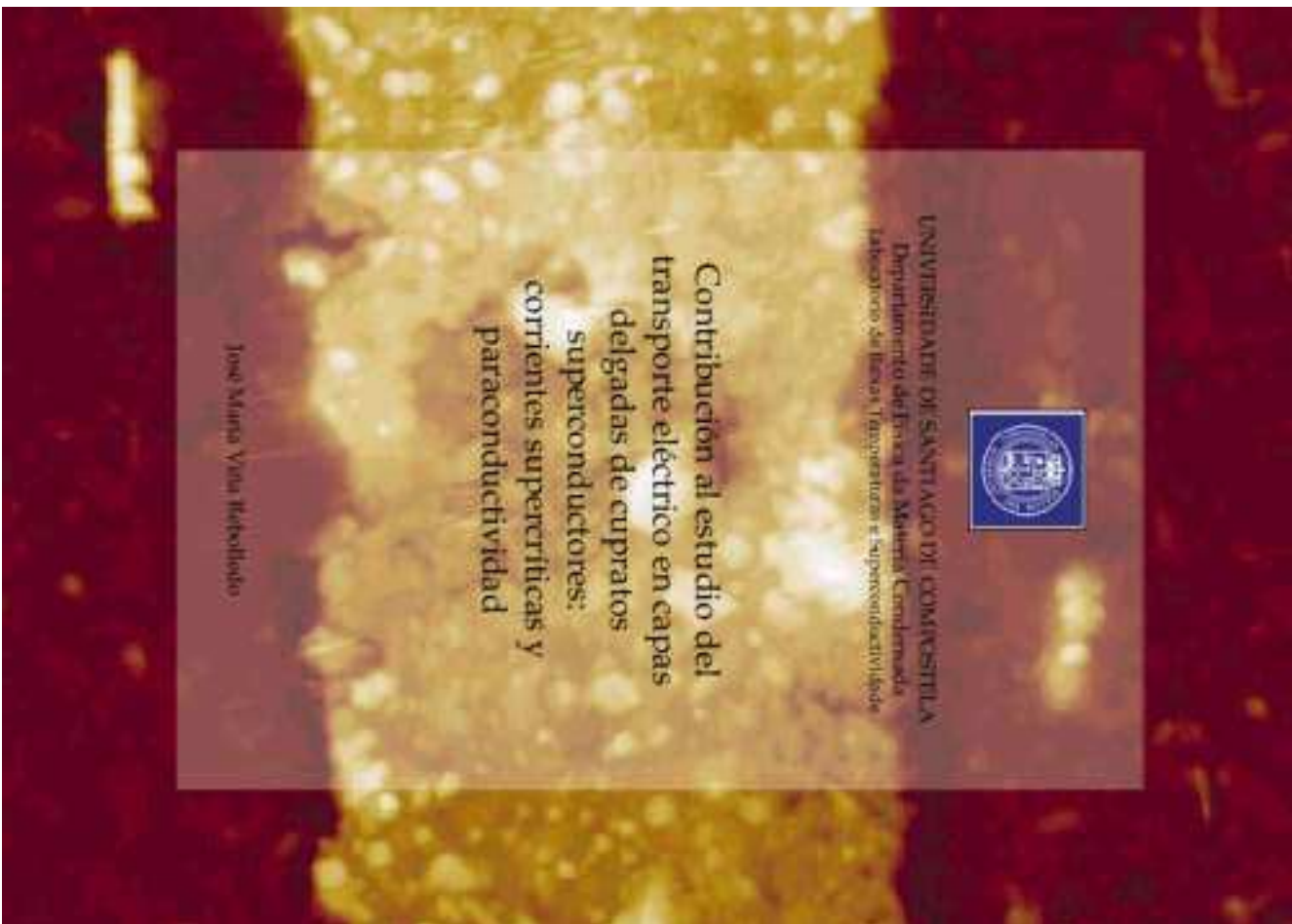




This is a special version of the original document,
adapted for the **arXiv.org e-Print archive**.

Ph.D. Thesis. 302 pages, 121 EPS figures.

In Spanish, with summary and outline in English.

Posted on 30th May 2003, cond-mat/0305712

*Contribution to the study of the electric transport
in cuprate superconducting thin films:
supercritical currents and paraconductivity.*

José María Viña Rebolledo, fmjose@usc.es

Abstract: In type-II superconductors, in the regime of very high applied current density, an abrupt transition is experimentally observed from the mixed state to a highly dissipative regime, probably the normal state. This provokes a high voltage jump in the Current-Voltage Characteristics (CVC) of the samples, at a current density J^* larger than the critical current J_c . In this work we study Y-123 (YBCO) microbridges sputtered over SrTiO₃ substrates. We measure their CVCs for different temperatures close to T_c , and with low applied magnetic field, from 0 to 1 T. We compare the dependences of J_c and J^* , and find that some of the typical experimental results in this regime could be explained by only considering the effect of the current self-field. This suggests that the depairing of the supercarriers could be involved in the abrupt transition. We also study the influence of thermal effects, by using a simplified model to describe the thermal evolution of our samples. We find that the uniform self-heating can produce an abrupt thermal runaway, at high current density, which could explain the occurrence of J^* , as well as its dependence on temperature and applied magnetic field. These results do not totally exclude the implication of other more intrinsic mechanisms (like Cooper pairs depairing, or a change in the regime of the vortex dynamics), but suggest that the uniform self-heating is more relevant than what was considered up to now. In a shorter second part of the thesis, the contribution of the author to the study of the paraconductivity in his laboratory is reflected.

Dissertation submitted to the

University of Santiago de Compostela, Spain,

for the degree of Ph.D.

Faculty of Physics, Santiago de Compostela (2003).

<http://www.usc.es>



UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTADE DE FÍSICA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DA MATERIA CONDENSADA
Laboratorio de Baixas Temperaturas e Superconductividade
Unidad Asociada al ICMM-CSIC

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL
TRANSPORTE ELÉCTRICO EN CAPAS
DELGADAS DE CUPRATOS
SUPERCONDUCTORES:
CORRIENTES SUPERCRÍTICAS Y
PARACONDUCTIVIDAD

*Memoria presentada por José María
Viña Rebolledo para optar ao grado de
Doutor en Física pola Universidade de
Santiago de Compostela.*

26 de decembro de 2002

*Contribución al estudio del transporte eléctrico en
capas delgadas de cupratos superconductores:
corrientes supercríticas y paraconductividad.*

*(Contribution to the study of the electric transport
in cuprate superconducting thin films:
supercritical currents and paraconductivity).*

José María Viña Rebolledo, fmjose@usc.es

Dissertation submitted to the
University of Santiago de Compostela, Spain,
for the degree of Ph.D.
Faculty of Physics, Santiago de Compostela (2003).
<http://www.usc.es>

In CD-ROM: ISBN 84-9750-180-2

cond-mat/0305712. Typeset on 2nd February 2008.

Ilustración de la cubierta: micropuente de YBCO
superconductor barrido con microscopio de fuerza atómica.

D. Félix Vidal Costa e D. Antonio Veira Suárez, catedrático e profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela respectivamente,

CERTIFICAN

que a presente memoria, titulada “*Contribución al estudio del transporte eléctrico en capas delgadas de cupratos superconductores: corrientes supercríticas y paraconductividad*”, foi realizada por **D. José María Viña Rebolledo** baixo a súa dirección, e que constitúe a Tese que presenta para optar ao grado de Doutor en Física.

E, para que así conste, asinan a presente en Santiago de Compostela a 26 de decembro de 2002.

Vº. e praxe
Félix Vidal Costa

Vº. e praxe
Antonio Veira Suárez

Facultade de Física
Universidade de Santiago de Compostela
17 de marzo de 2003

Directores de la tesis

Prof. Dr. D. Félix Vidal Costa
Universidade de Santiago de Compostela

Prof. Dr. D. Antonio Veira Suárez
Universidade de Santiago de Compostela

Miembros del tribunal

Prof. Dr. D. Maurice-Xavier François
Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Prof. Dr. D. Jean-Paul Maneval
École normale supérieure, Paris

Prof. Dr. D. Rafael Navarro Linares
Universidad de Zaragoza

Prof. Dr. D. José L. Vicent López
Universidad Complutense de Madrid

Prof. Dr. D. Jesús Maza Frechín
Universidade de Santiago de Compostela

*Pour qu'une chose soit intéressante,
il suffit de la regarder longtemps.*

G. Flaubert, Corresp. sept. 1845

*Quand on lit trop vite ou trop
doucement on n'entend rien.*

B. Pascal, Pensées, 41 (Papiers classés)

Índice general

Summary in English	15
General outline	21
Términos clave - Keywords	25
Notación	27
Parte I Corrientes supercríticas en filmes de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$	31
1. Introducción a la parte I	33
1.1. Contextualización del problema	33
1.1.1. Superconductividad	33
1.1.2. Estado mixto	36
1.1.3. Transición al estado normal inducida por corrientes altas	38
1.2. Objetivos de este trabajo	40
2. Síntesis, caracterización y preparación de las muestras	45
2.1. Síntesis de muestras mediante pulverización catódica .	46
2.2. Caracterización estructural: difracción de rayos-x .	51
2.2.1. Curvas de basculamiento	52
2.2.2. Difractogramas	54
2.3. Preparación de las muestras mediante fotolitografía . .	56

2.4. Caracterización geométrica: perfilometría y AFM . . .	62
2.5. Aplicación de contactos eléctricos	69
3. Dispositivos de medida	77
3.1. Criostato y campo magnético	77
3.2. Circuito eléctrico	85
3.2.1. Medidas de voltajes bajos con nanovoltímetro .	87
3.2.2. Medidas rápidas de voltajes elevados con tarjeta de adquisición	88
3.3. Otros aspectos	90
4. Resultados experimentales	93
4.1. Resistividad en función de la temperatura	93
4.2. Determinación de la temperatura crítica T_c	96
4.3. Curvas características campo eléctrico – densidad de corriente	97
4.3.1. Curvas a diferentes temperaturas y campos magnéticos	98
4.3.2. Obtención de las curvas $E-J$	104
4.4. Consideraciones sobre el calentamiento en torno al salto	111
4.4.1. Estimación del aumento de temperatura du- rante la medida	111
4.4.2. Tiempos térmicos característicos	112
5. Análisis de datos y comparación con los modelos teóricos	117
5.1. Dependencia del voltaje respecto de la temperatura y la corriente	118
5.2. Modelos habituales para el salto	122
5.2.1. Transición causada por calentamiento	123
5.2.2. Transición causada por movimiento de vórtices .	124
5.2.2.a. Avalancha de Larkin-Ovchinnikov (LO)	124
5.2.2.b. Otros mecanismos de dinámica de vórtices	125

5.2.3.	Otras posibilidades como causa de la transición	126
5.3.	Dependencias de los parámetros críticos J^* , E^* y J_c	128
5.3.1.	Determinación de los parámetros críticos	128
5.3.2.	Dependencia respecto de la temperatura de J^* y J_c	131
5.3.3.	Dependencia respecto del campo magnético de J^* , J_c^{pin} y E^*	134
5.3.4.	Dependencia respecto de la duración de la medida	149
5.4.	Variación de la potencia disipada antes del salto	151
6.	Modelo de calentamiento en avalancha	155
6.1.	Introducción	155
6.2.	Aspectos básicos del modelo	156
6.2.1.	Variación de la disipación con la temperatura	157
6.2.2.	Intercambio térmico de la muestra	159
6.2.2.a.	Modelización de la geometría	162
6.2.2.b.	Aumento de temperatura	165
6.2.3.	Generación de calor en avalancha en el filme	169
6.3.	Detalles del cálculo y mejoras al modelo	177
6.3.1.	Disipación en función de la temperatura	177
6.3.2.	Mejoras al modelo sencillo	177
7.	Predicciones del modelo de calentamiento	183
7.1.	Predicciones del modelo y comparación con los experimentos	184
7.1.1.	Variación del valor de J^* en función de la duración de la medida	184
7.1.2.	Variación de la potencia disipada previa al salto W^* con la temperatura y el campo	200
7.1.3.	Curvas características $E-J$ afectadas de calen- tamiento	201
7.1.4.	Variación de la corriente de salto J^* con la temperatura	205

7.1.5. Correlación entre potencia disipada y aumento de temperatura	207
7.2. Condición de avalancha térmica	211
8. Resumen y conclusiones de la parte I	229
8.1. Resumen	229
8.1.1. Del experimento	229
8.1.2. Del análisis	231
8.1.3. Del modelo de calentamiento en avalancha . . .	233
8.2. Conclusiones	235
8.3. Líneas de continuación	236
 Parte II Paraconductividad: tiempos de relajación y altas temperaturas reducidas	 239
9. Introducción a la parte II	241
9.1. Definición de paraconductividad	241
9.2. Medida experimental	243
9.2.1. Determinación y errores	243
9.2.2. Resolución experimental	245
 10. Resultados y conclusiones de la parte II (separatas de los artículos publicados)	 251
 Apéndice	 289
A. Herramientas de edición y cálculo	291
A.1. Herramientas de edición	291
A.2. Cálculos con <i>Mathematica</i>	292
 Bibliografía	 311
 Índice de tablas	 321

<i>ÍNDICE GENERAL</i>	13
-----------------------	----

Índice de figuras	323
-------------------	-----

Agradecimientos	331
-----------------	-----

Lista de publicaciones	333
------------------------	-----

Índice alfabético	335
-------------------	-----

Summary in English

Part I

Some of the most interesting properties of high temperature superconductors (HTSC), both from the fundamental and applied points of view, are those associated with the electrical transport. Since the discovery, in 1986, of these materials [1], such properties have been intensively studied, and nowadays many of the mechanisms and phenomena implied in electrical transport are known and understood [2, 3].

Nevertheless, there still remain some important unanswered questions about these properties. Among them are the phenomena that occur in the mixed state at high current density, above the critical current $J_c(T, H)$ —where dissipation appears without destroying superconductivity— up to the current density $J^*(T, H)$ where the material transits to the normal state, usually in an abrupt jump. In figure 1 a schematic diagram of a typical E – J characteristic curve of a superconducting $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (Y-123) is shown. To give some orders of magnitude, let us say that in a good quality Y-123 thin film, while J_c is about 10^6 A/cm² at zero applied magnetic field, J^* can be one order of magnitude larger, depending on temperature. In good samples —without stoichiometrical or structural defects that could generate weak links between different parts of the sample— the physical origin of J_c is now clearly related to the depinning and movement of magnetic vortices. (At zero applied field, these vortices are those created by

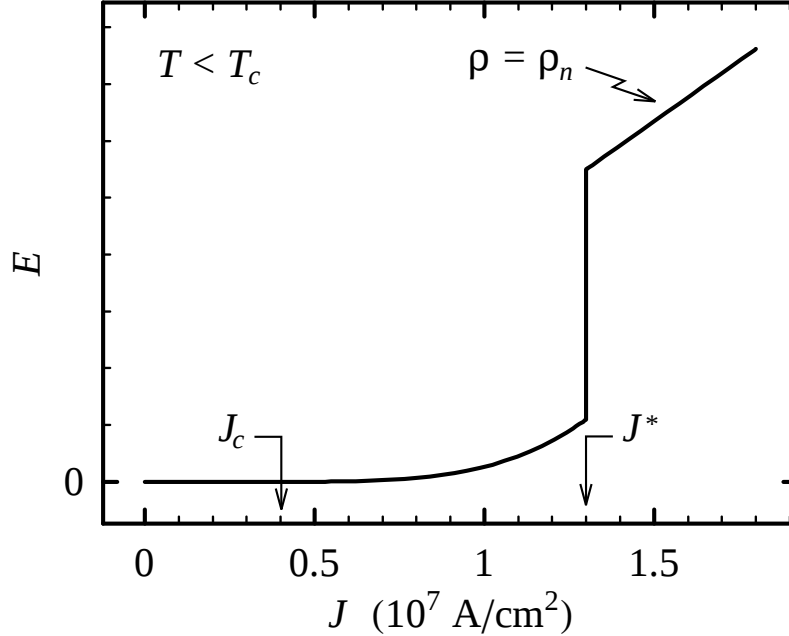


Figure 1: Schematic diagram of a typical E - J curve for a $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ superconductor at $T < T_c$. Below the *critical current* J_c the vortices are pinned or do not exist, there is no dissipation, and resistivity is zero. Above J_c the vortices move and dissipation appears. At J^* the sample abruptly transits to the normal state: the jump in resistivity can be larger than that shown in this diagram.

the self-field of the injected current [4, chap. 9]). However, on the contrary, the mechanisms that originate J^* are still not so clear.

This abrupt destruction of superconductivity at high current density was already observed in metallic, low critical temperature superconductors [5], but the interest of its study considerably grew since the discovery of HTSC [6, and references therein]. This is due, primarily, to the relevance of the physical mechanisms possibly implied: high speed vortex flow, breakage and electrical saturation of domain junctions, hot-spot propagation, avalanches and thermal interchange, and other possible processes of superconductivity destruction. Furthermore, the studies around J^* are also interesting from the practical point of view for the design of devices exploiting the

superconducting transition, like current limiters, bolometric detectors or ultra-fast switches.

During the last years, various laboratories—including our group—have studied the transition at J^* in HTSC [5, 7–10]. In our laboratory, these studies begun with the Ph.D. Thesis of Dr. Severiano R. Currás, submitted in 2000 [11], which may be considered as the *local* precedent of our present work, as well as of the studies also carried on by M.T. González in the case of bulk textured HTSC [12–14]. However, in spite of these important affords, the behaviour and the physical origin of $J^*(T, H)$ in HTSC are still not well settled. As a continuation of these studies, the central motivations of the present work were:

i) To study in depth the causes of the jump, using faster devices to permit detailed measurements of the phenomena that occur around J^* . In particular, in a typical transition in a Y-123 thin film, at 77 K and zero applied magnetic field, the resistivity has been observed to increase by a factor of several hundreds in less than 10 μ s, which is the time resolution of our experimental setup. The electronic devices used in the present work are more that 1000 times faster than in the studies of S. R. Currás, where the time resolution was about 30 ms. Although our measurement time does not allow a complete discrimination of the full jump, it is fast enough to observe the footpoint of the transition close to J^* , which, in particular, will let us study the influence of the length of current pulses.

ii) Improve understanding of the role of the magnetic vortices around J^* . For that, we made studies with low applied magnetic field, from the order of the self-field (typically $\mu_0 H = 10^{-2}$ T) up to $\mu_0 H = 1$ T. This is a region of fields still little explored in the bibliography [7, 15–17], but that can give relevant information about the causes of the transition.

iii) Study the influence of thermal effects. The superconducting transition is strongly affected by apparently small changes in temperature, which can happen even under excellent refrigeration conditions. In the instant just before the jump, the dissipated power

density $W^* = E^* \times J^*$ in our samples is typically about 10^7 W/cm³. We will analyze if this generated heat can affect the transition observed in J^* .

In the experimental work we have made use of microbridges patterned on YBa₂Cu₃O_{7- δ} thin films, made in our laboratory. These films were sputtered over crystalline substrates of SrTiO₃. The main advantage of these samples is, apart from their good quality, their small size —typically $150\text{ nm} \times 10\text{ }\mu\text{m}$ in cross section and $50\text{ }\mu\text{m}$ long. On the one hand, due to the reduced cross section, it is easy to reach high current density applying low absolute currents. On the other hand, as a result of the large surface/volume ratio and the fact that they have a good thermal contact with the substrates, the heat removal is appreciably better than in other kinds of sample.

The analysis of the thermal interchanges between microbridges and their environment, essentially the substrate, constitute a relevant and original part of this dissertation. In principle, to do this thermal analysis one could think of solving the heat conduction equation. Due to the complexity of the system, however, the detailed solution becomes difficult even by numerical methods. In this work we propose a simplified model to describe the thermal evolution of our samples, based on elementary concepts. This model will allow us to show that the thermal processes that take place at high current density could explain, even quantitatively, some of the essential aspects of the behavior of the E – J curves close to J^* . In particular, our model, despite its simplicity, addresses two of the main and more frequent arguments against considering thermal effects as the fundamental cause of the transition to the normal state in the regime of high current density.

The first argument is the universal dependance of $J^*(\varepsilon) \propto \varepsilon^{3/2}$ [15], being $\varepsilon \simeq 1 - T/T_c$ the denominated *reduced temperature*. Until now there were no models essentially based in heating around J^* that could account for this dependance. We will show that our thermal model can explain it.

A second argument used to discard the thermal origin of J^* is that the dissipated power right before the jump $W^* = E^* \times J^*$ augments when the applied magnetic field is increased [8, 18, 19]. This behavior seems to be paradoxical if one attributes the transition to heat and supposes that the temperature of the sample is increased up to above T_c . It is well known that applying a magnetic field has the effect of decreasing the critical temperature T_c : being the sample at a given temperature, if we increase this field, we also *thermally* approximate the sample to the transition. Why would we need then, to raise the temperature above T_c , more dissipation W^* the closer to T_c ? In principle, if the cause of the jump were the heat, one would expect the necessary power to provoke the transition to decrease with the applied field or, in any case, to be independent of it [8]. Although less frequently, in some samples this increase of the power W^* was also observed when directly raising the temperature [10, 20], not only the applied field. The thermal model that we introduce solves this apparent paradox; we will see that not only the value of the power W is relevant to provoke a thermal avalanche, but also that we need to include its derivative with temperature dW/dT . At equal values of dissipated power, this derivative can be smaller close to $T_c(H)$.

Our model of avalanche heating will explain the existence of J^* , and its dependance on T and H , appealing only to a purely thermal (extrinsic) mechanism. As will be shown, our proposal does not exclude the implication, in the transition to the normal state induced by a current, of other intrinsic mechanism (like Cooper pair depairing, or a change in the regime of the vortex flow). Nevertheless, even when these other intrinsic mechanisms are present, our results suggest that the *cascade heating* must play an important role both in the measured values of J^* and in its dependance on T and H .

Part II

The second part of this dissertation summarizes the studies about the influence of thermal fluctuations above T_c on the electrical conductivity (paraconductivity) of the superconducting cuprates. This summary is made gathering the publications of our lab (LBTS) in which the author of this dissertation has participated.

In the two first publications, the relaxation time of the fluctuating Cooper pairs will be studied. In the three following papers, we study the behaviour of the paraconductivity at *high* reduced temperatures, for $\varepsilon \equiv \ln(T/T_c) \gtrsim 0.1$. The main result of this last study is the suggestion that at high reduced temperatures the superconducting fluctuations are dominated by the Heisenberg uncertainty principle, that limits the *shrinkage* of the superconducting wave function when T increases above T_c .

The contributions of the author of this dissertation to the mentioned studies are, mainly, the measurements of resistivity as a function of temperature, the extraction of the paraconductivity from these measurements, and the analysis of the experimental errors and uncertainties associated with the estimations of the background and the critical temperature.

General outline

The present work is divided in two parts. The **first part**, from chapter 1 to 8, studies the transition from superconducting to normal state that takes place in the regime of high current density, in type-II superconductors.

Chapter 1 gives a detailed introduction to the phenomenon of the transition to the normal state induced by high current density, in high temperature superconductors. It is an extension of what was exposed in the previous Summary.

Chapter 2 describes how we synthesized and characterized the samples used in the experiments of this work. We used $10\text{ }\mu\text{m}$ wide and 20, 50 and $100\text{ }\mu\text{m}$ long microbridges, patterned by chemical wet photolithography on 150 nm $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ thin films. These films were synthesized by DC sputtering over 1 cm^2 SrTiO_3 substrates. For characterization we used x-ray diffractometry (XRD), profile meter, and atomic force microscopy (AFM). We applied low resistance electrical contacts by ultrasonic microsoldering.

Chapter 3 describes the experimental setup used for the measurements, and comments its advantages over former setups in our laboratory. We used a cryostat refrigerated with liquid nitrogen with samples in helium atmosphere. Magnetic field up to $\mu_0 H = 1\text{ T}$ was applied by surrounding coils. Current was

injected in the sample by a programmable current source, and voltage was measured with a nanovoltmeter —for low signals— and a data acquisition card (DAQ) —for fast measurements in the high dissipation regime—.

Chapter 4 shows the different experimental data acquired, and studies some of the thermal properties of the system.

Chapter 5 analyses in detail the previous data, and makes a review of some of the theoretical models that have been proposed to explain the results. The effect of the self-field in the regime of low applied magnetic fields is considered.

Chapter 6 proposes a simple model to describe the thermal behavior of our samples, based in the feedback that the increase of temperature causes in the dissipation, and in the temperature distribution that the heat removal produces in the substrate. Both elements can generate, under certain circumstances, a thermal avalanche that increases the temperature of the sample above the critical temperature in short periods of time, causing the sample to transite to the normal state.

Chapter 7 compares the predictions of the model proposed in chapter 6 with the experimental data, and suggests an avalanche condition derived from our thermal model. This chapter shows how, despite the simplicity of the model, it can explain, quite accurately, the main phenomena observed around the transition to the normal state at high current density. This will lead to the conclusion that the thermal effects can have special relevance in the mechanisms that break superconductivity in this current regime.

Chapter 8 summarizes the main conclusions of this first part.

The **second part** gathers the main results of the study of the paraconductivity (excess of electrical conductivity due to thermal

fluctuations) in the regime of high temperature, in which the author of this dissertation was participant during his doctorate period.

Chapter 9 makes a brief introduction to this second part explaining the importance of fluctuation effects in HTSC, and considers some experimental details related to the measurement of paraconductivity.

Chapter 10 collects the publications of our laboratory about this topic where the author has participated. The main contributions were the experimental measurements of paraconductivity in different thin films, and data analysis.

At the end,

Appendix A explains how some of the calculations and graphics of this dissertation were done, what could be of interest for those who want to continue or revise these works.

Términos clave - Keywords

Superconductividad; $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (YBCO, Y-123); capas delgadas, filmes o películas superconductoras; alta densidad de corriente; transición superconductor-normal; avalancha o cascada; realimentación; dinámica de vórtices magnéticos; efectos térmicos; autocalentamiento; inestabilidad Larkin-Ovchinnikov del movimiento de vórtices.

Superconductivity; $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (YBCO, Y-123); superconducting thin films; high current density; superconducting-normal (SN) transition; avalanche, quench; feed-back; magnetic vortex dynamics; thermal effects; self-heating; Larkin-Ovchinnikov (LO) flux flow instability.

Notación

a Ancho del micropuente.

α Factor geométrico para corregir la distribución de temperatura dentro de v_s .

$B = \mu_0 H$ Densidad de flujo magnético aplicado.

B_{sf} Autocampo, densidad de flujo magnético generado por la corriente aplicada.

c_p Capacidad calorífica por unidad de volumen, a presión constante.

$D = \kappa/c_p$, difusividad térmica.

d Espesor del filme.

ΔT_{ci} Anchura de la transición superconductora en $\rho(T)$, determinada como la anchura a mitad de altura de la derivada $d\rho/dT$.

$\Delta\sigma = 1/\rho - 1/\rho_{bg}$, paraconductividad: exceso de conductividad eléctrica en el estado normal debido a fluctuaciones termodinámicas.

E Campo eléctrico, determinado experimentalmente como $E = V/l$.

E^* Valor del campo eléctrico en el momento del salto, en J^* .

E – J Curva característica campo eléctrico – densidad de corriente.

$\varepsilon \equiv \ln(T_c/T) \simeq 1 - T/T_c$, temperatura reducida. En el estado normal, donde $T > T_c$, la definición cambia de signo.

H Campo magnético.

h Coeficiente de transferencia de calor entre filme y sustrato.

H_{sf} Autocampo magnético generado por la corriente aplicada.

I Intensidad de corriente.

I^* Intensidad de corriente en que se produce el salto al estado normal.

J Densidad de corriente, establecida experimentalmente como $J = I/(ad)$.

J_c Densidad de corriente crítica, en la que aparece disipación medible dentro del estado mixto (umbral en campo E).

J_c^{pin} Densidad de corriente crítica en la que los vórtices salen de sus anclajes (umbral en velocidad v).

J_d Densidad de corriente de desapareamiento de los pares de Cooper.

J^* Densidad de corriente en que se produce el salto al estado normal.

κ Conductividad térmica.

l Longitud del micropuente, distancia entre contactos de voltaje.

$P = W v_f$, potencia total disipada en el filme.

$P^* = W^* v_f$, potencia total disipada en el momento del salto.

Q Calor total disipado en el filme.

$\dot{Q}$ Calor evacuado por unidad de tiempo desde la muestra a su entorno.

$r(t) \propto \sqrt{D t}$, distancia recorrida por el calor en un tiempo t .

$\rho \equiv E/J$, resistividad eléctrica.

ρ_{ab} Resistividad eléctrica en los planos ab del filme.

ρ_{bg} Resistividad eléctrica de fondo (*background*), en ausencia de transición superconductora.

ρ_n Resistividad eléctrica en el estado normal.

T Temperatura.

t Tiempo.

T_b Temperatura del baño.

T_c Temperatura crítica.

T_{c0} Temperatura más alta a la que $\rho(T) = 0$, a campo H aplicado nulo.

T_{ci} Temperatura en la que $\rho(T)$ tiene su punto de inflexión en la transición superconductora, determinada como el máximo de la derivada $d\rho/dT$.

T_f Temperatura del filme.

T_s Temperatura promedio del volumen $v_s(t)$.

$\tau_B = \frac{C_p d}{h}$, tiempo bolométrico de enfriamiento.

$\tau_\epsilon = (\tau_{ee}^{-1} + \tau_{ef}^{-1})^{-1}$, tiempo de relajación energética de los portadores superconductores.

τ_{ee} Tiempo de dispersión electrón-electrón.

τ_{ef} Tiempo de dispersión electrón-fonón.

τ_i Tiempo característico de inercia térmica de la muestra.

V Diferencia de potencial, voltaje.

$v = E/\mu_0 H$ velocidad de los vórtices.

$V-I$ Curva característica voltaje – corriente.

$v_f = l \times a \times d$, volumen del filme (micropuente).

$v_s(t)$ Volumen total que se ha calentado en un tiempo t , de micropuente más sustrato.

$W = E \times J$, potencia disipada por unidad de volumen.

$W^* = E^* \times J^*$, potencia disipada por unidad de volumen en el momento del salto.

Parte I

Corrientes supercríticas en filmes de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$

Capítulo 1

Introducción a la parte I

1.1. Contextualización del problema

1.1.1. Superconductividad

Superconductividad es un término que se refiere a un conjunto de propiedades especiales, eléctricas y magnéticas, que presentan algunos materiales cuando se enfrían hasta bajas temperaturas. Estas propiedades no fueron descubiertas hasta que los refrigerantes criogénicos permitieron, a principios del siglo XX, disminuir la temperatura en los experimentos hasta los valores requeridos para su observación. En 1908, el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes, en la universidad de Leiden, logró la licuefacción del helio, y obtuvo de este modo un refrigerante que le permitió estudiar diversas propiedades físicas de la materia hasta temperaturas tan bajas como 1 K ($-272\text{ }^{\circ}\text{C}$). Tres años más tarde, estudiando el comportamiento del mercurio en esta región de temperaturas, descubrió que su resistividad eléctrica en corriente continua caía bruscamente a cero por debajo de 4.15 K [21]. Éste fue el primer experimento en que se apreciaban los sorprendentes efectos de la superconductividad. En los años siguientes fue descubriendo diversos mecanismos que destruían este estado de

resistencia nula, como la aplicación de corrientes eléctricas o de campos magnéticos excesivamente elevados. Por sus investigaciones en el régimen de bajas temperaturas, Kamerlingh Onnes recibió el Premio Nobel de Física en 1913.

Durante mucho tiempo se creyó que, a parte de esta ausencia de resistencia eléctrica a temperaturas muy bajas, las restantes propiedades físicas de estos materiales eran las comunes a los materiales normales. Pero en 1933 se descubrió que en realidad los superconductores presentan no sólo una conducción eléctrica perfecta, sino también un diamagnetismo perfecto. Un simple conductor ideal lograría mantener la densidad de flujo magnético *constante* en su interior, debido a las corrientes que se inducirían en su superficie sin coste energético alguno: las variaciones de campo externo se verían compensadas por las corrientes inducidas. Pero un superconductor hace más que eso: no sólo mantiene la densidad de flujo constante en su interior, sino que además este valor constante es siempre cero. Si aplicamos campo magnético a una muestra de este tipo cuando está en el estado normal —a temperatura elevada, por encima de la temperatura crítica T_c —, y posteriormente la enfriamos hasta $T < T_c$ para hacer que transite al estado superconductor, todo el flujo magnético será expulsado de su interior. El campo magnético queda restringido a una delgada capa superficial, donde es apantallado por las corrientes inducidas en una longitud de penetración λ , característica del material [22]. Este fenómeno se conoce como efecto Meissner-Ochsenfeld [23].

Con el paso de los años, y en paralelo a un trabajo de análisis de materiales que aumentaba sucesivamente el listón de temperatura crítica T_c de la transición superconductora —como ejemplos, 4.1 K en 1911 (Hg), 9.2 K en 1930 (Nb), 18.1 K en 1954 (Nb₃Sn), 23.2 K en 1973 (Nb₃Ge) [4, cap. 2]—, se avanzaba también parcialmente en la comprensión de los mecanismos físicos responsables de estas novedosas propiedades de la materia [22, 24]. Por el momento, la mejor interpretación de los mecanismos microscópicos que originan

la superconductividad se la debemos a J. Bardeen, L. Cooper y J. R. Schrieffer, que en 1957 publicaron la teoría hoy conocida como BCS [25], que dio a sus autores el Nobel de Física en 1972. En el contexto de esta teoría, las partículas portadoras de *supercorriente* son pares de Cooper [26], parejas de electrones normales ligados entre sí, que al ser bosones (*spin* entero) conforman estados de alta coherencia. En la interacción que mantiene ligados a los electrones median los átomos de la red cristalina: esquemáticamente, el paso de un electrón cerca de un átomo desplaza a éste ligeramente de su posición de equilibrio, y esta distorsión de la red influye en un segundo electrón, cuyo momento lineal se ve alterado, ligándose de este modo al primero. La distribución de energías de estos electrones no es uniforme, existe una separación (*gap*) en energía entre los estados normal y superconductor.

En 1986, J. G. Bednorz y K. A. Müller publicaron un artículo titulado *Possible High T_c Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System* [1], que dio pie a la síntesis de nuevos materiales superconductores, basados en óxidos de cobre, con temperaturas críticas cada vez más elevadas: son los superconductores de alta temperatura, conocidos por sus siglas anglosajonas como HTSC. Pronto, en 1987, se superó el umbral de la temperatura del nitrógeno líquido a presión atmosférica (unos 77 K, -196°C), que es un refrigerante mucho más barato, eficiente y cómodo de manejar que el helio líquido, con lo que el campo de investigación y las aplicaciones prácticas de la superconductividad se hicieron mucho más amplios. La progresión de los valores de T_c a partir de ese momento tiene como ejemplos los siguientes hitos: 30 K en 1986 ($\text{Ba}_x\text{La}_{5-x}\text{Cu}_5\text{O}_y$), 92 K en 1987 ($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$), 110 K en 1988 ($\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$), 133 K en 1993 ($\text{HgBa}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{8+x}$) [4, cap. 2]. El $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (abreviado YBCO o Y-123) sigue siendo uno de los HTSC más estudiados en la actualidad.

1.1.2. Estado mixto

Conforme se avanzaba en el conocimiento de estos materiales, se descubrió que existen dos tipos de superconductores con propiedades eléctricas y magnéticas diferentes. En los superconductores de tipo I, el efecto Meissner-Ochsenfeld impide que el flujo magnético B penetre en el interior de la muestra mientras ésta permanezca en estado superconductor. En superconductores de tipo II —de los que los HTSC forman parte destacada—, por el contrario, resulta energéticamente favorable, a partir de que aplicamos un cierto campo o una cierta corriente (la cual genera siempre un *autocampo* magnético B_{sf}), la aparición de vórtices magnéticos [27] en el interior de la muestra antes de que se rompa del todo la superconductividad: es el estado mixto [28, cap. 12]. Esto permite que el flujo magnético (ya sea el externo aplicado B o el autocampo B_{sf}) penetre más allá de la superficie, alcanzando mayor proporción de volumen, aunque siempre localizado dentro de esos vórtices. En una imagen sencilla, la mayor parte del volumen de la muestra permanece en estado superconductor, y aparecen muchos *tubos* delgados que la atraviesan, con núcleos en estado normal, que permiten el paso del campo magnético a su través. En cada vórtice hay exactamente un cuanto de flujo magnético,

$$\Phi_0 = \frac{hc}{2e} \simeq 2 \times 10^{-11} \text{ T cm}^2. \quad (1.1)$$

Cuanto más campo aplicado se tenga o mayor sea la corriente inyectada en la muestra, más vórtices se crean. Mientras los vórtices puedan permanecer anclados (ya sea en defectos de la red cristalina, en puntos de dopaje, o en general en cualquier pozo de potencial) no se producirá disipación, y el estado mixto seguirá implicando un voltaje nulo al paso de corriente. Pero en el momento en que las fuerzas de Lorentz, a que están sometidos los vórtices por la aplicación de la corriente eléctrica, venzan esos pozos de potencial, los vórtices comenzarán a moverse, generando un campo eléctrico paralelo a la corriente aplicada, y en su mismo sentido. Aparece así disipación, y mantener dicha corriente exige mantener una diferencia de potencial a

lo largo de la muestra. Para una profusa revisión del comportamiento de los vórtices en el estado mixto, remitimos a la referencia [29].

La densidad de corriente a la que comienza a verse experimentalmente esta disipación suele denominarse *densidad de corriente crítica*, y se representa por J_c . En su determinación experimental, normalmente se establece que es aquella en la que se supera un cierto umbral en el campo eléctrico E medido. Este umbral es, por supuesto, todo lo pequeño que la resolución permita. J_c no es, por tanto, la densidad de corriente que destruye la superconductividad, sino la que empieza a generar disipación mensurable, manteniéndose la muestra en el estado mixto.

En estas muestras de tipo II podemos seguir aumentando la corriente por encima de J_c y detectar distintas tendencias del movimiento de los vórtices, siempre dentro del estado mixto. El tipo de movimiento más elemental de los vórtices es, por ejemplo, el *free flux flow* [30], en que la velocidad v de los vórtices es proporcional a la corriente aplicada J , y por lo tanto también lo es el campo $E = v B$ que se mide a B aplicado constante. Las curvas características E - J (curvas V - I escaladas a las dimensiones de las muestras), a grandes rasgos, tienen valor cero hasta J_c y son una línea recta por encima de esta corriente [28, cap. 13].

Estas curvas características pueden ser más complejas debido a diversos mecanismos. Por ejemplo, en los superconductores de alta temperatura crítica T_c pueden estar involucrados efectos térmicos que hagan que se aprecie disipación incluso antes de que las fuerzas de Lorentz desplacen a *todos* los vórtices de sus centros de anclaje. La energía térmica crearía fluctuaciones locales que arrancarían a uno o más vórtices de su lugar y, dependiendo de las interacciones entre vórtices, se tendrían así diversas posibles señales de voltaje experimental [31, cap. 9]. Esto es lo que ocurre por ejemplo en el *flux creep*, donde la variación de E con J ya no es lineal, sino curva. Pero en estas y otras variantes de la linealidad la muestra sigue en el estado mixto.

1.1.3. Transición al estado normal inducida por corrientes altas

En estos superconductores de tipo II, si seguimos aumentando la corriente aplicada muy por encima de J_c llegamos a observar experimentalmente una ruptura brusca del estado mixto. Si J supera un cierto umbral de corriente J^* (siendo ésta hasta un orden de magnitud mayor que J_c) se induce una transición abrupta de toda la muestra a un estado de alta disipación, que suele identificarse con el estado normal. El correspondiente salto en resistividad aparente $\rho = E/J$ es típicamente de dos órdenes de magnitud. Esta transición se observa en todos los superconductores de tipo II, tanto en los de alta como en los de baja T_c [5, 7, 8, 17, 32, 33]. En este trabajo nos referiremos frecuentemente a esta transición abrupta al estado normal llamándola simplemente *el salto en J^** .

En la figura 1.1 se muestra un esquema de las curvas E – J de un $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (Y-123) superconductor. Por encima de J_c la variación del campo E con la corriente J no es lineal sino curva, típica del *flux creep*. Para dar órdenes de magnitud digamos que, en una capa delgada de Y-123, si J_c ronda los 10^6 A/cm² en ausencia de campo magnético externo, J^* puede llegar a ser un orden de magnitud mayor, dependiendo de la temperatura. Así como en buenas muestras —sin defectos estequiométricos o estructurales, que podrían generar uniones débiles entre diferentes partes de la muestra— el origen físico de J_c está claramente vinculado al desanclaje y movimiento de los vórtices magnéticos, no está tan claro qué mecanismo induce el fenómeno observado en J^* . Las causas de esta transición abrupta en J^* podrían ser diversas, incluso variar de una muestra a otra o de un tipo de material a otro. En los últimos veinticinco años se han considerado varios modelos que explicarían este salto al estado normal. En general se enmarcan en dos grandes conjuntos.

En un primer grupo de modelos, la causa de la transición en J^* se busca también en el movimiento de los vórtices. Análogamente a como

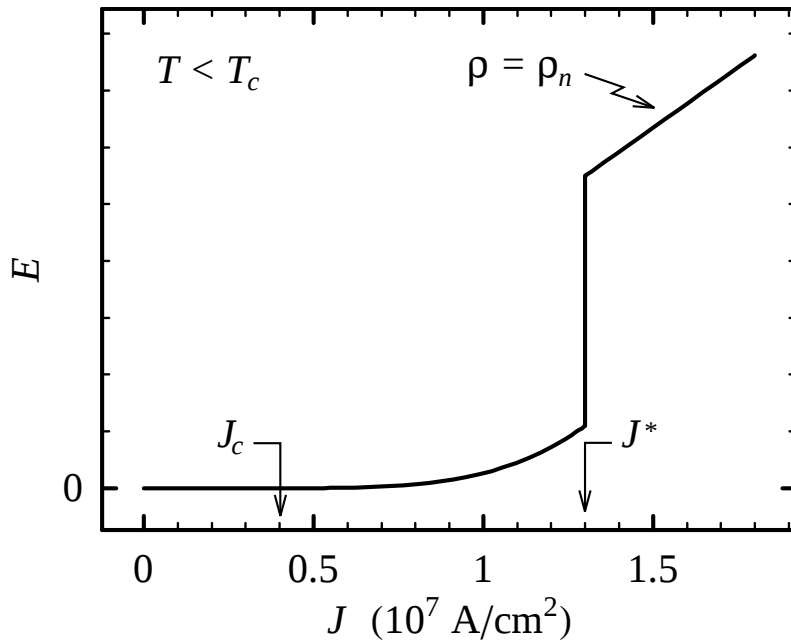


Figura 1.1: Representación esquemática de una curva E - J típica de un $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ superconductor a $T < T_c$. El eje vertical (el campo eléctrico) no está proporcionado con el horizontal, para que se puedan apreciar los distintos regímenes de transporte. Por debajo de la *corriente crítica* J_c los vórtices permanecen anclados o no existen, no hay disipación, y la resistividad es cero. Por encima de J_c los vórtices se mueven, y aparece disipación: la resistividad aparente es mayor que cero. Por encima de J^* la muestra transita al estado normal. La transición en J^* es abrupta, y el salto en resistividad puede ser mucho más grande de lo que se representa en este esquema (ver texto).

en J_c dicho movimiento sufre un cambio de régimen (ya sea porque se pasa del reposo al movimiento, o porque se produce un movimiento global más intenso que los previos locales), en J^* se produciría un cambio de comportamiento de los vórtices al moverse.

En el otro gran grupo de modelos están los que explican la transición exclusivamente con calentamiento. Se basan en la idea de que la muestra ve elevada su temperatura por encima de T_c destruyéndose así la superconductividad.

Los distintos modelos, dentro de uno u otro grupo, describen diversos posibles mecanismos para explicar cómo es y qué causa la transición. Nos referiremos a varios de ellos en el capítulo 5. Sin que encaje claramente en alguno de estos dos grupos previos, tampoco se debe olvidar la posibilidad de que J^* coincida con la corriente de desapareamiento J_d de los pares de Cooper. Esta corriente J_d es la que imprime tanta energía cinética a los pares de Cooper que la existencia de estos se vuelve desfavorable energéticamente respecto a la de los electrones normales disociados ([31, sec. 4.4] y [4, sec. 10.XIX]). De ser esta la causa, el fenómeno sería mucho más intrínseco que cualquiera de los anteriores, e impondría una cota superior infranqueable a la corriente máxima que la muestra puede transportar.

1.2. Objetivos de este trabajo

Este comportamiento de las curvas $E-J$ que se ha descrito se observó ya en los superconductores metálicos de baja temperatura crítica [5], pero el interés de su estudio se ha acrecentado desde el descubrimiento de los HTSC¹. Esto se debe en primer lugar a la relevancia de los posibles mecanismos físicos implicados: movimiento de vórtices a grandes velocidades, ruptura y saturación eléctrica de uniones entre dominios, propagación de puntos calientes, avalanchas

¹A modo de ejemplo, la referencia [6] es un artículo muy reciente en el que se relaciona la bibliografía más destacada.

e intercambios térmicos, y otros posibles mecanismos de destrucción de la superconductividad. Además, los estudios en torno a J^* son también interesantes desde el punto de vista aplicado, para el diseño de dispositivos basados en la transición superconductora, como limitadores de corriente, detectores bolométricos o conmutadores ultrarrápidos.

Durante los últimos años, varios laboratorios —incluido nuestro grupo— han estudiado la transición en J^* en HTSC [5, 7–10]. En nuestro laboratorio estos estudios se iniciaron con la tesis doctoral de Severiano R. Currás, defendida en el 2000 [11], que se puede considerar como el precedente *local* del presente trabajo, así como del que está llevando a cabo M.T. González en el caso de superconductores texturados masivos [12–14]. En cualquier caso, a pesar de estos esfuerzos, el comportamiento y el origen físico de $J^*(T, H)$ en HTSC no están todavía bien establecidos. Como continuación de estos estudios, la motivaciones principales del presente trabajo fueron:

i) Profundizar en las causas del salto haciendo medidas con dispositivos electrónicos más rápidos, que permitiesen apreciar con más detalle los fenómenos que ocurren en torno a J^* . Apuntemos que en una transición típica de una película de Y-123, a 77 K y sin campo magnético aplicado, la resistividad aparente puede aumentar en un factor de varios cientos en menos de $10\ \mu\text{s}$, que es la resolución temporal de nuestros dispositivos. La electrónica empleada en el presente trabajo es más de mil veces más rápida que la empleada en los trabajos de S. R. Currás, en los que la resolución temporal era de unos 30 ms. Si bien nuestros tiempos de medida tampoco permiten una discriminación completa de todo el salto, son lo suficientemente rápidos como para observar el arranque de la transición cerca de J^* , lo que en particular nos permitirá estudiar la influencia de la duración de los pulsos de corriente.

ii) Intentar conocer mejor el papel que desempeñan los vórtices magnéticos en torno a J^* . Para ello nos propusimos estudiar el salto con campos magnéticos aplicados bajos, desde del orden del

autocampo (típicamente $\mu_0 H = 10^{-2}$ T) hasta $\mu_0 H = 1$ T. Esta es una región de campos todavía poco explorada en la bibliografía sobre el tema [7, 15–17], y que sin embargo puede aportar información relevante acerca de las causas de la transición.

iii) Estudiar la influencia de los efectos térmicos. La transición superconductora se ve fuertemente afectada por aparentemente pequeñas variaciones de temperatura, que se pueden originar incluso bajo excelentes condiciones de refrigeración. En el instante previo al salto la potencia disipada por unidad de volumen $W^* = E^* \times J^*$ en nuestras muestras ronda típicamente los 10^7 W/cm³. Analizaremos si este calor generado puede influir en la transición que se observa en J^* .

En nuestro estudio hemos empleado micropuentes grabados sobre capas delgadas de YBa₂Cu₃O_{7- δ} depositadas sobre sustratos cristalinos de SrTiO₃. Las principales ventajas de nuestras muestras, crecidas en nuestro laboratorio, se deben, además de a su buena calidad, a su reducido tamaño, típicamente de $150 \text{ nm} \times 10 \text{ }\mu\text{m}$ de sección por $50 \text{ }\mu\text{m}$ de largo. Por un lado, en virtud de su sección tan pequeña, es fácil alcanzar altas densidades de corriente aplicando corrientes absolutas muy bajas. Pero además, gracias a su elevada relación superficie/volumen y a que tienen buen contacto térmico con el sustrato cristalino, la evacuación del calor es notablemente mayor que en otros tipos de muestras.

El análisis de los intercambios térmicos entre los micropuentes y su entorno, esencialmente el sustrato, constituye una parte muy relevante y original de esta tesis. Para hacer este análisis térmico en principio se podría emplear directamente la ecuación de conducción del calor, pero debido a la complejidad del sistema su resolución detallada se hace difícil incluso por métodos numéricos. En este trabajo propondremos un modelo simplificado para describir la evolución térmica de nuestras muestras basado en conceptos muy elementales. Este modelo nos permitirá mostrar que los procesos térmicos que tienen lugar a altas densidades de corriente podrían explicar, incluso cuantitativamente, algunos de los aspectos esenciales

del comportamiento de las curvas E – J en las cercanías de J^* . En particular, podemos mencionar ya aquí que nuestro modelo térmico, a pesar de su sencillez, da respuesta a dos de los principales y más habituales argumentos empleados en contra de que los efectos térmicos sean la causa esencial de la transición al estado normal en el régimen de altas densidades de corriente.

El primer argumento es el comportamiento universal de $J^*(\varepsilon) \propto \varepsilon^{3/2}$ [10, 15], siendo $\varepsilon \simeq 1 - T/T_c$ la denominada temperatura reducida. Hasta el momento no había un modelo basado esencialmente en el calentamiento alrededor de J^* que diese cuenta de esta dependencia. Veremos que nuestro modelo térmico sí puede explicarla.

Un segundo argumento empleado para descartar el origen esencialmente térmico de J^* es que la potencia disipada justo antes del salto $W^* = E^* \times J^*$ aumenta cuando se incrementa el campo magnético aplicado [8, 18, 19]. Este comportamiento resulta paradójico si se piensa en el calor como causa de la transición, y se supone por tanto que la temperatura de la muestra aumenta hasta por encima de T_c . Es conocido que aplicar campo magnético tiene el efecto de disminuir la temperatura crítica T_c : con la muestra a una temperatura dada, si aumentamos el campo aproximamos *térmicamente* la muestra a la transición. ¿Por qué, entonces, para elevar la temperatura por encima de T_c habríamos de necesitar más calor W^* cuanto más cerca de T_c ? En principio, si lo que induce el salto fuese el calor, se podría esperar que la potencia necesaria para causar la transición disminuyese con el campo aplicado o, en todo caso, fuese independiente de él [8]. Aunque con menos frecuencia, en algunas muestras este aumento de la potencia W^* también se ha observado al aumentar directamente la temperatura [10, 20], no sólo el campo aplicado. El modelo térmico que proponemos resuelve esta aparente paradoja: veremos que no sólo el valor de la potencia W es relevante para causar una avalancha, sino que tenemos que implicar también a su derivada con la temperatura dW/dT . A igualdad de potencia disipada, esta derivada puede ser menor más cerca de $T_c(H)$.

Nuestro modelo de calentamiento permitirá explicar la existencia de J^* , y su dependencia respecto de T y H , invocando sólo un mecanismo puramente térmico (extrínseco). Como veremos, nuestra propuesta no excluye que en la transición al estado normal inducida por una corriente *supercrítica* estén también involucrados mecanismos más intrínsecos (desapareamiento de pares de Cooper, cambio de régimen del movimiento de vórtices...). Sin embargo, incluso en el caso de que dichos mecanismos intrínsecos estén presentes, nuestros resultados sugieren que el *calentamiento en cascada* debe de desempeñar un papel importante tanto en los valores de J^* medidos como en su dependencia respecto de T y H .

Capítulo 2

Síntesis, caracterización y preparación de las muestras

Las muestras que se emplearon para los experimentos del presente trabajo se elaboraron en este Laboratorio de Baixas Temperaturas e Superconductividade. Son capas delgadas de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ crecidas por pulverización catódica sobre sustratos monocristalinos de SrTiO_3 . En estas películas superconductoras se grabaron micropuentes con configuración de cuatro contactos en línea, para medidas de voltaje a cuatro hilos. Las dimensiones típicas de los micropuentes son de $150 \text{ nm} \times 10 \text{ }\mu\text{m}$ de sección por $50 \text{ }\mu\text{m}$ de largo.

Además de tener buena calidad, ser muy homogéneas y con temperaturas críticas rondando los 90 K, las principales ventajas de este tipo de muestras se encuentran, a los efectos de los experimentos que realizamos, en su reducido tamaño. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, debido a la pequeñez de su sección es fácil alcanzar altas densidades de corriente aplicando corrientes absolutas muy bajas. Inyectando en el micropuente 50 mA, por ejemplo, se alcanza una densidad de corriente superior a $3 \times 10^6 \text{ A/cm}^2$. Además, debido a la elevada relación superficie/volumen que tienen, de casi $7 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$, y a que además presentan buen contacto térmico con el sustrato cristalino, la evacuación del calor en estos filmes es notablemente

mayor que en otros tipos de muestras. Veremos que los efectos térmicos tienen un papel muy importante en la región de altas densidades de corriente, donde la disipación es elevada, así que optimizar la refrigeración es una de los requisitos esenciales en estos experimentos.

2.1. Síntesis de muestras mediante pulverización catódica

La pulverización catódica (*sputtering*) es una técnica de crecimiento de materiales en la cual se extraen átomos de la superficie de un blanco, mediante el bombardeo con iones de un plasma gaseoso. El blanco es normalmente una pastilla policristalina con la misma composición estequiométrica que el material que se pretende crecer. Los átomos de este blanco, arrancados poco a poco, se condensan sobre un sustrato cristalino, y se va construyendo así una película delgada con alto grado de ordenación. El sustrato y el material que sobre él se crece deben tener parámetros de red cristalina lo más parecidos posible.

Nuestras muestras se crecieron por pulverización catódica DC reactiva, con disposición de blanco y sustrato alineados en el mismo eje vertical, y con oxigenado inmediato en el propio banco (técnica *in situ*). Explicamos qué significa todo esto:

La pulverización catódica DC aplica un voltaje continuo entre los electrodos que generan la descarga del plasma. En nuestro caso, el blanco es el cátodo, y es bombardeado por iones positivos de oxígeno. Estos iones, tras bombardear la superficie del blanco, se neutralizan y regresan al proceso como átomos neutros.

En general, que el proceso sea reactivo implica la presencia, en el gas de *sputtering*, de un gas que reacciona con el material que se crece, dopándolo o favoreciendo la formación de otro compuesto distinto. En nuestro caso, el propio gas de *sputtering* que empleamos



Figura 2.1: Banco de pulverización (*sputtering*) Plassys MP400 modificado. En primer plano, elevada sobre cuatro patas, la campana cilíndrica de deposición, con pequeñas mirillas laterales. Sobre ella, una gran campana prismática de metacrilato, que se dispuso para unas pruebas de aislamiento. En segundo plano, el ordenador de control y los dispositivos de alimentación y monitorización. Al fondo de todo, un compresor y un sistema de refrigeración. Hacia la derecha salen los tubos que llevan a la bomba de vacío primario y a las balas de gases.

es el que reacciona con el material, oxigenándolo. Así que la atmósfera empleada, en este caso, tiene doble función: por un lado genera el plasma que bombardea el blanco, pero por otro también reacciona con el material que se crece, mejorando sus propiedades.

A pesar de esta oxigenación, esta pulverización hace crecer el $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, con estructura tetragonal, no superconductora. Este crecimiento se hace a temperaturas entre 650 y 850 °C y con presión de O_2 entre 10^{-2} y 1 Torr. Tras el crecimiento, un proceso de oxigenación *in situ* permite alcanzar el dopaje óptimo de O_2 , y hace que la muestra transite a una fase ortorrómbica, ya superconductora. Este proceso se realiza manteniendo a la muestra a 600 °C durante media hora, con una presión de O_2 de 500 Torr. La rampa de descenso desde la temperatura de crecimiento hasta la de oxigenación es de 70 °C/min. Mientras se disminuye la temperatura, la presión de oxígeno se aumenta paulatinamente hasta los 500 Torr.

Hemos empleado el banco de pulverización comercial Plassys MP400 de que disponemos en nuestro laboratorio —que se muestra en la figura 2.1—, modificado para el crecimiento en alta presión ($\simeq 1$ mbar). Para una detallada descripción del banco y de las modificaciones que se realizaron recomendamos consultar la tesis doctoral de S. R. Currás [11]: gran parte de ese trabajo está dedicado a la puesta a punto y aplicación del banco que empleamos en nuestro laboratorio, y se recogen en esa memoria tanto una ilustrativa introducción a esta técnica de crecimiento como detalles prácticos de interés.

Los parámetros de crecimiento que dieron las mejores muestras (entre las que se encuentran las de esta memoria) son los que se muestran resumidos en la tabla 2.1.

Los datos experimentales que se muestran en este trabajo corresponden a las muestras cuyas características se recogen en la tabla 2.2. Las de peor calidad, con transiciones más anchas y con temperaturas críticas más bajas (como las muestras F y H), se emplearon en los experimentos en los que la muestra corría más riesgo

Cuadro 2.1: Principales parámetros del crecimiento por pulverización catódica de las películas empleadas en este trabajo.

Parámetro	Valor
Potencia de pulverización	~ 110 W
Corriente de pulverización	~ 400 mA
Distancia blanco-substrato	3 cm
Presión de O ₂ en crecimiento	1.5–2.0 Torr
Temperatura del substrato	830 °C
Substrato	SrTiO ₃ orientado (100)
Tamaño substrato	1×1 cm ² $\times$ 1 mm
Tiempo de crecimiento	2 h
Tiempo de oxigenación	30 min
Presión de oxigenación	500 Torr
Temperatura de oxigenación	600 °C

de destruirse debido al calentamiento, como caracterizaciones térmicas con pulsos muy largos o en regímenes de muy alta disipación (incluso en el estado normal). Otras muestras de mejor calidad (como las muestras A, D y G) se reservaron para las medidas más importantes y delicadas, las relativas a las variaciones de la corriente de salto con la temperatura y el campo. La determinación de los parámetros que se muestran en esta tabla 2.2 (extraídos de las medidas de resistividad en función de temperatura) se verá con detalle en el capítulo 4.

La primera caracterización se hace en cuanto la muestra sale del proceso de síntesis: tras aplicar contactos eléctricos con microsoldadura directamente sobre el filme, en sus cuatro esquinas (método Montgomery [34]), se hace una primera medida de la resistividad de la muestra en función de la temperatura, principalmente para apreciar si hay transición superconductora. Este método de medida de la resistividad, abarcando toda la muestra, hace que se manifiesten las inhomogeneidades¹ (estequiométricas, de espesor...) que ésta

¹Empleamos el término *inhomogéneo*, habitual en ciencia de materiales en

Cuadro 2.2: Relación de las muestras (M) empleadas en los experimentos de este trabajo, y sus alias en la nomenclatura de nuestro laboratorio. Sus parámetros característicos: longitud l del micropuente, presión P de crecimiento, temperatura de inflexión en la transición T_{ci} , ancho de la transición ΔT_{ci} , temperatura T_{c0} más alta con $\rho(T) = 0$, y resistividades ρ_{100} y ρ_{300} medidas a 100 K y 300 K. La muestra J no es superconductora debido a un percance sucedido durante el proceso de oxigenación. Los parámetros que se dejan en blanco no se midieron. Todos los micropuentes tiene un ancho $a = 10 \mu\text{m}$ y un espesor promedio $d \simeq 150 \text{ nm}$.

M	Alias	l μm	P Torr	T_{ci} K	ΔT_{ci} K	T_{c0} K	ρ_{100} $\mu\Omega \text{ cm}$	ρ_{300} $\mu\Omega \text{ cm}$
A	sys116(1)p2	50	1.54	90.6	0.9	89.8	116.7	373.7
B	sys111p1	100	1.59	90.0	2.2	87.0	236.0	707.6
C	sys120(1)p1	100	1.84	90.8	1.2	89.5	91.2	269.9
D	sys116(2)p2	50	1.54	90.6	0.9	89.7	147.3	464.5
E	sys54p1	100	1.65	90.9	1.6	80.0	109.3	337.2
F	sys96Bp2	50	1.69	89.7	1.4	86.3	220.1	641.3
G	sys117(1)p2	50	1.82	90.7	0.6	89.8	115.7	~ 400
H	sys121p3	20	1.82	89.4	1.6	85.0	170.7	536.9
I	sys93p2	50	1.70	88.0	3	80.0		
J	sys119(1)p2	50	1.84	-	-	-		

pueda tener en toda su extensión (1 cm^2), sobre todo en los bordes del sustrato donde la *pluma*, la nube de pulverización, llega más deficientemente: así se miden transiciones superconductoras anchas y a temperaturas inferiores a la óptima, que ronda los 90 K. Dichas inhomogeneidades no se ponen de manifiesto en los micropuentes que posteriormente se grabarán, ya que éstos abarcan un área mucho más pequeña y se realizan en la parte central de la película, más homogénea. La temperatura crítica de los micropuentes suele ser al menos dos grados más elevada que la primera estimación que se hace en todo el filme.

contraposición a *homogéneo*, para indicar un leve grado de heterogeneidad. Las *inhomogeneidades* son, por tanto, pequeñas deficiencias más o menos localizadas que alteran parcialmente la homogeneidad general de la muestra.

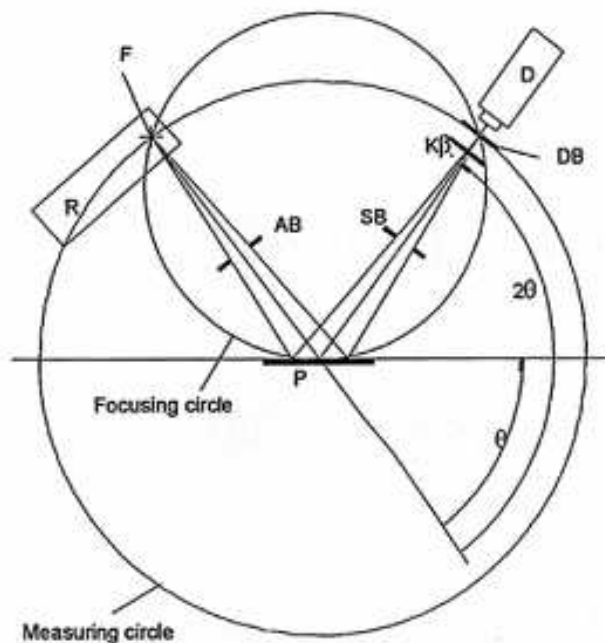


Figura 2.2: Geometría Bragg-Brentano de difracción de rayos-x del equipo Siemens D-5005 empleado para la caracterización estructural de nuestras muestras. Se señalan los ángulos θ y 2θ que determinan los brazos de la fuente y del detector respectivamente.

2.2. Caracterización estructural: difracción de rayos-x

Mediante difracción de rayos-x (XRD) estudiamos la calidad estructural de las películas, centrandó nuestra atención en tres aspectos: la presencia de fases secundarias, la dirección de crecimiento —que nos da información acerca de la orientación global preferente de la película— y la mosaicidad —que nos dice cómo es la distribución de orientaciones, en torno a esa preferente, de los microgranos que componen la muestra—. Empleamos un difractómetro Siemens D-5005 disponible en los servicios generales de nuestra universidad.

En la figura 2.2 vemos un esquema del difractómetro en el que se

indican los ángulos θ y 2θ que determinan los brazos de la fuente y del detector respectivamente. Destaquemos que, en esta convención, el ángulo 2θ del detector es el que forma respecto a la prolongación del brazo de la fuente. El emisor de rayos-x es un ánodo de Cu que hacemos funcionar en torno a 40 kV y 30 mA. Empleamos la radiación K_α del Cu, eliminando la K_β con un monocromador en el detector. El emisor tiene un colimador (en la figura, etiquetado como AB) con 0.2 mm de apertura, y el receptor otro (DB) con 0.1 mm. Una tercera rendija (SB), con 0.1 mm de apertura, elimina la radiación dispersada. La resolución del goniómetro es de 0.01° .

Con este difractómetro se pueden mover los brazos de la fuente de rayos-x y del detector —bien desacoplados, bien acoplados de diferentes maneras—, mientras que la muestra permanece estática. Esta versatilidad permite realizar distintos tipos de medidas. Para las que nos interesan, emplearemos dos tipos de movimientos acoplados entre los brazos: difractogramas θ - 2θ y curvas de basculamiento.

Esta independencia del movimiento de los brazos permite, además, corregir cualquier leve desalineamiento de la muestra: ésta debe ser tangente a la circunferencia de enfoque en la geometría Bragg-Brentano que empleamos (elemento P en fig. 2.2) para obtener máximas intensidades en el detector, y al situarla en el portamuestras no se consigue tanta precisión (siempre hay pequeñas desviaciones de hasta 1°). Se pueden desplazar ambos brazos un cierto ángulo para hacerlos equidistantes de la verdadera recta normal a la muestra. Para establecer cuál es este ángulo de corrección tenemos que entender antes en qué consisten las curvas de basculamiento.

2.2.1. Curvas de basculamiento

En las medidas de basculamiento (*rocking curves*) mantenemos fijo el ángulo 2θ del detector respecto a la fuente, de manera que fijamos las posiciones relativas de ambos brazos. Elegimos para esto el ángulo correspondiente a una reflexión de Bragg del Y-123

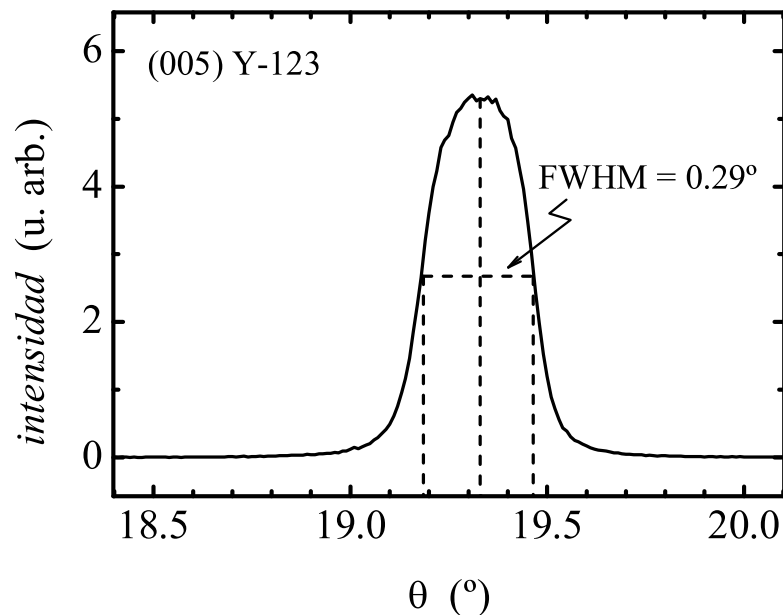


Figura 2.3: Curva de basculamiento (*rocking curve*) típica para el pico (005) de una de nuestras capas delgadas de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. La anchura a mitad de altura (FWHM) nos informa de la dispersión de orientaciones de los microgranos que conforma la muestra, en torno a la orientación preferente. En este caso, la mayoría de los granos están alineados en una misma dirección con una dispersión menor de 0.3° .

conocida, típicamente la del pico (005) —veremos en la siguiente caracterización por rayos-x que la película está orientada con la dirección c perpendicular al sustrato—. Movemos los dos brazos asíacoplados, variando el ángulo θ de la fuente. Vemos un resultado típico de este tipo de medida en la figura 2.3. Estas medidas dan información acerca de la dispersión de orientaciones de los granos que la conforman en torno a la orientación preferente (mosaicidad). El parámetro que caracteriza esta dispersión es la anchura de la curva de basculamiento a la mitad de su altura (FWHM, *Full Width at Half Maximum*). En el ejemplo de la figura, vemos que la mayor parte de los granos que conforman la película están alineados en torno a la dirección preferente con menos de 0.3° de dispersión. Este valor pone de manifiesto el alto grado de ordenación de nuestras muestras.

En todas las películas medidas la FWHM es similar, y su anchura está limitada por la propia mosaicidad del sustrato ($\sim 0.2^\circ$).

Para las curvas de basculamiento empleamos una velocidad de barrido de $0.5^\circ/\text{min}$, y variamos θ unos pocos grados en torno a la reflexión de Bragg que hemos elegido.

Esta medida también nos dice cuánto tenemos que corregir el desalineamiento de la muestra respecto de los brazos, al ver cómo se desvía el máximo de la curva de basculamiento respecto de la posición esperada. Esto implica, claro, presuponer que la orientación preferente (máximo de intensidad) es con el eje c perpendicular al plano del sustrato, pero esta es una suposición razonable: cualquier leve desviación en conjunto de toda la muestra es energéticamente desfavorable —a la temperatura de deposición empleada de $\sim 830^\circ$ —, y es de esperar que los microgranos tengan una dispersión de sus orientaciones en torno a esta orientación preferente. Una vez corregido el desalineamiento de la muestra, repetimos esta medida de basculamiento, y realizamos el siguiente difractograma.

2.2.2. Difractogramas

En la difracción $\theta-2\theta$ ambos brazos se mueven acopladamente de manera que una variación del ángulo de la fuente implica una variación doble del ángulo del detector (recordemos en la figura 2.2 que este último se define sobre la prolongación del brazo de la fuente). Esto es equivalente a decir que ambos brazos mantienen el mismo ángulo $90^\circ - \theta$ respecto de la normal al plano de la muestra, uno a cada lado. Es la medida de difracción más convencional.

La velocidad de barrido que empleamos para esta medida es de $2^\circ/\text{min}$. En la figura 2.4 se muestra el difractograma típico de nuestras películas de Y-123, crecidas según hemos descrito en la sección previa. Se puede apreciar que las muestras han crecido orientadas con el eje cristalográfico c perpendicular al sustrato: sólo se detectan picos de la

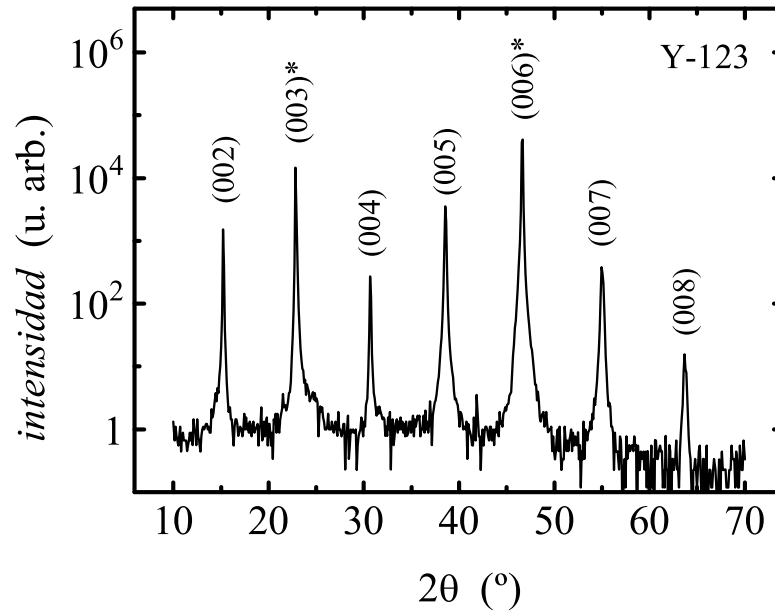


Figura 2.4: Difractograma θ - 2θ típico para una de nuestras capas delgadas, en representación logarítmica. La orientación preferente de la muestra es con la dirección c perpendicular al plano del sustrato: sólo se detectan picos de la familia (001). Los picos (003) y (006), señalados con un asterisco, coinciden con los picos (100) y (200) del sustrato de SrTiO_3 , por lo que la intensidad es mayor.

familia (001). Los picos más intensos, de la forma (003h) —señalados con un asterisco en el difractograma— coinciden con los picos (h00) de sustrato: la película es muy delgada y el sustrato muy masivo, así que la intensidad de los picos de este último es notablemente mayor.

También se puede observar en este difractograma la total ausencia de fases secundarias en la muestra, dentro de la resolución experimental ($\sim 1\%$).

2.3. Preparación de las muestras mediante fotolitografía

Sobre los filmes crecidos por deposición catódica sobre un substrato con superficie de 1 cm^2 grabamos mediante fotolitografía los micropuentes sobre los que posteriormente realizaremos las medidas. Este proceso nos permite crear circuitos superconductores con la forma apropiada para nuestros experimentos. En concreto, para este trabajo hemos grabado varios micropuentes en cada película, de distintas longitudes, pero con anchos iguales de $10\text{ }\mu\text{m}$, con disposición de cuatro contactos en línea para medir a cuatro hilos.

El fotolitografiado es un proceso similar al revelado fotográfico convencional. Se cubre la película con una resina fotosensible, y se estimula con radiación ultravioleta que pase a través de una máscara con el diseño del circuito deseado. De este modo, la parte de la resina que estaba en sombra por la máscara queda inalterada, pero la resina iluminada se vuelve atacable por agentes químicos que *revelan* la imagen de la máscara. Hay resinas positivas y negativas, en función de que la iluminación ultravioleta las haga sensibles o resistentes a los líquidos reveladores correspondientes. Dependiendo de cuál empleemos, la máscara con el circuito deberá ir en negativo o en positivo.

Una vez revelada la imagen de la máscara en la resina, tenemos que parte del filme de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ queda al descubierto, mientras que otra parte, con la forma del circuito que deseamos grabar, permanece protegido por la resina. En este estado, atacamos químicamente la película, de modo que eliminemos la parte de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ desprotegida. Posteriormente eliminamos la resina restante, y tenemos así grabado el circuito superconductor de la máscara.

En la figura 2.5 mostramos un esquema de la máscara que grabamos sobre nuestras películas. Las proporciones de los distintos elementos no están a escala, para poder apreciarlos. Los micropuentes



Figura 2.5: Esquema de la máscara para el fotolitografiado de los micropuentes. Sus distintos elementos no están representados en proporción relativa, para poder apreciar los más pequeños. Hay tres micropuentes de 100, 50 y 20 μm de largo y 10 μm de ancho, unidos por un puente grande de 1 cm de largo en total, por 200 μm de ancho. Hacia arriba salen los contactos para las sondas de voltaje. Los anchamientos del puente se reservan para los contactos de corriente.

tiene 100, 50 y 20 μm de largo por 10 μm de ancho, pero el puente grande que los une tiene en total casi 1 cm de largo por 200 μm de ancho. De este salen lateralmente contactos de 100 μm de ancho, para las sondas de voltaje. En los anchamientos del puente grande, a los extremos y entre los micropuentes, se dispondrán los contactos de corriente.

Los contactos de voltaje pueden parecer muy anchos y muy alejados de los micropuentes, pero recordemos que en las medidas $E-J$ en que centraremos nuestro interés toda esa parte de la película permanece en estado superconductor, y por lo tanto no es resistiva. Sólo los micropuentes son suficientemente estrechos como para que en ellos la densidad de corriente sea superior a la crítica J_c en que aparece disipación. En las medidas que hagamos por encima de T_c , sin embargo, toda la muestra se vuelve resistiva, así que deberemos tener en cuenta convenientemente toda esa parte añadida de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ a mayores del micropuente cuando, por ejemplo, queramos calcular la resistividad a partir de medidas de voltaje.

El proceso de fotolitografiado incluye los siguientes pasos:

1. Aplicación de la fotorresina. Se emplean un par de gotas de Shipley Microposit S1400-37, y se homogeneiza el espesor de esta capa protectora centrifugando la muestra a 4000 r.p.m durante



Figura 2.6: Banco de insolación ultravioleta que empleamos para fotolitografiar los micropuentes en las películas de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. Bajo el ocular, en el centro de la mesa, se alinean la máscara y la muestra. El ocular se aparta luego lateralmente hacia la derecha y en su lugar, sobre la muestra, se dispone lámpara de xenón que se ve en el extremo izquierdo de la mesa, con un protector negro (KarlSuss IN470).

unos treinta segundos (centrifugadora Headway Research PWH 101).

2. Endurecimiento de la fotorresina. Se introduce la muestra en un horno a 90 °C durante 30 min para eliminar el disolvente de la resina.
3. Impresión del circuito. Bajo una lámpara insoladora ultravioleta (KarlSuss IN470 con lámpara de xenón, en la figura 2.6) se alinean con cuidado la máscara y la muestra, y se iluminan durante 10 s.
4. Segundo endurecimiento. Horneado igual que el previo, para reforzar la adhesión de la fotorresina a la película, que puede estar debilitada por la acción del revelador. Así se aumenta la definición en el revelado y se consigue mayor resolución lateral. ([35, p. 64] y [36, p. 545]).
5. Revelado. Se introduce la muestra en líquido revelador (Shipley Microposit Developer) durante unos 15 s, agitándola leve pero constantemente. Así se elimina la resina sensibilizada. Posteriormente se aclara con agua destilada. Hasta aquí el proceso de fotolitografiado es reversible, ya que el $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ todavía no se ha atacado. Podríamos volver a iniciar el proceso, eliminando toda la resina con un baño de acetona.
6. Grabado químico (o mordido). Se introduce la muestra en una disolución acuosa de ácido ortofosfórico al 1 % durante unos 5–10 s, agitando ligeramente. El ácido elimina las regiones de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ que no están protegidas con la resina, grabando el circuito de la máscara. Volvemos a aclarar rápidamente con agua destilada.
7. Limpiado y secado. Eliminamos la resina restante, que todavía protege al $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, con un baño de acetona, y secamos con aire seco comprimido. A partir de este momento el $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$

queda desprotegido, por lo que se debe poner extremo cuidado en la manipulación de la muestra: no debe entrar en contacto con el ácido o el agua destilada, y hay que conservarla en ambiente seco.

8. El grabado puede ser deficiente en los bordes del sustrato, en donde suelen quedar caminos superconductores que ponen en contacto distintas regiones de los micropuentes. Como el borde es una región alejada de los delicados micropuentes, podemos abrir estos caminos con un leve corte de bisturí.
9. Es conveniente realizar una limpieza en profundidad de la muestra resultante, mediante ultrasonidos en un baño de acetona durante al menos quince minutos. Los efectos de esta limpieza de verán en el apartado de caracterización por AFM.

En la figura 2.7 se ven dos imágenes de vídeo de uno de los micropuentes así grabados. En la imagen superior, tomada con menos aumentos que la inferior, se ven también los contactos laterales para las sondas de voltaje. Las áreas de color claro, de forma redondeada, son parte de unas capas circulares de oro que se depositaron para la posterior aplicación de contactos eléctricos. Veremos esto en detalle en una sección posterior. En la imagen inferior se aprecian con más detalle algunos defectos del sustrato, en forma de muescas sobre su superficie, debidos probablemente a que eran sustratos reciclados de crecimientos anteriores.

Para más información acerca del proceso de fotolitografiado se pueden consultar las siguientes referencias: [11, 35–37].

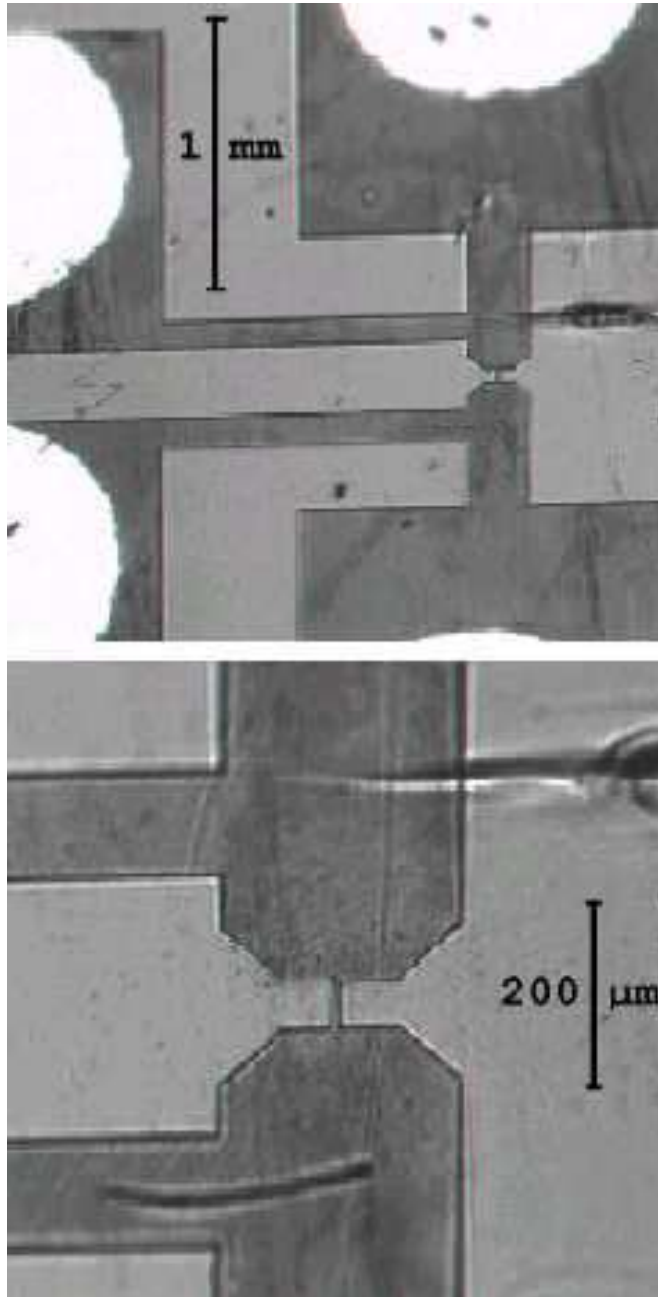


Figura 2.7: Imágenes por vídeo digital de un micropuente, la de abajo con mayor aumento que la de arriba. Las áreas blancas redondas que se aprecian parcialmente en los bordes de la imagen superior son capas de oro depositadas por evaporación, para la posterior aplicación de contactos eléctricos.

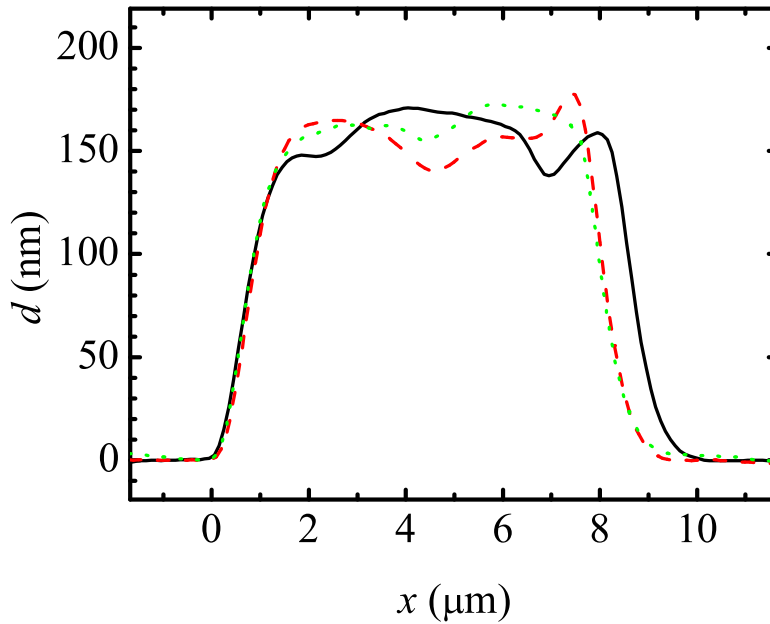


Figura 2.8: Resultados típicos de las medidas de perfilometría en un micropuente, en tres diferentes puntos de su longitud. El resultado es, en cada medida, un corte transversal de la muestra: el espesor en función de la posición x a lo ancho. El espesor promedio ronda los 150 nm.

2.4. Caracterización geométrica: perfilometría y AFM

Sólo después de haber grabado los micropuentes se puede medir el espesor de las películas: para hacerlo hace falta tener un escalón entre el sustrato y la película cuya altura podamos medir, y este escalón sólo se consigue eliminando parte de la película crecida sobre el sustrato. Por otra parte, lo que nos interesa es el espesor del micropuente que estudiaremos, no el del conjunto de toda la película.

Las primeras caracterizaciones del espesor de nuestros puentes las hicimos con un perfilómetro de punta de contacto DekTak 3, disponible en la Escola de Óptica e Optometría de esta universidad. En la figura 2.8 mostramos algunos resultados de perfilometrías sobre uno



Figura 2.9: Conjunto de dispositivos que conforman el microscopio de fuerza atómica (AFM) de nuestro laboratorio, un Digital Instruments NanoScope E. A la izquierda, bajo un visor óptico para inspección ocular, la unidad con el portamuestras y los sensores. Ésta se conecta a la unidad de control e interface (*Scanning Probe Microscope Controller*), que a su vez va conectada a un ordenador PC que gestiona los datos adquiridos. Vemos las dos pantallas del ordenador en las que se monitoriza la medida.

de nuestros micropuentes, en tres diferentes puntos de su longitud. El resultado es, en cada una de las medidas, un corte transversal del micropuente, pues se mide el espesor d en función de la posición x a lo ancho de la muestra. Vemos que el promedio de espesor ronda los 150 nm, y que la superficie es, en el caso de esta muestra, bastante irregular, con oscilaciones de hasta el 25 %. Veremos que esto no es igual en todas las muestras y que, en todo caso, la mayor parte de estas irregularidades son precipitados aislantes que no intervienen en la sección eficaz conductora del micropuente.

Parece que la anchura del micropuente varía a lo largo de su longitud (las tres perfilometrías tienen anchuras ligeramente diferentes), pero esto podría deberse también a un inevitable desalineamiento del micropuente con la punta: si la dirección del desplazamiento de la punta durante el barrido no es exactamente perpendicular al micropuente podemos estar leyendo una anchura falseadamente más ancha.



Figura 2.10: Detalle de la unidad de medida del AFM (LFM-3/269). En la base cilíndrica se ven dos contadores digitales, que muestran las señales de desviación de la punta (*cantilever*) en vertical y horizontal. Sobre esta base, otros cilindros metálicos alojan los dispositivos piezoeléctricos del portamuestras —pues en este sistema es la muestra quien se mueve para mantener constante la desviación de la punta de AFM—. Por último, un cabezal prismático aloja el *cantilever*, el láser, y los fotodiodos de detección. Sobre la unidad, sujeto por un brazo articulado, tenemos un visor para inspección ocular de la muestra.

Esta caracterización mediante perfilometría es bastante simple: sólo se pueden medir espesores, y además en regiones muy localizadas. Para poder estudiar otros aspectos interesantes de este tipo de muestras, en nuestro laboratorio decidimos adquirir un microscopio de fuerza atómica (AFM), lo que en concreto nos ha permitido medir con más detalle la geometría de los micropuentes. El equipo de que disponemos para medidas de AFM es un microscopio Digital Instruments NanoScope E con unidad de medida LFM-3/269 (figuras 2.9 y 2.10), que en un futuro permitirá un estudio sistemático de la geometría del micropuente y su influencia en los parámetros de transporte. Por el momento lo hemos empleado para tener una imagen de la forma de los micropuentes más detallada que la que nos aporta el perfilómetro.

La microscopía de fuerza atómica que empleamos es de contacto. La muestra se desplaza lateralmente bajo una punta nanoscópica de nitruro de silicio², que está en el extremo de un pequeño brazo flexible (*cantilever*). Las irregularidades de la superficie de la muestra hacen que este brazo flexible se curve más o menos. Un sistema de realimentación mide la desviación del brazo empleando un láser que se refleja sobre él, y ajusta en la dirección vertical un dispositivo piezoeléctrico que está en la base de la muestra, para mantener dicha desviación en un valor constante. El sistema devuelve el dato de la altura de la muestra en función de cuánto haya tenido que alterar la posición de este piezoeléctrico vertical.

Los piezoeléctricos horizontales de nuestro AFM permiten hacer barridos en un área cuadrada máxima de unas $12 \times 12 \mu\text{m}^2$, suficiente para hacer medidas de la altura del escalón del micropuente respecto al sustrato en alguna región de su longitud. Pero si queremos tomar una imagen completa de un micropuente debemos solapar varios de estos barridos de AFM, para componer una imagen mayor. Esto es lo que se hizo en las imágenes de las figuras 2.11 y 2.12.

En esas imágenes se puede apreciar como algunas películas

²Referencia comercial: Nanoprobe SPM tip type OTR8-35.

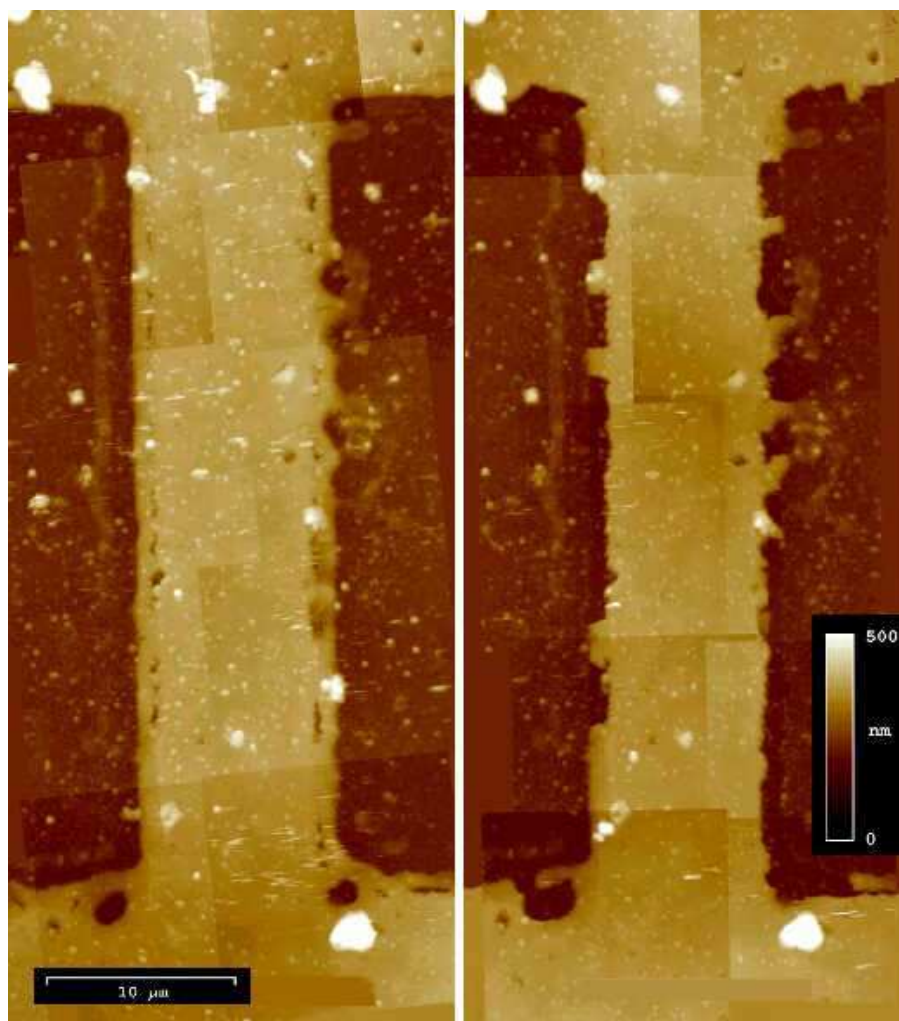


Figura 2.11: Dos imágenes compuestas por diversos barridos de AFM solapados. Corresponden al mismo micropuente (muestra I), pero la de la izquierda fue tomada justo después de la fotolitografía, mientras que la de la derecha es tras un proceso posterior de limpieza por ultrasonidos, en baño de acetona durante 15 min. Parte de los residuos del proceso de grabado se han desprendido, estrechando el micropuente.

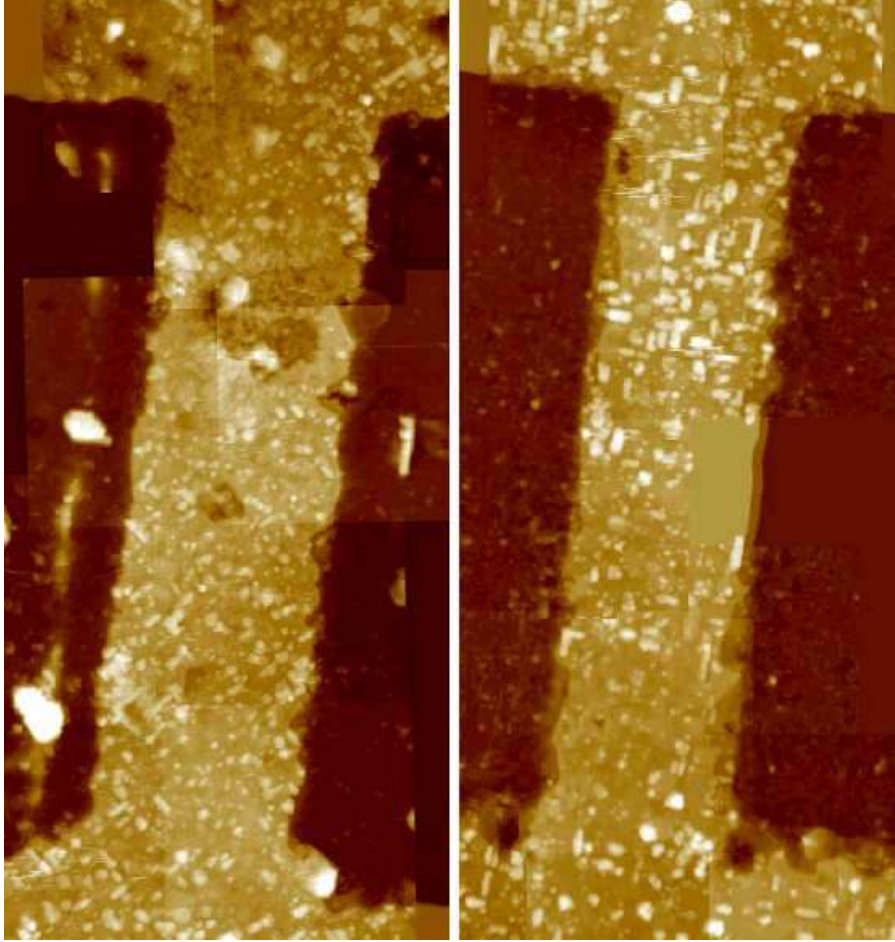


Figura 2.12: Dos imágenes compuestas por diversos barridos de AFM solapados. Algunas áreas no barridas se han completado simuladamente, para facilitar la interpretación de las imágenes. Corresponde a dos micropuentes distintos: a la izquierda, la muestra J, y a la derecha la C. Se aprecia que presentan más rugosidad superficial que el micropuente I de la figura 2.11. Esto no es relevante para la calidad superconductora: mientras que la muestra C es de mucha mejor calidad que la I, la J es, por el contrario, mucho peor, tanto que no es superconductora. Esta no es, probablemente, una rugosidad intrínseca a la muestra, sino causada por los precipitados aislantes o los residuos del fotolitografiado comentados en el texto.

muestran superficies más irregulares que otras: los pequeños granos blancos, de distinto tamaño dependiendo de la muestra, son bultos que sobresalen en altura del resto del puente. Estos bultos son, de lo que se deduce de medidas de microscopía electrónica de barrido [11], precipitados eléctricamente aislantes, posiblemente compuestos ricos en cobre [38–44], quizá causados por las características del blanco empleado en el crecimiento [45]. También pueden ser restos de todo el proceso de fotolitografiado. Por este motivo los excluimos de la sección eficaz conductora de nuestros micropuentes³. Todas las muestras presentan pequeñas variaciones del espesor dependiendo del punto concreto de su longitud que consideremos, pero en promedio rondan los 150 nm, si descontamos estos precipitados aislantes. Esto es razonable, pues todas las películas han sido crecidas con procesos de *sputtering* de igual duración. Por todo esto hemos considerado que todas las muestras empleadas en este trabajo tienen un espesor promedio $d \simeq 150$ nm, con un error que estimamos rondando ± 10 nm.

En la figura 2.11 se ponen de manifiesto los efectos de una limpieza con ultrasonidos, en baño de acetona, tras el fotolitografiado⁴. La imagen de la izquierda, con restos de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ mal eliminados por el grabado, fue tomada antes de la limpieza. En la imagen de la derecha, tomada después de dicha limpieza por ultrasonidos durante quince minutos, se ven como algunos de los restos (probablemente no superconductores, atacados a medias por los agentes químicos) se han desprendido, haciendo que el micropuente sea más estrecho. Esta limpieza también mejora la nitidez de los barridos AFM: se aprecian

³Si estos precipitados no se manifiestan en las medidas de rayos-x es, probablemente, debido a que son cristales con orientaciones aleatorias y con una contribución volúmica pequeña.

⁴Empleamos una máquina P-Selecta Ultrasons, que mediante un transductor aplica ultrasonidos de 40 kHz a una cubeta de agua. En esta cubeta se introduce un vaso con acetona de modo que el nivel de líquidos sea semejante, y en el interior de la acetona se dispone la muestra para su limpieza. Las ondas sonoras se propagan hasta las cercanías de la muestra. Un efecto de cavitación origina burbujas microscópicas de baja presión, que eliminan las impurezas superficiales.

menos trazas horizontales a lo largo del puente, que son claros defectos generados por suciedad atrapada en la punta.

Estos restos, y en general el proceso de fotolitografiado, hacen que el ancho del micropuente no sea exactamente igual en toda su longitud, como ya veíamos en las medidas por perfilometría . (Tampoco podemos estar seguros de que todo el ancho de micropuente que vemos sea de igual calidad superconductora, pues los bordes podrían estar afectados por el ataque químico). Pero las variaciones no son grandes en torno al valor promedio $a \simeq 10 \mu\text{m}$, cuyo error máximo estimamos en un 20 %. Si los micropuentes fuesen más anchos, estas mismas deficiencias laterales se traducirían en un error relativo mucho menor.

La longitud del micropuente está relativamente mejor establecida, con un error que estimamos en $\pm 2 \mu\text{m}$, lo que para los puentes de $l = 50 \mu\text{m}$ supone un 4 %.

De este modo, el promedio geométrico de los errores lleva a que el error total de la resistividad medida en estos micropuentes sea de aproximadamente un 21 %.

2.5. Aplicación de contactos eléctricos

Previa a la aplicación de hilos eléctricos se depositan sobre el $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ una capa de oro de $1 \mu\text{m}$ de espesor y de aproximadamente 1 mm de diámetro en los lugares en los que se realizarán las soldaduras, mediante una máscara metálica y un evaporador Balzers BAE 250 o un pulverizador catódico Edwards Scancoat Six. El empleo de uno u otro sistema depende del número de muestras que se quiera preparar simultáneamente, para reducir en todo lo posible el gasto de oro: el evaporador gasta más metal que el pulverizador, pero cubre un área mayor de aplicación, por lo que se puede poner mayor número de muestras.

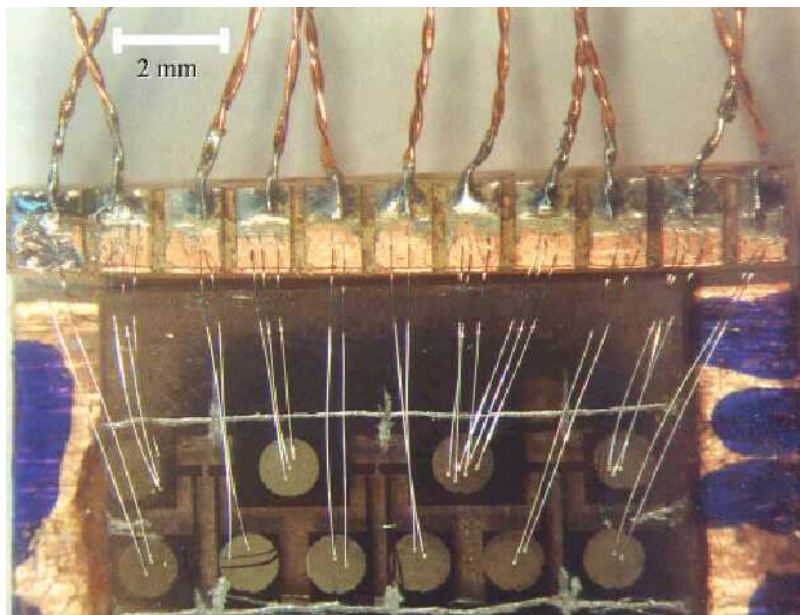


Figura 2.13: Fotografía de un filme sobre el portamuestras de cobre intermedio. El ancho del sustrato es de 1 cm. Sobre el superconductor, con micropuentes grabados por fotolitografía, se ven las capas circulares de oro sobre las que se sueldan, mediante ultrasonidos, hilos de aluminio. Estos hilos, en su otro extremo, se llevan a las patillas del portamuestras intermedio, de las que a su vez salen hilos trenzados de cobre, soldados con aleación de estaño. Sobre el sustrato del filme se ven los cortes con bisturí para abrir los caminos conductores residuales del litografiado. Las marcas oscuras de los laterales del portamuestras de cobre son señales identificativas.

Tras la aplicación de estas capas circulares de oro en cada contacto (que se pueden apreciar en las figuras 2.7 y 2.13), sometemos la muestra a un proceso que mejore la interdifusión de oro e $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. Se cubre la película con un trozo de Y-123 masivo de sus mismas dimensiones, y se introduce así en un horno tubular, con un pequeño flujo de oxígeno a presión ligeramente superior a la atmosférica, a 600 °C y durante 15 min.

Luego se sitúa la muestra en un portamuestras intermedio de cobre, adherida con grasa termoconductora Apiezon N, tal y como se muestra en la figura 2.13. El portamuestras tiene unas patillas metálicas para los hilos eléctricos que provienen de la muestra, y a



Figura 2.14: Microsoldador Kulicke & Soffa 4523 Manual Wire Bonder empleado para la aplicación de contactos eléctricos sobre los micropuentes.

las que también se sueldan los hilos que llevan al resto del circuito experimental. Estas patillas se realizaron con cobre de una plancha para circuitos impresos. (En algunos casos, como prueba, también se empleó latón, pero resultaba más incómodo de manejar). Soldamos, desde cada contacto de la película a una de las patillas, hilos de aluminio con un 1 % de silicio, de $25\ \mu\text{m}$ de diámetro, empleando para esto el microsoldador por contacto con ultrasonidos Kulicke & Soffa 4523 Manual Wire Bonder de la figura 2.14. Normalmente se disponen varios hilos para una misma unión eléctrica por seguridad, por si alguno se suelta durante su manipulación. Se pueden ver imágenes detalladas de estas microsoldaduras por ultrasonidos en las figuras 2.15 y 2.16. Posteriormente, para mejorar su resistencia mecánica y aumentar el área de contacto eléctrico, se aplica una gota de pasta conductora Dupont 4929 sobre las soldaduras de la muestra y de las patillas, que se seca bajo una lámpara de infrarrojos durante una

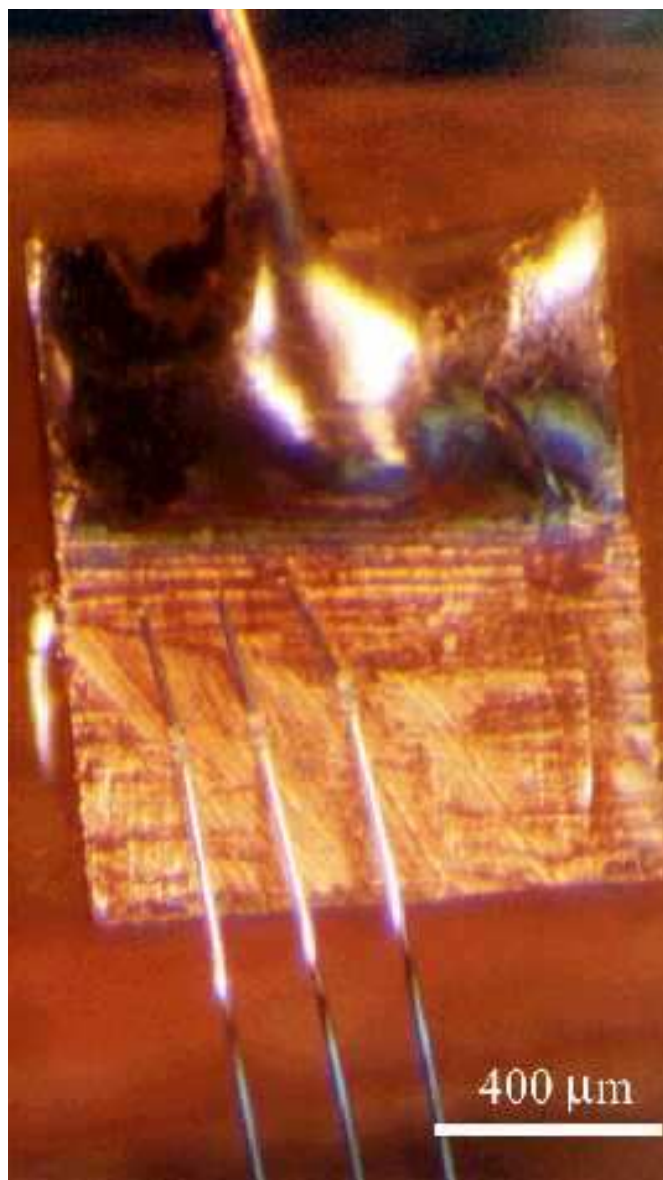


Figura 2.15: Detalle de una patilla del portamuestras de cobre intermedio. Por un lado llegan del filme los hilos de aluminio microsoldados con ultrasonidos. Por el otro, sale un hilo de cobre (en este caso sencillo), soldado previamente con aleación de estaño.

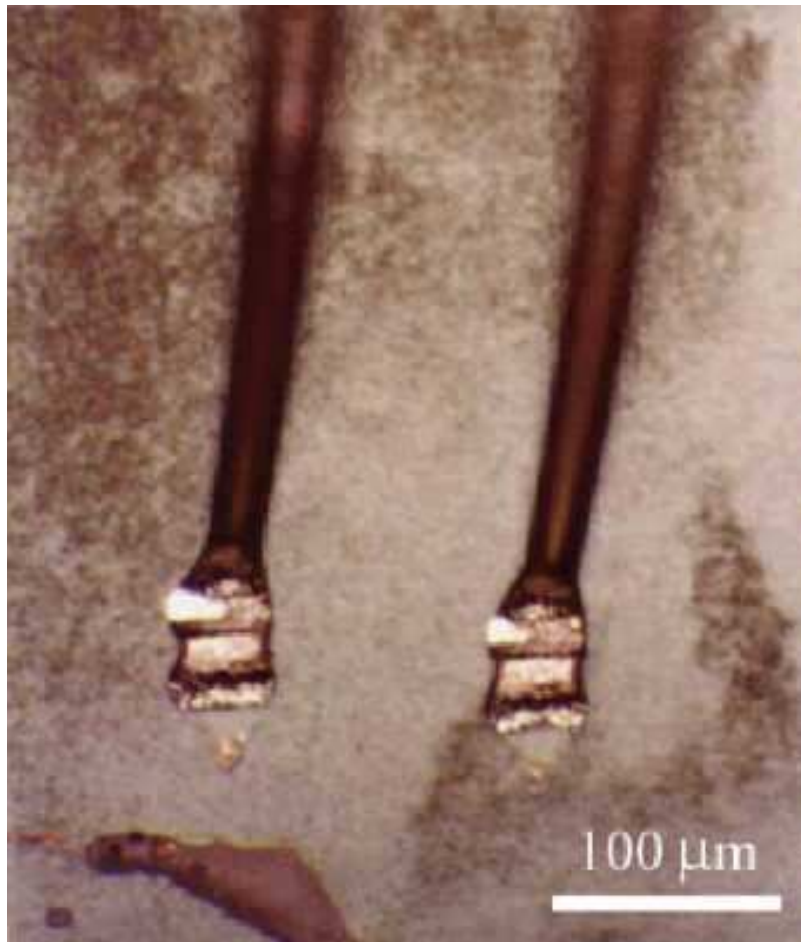


Figura 2.16: Detalle de las microsoldaduras de hilos de Al/Si-1% de 25 μm de diámetro. Sobre estas soldaduras se aplica luego una gota de pasta conductora para mejorar la resistencia mecánica y aumentar el área de contacto.

Cuadro 2.3: Parámetros más convenientes para las microsoldaduras realizadas con el KS 4523 Wire Bonder. Se regulan dentro de una escala del 0 al 10.

Superficie	Power	Time	Force
Oro	2–3	2–3	2–3
Cobre	3.5–5	3–4	1–2
Latón	3–3.5	3	2–2.5

media hora.

Las microsoldaduras del hilo de Al/Si-1 % se realizan por presión de una punta de carburo de wolframio pulida y plana⁵ mientras se aplican ultrasonidos. Cada soldadura se caracteriza por tres parámetros en el microsoldador: la potencia de ultrasonidos (power), el tiempo de soldadura (time) y la fuerza de empuje de la punta sobre la soldadura (force). Estos parámetros se regulan en una escala del 0 al 10. En la tabla 2.3 se recogen los más adecuados para las superficies que hemos empleado (oro sobre la muestra, y latón o cobre en las patillas del portamuestras intermedio). Las patillas de cobre, de plantillas para circuitos impresos, son más delgadas que las de latón. Para hacer soldaduras sobre ellas apropiadamente, se necesita aumentar el tiempo y la potencia mientras que se disminuye la fuerza de la aguja, en comparación con los parámetros que se emplean para el latón, más masivo.

Los contactos aplicados sobre el filme presentan una resistencia inferior a 0.1Ω , al menos diez veces menor que la propia resistencia típica del micropuente superconductor en las regiones más disipativas de la curva $V-I$, y quinientas veces menor que la resistencia del micropuente a 100 K. Además, los contactos aplicados están alejados del micropuente una distancia que es al menos diez veces la longitud de éste: toda esa distancia entre los contactos soldados y el micropuente objeto de nuestro estudio está cubierta por caminos eléctricos superconductores. De este modo, es de esperar que la disipación en los

⁵Referencia comercial P/N 40427-0004-151.

contactos eléctricos tenga poco efecto sobre el micropuente: la propia disipación del micropuente será mucho mayor.

Una vez preparada la muestra y sus contactos en el portamuestras intermedio, ya está dispuesta para introducirse en el dispositivo de medida que explicamos en el siguiente capítulo.

Capítulo 3

Dispositivos de medida

Los elementos básicos que componen nuestro dispositivo experimental son un criostato para la regulación de la temperatura, unas bobinas para aplicar campo magnético externo, y diversas fuentes y voltímetros para medir la caída de voltaje en el micropuente al paso de una corriente eléctrica.

3.1. Criostato y campo magnético

Al principio, en nuestro laboratorio estos experimentos se realizaban con la muestra sumergida directamente en un baño de nitrógeno líquido, cuya temperatura se regulaba presurizando el baño con gas [11]. Cuando tuvimos la necesidad de aplicar campo magnético externo, introducimos cerca de la muestra, dentro del baño, unas pequeñas bobinas de Helmholtz que apenas alcanzaban los 150 Gs, lo que en principio estimábamos sería el autocampo de la corriente inyectada en la muestra. Al no observar efectos sobre las medidas con este campo, vimos la necesidad de emplear las bobinas magnéticas de nuestro criostato Oxford, más potentes, lo que no permitía con facilidad usar un baño líquido presurizado. De este modo, los experimentos que se muestran en este trabajo se realizaron con la

muestra en atmósfera de helio gas, y la temperatura regulada con los elementos de dicho criostato. No se aprecian substanciales diferencias entre las medidas tomadas con baño líquido [11, 13, 46] o baño gaseoso, al menos mientras la muestra no transita completamente al estado normal y se vuelve altamente disipativa. Esto es razonable, pues en los tiempos tan cortos de medida que empleamos la interacción más importante ocurre entre el micropuente y su substrato y quizá el portamuestras, no con la atmósfera. El coeficiente de transferencia de calor h entre la muestra y el substrato es muy superior al que presentan la muestra o el substrato con la atmósfera circundante, ya sea ésta líquida o gaseosa. Los valores son de $1000 \text{ W/cm}^2 \text{ K}$ para filme-substrato [47], y de $1 \text{ W/cm}^2 \text{ K}$ para filme-entorno cuando este último es nitrógeno líquido [48–50], por lo que será incluso menor si es gas. Los efectos de la atmósfera se harían relevantes para mayores duraciones de medida. Estimaremos estos tiempos en capítulos posteriores.

La muestra, sobre su portamuestras intermedio de cobre, se dispone a su vez sobre otro portamuestras mayor, también de cobre, que se introduce en una cámara refrigerada de nuestro criostato. Con los portamuestras de cobre aseguramos una buena termalización del substrato —y por lo tanto también de la película superconductora— con el entorno de la muestra, en nuestro caso helio gas. Ambos están adheridos entre sí con grasa Apiezon N, igual que el substrato al portamuestras intermedio.

Adherido igualmente con Apiezon N al portamuestras de cobre situamos un termómetro resistivo Pt-100. Éste se alimenta con una fuente DC de voltaje¹, y ponemos una resistencia tampón de $100 \text{ k}\Omega$ en serie para mantener constante la corriente en $100 \mu\text{A}$. El voltaje del termómetro lo medimos con un voltímetro². De esta manera determinamos la temperatura del conjunto de la muestra y los portamuestras de cobre.

En la fotografía de la figura 3.1 podemos ver el criostato empleado

¹Hewlett-Packard (Agilent) 6181

²Hewlett-Packard (Agilent) 3457A



Figura 3.1: Fotografía de los principales elementos experimentales. A la izquierda, conjunto de dispositivos electrónicos y ordenador de control. A la derecha, vista general del criostato Oxford, y de las bobinas para la aplicación de campo magnético hasta $\mu_0 H = 1$ T. Los cables que llegan a la muestra bajan desde el cabezal del portamuestras —en la parte superior de la imagen, sobre el criostato— hasta un punto centrado entre las bobinas. Al fondo, en la pared, el cuadro de llaves para la purga de las cámaras y entrada/salida de gases.

para la refrigeración de las muestras, y las bobinas para la aplicación de campos magnéticos. En la serie de fotografías de las figuras 3.2 y 3.3, tomadas durante su puesta a punto, podemos ver la estructura interna del criostato. En la figura 3.4 se muestra un esquema del corte longitudinal del criostato, con sus distintas cámaras. La cámara que aloja la muestra es un tubo vertical que recorre todo el criostato. En el fondo se sitúa la muestra, en un punto centrado entre las bobinas que generan el campo magnético. Para ello se dispone de un largo bastón de 1.30 m, esquematizado en la figura 3.5, que lleva los cables desde el cabezal superior hasta el fondo del criostato, donde está el portamuestras con la muestra y su termómetro. Esta cámara de la muestra es estanca: se cierra con el propio cabezal del bastón

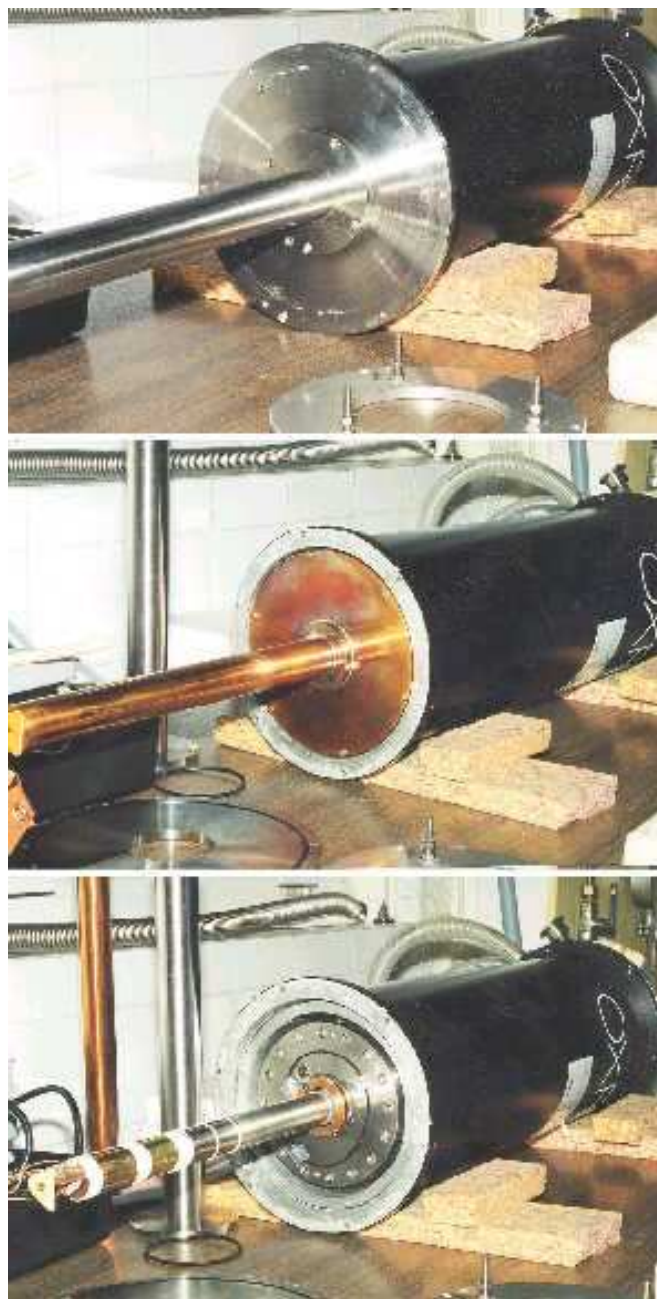


Figura 3.2: Fotografías de las distintas paredes que constituyen el criostato Oxford. Fueron tomadas durante una reparación del criostato.

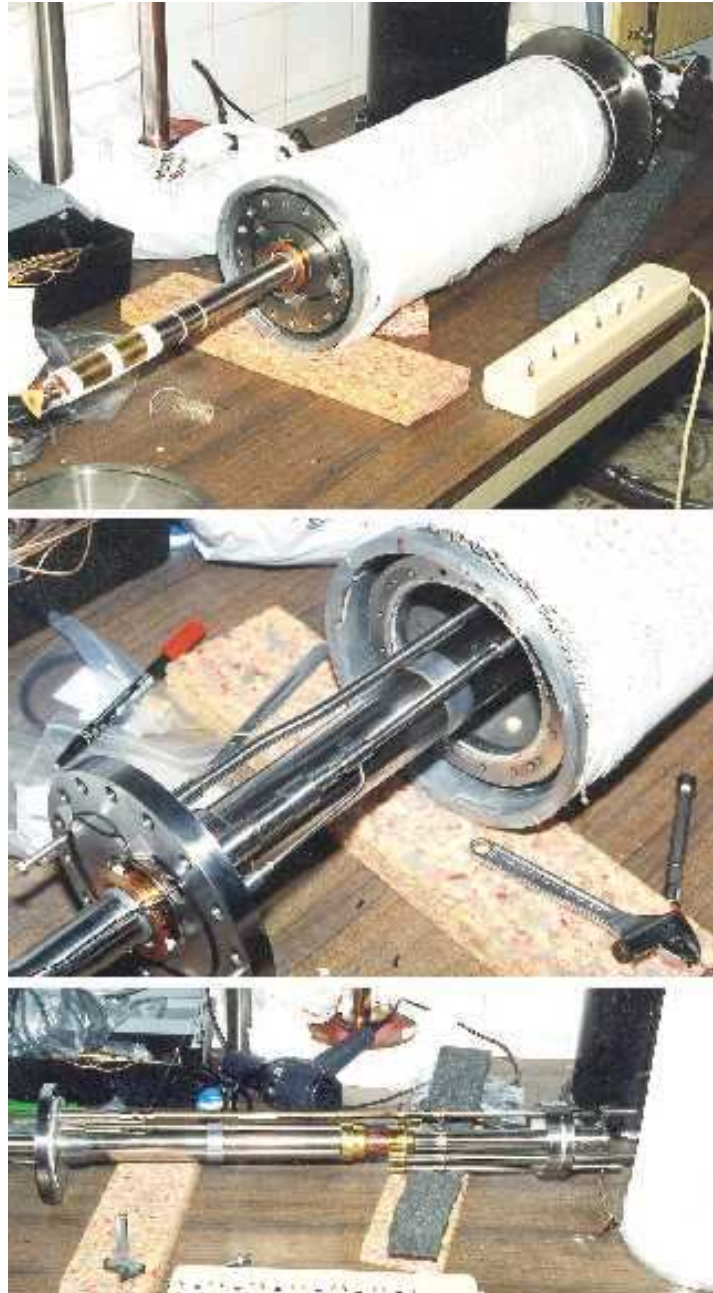


Figura 3.3: Fotografías de las paredes y tubos interiores que constituyen el criostato Oxford. Fueron tomadas durante una reparación del criostato.

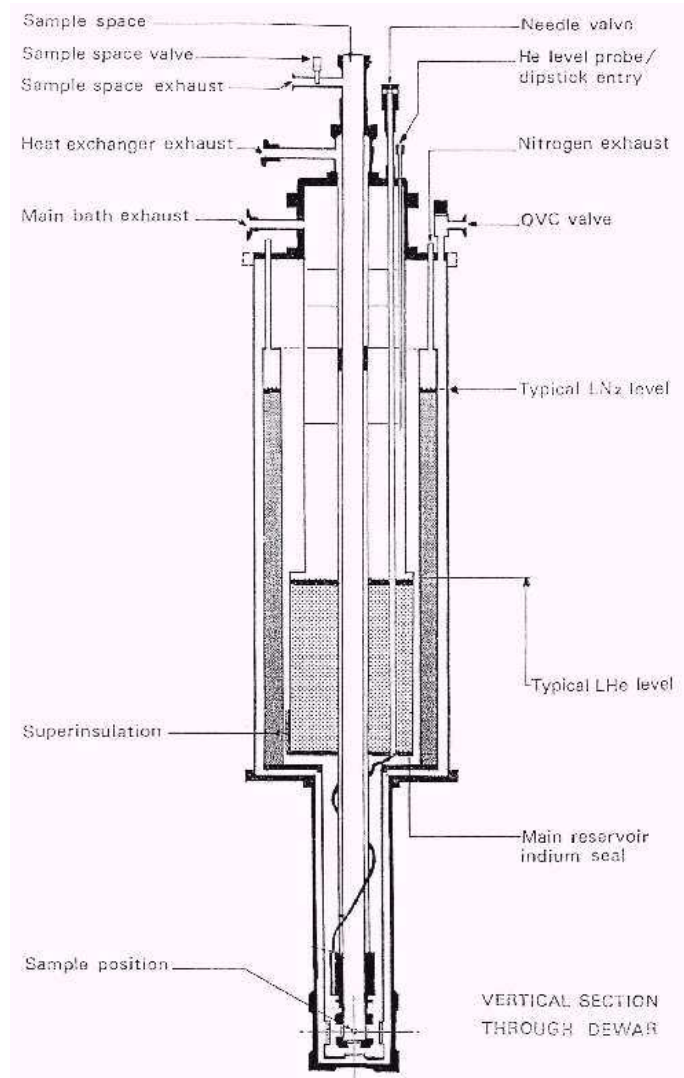


Figura 3.4: Corte longitudinal esquemático del criostato empleado para las medidas experimentales. Aunque está diseñado sobre todo para trabajar con helio líquido (LHe) como refrigerante, nosotros hemos empleado nitrógeno líquido en su lugar. Otra cámara rellena de nitrógeno líquido (LN₂) apantalla térmicamente el depósito principal. El refrigerante circula hasta la parte inferior de la cámara central, donde se aloja la muestra. El flujo se regula con una válvula de aguja, y la temperatura se compensa con un calentador controlado electrónicamente.

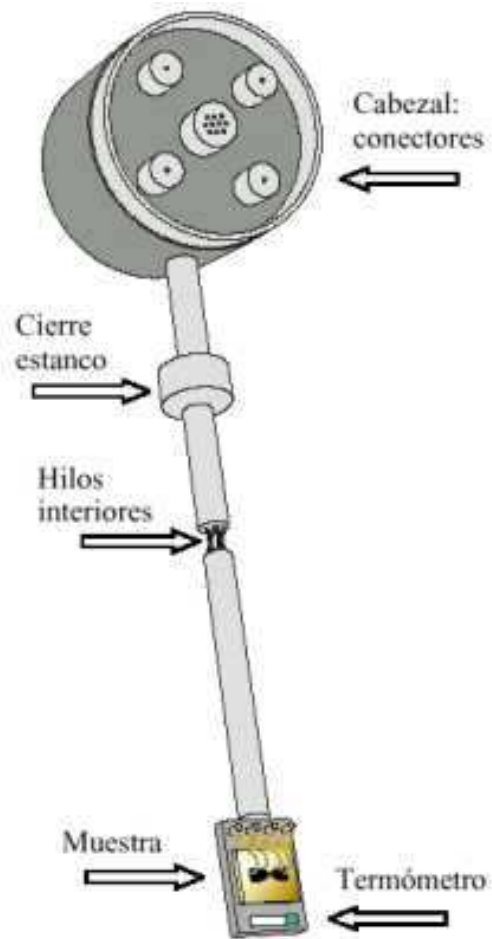


Figura 3.5: Esquema del bastón portamuestras que sitúa a la muestra y su termómetro en su lugar apropiado, al fondo del criostato. Por su interior circulan los hilos eléctricos que llegan desde los dispositivos de medida. El propio cabezal cierra herméticamente la cámara.

portamuestras, y se llena de helio gas. La atmósfera de helio se refrigera mediante un serpentín, en la base de la cámara, por el que circula gas evaporado de un líquido criogénico, en nuestro caso nitrógeno. El flujo del gas se regula con una válvula de aguja, y se genera por su propia presión, hacia la atmósfera del laboratorio, pero se puede forzar ligeramente succionando con una bomba. La temperatura de la cámara de la muestra se regula mediante un calentador resistivo controlado electrónicamente³, que contrarresta esta refrigeración criogénica. El depósito de líquido refrigerante está apantallado del exterior por una cámara rellena de nitrógeno líquido. Esta cámara sería especialmente relevante en el caso de que el refrigerante fuese helio líquido, pero en nuestro caso, en que empleamos nitrógeno, también es de utilidad para hacer el sistema más estable térmicamente. Todas estas cámaras se aíslan del entorno con un vacío intermedio que las envuelve. Para obtener este vacío empleamos una bomba turbomolecular⁴ dentro de la cual, en buenas condiciones, se alcanzan vacíos de 7×10^{-7} mbar, lo que genera vacíos intermedios en el criostato mejores que 10^{-3} mbar. En los casos en que el criostato responde peor o se ponen de manifiesto pequeñas fugas, dejamos bombeando continuamente el vacío intermedio para garantizar un buen aislamiento térmico. En la tapa superior del criostato se encuentran las llaves y válvulas de seguridad de las distintas cámaras.

La medida de una serie de curvas $V-I$ a distintos campos y a temperatura constante puede prolongarse hasta casi hora y media. Durante este tiempo la temperatura debe permanecer todo lo estable que sea posible. A temperaturas cercanas a la de ebullición del nitrógeno líquido, el refrigerante que empleamos, la estabilización es ligeramente mejor que a temperaturas mayores. Como ejemplos,

³Controlador de temperatura Oxford ITC-4. En nuestra configuración, el termómetro del controlador no es el que está adherido al portamuestras sino otro, fijo al fondo de la cámara central del criostato: esto hace que la temperatura que se programa y la que realmente alcanza la muestra (medida con su propio termómetro) sean levemente diferentes.

⁴Pfeiffer-Balzers TSH 332.

mencionamos que en una medida concreta realizada a 76.2 K, la lectura de la temperatura oscilaba en la centésima de Kelvin, entre 76.22 y 76.24 K, durante 90 minutos. En otra medida a 84.1 K, la lectura durante un tiempo semejante oscilaba entre 84.12 y 84.19 K.

El electroimán consiste en unas bobinas externas de cobre, con polos cónicos truncados que dirigen el campo convenientemente a la zona en que se sitúa la muestra. Se refrigera por flujo de agua, y permite la aplicación de campos magnéticos de hasta poco más de $\mu_0 H = 1$ T, mediante corrientes de hasta casi 20 A con una fuente de potencia⁵. El campo se mide con un magnetómetro de efecto Hall⁶ cuya sonda se sitúa en la misma zona de la muestra, exteriormente al criostato.

3.2. Circuito eléctrico

La muestra, una vez preparada como hasta aquí hemos descrito, se conecta dentro del circuito eléctrico que se esquematiza en la figura 3.6. Mediremos la caída de voltaje en el micropuente con una configuración de cuatro hilos. La corriente se inyecta con una fuente de corriente programable y de precisión⁷, por lo que tomamos como valor de la corriente el que programamos en la propia fuente. De todos modos, disponemos de una resistencia conocida en serie con la muestra, para que en las medidas de curvas $V-I$ rápidas, en las que programamos varios valores de corriente seguidos en una misma medida, podamos identificar cómodamente a qué pulso de corriente corresponde cada dato adquirido.

El dispositivo que mide el voltaje de la muestra dependerá de en qué régimen de disipación nos encontremos. Para señales débiles emplearemos un nanovoltímetro, y para el régimen de alta disipación,

⁵KSM Brookmans PK Herts Stabilised Power Supply, 20A-250V.

⁶Oxford Hall Effect Magnetometer 5200

⁷Keithley 2400 SourceMeter.

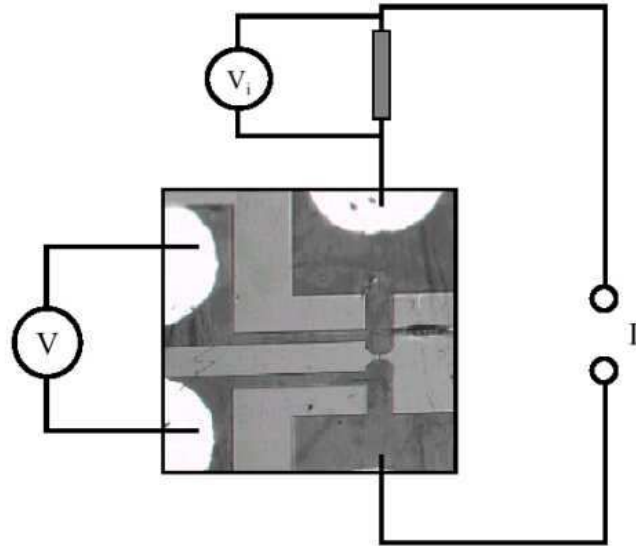


Figura 3.6: Esquema del circuito eléctrico de medida a cuatro hilos, empleado en nuestros experimentos. La corriente se inyecta mediante la fuente de corriente I , y la caída de voltaje en el micropuente se mide con el dispositivo V (un nanovoltímetro o una tarjeta de adquisición, dependiendo del régimen de disipación). En serie con el micropuente se dispone una resistencia conocida para medir, con la tarjeta de adquisición, un voltaje V_i que nos sirva para saber qué corriente está siendo aplicada. Esto es relevante sólo para las medidas rápidas de toda la curva $V-I$, porque en general tomamos como valor de la corriente el que programamos en la fuente.

donde el calentamiento es notablemente influyente en los resultados, empleamos una tarjeta de adquisición mucho más rápida [51], con el fin de minimizar los efectos de autocalentamiento.

Debido a las deficiencias de la toma de tierra que tiene la instalación eléctrica de nuestra Facultad, es habitual apreciar en nuestros experimentos algunos problemas de ruido parásito, sobre todo en las medidas de señales más bajas. Tras diversas pruebas encontramos que la configuración más aislada se conseguía uniendo entre sí las tierras de las fuentes (la de la muestra y la del termómetro), y éstas a la carcasa del criostato, pero dejando flotantes las tierras de los dispositivos de medida. Conectar con las tierras mencionadas también la de la alimentación trifásica de la fuente de las bobinas no

mejoraba la calidad de la medida, pero parecía proteger las muestras de algunas destrucciones espontáneas que tenían lugar al manipular dicha fuente, sobre todo al encenderla.

3.2.1. Medidas de voltajes bajos con nanovoltímetro

Para determinar experimentalmente la densidad de corriente crítica J_c emplearemos un criterio umbral en campo eléctrico de $E_c = 10 \mu\text{V}/\text{cm}$, muy habitual en la bibliografía. Para una longitud típica del micropuente $l = 50 \mu\text{m}$, nos vemos por lo tanto obligados a medir voltajes tan pequeños como $5 \times 10^{-8} \text{ V}$, para lo cual empleamos un nanovoltímetro Hewlett-Packard (Agilent) 34420A. Las medidas típicas se realizan en 10 NPLC (*number of power line cycles*, 1 NPLC = 20 ms), diez ciclos de red, a corriente aplicada constante (superior a 1 mA). Como la disipación es tan baja podemos despreciar los efectos térmicos, y hacer medidas de larga duración con el fin de minimizar el ruido. Cada punto de la curva $E-J$ se adquiere haciendo la semidiferencia de dos medidas con corrientes de igual valor absoluto, pero de sentidos contrario: de este modo se eliminan los efectos termoelectricos, que son bastante notables cuando la señal es tan baja. Midiendo a 10 NPLC tenemos una resolución mejor que el nanovoltio, lo que para un puente típico de $50 \mu\text{m}$ de largo implica una resolución en el campo eléctrico mejor que $0.2 \mu\text{V}/\text{cm}$. A pesar de los promedios en varios ciclos de red, el ruido experimental aumenta el error por encima de esta resolución, aunque se mantiene siempre por debajo del umbral de campo $E_c = 10 \mu\text{V}/\text{cm}$ que elegimos para la determinación de J_c .

3.2.2. Medidas rápidas de voltajes elevados con tarjeta de adquisición

Cuando, al aumentar la corriente inyectada, la disipación se hace tan elevada que los efectos térmicos se vuelven muy relevantes, nos vemos obligados a hacer las medidas a gran velocidad para tratar de minimizarlos. Con el fin de reducir los tiempos de medida que en este tipo de experimentos se venían usando en nuestro laboratorio [10, 11], en los que cada punto de la curva E - J se tomaba en típicamente 30 ms, parte de este trabajo consistió en la instalación, integración y programación de una tarjeta adquisidora de datos (DAQ [51]) National Instruments PCI 6035E, que permite medidas de voltaje de hasta 2×10^5 muestras/s, o de un punto cada $5 \mu\text{s}$. Tiene una resolución de 16 bits en cada uno de sus rangos bipolares de medida ($\pm 50 \text{ mV}$, $\pm 500 \text{ mV}$, $\pm 5 \text{ V}$ y $\pm 10 \text{ V}$). Usando dos canales, uno para la muestra y otro para la resistencia en que medimos la corriente aplicada, la velocidad de medida por canal se reduce a la mitad de ese valor: un punto cada $10 \mu\text{s}$.

Esto nos permite estudiar la evolución temporal de la señal de voltaje, a corriente aplicada constante, de lo que podremos obtener información a cerca del comportamiento térmico de la muestra. Como esta variación es muy rápida (veremos que los cambios más drásticos se producen en apenas $100 \mu\text{s}$, y se tienen estabilizaciones en 1 ms), cualquier dispositivo que mida a velocidades más lentas se perderá estos detalles. La transición al estado normal en J^* ocurre tan abruptamente que ni siquiera con nuestro sistema de adquisición rápida podemos apreciar todos los detalles del salto, pero sí que alcanza para ver el arranque de la transición y estudiar los efectos que la duración de la medida tiene en la determinación de J^* .

La velocidad de la tarjeta de adquisición también nos permite medir curvas E - J completas en breves periodos de tiempo, de manera que garanticemos la estabilidad de la temperatura durante toda la medida. La fuente de corriente que empleamos no permite aplicar

pulsos más breves que de unos 0.7 ms, así que estas medidas de curvas completas las realizamos con rampas escalonadas: cada *peldaño* de corriente constante tiene la duración más corta que la fuente permite, y se recorren varios valores de corriente entre J_c y J^* en, típicamente, 20-30 ms, midiendo constantemente el voltaje. El tener peldaños de corriente constante nos permite descartar efectos inductivos, eliminando los datos tomados en las transiciones entre peldaños.

Al aplicar densidades de corriente elevadas, cercanas a J^* , se observan variaciones de voltaje en el tiempo que dura cada escalón aplicado, signos claros de calentamiento de la muestra. En muchas de las curvas $E-J$ que mostraremos, el valor de E para cada J se ha tomado como el promedio de los valores medidos en un peldaño estable de la rampa. (Salvo en los puntos más cercanos a la transición, en que no siempre se promedian, para mostrar su evolución). Haremos estudios de los efectos que tienen en la determinación de la curva $E-J$ y del valor de J^* tanto la duración de la rampa como el hecho de medir con rampa escalonada o con pulsos aislados.

Las medidas de curvas $V-I$ con la DAQ suelen hacerse empleando su ganancia máxima de un factor 100, para medir en la escala bipolar de ± 50 mV, al menos en la región por debajo de la transición. Estas medidas tienen una resolución de $100 \text{ mV}/2^{16} = 1.5 \mu\text{V}$, pero una dispersión debido al ruido experimental de unos $80 \mu\text{V}$. Haciendo medidas en escalones obtenemos entre 60 y 70 puntos útiles (descontando las transiciones) con una desviación típica de $30 \mu\text{V}$. Con 60 puntos, esto supone un intervalo de confianza al 95 % de $2 \times 30 \mu\text{V}/\sqrt{60} = 8 \mu\text{V}$. Para un puente de $50 \mu\text{m}$ de largo esto implica un error en el campo eléctrico menor que $\pm 2 \text{ mV/cm}$. Este error es menor del 0.1 % para los valores típicos en torno al salto, pero muy grande para los rangos en torno a J_c , por eso en ese caso empleamos el nanovoltímetro, que mide promediando el ruido sobre varios ciclos de red.

Por comodidad en el análisis, en estas medidas en rampa

consideramos que la corriente I inyectada es la nominal de la fuente en el cero y en un punto elevado de la rampa. Con estos dos puntos fijos se escalan todas las lecturas de la resistencia patrón, simultáneas con las del voltaje de la muestra⁸, también promediando en cada escalón de la rampa. La desviación típica de estas medidas (que se realizan con la DAQ en la escala de ± 5 V) es unos $10 \mu\text{A}$, lo que para 60 adquisiciones implicaría un intervalo de confianza al 95 % de unos $3 \mu\text{A}$ en la medida de la corriente. Para un micropunto típico, esto supone un error en la determinación de J de 200 A/cm^2 , poco más de 30 partes por millón en torno a J^* .

Para la medida de curvas de resistividad en función de la temperatura se empleó indistintamente el nanovoltímetro o la tarjeta de adquisición, lo que resultase más cómodo en cada momento, a pesar de que estas medidas se hacen siempre en un régimen de no muy alta disipación ($J \sim 100 \text{ A/cm}^2$). La tarjeta DAQ proporciona resultados más ruidosos y con peor resolución que el nanovoltímetro, pero las curvas $\rho(T)$ que se mostrarán en esta primera parte de la memoria no son más que caracterizaciones generales de las muestras, y no centramos nuestro interés en ellas. Veremos un caso singular de medida de resistividad en función de la temperatura con altas corrientes, a propósito para ver efectos térmicos. En este caso, por supuesto, se empleó la DAQ para hacer medidas rápidas.

3.3. Otros aspectos

Gran parte del tiempo de este trabajo de doctorado se invirtió en la preparación de este montaje experimental que hemos descrito.

⁸Esta tarjeta DAQ no mide simultáneamente en todos sus canales, sino que conmuta la lectura de uno a otro en intervalos regulares de tiempo. En nuestras medidas, un canal tiene un retraso respecto del otro de $10 \mu\text{s}$, lo que resulta despreciable dentro de la duración típica de un escalón de corriente constante, en torno a 0.75 ms .

Los aspectos que principalmente ocuparon el tiempo dedicado a la preparación del experimento fueron dos:

Por un lado, la puesta a punto del criostato. Durante la búsqueda de una fuga en una de sus cámaras estancas, cuya localización⁹ y reparación ocupó varias semanas, se tomaron las fotografías mostradas previamente.

Por otro lado, se dedicó largo tiempo a la elaboración de un programa escrito inicialmente en HP-BASIC y posteriormente en Visual Basic, que controla y sincroniza los diversos dispositivos electrónicos y permite realizar medidas de curvas $V-I$ en breves intervalos de tiempo. El tiempo invertido en el diseño de este programa ha dado buenos frutos, pues hemos podido tomar con comodidad y rapidez las medidas que se muestran en sucesivos capítulos. Además, se facilita enormemente la continuidad de trabajo, pues la modularidad y sencillez de uso del programa permiten adaptarlo a nuevas necesidades con poco trabajo extra.

⁹Con un detector de fugas de helio Balzers HLT 150.

Capítulo 4

Resultados experimentales

4.1. Resistividad en función de la temperatura

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran las resistividades eléctricas de algunos de los micropuentes empleados en este trabajo. Algunas curvas fueron medidas también con campo magnético aplicado, como caracterización complementaria.

Estas medidas de resistividad se realizaron aplicando corrientes bajas, para disminuir todo lo posible la disipación y la alteración de la medida con calentamiento. Se inyectan en el micropuente típicamente $10\text{ }\mu\text{A}$, lo que supone una densidad de corriente de $6.7\times 10^2\text{ A/cm}^2$. Disminuir la corriente en un factor cinco no produce variaciones de la medida, por lo que los efectos térmicos pueden descartarse. Como las películas han sido crecidas en la dirección cristalográfica c , la resistividad que se mide sobre los micropuentes es la correspondiente al promedio en las direcciones a y b : por este motivo denominamos a esta resistividad ρ_{ab} . De este tipo de medidas se extraen varios de los parámetros descriptivos de las muestras. Concretamente, empleamos estas caracterizaciones para determinar la temperatura crítica de cada muestra.

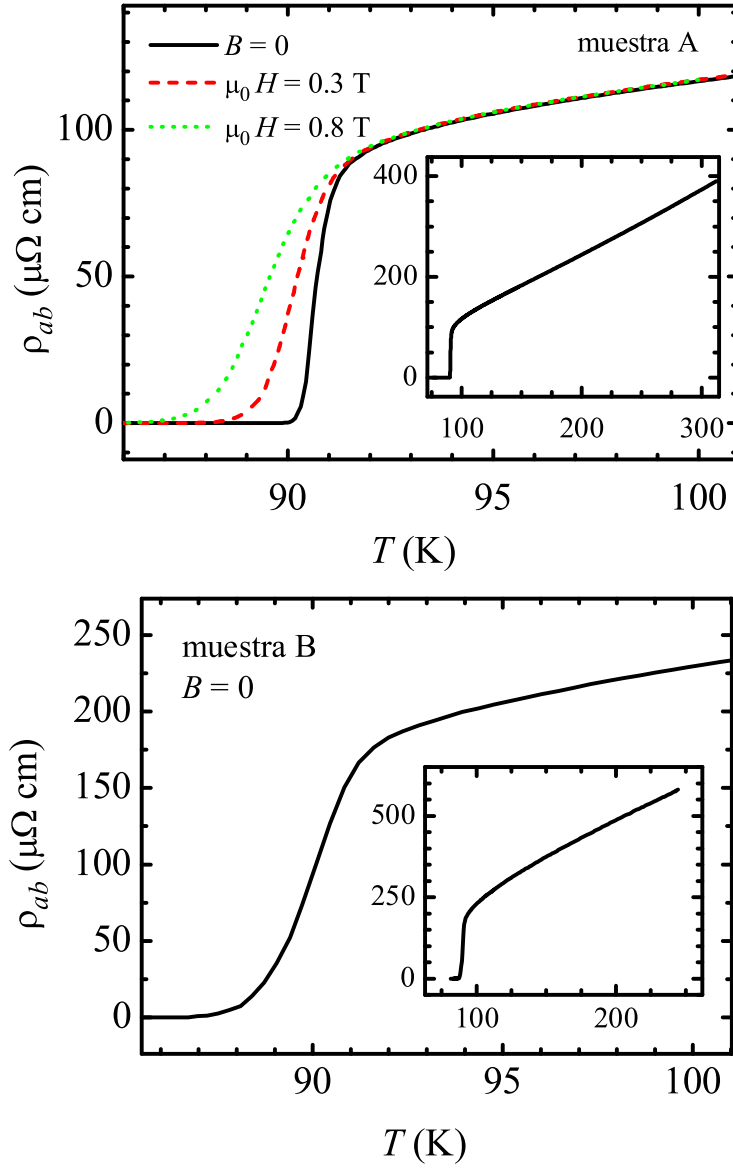


Figura 4.1: Resistividad en función de la temperatura para las muestras A y B, para $B = 0$ y con campo magnético aplicado.

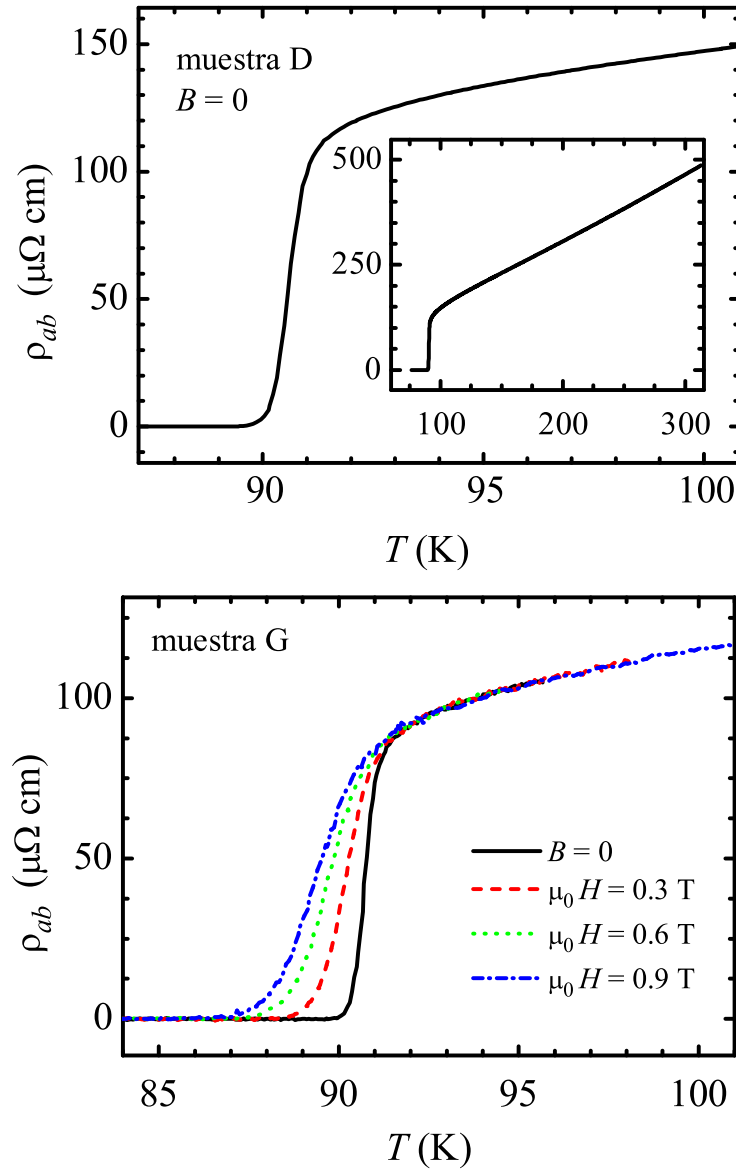


Figura 4.2: Resistividad en función de la temperatura para las muestras D y G, para $B = 0$ y con campo magnético aplicado.

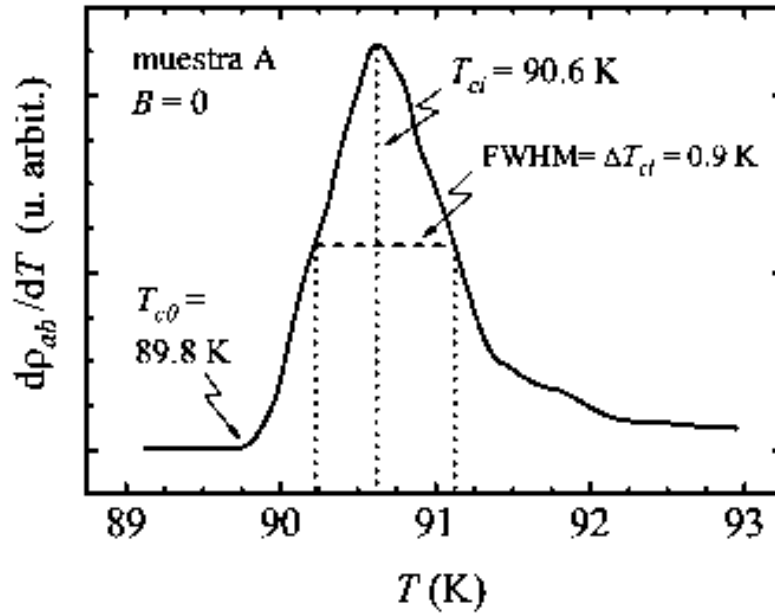


Figura 4.3: Un ejemplo de derivada de la resistividad en función de la temperatura, empleada para la determinación de la temperatura crítica. El punto de la transición con derivada máxima (el punto de inflexión de la transición) es T_{ci} , y es la temperatura que tomaremos como la T_c de la muestra. El ancho de esta curva a mitad de altura (FWHM) es el parámetro ΔT_{ci} , indicativo de la estrechez de la transición, y por lo tanto de la homogeneidad estequiométrica de la muestra. La temperatura máxima T_{c0} a la que la resistividad es cero también se pone de manifiesto en esta representación.

4.2. Determinación de la temperatura crítica T_c

Del análisis exclusivo de $\rho(T)$ sólo podemos estimar la localización de T_c fijándonos en alguna discontinuidad fruto de la transición superconductora. Ya sea por la existencia de inhomogeneidades¹ estequiométricas en la muestra (varios dominios con temperaturas críticas diferentes) o, aún en el mejor de los casos, por la inevitable presencia de las fluctuaciones termodinámicas, la transición aparece

¹Ver nota 1 de la página 49.

siempre redondeada². De las medidas de $\rho(T)$ obtenemos unos cuantos parámetros que caracterizan esta transición. La temperatura más alta T_{c0} a la que la resistividad es nula, a corrientes bajas y sin campo magnético aplicado

Otros parámetros característicos relevantes son la temperatura en que la transición alcanza su punto medio, y la anchura de dicha transición. En la figura 4.3 se representa un ejemplo de derivada de la resistividad en función de la temperatura para uno de los micropuentes, y se muestra cómo se determinan estos parámetros. El punto de inflexión de la transición, donde la derivada es máxima, establece la temperatura T_{ci} . La anchura a mitad de altura (FWHM) de esta derivada caracteriza la anchura de la transición, dando el parámetro ΔT_{ci} . Todos estos parámetros para las distintas muestras fueron recopilados previamente en la tabla 2.2 (p. 50).

En general, tomaremos como temperatura crítica T_c de cada muestra el valor de T_{ci} , salvo cuando se indique lo contrario específicamente.

4.3. Curvas características campo eléctrico – densidad de corriente

Las curvas características campo eléctrico–densidad de corriente E – J son las curvas características V – I de las muestras escaladas a sus correspondientes dimensiones geométricas, para facilitar la comparación de los resultados. De este modo, $E = V/l$ y $J = I/(a d)$, donde l es la longitud del micropuente, y a y d su ancho y espesor respectivamente.

²La mejor manera de estimar T_c en muestras de elevada calidad, sin inhomogeneidades, es hacer medidas de un observable menos afectado por fluctuaciones, por ejemplo de la susceptibilidad magnética con el campo paralelo a los planos superconductores. Pero ni siquiera los mejores dispositivos mejoran la resolución en 0.1 K.

4.3.1. Curvas a diferentes temperaturas y campos magnéticos

En las figuras 4.4–4.6 vemos varias representaciones de las isothermas E – J a campo aplicado nulo para una de nuestras muestras. Se varía el rango de representación para apreciar los distintos detalles. Cada una de estas curvas isothermas (curvas a constante temperatura *del baño*, que no necesariamente de la muestra) se midió en dos partes —con un nanovoltímetro (medidas largas en el régimen de baja disipación) y con una tarjeta de adquisición (medidas rápidas con alta disipación)— que se empalmaron posteriormente en el análisis de datos, para reconstruir las curvas completas.

Se impone un límite superior en voltaje a la fuente de alimentación, para evitar el deterioro de la muestra por disipaciones excesivas. Este límite lo determina la experiencia, tras haber destruido varios micropuentes por exceso de calor. Puede variar de una muestra a otra, sobre todo en función de la longitud del micropuerto, lo que parece indicar que esta longitud es un parámetro directamente relacionado con la capacidad de refrigeración del sistema, y merecería un estudio detallado. En el caso que se muestra, se fija el campo E máximo en unos 4×10^3 V/cm.

En las isothermas más cercanas a T_c se aprecia que la transición se suaviza, y se pierde el salto abrupto. En la figura 4.5.b se compara la isoterma medida a $T = 92.1$ K, por encima de T_c , con la recta E – J correspondiente al valor de la resistividad a esa temperatura, medida a corrientes bajas, de la figura 4.1. La isoterma E – J experimental se desvía de esta tendencia recta a corrientes altas, probablemente debido al aumento de la temperatura de la muestra causada por la elevada disipación. Este efecto debe de manifestarse también en las otras isothermas por debajo de T_c , así que es probable que todas estén afectadas de calentamiento en las regiones de alta disipación (principalmente en el estado normal).

Las figuras 4.7 y 4.8 recogen otras curvas características E – J

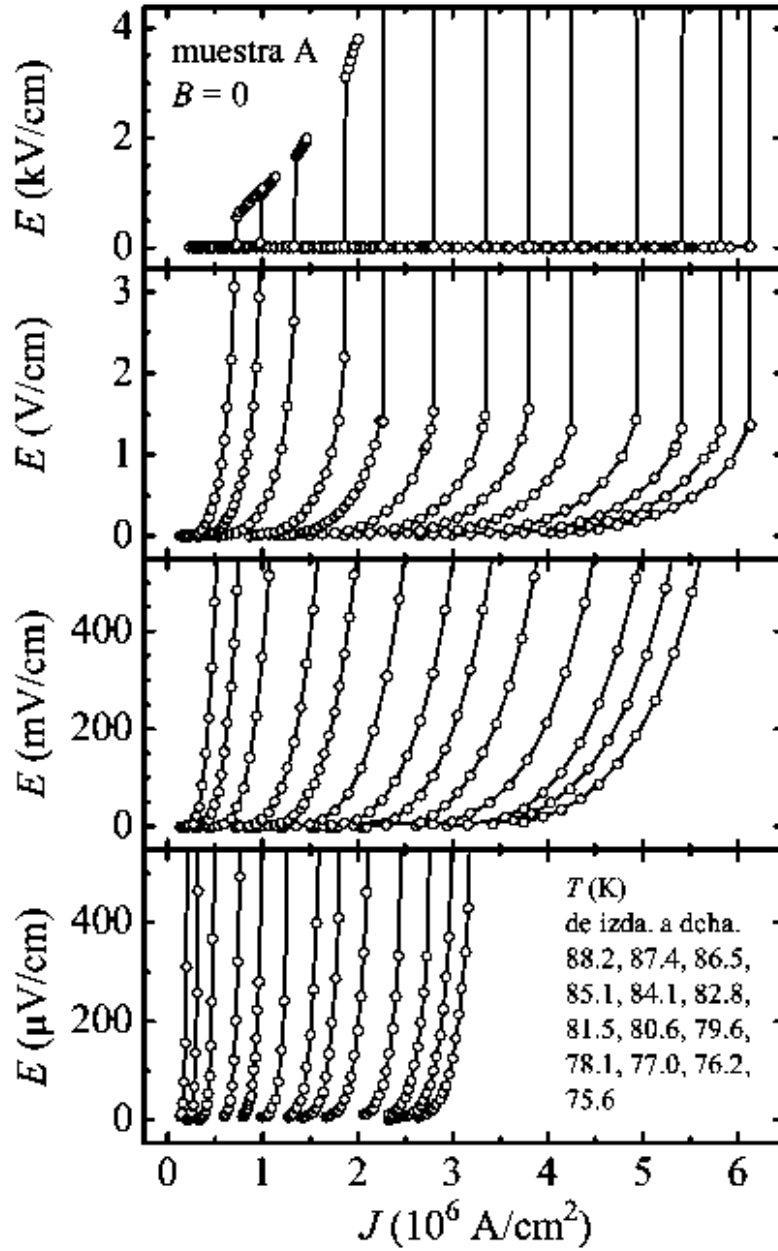


Figura 4.4: Curvas características E – J para la muestra A, a distintas temperaturas por debajo de T_c , a campo magnético aplicado nulo. En las distintas gráficas se representan las mismas curvas, pero disminuyendo sucesivamente el rango de representación en campo E para apreciar los detalles.

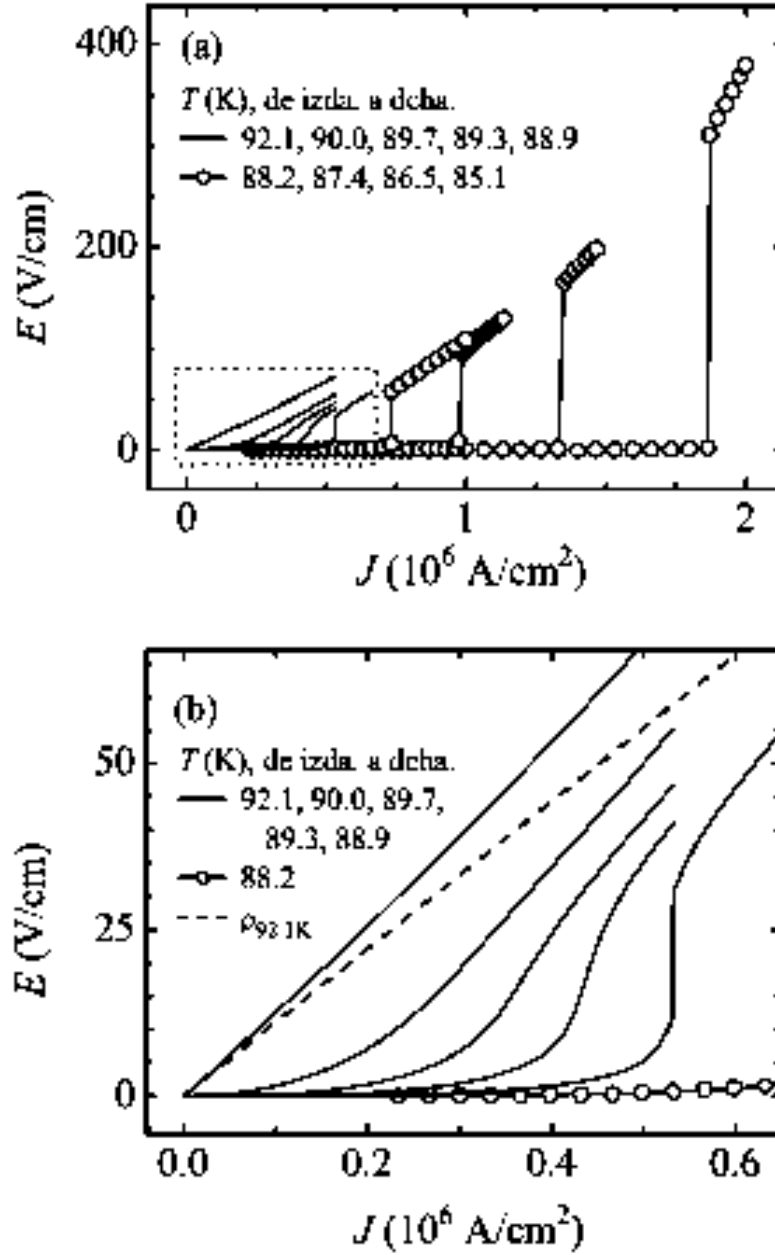


Figura 4.5: En (a), detalle de la figura 4.4, para apreciar la región normal por encima de J^* . En línea continua se incluyen otras isothermas que, por claridad, no estaban en la figura previa. En (b), ampliación de la región encuadrada arriba, para apreciar las isothermas más cercanas a T_c . Ver texto.

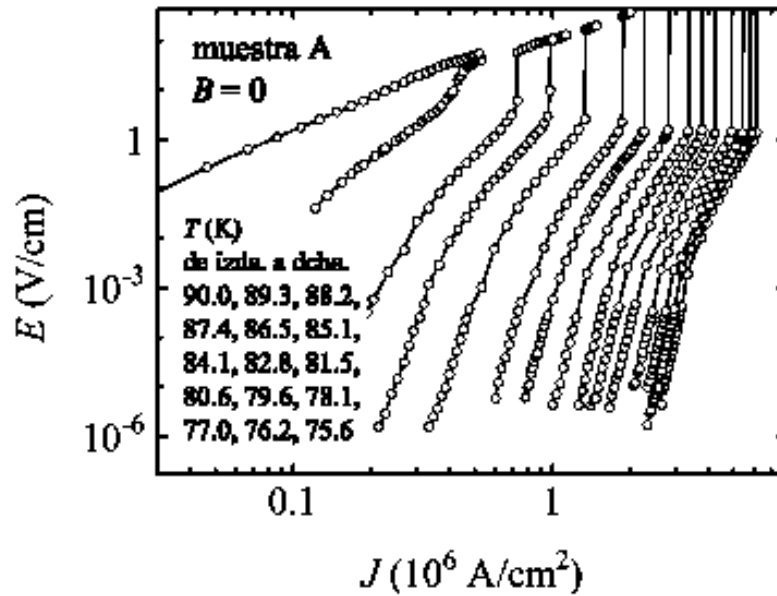


Figura 4.6: Curvas características E – J para la muestra A, a distintas temperaturas por debajo de T_c , a campo magnético aplicado nulo. Son las mismas isothermas de las figuras 4.4 y 4.5, pero ahora en representación logarítmica para apreciar globalmente sus tendencias. El límite en voltaje impuesto a la fuente de alimentación establece el campo E máximo en unos 4×10^3 V/cm.

para esta misma muestra, pero esta vez manteniendo constante la temperatura y variando el campo magnético aplicado externamente. La figura 4.7 es a $T = 76.2$ K, y presenta una zona en el estado normal, tras el salto en J^* , con campo E superior al umbral impuesto en nuestra fuente. En la figura 4.8 podemos apreciar esa región normal para una temperatura superior $T = 84.1$ K, más cerca de T_c , donde los voltajes correspondientes son asequibles a nuestro experimento dentro del límite fijado. Nótese que esto *no* es porque la resistividad sea menor cuando crece la temperatura: para resistividades similares o incluso mayores, el campo $E = J \rho_n$ con $J \gtrsim J^*$ correspondiente a la región normal es menor cuando J^* disminuye.

En la figura 4.8 representamos también la recta E – J que corresponde a la resistividad extrapolada desde la zona normal hasta

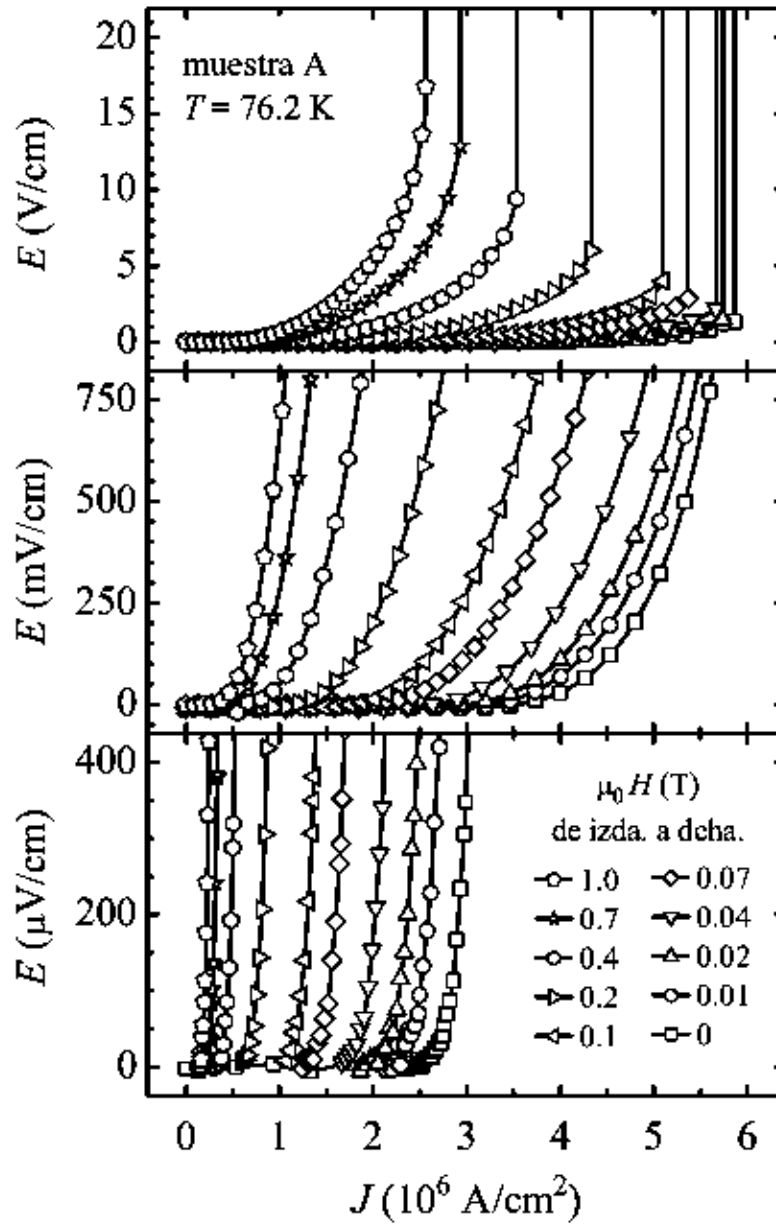


Figura 4.7: Curvas características E - J para la muestra A, a distintos campos magnéticos aplicados $0 < \mu_0 H < 1 \text{ T}$, a temperatura constante $T = 76.2 \text{ K}$. En las distintas gráficas se representan las mismas curvas, pero disminuyendo sucesivamente el rango de representación en campo E para apreciar los detalles. El límite en voltaje impuesto a la fuente de alimentación, impide ver la región normal.

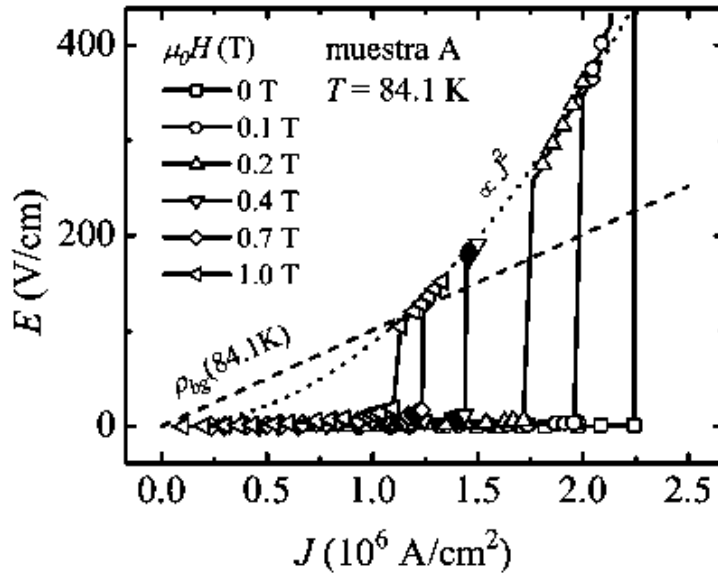


Figura 4.8: Curvas características E - J para la muestra A, a distintos campos magnéticos aplicados $0 < \mu_0 H < 1$ T, a temperatura constante $T = 84.1$ K. En contraste con la figura 4.7, ahora la región normal presenta un voltaje inferior al umbral fijado en la fuente, por lo que se puede medir. La recta de trazo discontinuo corresponde a la resistividad extrapolada desde el estado normal para $T = 84.1$ K. Todas las isothermas, en la región normal, se desvían de esta tendencia recta, probablemente debido a la elevación de la temperatura de la muestra por la disipación. La tendencia se ajusta aproximadamente a una función proporcional al cuadrado de la corriente aplicada.

$T = 84.1$ K, como guía comparativa. Los puntos en la región normal de las curvas E – J se desvían nuevamente de esta tendencia recta, con una dependencia aparentemente cuadrática respecto de la corriente.

Las curvas E – J de nuestras muestras son análogas a las que en la bibliografía presentan muestras similares. Ver, por ejemplo, las referencias [18, 52, 53]. Como ya mencionamos en la sec. 3.1, tampoco hay diferencias entre estas curvas y las medidas con una refrigeración líquida en vez de gaseosa [11, 13, 46], por lo menos mientras la muestra no transita completamente al estado normal y se vuelve altamente disipativa.

4.3.2. Obtención de las curvas E – J

Las figuras 4.9–4.11 muestran un experimento típico para la determinación de las curvas E – J mostradas previamente, en el rango en que la disipación exige medidas rápidas con la tarjeta adquisidora. Se aplica una rampa de corriente escalonada, y se mide el voltaje en el micropuente y en la resistencia patrón, a una velocidad de 10^5 adquisiciones/s por canal (se hace una adquisición cada $5 \mu\text{s}$, alternando los dos canales: las medidas no son simultáneas). Cuando se produce la transición en J^* la resistencia de la muestra aumenta, de modo que la impedancia del circuito crece notablemente. La fuente de corriente acusa este fenómeno: si el límite máximo de voltaje impuesto es bajo, la corriente cae bruscamente y el estado normal no es asequible al experimento.

En la región de mayor disipación, cerca de la transición, el voltaje crece suavemente mientras la corriente permanece en un escalón constante: esto se atribuye a un aumento de temperatura de la muestra. Cuando de estas medidas se compone la gráfica V – I (fig. 4.11, que una vez escalada a las dimensiones de la muestra dará la E – J), se aprecia cómo los puntos experimentales aumentan su dispersión cuando estamos cerca de J^* debido a este efecto térmico. Para la presentación final de las curvas E – J se eliminan los puntos que

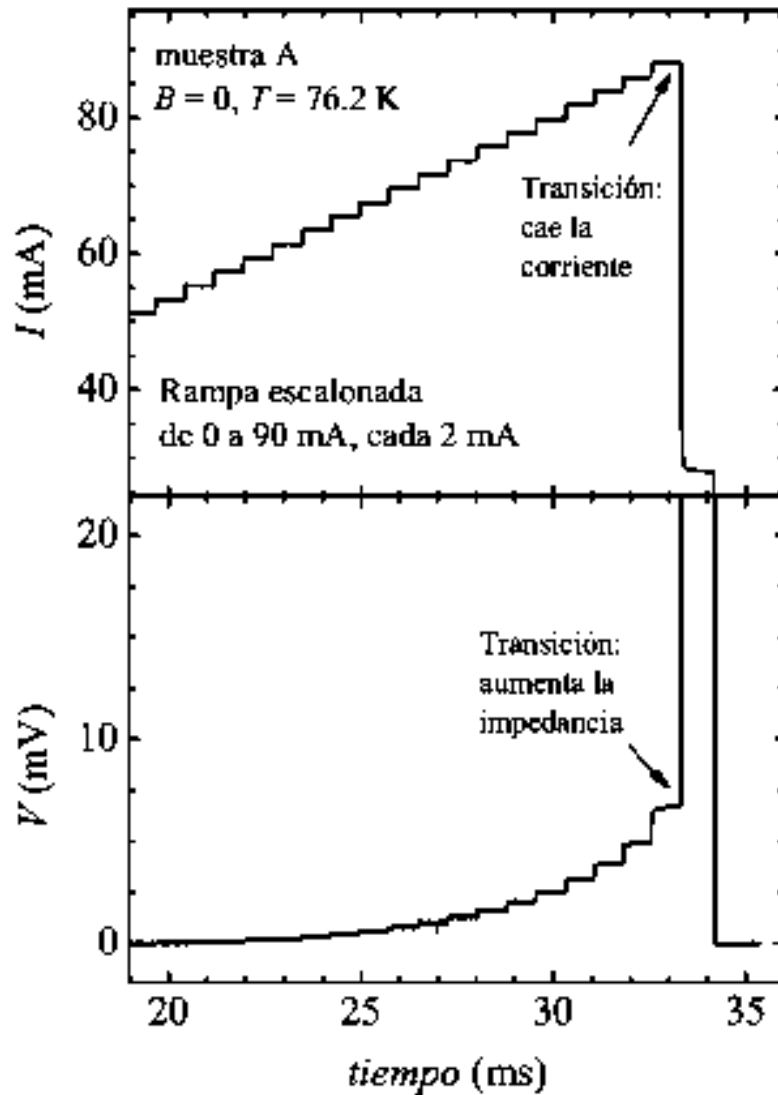


Figura 4.9: Experimento típico para la determinación de curvas E – J en el régimen de alta disipación, con tarjeta adquisidora (DAQ). Arriba, la rampa escalonada de corriente que se aplica, determinada sobre una resistencia conocida en serie con el micropuente. Abajo, el voltaje leído en el micropuente. Se muestra sólo la parte final de la rampa. En el momento en que se produce la transición al estado normal la impedancia del circuito aumenta notablemente, y si la fuente tiene un límite máximo en voltaje la corriente aplicada cae bruscamente. Posteriormente termina la medida y se elimina la corriente.

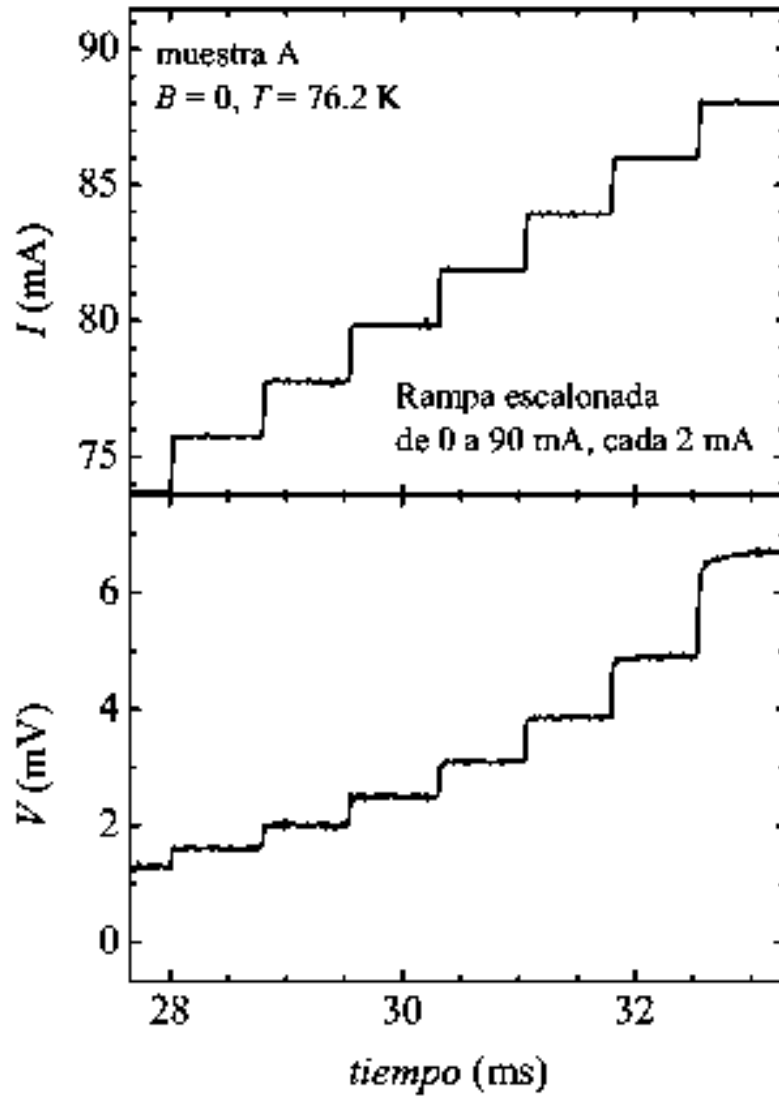


Figura 4.10: Experimento típico para la determinación de curvas E - J en el régimen de alta disipación, con tarjeta adquisidora (DAQ): detalle de la figura 4.9. Arriba, la rampa escalonada de corriente que se aplica. Abajo, el voltaje leído en el micropuente. En la región de mayor disipación, cerca de la transición, el voltaje crece suavemente mientras la corriente permanece en un escalón constante: esto se atribuye al aumento de temperatura de la muestra.

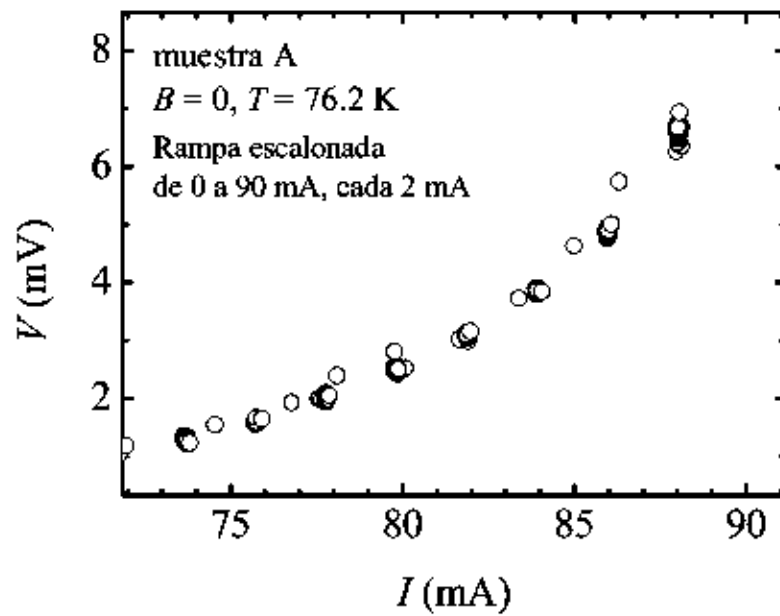


Figura 4.11: De las medidas de la figura 4.10 se compone una gráfica característica $V-I$. Algunos puntos dispersos correspondientes a los saltos de escalones de corriente son posteriormente eliminados, pues están muy afectados de incertidumbre y efectos inductivos. La variación del voltaje por calentamiento puesta de manifiesto en la figura anterior se aprecia también aquí cuando la disipación es mayor: los puntos experimentales están más dispersos a corrientes altas.

coinciden con un salto de escalón de corriente, pues en estos la incertidumbre y los efectos inductivos son demasiado grandes.

La figura 4.12 muestra los efectos de variar la duración total de la rampa. Como el ancho temporal de los peldaños que nuestra fuente puede aplicar tiene un mínimo en algo menos de 1 ms, la duración de la rampa la establecemos variando el número de escalones totales, haciéndolos de mayor o menor altura. En esta figura podemos ver cómo el valor de la corriente de salto no se ve especialmente afectado por el tiempo que dure la rampa, al menos en este rango en que nos encuadramos. Las rectas de trazos discontinuos unen los puntos en que se produce la transición, tanto en la gráfica de corriente como en la de voltaje. El valor del voltaje de salto, sin embargo, sí que acusa los efectos térmicos: la variación al aumentar el tiempo de la rampa en un factor ocho es del 14 %.

Los valores de J^* y de E^* que emplearemos en los análisis posteriores los extraemos del último punto de la curva $E-J$ que medimos antes de la transición. Cometemos por tanto un error en esta determinación relacionado con la resolución de la rampa de corriente que aplicamos: dependiendo de la altura de los escalones que apliquemos, determinaremos con mayor o menor exactitud estos valores. Pero dentro de los rangos temporales en que nos movemos, aumentar la resolución de la rampa de corriente no mejora mucho la determinación de J^* . En la figura 4.13 comparamos los valores de J^* que se determinaron con rampas de distinta resolución, que se refleja en la barra de error de cada punto. Los correspondientes a las rampas con más detalle están sistemáticamente desplazados hacia valores más bajos de J^* . Esto se debe probablemente a efectos de calentamiento de la muestra: las rampas más detalladas son también las más largas temporalmente, y calientan por más tiempo la muestra, incluso si las iniciamos directamente en escalones muy cercanos al valor esperado de J^* .

En el límite opuesto, empleando pulsos aislados, de sucesivamente mayor corriente, se obtienen valores compatibles con estos: como la

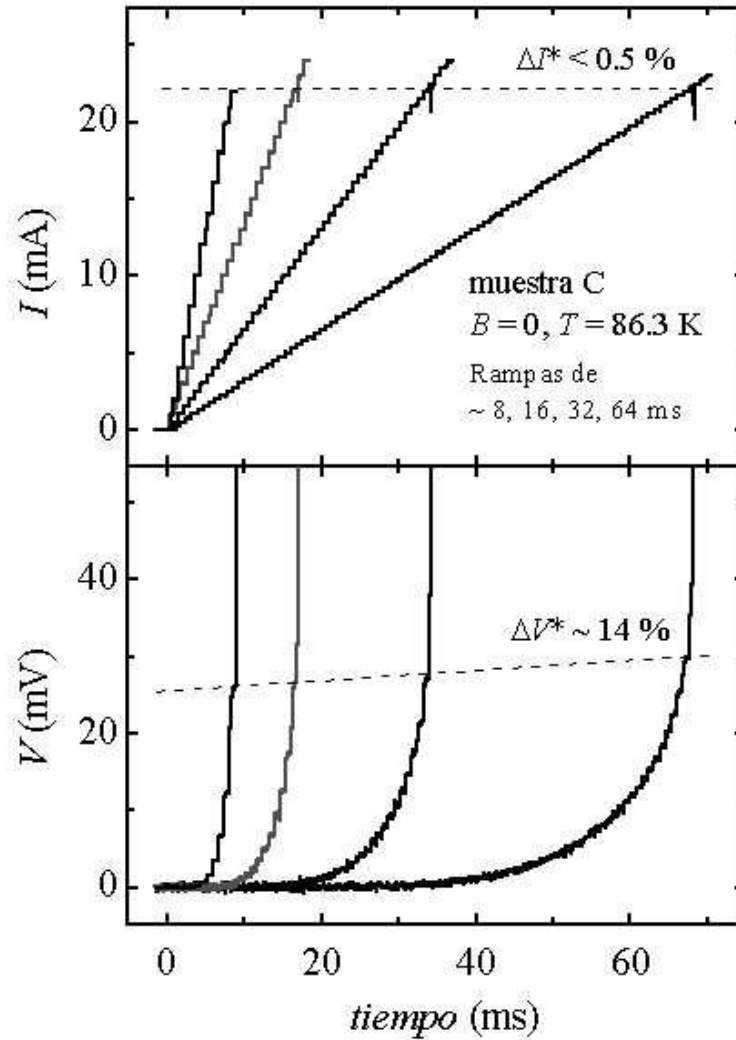


Figura 4.12: Rampas de corriente escalonadas de distinta duración, variando el número de escalones entre la corriente inicial y final. Arriba, corriente aplicada. La corriente de salto se reconoce por un pequeño pico, causado por el aumento repentino de impedancia en el circuito. Ahora la limitación de voltaje en la fuente no impide seguir aumentando la corriente tras el salto. Abajo, voltaje leído en el micropuente. Las rectas de trazo discontinuo unen las corrientes y los voltajes de salto. Mientras que la corriente apenas varía un 0.5%, el voltaje aumenta hasta un 14% debido al calentamiento.

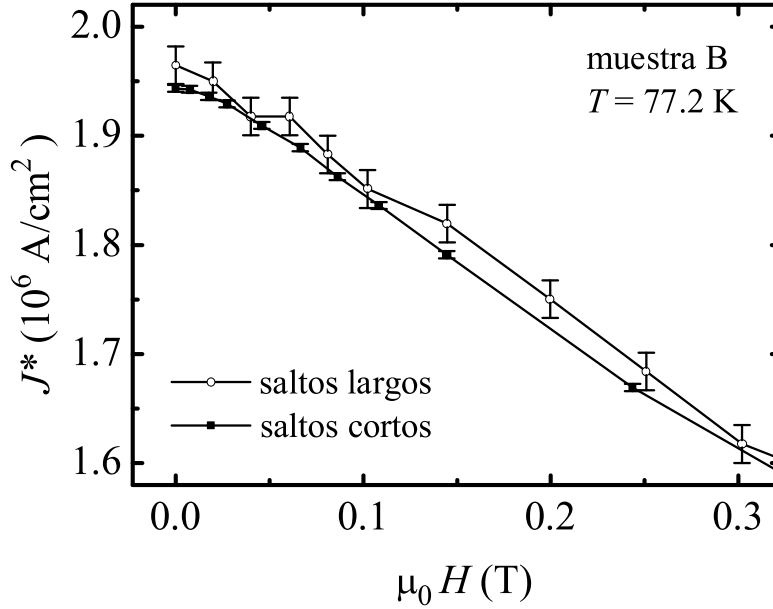


Figura 4.13: Comparación de los valores de J^* determinados con rampas de corriente de distinta resolución. La barra de error de cada punto la determina la altura del escalón de su rampa correspondiente. Las rampas con mayor resolución son también las más largas temporalmente, por lo que acusan un desplazamiento sistemático de J^* hacia valores más bajos debido al calentamiento. Las líneas son guías para los ojos.

lectura del voltaje muy cerca de J^* se ve inevitablemente afectada de calentamiento, se hace difícil saber cuál es exactamente el último valor *previo* a la transición. Como hemos visto, esta influencia del calentamiento se manifiesta sobre todo en la incertidumbre de E^* , pero es de suponer que indirectamente afecta también al valor de J^* .

Tras todas estas consideraciones, hemos empleado rampas de corriente de duración y resolución que compensan en lo posible estos problemas (el calentamiento por un lado, y la falta de resolución por el otro). De este modo, hemos procurado que los valores de J^* que mostramos tengan un error inferior al 5 %, entendiendo éste como la dispersión de los resultados al emplear diferentes parámetros de rampa dentro de los rangos que permiten nuestros dispositivos (sin considerar

otros errores sistemáticos, como los provenientes de la caracterización geométrica de las muestras).

4.4. Consideraciones sobre el calentamiento en torno al salto

4.4.1. Estimación del aumento de temperatura durante la medida

Hemos realizado medidas de la correlación entre la potencia disipada y el incremento de temperatura, en una muestra de igual geometría a las empleadas en el resto de las medidas, en el estado normal, aunque no muy lejos de la transición. En el estado normal se puede suponer que la resistividad no depende de la corriente aplicada (lejos de la región más afectada de fluctuaciones térmicas, y suponiendo que no hay magnetorresistencia), y atribuir toda diferencia que se observe en la resistividad, dependiendo de la corriente aplicada, a un aumento de temperatura.

De varias medidas de la evolución de la resistividad en función del tiempo como la de la figura 4.14, a altas corrientes aplicadas y a distintas temperaturas, se obtiene una curva $\rho_{ab}(T)$ como la de la figura 4.15 (línea de puntos), desplazada respecto de las que se miden con corrientes bajas (línea continua) en las que se supone que no hay calentamiento apreciable. El desplazamiento horizontal en temperatura ΔT de una respecto de la otra es mayor cuanto más es la disipación $W = J^2 \rho_{ab}$. De esto se obtiene una correlación de ΔT con la potencia disipada por unidad de volumen $W = E \times J = \rho_{ab} \times J^2$. Si no involucramos en esta correlación variables temporales, esto sólo tiene sentido en estados estacionarios, cuando ρ (que es proporcional a E) está bien definida; es decir, cuando pasado cierto tiempo, se estabiliza. En estas medidas (fig. 4.14), el voltaje parece estabilizarse en menos

de 1 ms, y es este valor estable el que tomamos para determinar E (del que extraemos W) y ΔT .

Los resultados de la correlación cerca de la transición se muestran en la figura 4.16. Si extrapolamos este comportamiento térmico hasta $T < T_c$, a regiones superconductoras³, tenemos que para las potencias típicas disipadas antes del salto, $W^* \simeq 10^7$ W/cm³, el aumento de temperatura máximo sería de 0.5 K. Esto daría pie a descartar el calentamiento homogéneo como causa de la transición abrupta: no parece, de estas medidas, que se esté produciendo un aumento de temperatura de la muestra de decenas de grados, hasta elevarse por encima de T_c . Sin embargo, veremos en los capítulos 6 y 7 que esta conclusión es precipitada, y que hace falta un análisis más detallado del comportamiento térmico del sistema para poder descartar por completo el calentamiento.

4.4.2. Tiempos térmicos característicos

En la figura 4.17.a ponemos de manifiesto los estados casi estacionarios que se alcanzan por debajo de J^* , a J constante, tras un calentamiento inicial de la muestra. Aplicamos aquí pulsos más largos que los hasta ahora mostrados, y vemos que efectivamente el valor del voltaje —y por lo tanto el de la temperatura— se estabiliza pasado aproximadamente un milisegundo, con independencia de la disipación que se genere: es un tiempo que caracteriza la inercia térmica del sistema.g

Esta muestra H presenta una transición superconductora más ancha que otras muestras, lo que pone de manifiesto su menor

³Esta extrapolación parece en principio una buena aproximación, pues los principales mecanismos térmicos no varían notablemente por volverse superconductora la muestra: lo más relevante es la interacción con el medio, principalmente el sustrato. En todo caso la superconductividad mejora la conductividad térmica del micropuente, por lo que esta correlación daría una cota superior al aumento de temperatura.

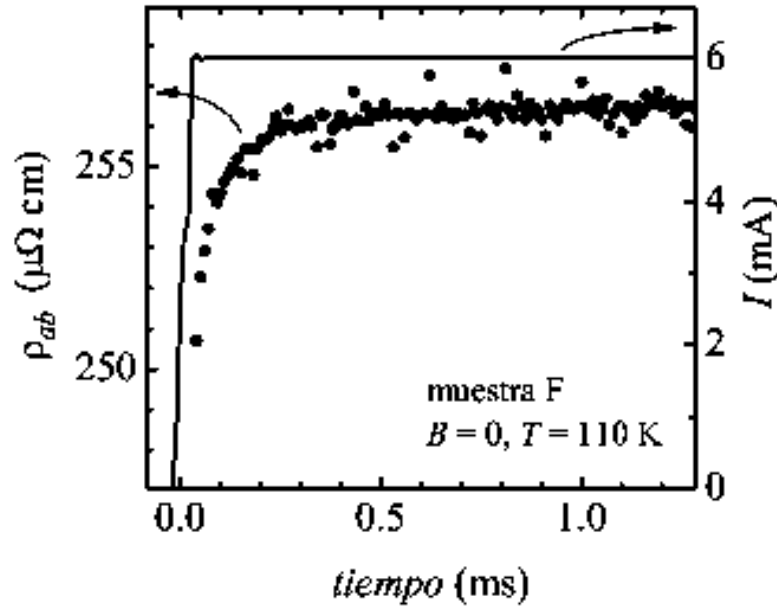


Figura 4.14: Medida de resistividad (proporcional al voltaje) a corriente constante para una muestra a temperatura mayor que T_c . A estas corrientes tan elevadas, la disipación causa un calentamiento de la muestra que se traduce en una variación del voltaje leído, análoga a la que se observa en las curvas E - J a $T < T_c$. La temperatura parece estabilizarse en aproximadamente 1 ms.

homogeneidad. Estas inhomogeneidades podrían ser las causantes de que los tiempos térmicos se prolonguen, al aparecer disipación extra, comparados con los de muestras de mejor calidad. En la figura 4.14, por ejemplo, veíamos cómo la mayor parte de la variación de temperatura se produce en los primeros 0.3 ms, siendo posteriormente casi constante.

Tras aplicar durante 200 ms esas corrientes elevadas, disminuimos J bruscamente hasta un valor más bajo $J_r = 0.3 \times 10^5 \text{ A/cm}^2$, siempre el mismo, en la figura 4.17.b. (Esta densidad de corriente J_r era, antes del experimento, del orden de J_c , de modo que no generaba una disipación muy alta y no se apreciaba calentamiento al aplicarla). Vemos, en contraste con la medida de calentamiento de la figura 4.17.a, que la velocidad de enfriamiento es ahora dependiente del valor de

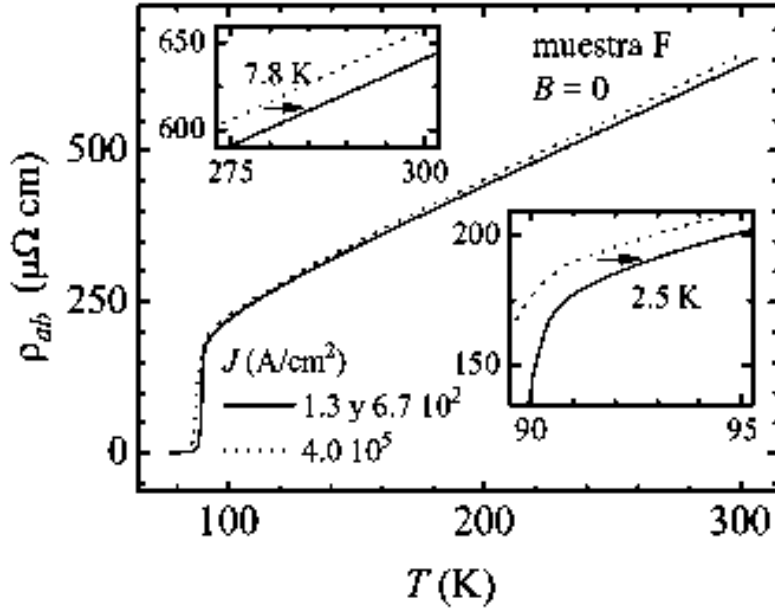


Figura 4.15: De varias medidas como la de la figura 4.14 a altas corrientes y a distintas temperaturas, se obtiene una curva $\rho_{ab}(T)$ desplazada respecto de la que se mide con corrientes bajas. En las gráficas de detalle vemos cómo el desplazamiento horizontal en temperatura ΔT de una respecto de la otra es mayor cuanto más es la disipación $W = J^2 \rho_{ab}$. De esto se obtiene una correlación entre ΔT y W .

la corriente aplicada *previamente*, y ocurre en tiempos notablemente más largos. La explicación de este resultado podría ser que esta corriente residual J_r es ahora más disipativa de lo que era *antes* del experimento, pues la resistividad de la muestra ha aumentado tras el calentamiento previo. Como el aumento de temperatura —y por lo tanto de resistividad— está relacionado con cuánta corriente estábamos inyectando, J_r es más disipativa en unos casos que en otros, y la velocidad de enfriamiento presenta tiempos característicos diferentes. En cualquier caso, estos tiempos son más largos que en el caso del calentamiento, donde las diferencias entre una disipación y otra eran menores, relativamente hablando.

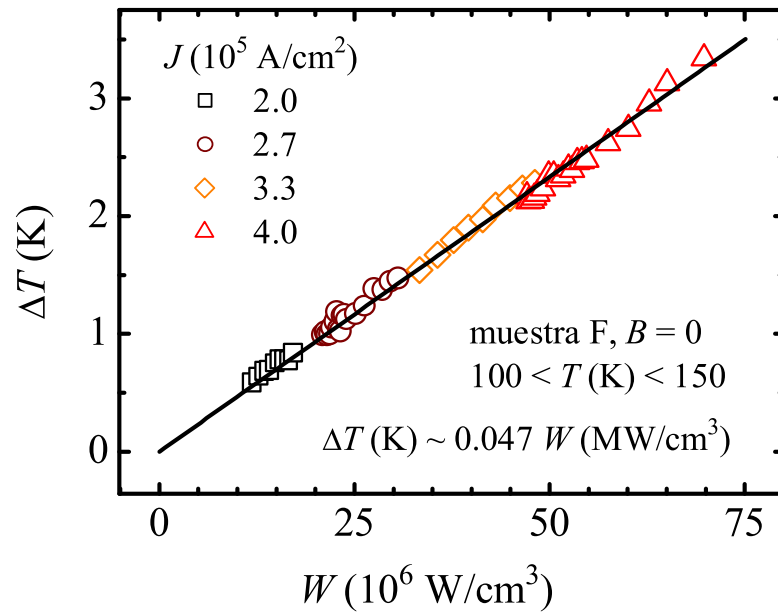


Figura 4.16: Correlación entre la potencia disipada y el incremento de temperatura de la muestra, en el estado normal, aunque no muy lejos de la transición. Ver texto para detalles.

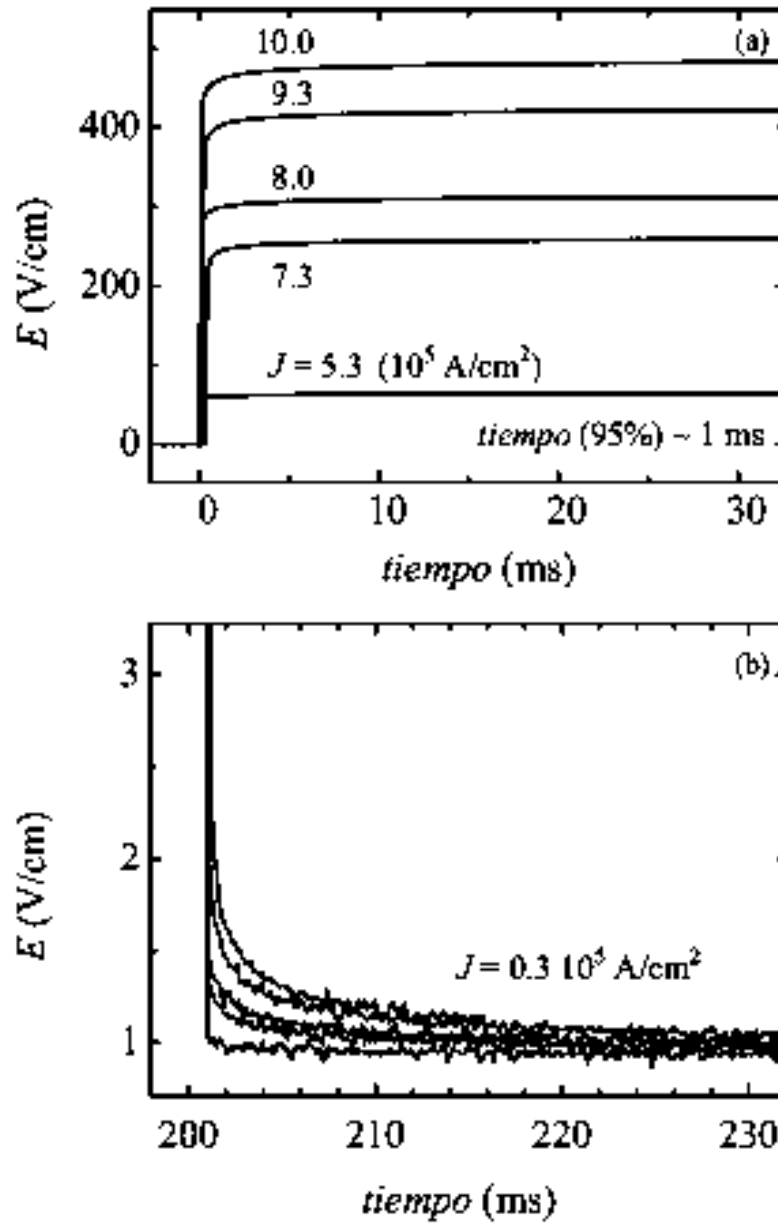


Figura 4.17: Muestra H: arriba, evoluciones temporales del voltaje experimental al aplicar durante largo rato distintas intensidades de corriente. La evolución acusa el calentamiento de la muestra: al 95 % del valor máximo se llega siempre pasado ~ 1 ms. Abajo, disminución brusca de la corriente, tras los largos pulsos anteriores, hasta un valor más bajo, de poca disipación.

Capítulo 5

Análisis de datos y comparación con los modelos teóricos

En este capítulo veremos en primer lugar la forma funcional que presentan las curvas características E – J dependiendo de la temperatura y el campo magnético. Esto nos servirá posteriormente para el estudio del salto en J^* , viendo cómo se desvían los datos respecto de la tendencia general al llegar a la región de altas corrientes.

Haremos también un repaso a los principales modelos teóricos que se emplean para explicar esta ruptura abrupta del estado superconductor. Veremos cómo varían los distintos parámetros críticos (J_c , J^* y E^* , principalmente) en función de la temperatura y el campo magnético aplicado, e intentaremos encajar estas dependencias en algunos de los modelos mencionados. Veremos que el efecto del autocampo magnético (el campo generado por la corriente inyectada) es determinante en la región de bajos campos aplicados.

Por último, estudiaremos la dependencia de la potencia disipada antes del salto $W^* = E^* \times J^*$ respecto de la temperatura y el campo magnético. Veremos cómo estas dependencias llevan a

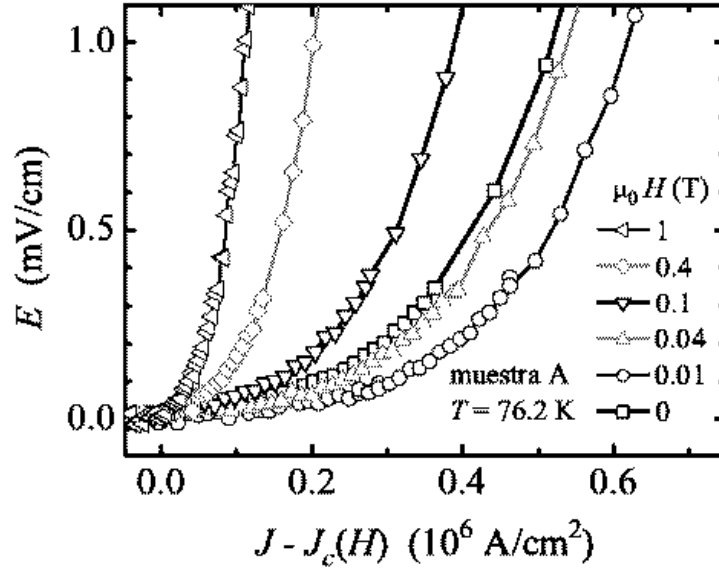


Figura 5.1: Campo eléctrico de la muestra A a distintos campos magnéticos aplicados y a temperatura constante. La representación es en $J - J_c(H)$, para hacer coincidir el arranque de todas las curvas en el mismo punto. La dependencia no lineal respecto de la corriente descarta que el régimen dinámico de vórtices sea de *free flux flow*.

ciertas conclusiones acerca de la naturaleza de la transición en J^* , conclusiones que no tienen por qué ser necesariamente ciertas si no se hacen con cuidado.

5.1. Dependencia del voltaje respecto de la temperatura y la corriente

Para el estudio de las corrientes de salto que posteriormente haremos en los capítulos 6 y 7 necesitaremos conocer cómo es la dependencia del campo E respecto de la corriente aplicada J y de la temperatura de la muestra. Emplearemos para ajustar nuestros

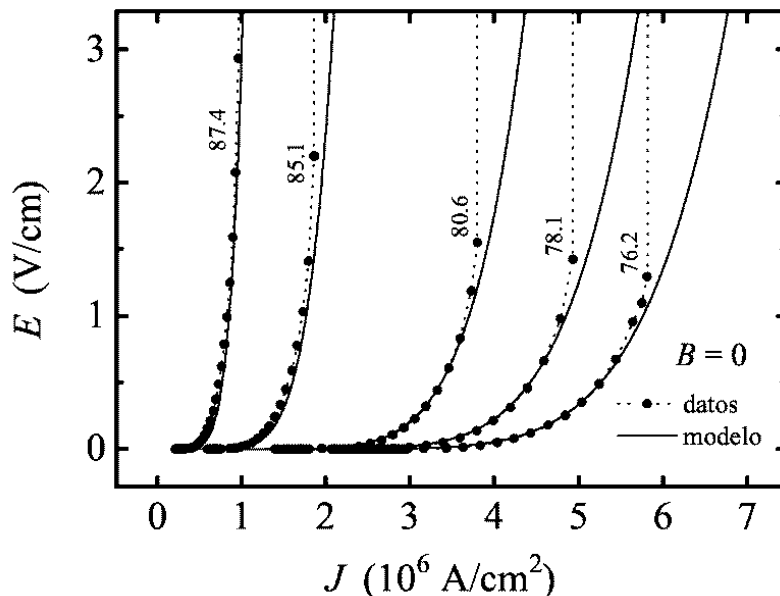


Figura 5.2: Comparación del modelo que se propone en la ecuación 5.1 con los datos experimentales de la muestra A, con $B = 0$. La temperatura inicial se indica al lado de cada curva. Los parámetros empleados son $E_0(1) = 1.04 \times 10^{-2}$ V/cm, $J_0(1) = 1.26 \times 10^7$ A/cm², $n = 5.86$, $g = 1.52$, $f = 1.26$ y $T_c = 89.8$ K

datos algunos modelos habituales que describen las curvas E - J , pero debemos señalar que *no estamos interesados* aquí en el significado de estos modelos: no queremos estudiar los mecanismos físicos que producen disipación en el estado mixto¹, sino, dada una dependencia para el voltaje experimental, ver cómo se producen desviaciones respecto de la tendencia en el régimen de alta disipación, debido a los mecanismos que causan la transición al estado normal.

En la figura 5.1 se representan los valores de E en función de $J - J_c(H)$, para hacer coincidir todas las curvas E - J en el punto en que comienza la disipación. La forma curvada hacia arriba que

¹Las curvas E - J del estado mixto en HTSC han sido estudiadas en profundidad en múltiples trabajos, y concretamente para películas de Y-123 [30, 53–67]. Para una revisión de los mecanismos implicados remitimos también a la tesis doctoral de M. T. González [14]

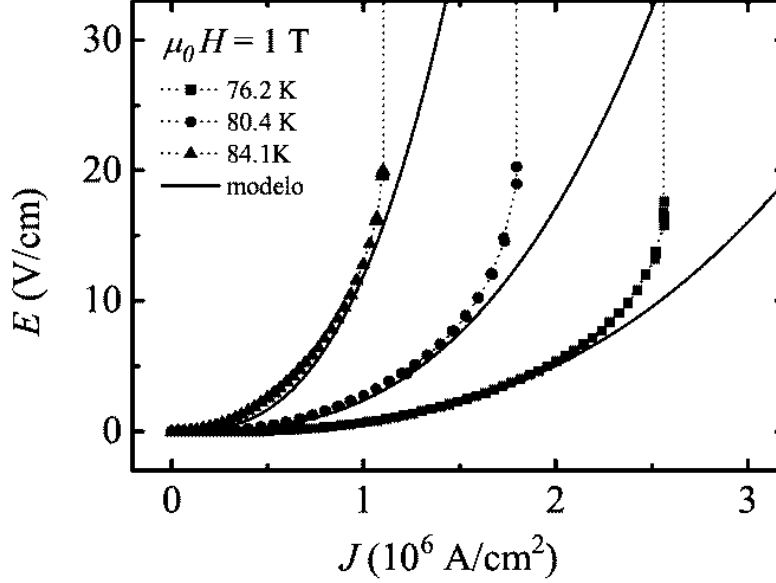


Figura 5.3: Comparación del modelo que se propone en la ecuación 5.4 con los datos experimentales de la muestra A, con $\mu_0 H = 1$ T. Los parámetros son $J_0(1) = 8.00 \times 10^6$ A/cm², $n = 2.85$, $f = 1.08$ y $T_c = 89.8$ K

presentan es característica de *flux creep* [31, 58, 65–67], no se explica con una dinámica de vórtices simple, de *free flux flow*: en este caso los datos mostrados deberían seguir una tendencia rectilínea.

Al analizar los datos correspondientes a la muestra A con $B = 0$ —mostrados previamente en la figura 4.4 y ahora de nuevo, resumidamente, en la figura 5.2—, encontramos que un modelo crítico en ley de potencias (*breakdown power law*, motivada por el *flux creep* de los vórtices) [13, 63] unifica *todas* las isothermas E – J en el rango que estamos estudiando, $J > J_c$ y $77 \text{ K} \lesssim T < T_c$. Este modelo da el campo eléctrico, *a temperatura constante*, con una función de tres parámetros libres:

$$E(J) = E_0 \left(\frac{J}{J_0} - 1 \right)^n. \quad (5.1)$$

La dependencia respecto de la temperatura está implícita en los parámetros E_0 y J_0 : de nuestros ajustes a los datos experimentales

vemos que varían con la temperatura reducida $\varepsilon \equiv \ln(T_c/T)$ como

$$E_0(\varepsilon) = E_0(1) \varepsilon^g \quad (5.2)$$

$$J_0(\varepsilon) = J_0(1) \varepsilon^f. \quad (5.3)$$

Insertando las ecuaciones 5.2 y 5.3 en la ecuación 5.1 obtenemos una única función que nos da el valor de $E(J, T)$. En estas ecuaciones, los ajustes son óptimos cuando se toma como valor de T_c el parámetro T_{c0} —la temperatura máxima a la que la resistividad es cero, sin campo magnético aplicado y a corrientes bajas—, en vez de T_{ci} como hacemos en general.

También necesitaremos una expresión análoga para los resultados con campo magnético aplicado. Para $\mu_0 H = 1$ T, por ejemplo, (figura 5.3) encontramos que cada curva isoterma E – J se describe mejor con una ley de potencias convencional [13, 63], de la forma

$$E(J) = \left(\frac{J}{J_0} \right)^n \quad (5.4)$$

donde de nuevo la dependencia respecto de la temperatura la recoge el parámetro J_0 , con la misma ecuación 5.3.

El que las funciones que describen las curvas E – J sean tan diferentes dependiendo de que haya o no campo aplicado (ecuaciones 5.1 y 5.4) se entiende si pensamos en cuál es el origen de la disipación. El campo eléctrico E por encima de J_c se origina por el movimiento de los vórtices magnéticos del estado mixto en presencia de una corriente aplicada [28, cap. 13]. En el caso $\mu_0 H = 1$ T, los vórtices dentro de la muestra son principalmente debidos al campo externo aplicado, y están presentes independientemente de cuál sea la J inyectada. Incluso a corrientes muy bajas existe *flux creep* y se observa disipación. Por el contrario, en el caso $B = 0$ los vórtices son sólo los que genera el autocampo asociado a J , de manera que habrá más o menos vórtices dependiendo del valor concreto de J . Cuando la corriente aplicada J tiene valores bajos no se tienen apenas vórtices que puedan causar

disipación, por lo que una función que imponga un umbral al campo E medible, como hace el *breakdown power law* de la ecuación 5.1, describe mejor los resultados experimentales.

Se puede apreciar la bondad de estas funciones en la gráficas 5.2 y 5.3, en donde se contrastan los ajustes con los resultados experimentales. Los parámetros empleados se indican en el pie de figura correspondiente. En los dos casos se ha tomado $T_c = T_{c0} = 89.8$ K (muestra A). Ambas funciones subestiman el voltaje experimental a corrientes y temperaturas altas, pero esto es lo apropiado: para hacer cálculos es importante que no recojan un posible calentamiento entremezclado en las medidas, y lo que hacen es seguir la tendencia de los datos con menos disipación. Veremos en los capítulos 6 y 7 que la desviación de los datos experimentales respecto de la tendencia general, en esos rangos de alta disipación, se puede explicar con el aumento de temperatura de la muestra. Este mismo calentamiento puede explicar también la transición al estado normal.

5.2. Modelos habituales para el salto

Como ya mencionamos previamente, el origen físico de la corriente crítica J_c , donde se mide por primera vez disipación en el estado mixto, está claramente vinculado al desanclaje y movimiento de los vórtices magnéticos. No está tan claro sin embargo qué mecanismo induce la transición abrupta observada en J^* . Las causas podrían ser diversas, incluso variar de una muestra a otra o de un tipo de material a otro. En los últimos veinticinco años se han considerado varios modelos que explicarían este salto al estado normal. A modo de contextualización hacemos un breve resumen de estos modelos. En general se enmarcan en dos grandes conjuntos.

5.2.1. Transición causada por calentamiento

Según este grupo de modelos, la transición al estado normal se produciría simplemente porque la temperatura de la muestra aumenta hasta por encima de T_c , sin que medie ningún cambio de régimen en el sistema de vórtices.

Este aumento de temperatura podría generarse a partir de un punto inicial localizado, pero que se propaga rápidamente. De esta posibilidad dan cuenta las teorías de punto caliente (*hot-spot*), un término bastante genérico que engloba distintos tipos de mecanismos: inhomogeneidades [68], distribuciones no uniformes de temperatura mantenidas por la corriente [69, 70], *phase slip centers* [71–73]...

Otra posibilidad es que el calentamiento sea más o menos uniforme en toda la muestra, debido a la disipación que producen los vórtices en su movimiento. En muestras escasamente refrigeradas (como cualquier muestra masiva en un medio líquido o gaseoso) en las que el calor disipado no se evacua al entorno de manera eficiente, se suele considerar que ésta es la causa más probable de transición al estado normal [74–76]. En otro trabajo desarrollado en nuestro laboratorio paralelamente al presente se estudian este tipo de muestras [12–14].

En muestras peliculares depositadas sobre substratos cristalinos, sin embargo, la evacuación del calor es mucho mejor, y suele descartarse que el calentamiento uniforme sea la causa de la transición [8, 10, 11, 15].

Nos referiremos a esta posibilidad del calentamiento como a un *efecto extrínseco*, en el sentido de que sería evitable si las condiciones de refrigeración fuesen óptimas, si las medidas se hiciesen tan rápidamente que no tuviese tiempo la muestra a calentarse, o si las muestras fuesen de mejor calidad y no tuviesen puntos calientes.

5.2.2. Transición causada por movimiento de vórtices

A estos mecanismos, por contraposición a los del grupo anterior, los llamaremos *intrínsecos*, pues estarían presentes aun en condiciones ideales de refrigeración y de síntesis de las muestras, y sólo podrían eliminarse con un anclaje de vórtices ideal.

5.2.2.a. Avalancha de Larkin-Ovchinnikov (LO)

En el modelo quizá más extendido de este otro grupo [77] se interpreta que los vórtices presentes en el estado mixto se desplazan contra una viscosidad del medio que no es lineal con la velocidad. Esta viscosidad aumenta con la velocidad de los vórtices hasta llegar a un máximo, pero a partir de ese punto vuelve a disminuir, contrariamente a lo habitual. Al superar ese máximo los vórtices, sometidos en todo momento a las fuerzas de Lorentz que los empujan, encuentran cada vez menos oposición a su movimiento: incrementan su velocidad, se reduce con ello cada vez más la viscosidad, se aceleran progresivamente y generan una avalancha. De este modo causan en muy poco tiempo altas disipaciones que hacen transitar la muestra al estado normal.

Esta variación de la viscosidad que experimentan los vórtices se debe a que el tiempo de dispersión interelectrónica τ_{ee} es finito, mayor o del orden del tiempo de dispersión electrón-fonón τ_{ef} que los termaliza con el entorno. De este modo, cuando un conjunto de electrones sufre alguna variación energética, esta energía no se distribuye con suficiente velocidad entre todos los electrones, y ya no los podemos considerar termalizados entre sí. La descripción de la función de distribución electrónica requiere un tratamiento matemático complicado [77], cuyas interpretaciones físicas son variadas [5, 7, 15]. Imaginemos qué sucede en estas condiciones cuando un vórtice se mueve en el seno del superconductor. Un vórtice es una isla de material en estado normal rodeada por

un mar superconductor. Al desplazarse, la región que previamente ocupaba vuelve al estado superconductor, y la región que acaba de ocupar transita al estado normal. Si el desplazamiento del vórtice es suficientemente rápido, el tiempo de relajación energética puede entrar en juego con efectos relevantes: no damos tiempo a que la nueva región ocupada transite *totalmente* al estado normal, mientras que la zona que se ha dejado atrás todavía no ha vuelto *del todo* al estado superconductor. El efecto sobre la función de distribución electrónica es que hay menos cuasipartículas (electrones normales) *dentro* del vórtice, y más fuera de él, que cuando el vórtice está en reposo o se mueve lentamente. Esto se interpreta como una disminución del diámetro del vórtice, que al estrecharse reduce su rozamiento con el entorno: así disminuye la viscosidad que experimenta en su movimiento.

Una variante de este modelo LO, publicada por Bezuglyj y Shklovskij (BS) [78], introduce correcciones que consideran el inevitable calentamiento que se tiene en cualquier estado disipativo, como es el estado mixto. Este modelo será el que empleemos para el análisis de nuestros datos, pues ya se ha comprobado que la variante sencilla, de LO, no explica correctamente estos experimentos [7, 13, 15, 79]. En todo caso, en este modelo BS el origen del salto sigue siendo la avalancha de vórtices que hemos descrito, y se considera que el calentamiento es una corrección de orden menor. Los autores que emplean estos modelos para explicar sus experimentos siempre estiman que el calor se evacua con mucha eficiencia desde la muestra al entorno, y que se puede despreciar salvo quizá como pequeña corrección.

5.2.2.b. Otros mecanismos de dinámica de vórtices

Hay otras posibilidades, dentro de los modelos que atribuyen a la dinámica de vórtices la causa del salto, que algunos autores no descartan. Así como en ciertos materiales ($\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+\delta}$) la transición abrupta ocurre en un régimen claramente de *free flux flow*, en que los

vórtices se mueven libremente y presentan una curva característica E - J muy lineal [18], en otros sin embargo ($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$) las curvas E - J previas al salto muestran dependencias no lineales. Como ya mencionamos, en estos casos se interpreta que los vórtices siguen globalmente anclados en toda la curva E - J , y que el voltaje que se observa se debe a pequeñas avalanchas locales o a saltos finitos de un punto de anclaje a otro (flujos activados térmicamente (*TAFF*), *flux creep* [29], criticidad auto-organizada (*SOC*) [80–83]...). De esta manera, la corriente J^* coincidiría con la de desanclaje, en la que todos los vórtices se liberan de los centros en que estaban clavados, generando una brusca disipación que hace transitar a la muestra. Pero en principio no parece muy probable que estos mecanismo den cuenta de la brusca y reproducible transición observada. En *flux creep*, por ejemplo, no hay un cambio brusco en el momento en que todos los vórtices se sueltan de sus centros de anclaje: esta transición ocurre suavemente [29, 31].

Recientemente se ha propuesto un mecanismo esencialmente opuesto a la avalancha LO, en el que los vórtices aumentan su tamaño, en vez de reducirlo, cuando se mueven a altas velocidades [6]. Esto ocurre cuando el tiempo de dispersión interelectrónica τ_{ee} es menor que el de dispersión electrón-fonón τ_{ef} , lo que sucede a temperaturas muy bajas y a campos magnéticos elevados. Al elevarse la temperatura de los electrones debido a la disipación, aumenta la región normal en torno a los vórtices, incrementando éstos su tamaño, y la viscosidad se reduce igualmente debido a que los gradientes en torno a los vórtices se suavizan con este aumento de tamaño. El efecto final es el mismo: la velocidad de los vórtices aumenta, y se alcanza una inestabilidad.

5.2.3. Otras posibilidades como causa de la transición

Otras interpretaciones, como las basadas en el efecto Josephson intrínseco [84–87] o la cristalización de la red de vórtices [88],

se tuvieron en cuenta en su momento, pero fueron descartadas por los experimentos para explicar este fenómeno en concreto [15]. Hemos mencionado aquí las que siguen de actualidad y se aplican con frecuencia a distintas muestras para explicar los resultados experimentales.

Pero existen otras interpretaciones que no se pueden descartar todavía, y que no encajan claramente en alguno de los dos grupos previos. Por ejemplo, es posible que electrones normales, que se inyectan a gran velocidad en el superconductor desde el resto del circuito, distorsionen el equilibrio dinámico de los pares de Cooper [71, 89]. Tampoco se debe olvidar la posibilidad de que J^* coincida con la corriente de desapareamiento J_d de los pares de Cooper. Esta corriente J_d es la que imprime tanta energía cinética a los pares de Cooper que la existencia de estos se vuelve desfavorable energéticamente respecto a la de los electrones normales disociados ([30], [31, sec. 4.4] y [4, sec. 10.XIX]). Aunque esta posibilidad se suele descartar porque la J^* experimental $= I^*/d$ a dista notablemente de la J_d teórica [11, 46], bastaría con que la distribución de corriente no fuese uniforme en toda la sección de la muestra, sino concentrada en una región menor (por ejemplo en filamentos laterales, por efecto Meissner [90, 91] o por lentitud de los vórtices en penetrar al interior de la muestra [92, 93]), para que la densidad de corriente real sea mucho mayor que la aparente. Esta posibilidad está siendo estudiada con más detalle en otro trabajo paralelo que se desarrolla en nuestro laboratorio [14], y aquí la consideraremos brevemente para el caso de los filmes.

5.3. Dependencias de los parámetros críticos J^* , E^* y J_c

5.3.1. Determinación de los parámetros críticos

Los puntos J^* y E^* de cada curva son en general fáciles de determinar: en ellos se manifiesta una discontinuidad clara de la curva E - J , y tomamos estas coordenadas como los últimos puntos experimentales que podemos medir antes de la transición. La incertidumbre de la medida, como hemos visto en la sección 4.3.2, proviene de la resolución en corriente con la que midamos la curva E - J , pero también del calentamiento que altera el valor de E^* . Además, a campos magnéticos aplicados altos, o a temperaturas cercanas a T_c , la transición al estado normal deja de ser abrupta, y el valor de J^* y, sobre todo, el de E^* , tienen más incertidumbre. En general no estudiaremos estos datos con mayor error, aunque en la referencia [13] se propone un criterio para determinar estos parámetros que permitiría ampliar el estudio a estas regiones.

En medidas más detalladas, cuando queramos medir J^* con más resolución, J^* será la corriente más alta que podamos aplicar durante el tiempo t que dure el experimento sin causar una transición al estado normal.

Para la determinación experimental de la corriente crítica J_c , lo habitual es ver a qué corriente se alcanza un cierto campo umbral E , típicamente de $10 \mu\text{V}/\text{cm}$. En la figura 5.4.b vemos dónde queda ese umbral, y las corrientes críticas J_c que determina para cada campo. De esta manera, como hemos venido explicando, J_c es la corriente en la que aparece por primera vez disipación mensurable con nuestros dispositivos. Esta es la corriente que hemos estudiado y comparado con J^* en función de la temperatura, a campo aplicado nulo. La disipación experimental $V = E l$ es proporcional a la velocidad que adquieren los vórtices de la muestra en su movimiento.

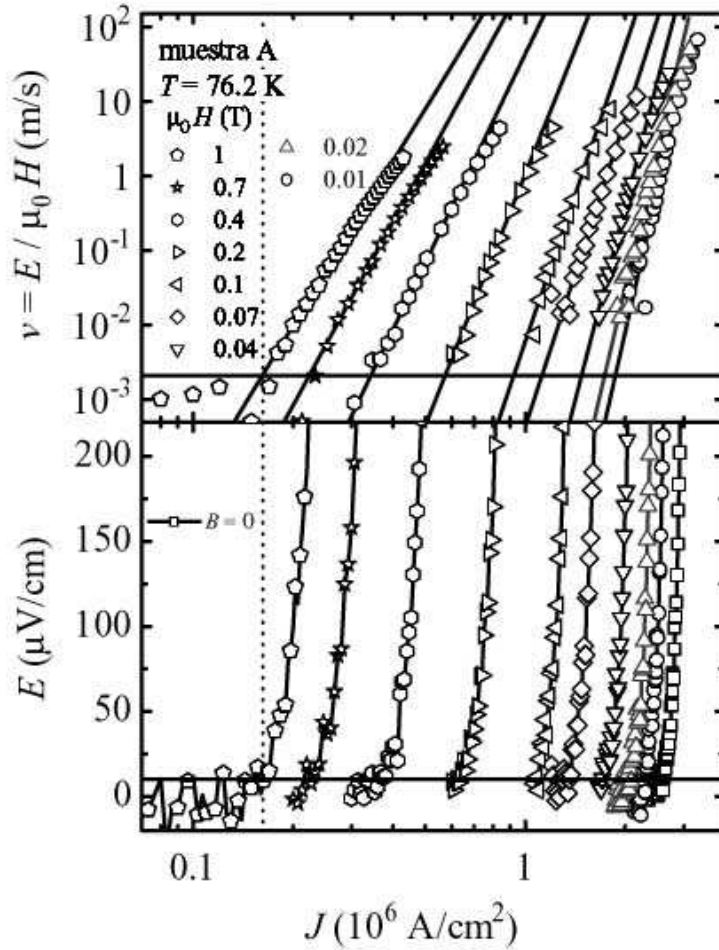


Figura 5.4: Determinación de las corrientes críticas J_c^{pin} y J_c . Abajo, J_c se determina estableciendo un umbral para el campo E de $10 \mu\text{V/cm}$ (línea horizontal). Arriba, J_c^{pin} se determina con un umbral en la velocidad de movimiento de vórtices, fijándolo de tal modo que J_c^{pin} y J_c coincidan en la curva medida con más campo. Para las restantes curvas a campo menor hay que hacer una extrapolación —pues los datos son ruidosos en esos rangos— de modo que J_c^{pin} es siempre menor que J_c .

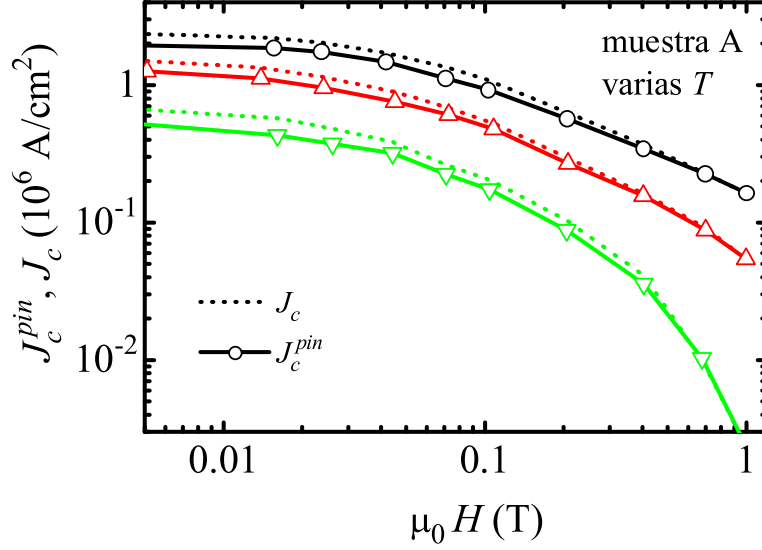


Figura 5.5: Comparación de la corriente crítica J_c , definida con un umbral en el campo E de $10 \mu\text{V}/\text{cm}$, con J_c^{pin} , definida con un umbral en la velocidad de los vórtices v (fig. 5.4). J_c^{pin} es, en general, ligeramente menor que J_c , aunque sus dependencias respecto de T y H son muy parecidas. Las curvas corresponden a $T = 76.2, 80.4$ y 84.1 K.

Sin embargo, para el estudio de estos efectos tan relacionados con la dinámica de los vórtices, esta corriente crítica J_c no es la más significativa cuando inyectamos vórtices extra, es decir, cuando aplicamos campo magnético externo. Como la disipación que medimos experimentalmente es proporcional no sólo a la velocidad de los vórtices, sino también al número de ellos que están presentes en la muestra, al aplicar campo magnético es conveniente establecer un criterio umbral diferente. Si fijásemos un umbral en el voltaje, estaríamos estudiando puntos diferentes de la dinámica de los vórtices: con campo aplicado bajo, sería un punto en que los vórtices se mueven rápido; con campo alto, el mismo voltaje experimental se alcanzaría con velocidades menores de los vórtices.

Por este motivo definimos otra corriente crítica J_c^{pin} , como aquella en que los vórtices presentes en la muestra alcanzan un cierto umbral

de velocidad, lo más bajo posible experimentalmente: se pretende reflejar en ella el momento en que los vórtices se sueltan de sus centros de anclaje (*pinning* [4, cap. 9.V y 9.VI]). En la figura 5.4.a vemos cómo se establece esta J_c^{pin} . La velocidad de los vórtices es $v = E/B = E/\mu_0 H$. Fijamos el umbral de velocidades en la más baja que hemos podido medir: de esta forma, J_c y J_c^{pin} coinciden en la curva E – J medida con mayor campo magnético aplicado, pero para las otras curvas establecemos J_c^{pin} con una extrapolación a velocidades menores —pues los datos experimentales son ruidosos en esos rangos—, de manera que J_c^{pin} es en general algo menor que J_c (ver fig. 5.5), aunque con dependencias respecto de T y H muy semejantes. A campos tan bajos, no se aprecian diferencias muy significativas entre los valores de J_c y J_c^{pin} .

5.3.2. Dependencia respecto de la temperatura de J^* y J_c

En la figura 5.6 mostramos la variación con la temperatura de J^* y J_c para una de las muestras. Ambas series de puntos se ajustan a una función dependiente de la temperatura reducida $\varepsilon \simeq (1 - T/T_c)$ con exponente $3/2$,

$$J(T) = J_0 (1 - b T/T_c)^{3/2}, \quad (5.5)$$

donde J_0 es la corriente en $\varepsilon = 1$, $T = 0$ K. Esta dependencia con un exponente $3/2$ aparece con mucha frecuencia para corrientes críticas J_c o de desapareamiento J_d [31]. El parámetro b , del orden de 1, se incluye aquí para dar cierta flexibilidad al modelo: es equivalente a dejar libre la temperatura crítica T_c , pues el modelo no tiene por qué ajustarse exactamente con el valor de T_c que hemos elegido. Los parámetros empleados para ajustar los puntos se indican en el correspondiente pie de figura. Los parámetros b (o, equivalentemente, las T_c que se extraen del ajuste) no son exactamente iguales en las dos series de datos, pero no podemos esperar mucho más de estos

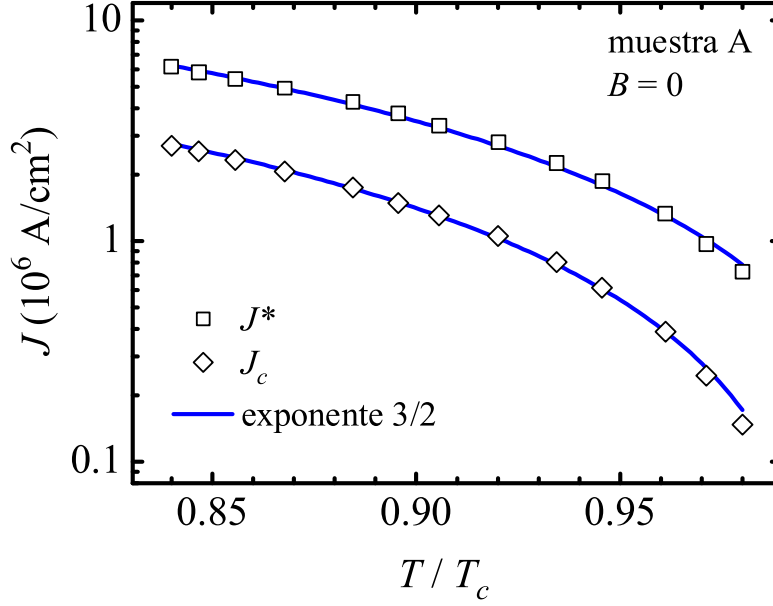


Figura 5.6: Corriente crítica J_c y de salto J^* en función de la temperatura, a campo magnético aplicado nulo. Ambas dependencias se ajustan con un modelo de exponente $3/2$ en temperatura reducida (ec. 5.5). Los parámetros para J^* son $J_0 = 80.7 \times 10^6$, $b = 0.97$, y $J_0 = 41.2 \times 10^6$, $b = 0.99$ para J_c .

modelos en potencias, que son aproximaciones muy sencillas. Lo que pretendemos aquí es simplemente discriminar entre un modelo con exponente $3/2$ y otros exponentes posibles. En la figura 5.7 se compara la dependencia de J^* respecto de la temperatura de otra muestra con la que acabamos de mostrar en la figura 5.6: también sigue la misma tendencia. Esta dependencia $J^*(T)$ con exponente $3/2$ se pone de manifiesto en todas las muestras [10, 11, 15], quedando descartada una posible funcionalidad con exponente $1/2$,

$$J(T) = J_0 (1 - b T/T_c)^{1/2}, \quad (5.6)$$

representada en la figura 5.7 con una línea de puntos. Esta última funcionalidad se encuentra en un modelo que explica el origen de

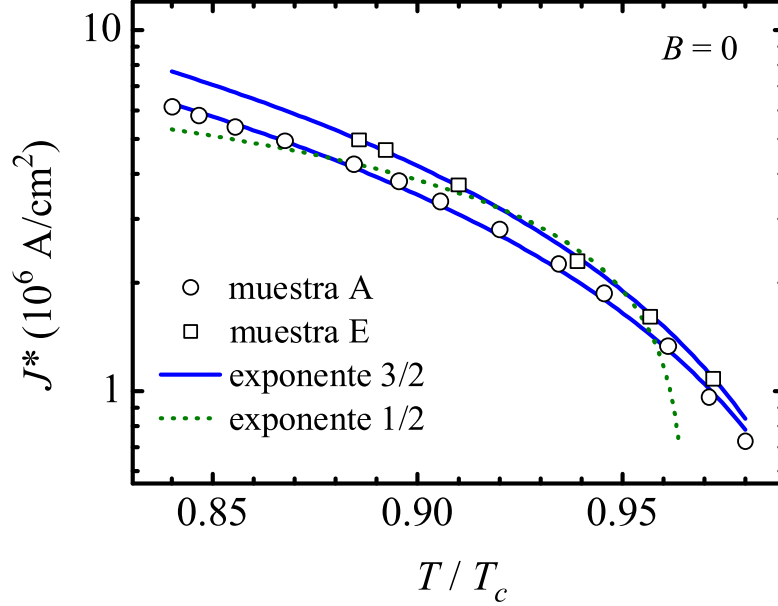


Figura 5.7: Corriente de salto J^* en función de la temperatura para dos muestras distintas, a $B = 0$. Ambas dependencias se ajustan con un modelo de exponente $3/2$ en temperatura reducida $\varepsilon = 1 - T/T_c$ (ec. 5.5, parámetros $J_0 = 80.7 \times 10^6$ A/cm², $b = 0.97$ —muestra A— y $J_0 = 102.6 \times 10^6$ A/cm², $b = 0.98$ —muestra E—). Un exponente $1/2$ queda, sin embargo, descartado (ec. 5.6, $J_0 = 14.7 \times 10^6$ A/cm², $b = 1.04$).

la corriente de salto J^* por puntos calientes [15, 69, 94]: no es raro encontrar en la bibliografía que los fenómenos térmicos se descartan para explicar el origen de J^* sólo porque los datos no se ajustan a la ecuación 5.6 [10, 11, 15]. Veremos con detalle en los capítulos siguientes lo inapropiado de este razonamiento: el calentamiento puede manifestarse de otras formas distintas de las de *hot-spot*.

En la figura 5.8 se muestra el cociente J_c/J^* en función de la temperatura, poniendo de manifiesto que lejos de T_c ambas temperaturas varían muy a la par, y más cerca de T_c ($T/T_c \rightarrow 1$) J_c comienza a caer más rápidamente con la temperatura que J^* . En la figura se incluyen también algunos puntos tomados con campo magnético aplicado, para ver la tendencia que manifiestan, aunque

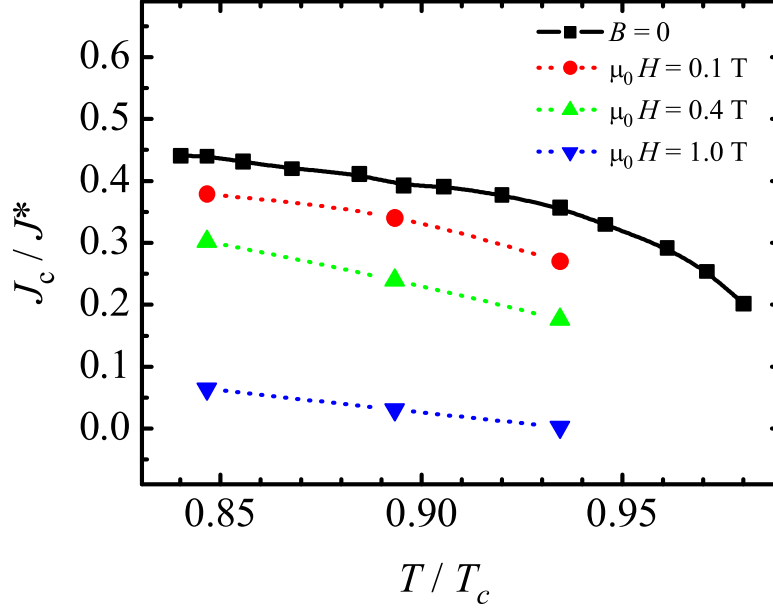


Figura 5.8: Cociente de la corriente crítica entre la de salto J_c/J^* , en función de la temperatura, a campo aplicado nulo. Se incluyen también unos cuantos puntos tomados a campos distinto de cero, para apuntar la tendencia que presentarían esas curvas. Las líneas son guías para los ojos.

este es un estudio que no se ha hecho en detalle.

Esta dependencia térmica con exponente $3/2$ que presenta $J^*(T)$ coincide con la de $J_c(T)$, y también con la corriente de desapareamiento $J_d(T)$ [10, 11, 30], por lo que resulta inevitable atribuir a J^* un origen relacionado con los mecanismos que generan J_c^{pin} , J_c o J_d . Pero sólo estos datos no son concluyentes, y no bastan para discernir unas causas de las otras [15].

5.3.3. Dependencia respecto del campo magnético de J^* , J_c^{pin} y E^*

En la figura 5.9 representamos la corriente crítica J_c^{pin} y la de salto J^* de varias muestras, en función del campo magnético aplicado

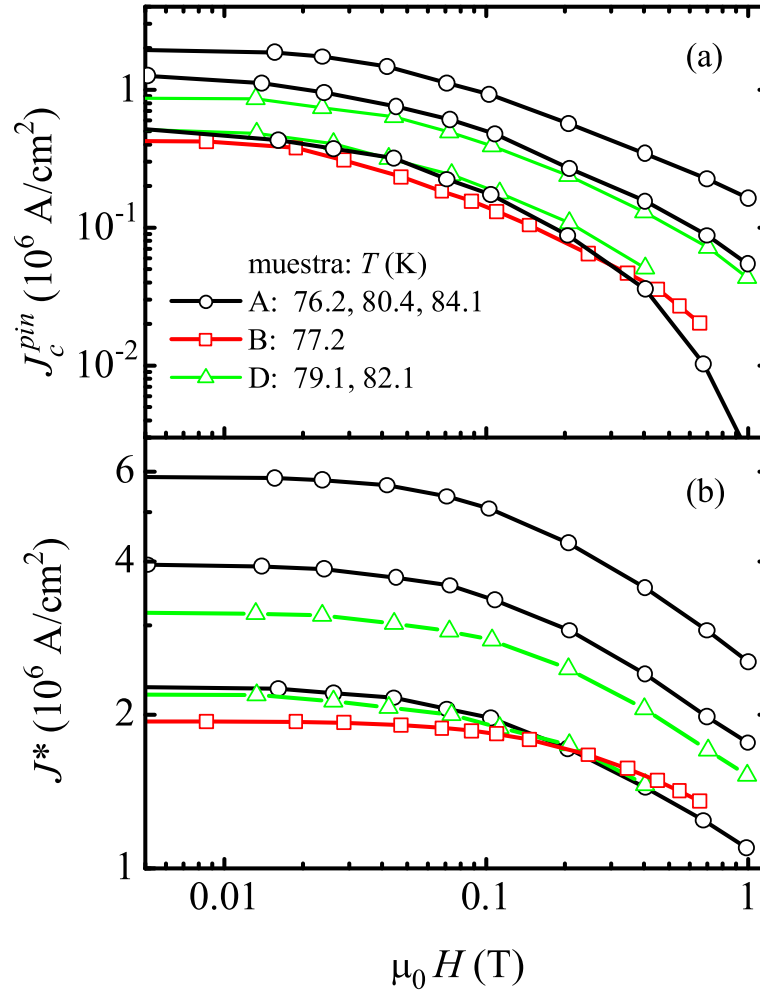


Figura 5.9: Corriente crítica J_c^{pin} y de salto J^* de varias muestras, en función del campo magnético aplicado y para varias temperaturas. La corriente crítica J_c^{pin} parece acusar antes que J^* la influencia del campo externo: varía para campos pequeños, mientras que, hasta aproximadamente $\mu_0 H = 0.05 \text{ T}$, J^* apenas se altera. Las líneas son guías para los ojos.

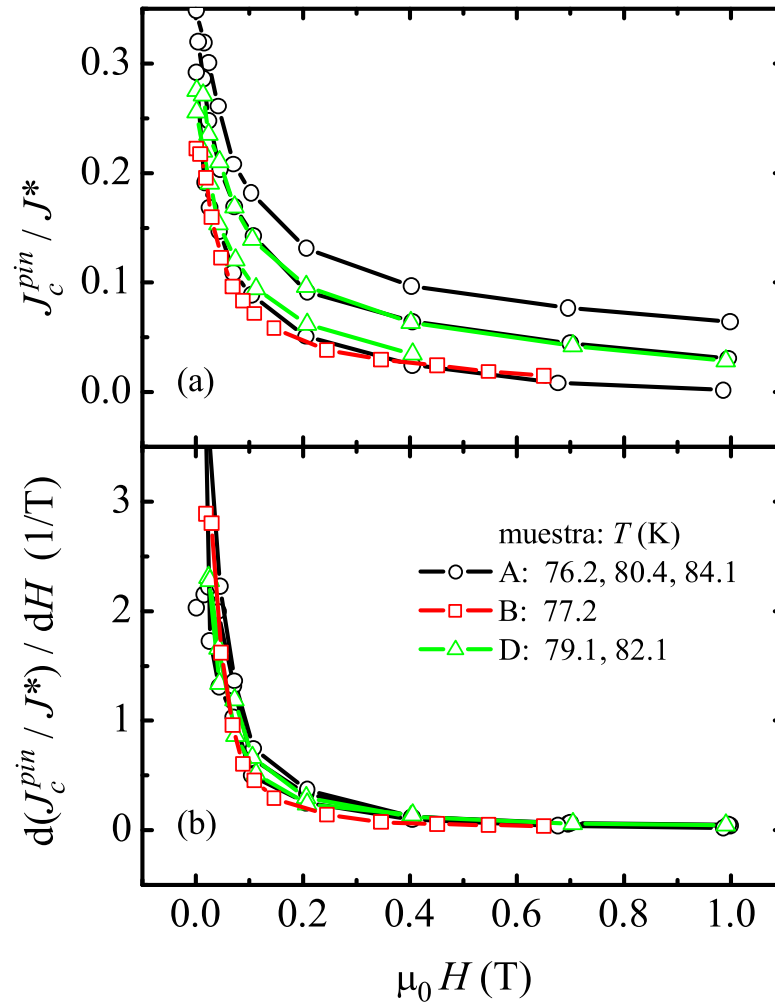


Figura 5.10: En (a), cociente de la corriente crítica y la de salto J_c^{pin}/J_c^* en función del campo magnético, para distintas muestras y temperaturas. (Datos de la figura 5.9). Se pone de manifiesto que J_c^{pin} varía más rápidamente que J_c^* a campos bajos, y sólo a partir de unos $\mu_0 H = 0.1$ T varían a la par. Las tendencias de todas las curvas para las distintas muestras y temperaturas son similares: en (b) se representa la derivada de las curvas de (a) respecto del campo aplicado, y se ve como todas son coincidentes. Las líneas son guías para los ojos.

y para varias temperaturas distintas. Es notable la diferencia de comportamiento a campos bajos: la corriente crítica² J_c^{pin} parece acusar antes que J^* la influencia del campo externo: varía para campos pequeños, mientras que J^* apenas se altera hasta que el campo aplicado supera la décima de Tesla. La figura 5.10.a resalta esta diferencia de comportamiento: se representa el cociente $J_c^{pin}/J^*(H)$ para las mismas curvas de la figura 5.9, y se ve cómo a campos bajos J_c^{pin} varía más rápidamente que J^* . A partir de aproximadamente la décima de Tesla comienzan a variar a la par, haciéndose constante el cociente. Todas las tendencias son muy similares, como pone de manifiesto la figura 5.10.b, en la que se representa la derivada respecto al campo del cociente J_c^{pin}/J^* : todas las derivadas se colapsan en la misma curva.

La tendencia de $J^*(H)$ parece apuntar a que existe un campo magnético de baja intensidad que se suma al externamente aplicado, de manera que sólo cuando este último supera un cierto valor (cercano a la décima de Tesla) puede competir con aquel y hacer notar sus efectos. El que esto se aprecie sólo en el comportamiento de $J^*(H)$ y no en el de $J_c^{pin}(H)$ hace pensar que este otro campo magnético extra es el autocampo generado por la corriente inyectada en la muestra: las corrientes en torno a J_c^{pin} son menores que los valores de J^* , por lo que sus autocampos serán también menores, y los efectos de éstos menos notorios.

Conviene por tanto tener una estimación de los valores del autocampo generado por la corriente inyectada, para analizar correctamente los datos. El campo $\mathbf{H}$ (Oe) que genera una corriente I (A) al circular por un conductor de longitud infinita y de sección rectangular, teniendo ésta un vértice inferior en (x_1, y_1) y el superior

²Aunque nuestra definición de J_c^{pin} no coincida exactamente con la más frecuentemente empleada J_c (recordemos que para la comparación con J^* que queremos realizar J_c^{pin} resulta más conveniente), sus valores son muy parecidos, y la variación con el campo aplicado análoga a la que en la bibliografía se encuentra para J_c [54, 95–97].

diagonalmente opuesto en (x_2, y_2) (cm), se expresa como [98]

$$\mathbf{H}(x, y) = \frac{\mu_0 I}{2 \pi (x_2 - x_1)(y_2 - y_1)} (h_x(x, y) \hat{\mathbf{x}} + h_y(x, y) \hat{\mathbf{y}}), \quad (5.7)$$

donde

$$\begin{aligned} h_x(x, y) &= \sum_{i,j=1}^2 (-1)^{i+j} (y - y_i) \arctan \left(\frac{x_j - x}{y - y_i} \right) + \\ &\quad + \sum_{i,j=1}^2 (-1)^{i+j} (x_j - x) \ln \left(\sqrt{(x - x_j)^2 + (y - y_i)^2} \right), \\ h_y(x, y) &= \sum_{i,j=1}^2 (-1)^{i+j+1} (x - x_i) \arctan \left(\frac{y_j - y}{x - x_i} \right) + \\ &\quad + \sum_{i,j=1}^2 (-1)^{i+j+1} (y_j - y) \ln \left(\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_j)^2} \right). \end{aligned}$$

En la figura 5.11 representamos la intensidad del campo magnético calculada según estas ecuaciones para la corriente que circula por una sección rectangular de ancho a y de alto d , en dos casos diferentes. Por un lado, cuando la corriente está uniformemente distribuida en toda la sección, de modo que calculamos el campo con $x_1 = -a/2$, $x_2 = +a/2$, $y_1 = -d/2$, $y_2 = +d/2$. Por otro lado, cuando la corriente se concentra sólo en unos filetes laterales de sección cuadrada y de lado d , de modo que el campo total es la suma del campo producido por la corriente en $x_1 = a/2 - d$, $x_2 = a/2$, $y_1 = -d/2$, $y_2 = +d/2$ más el de la corriente simétrica al otro lado de la muestra. El campo es máximo en los laterales $x = -a/2$ y $x = a/2$ en ambos casos, pero cuando la corriente se concentra, la intensidad es mayor en esos puntos que cuando se reparte por toda la sección.

En el caso de que la corriente esté *uniformemente* distribuida, el campo magnético en las coordenadas $(a/2, 0)$ tiene sólo componente $\hat{\mathbf{y}}$, y la expresión de su intensidad —igual, pero de signo contrario, a

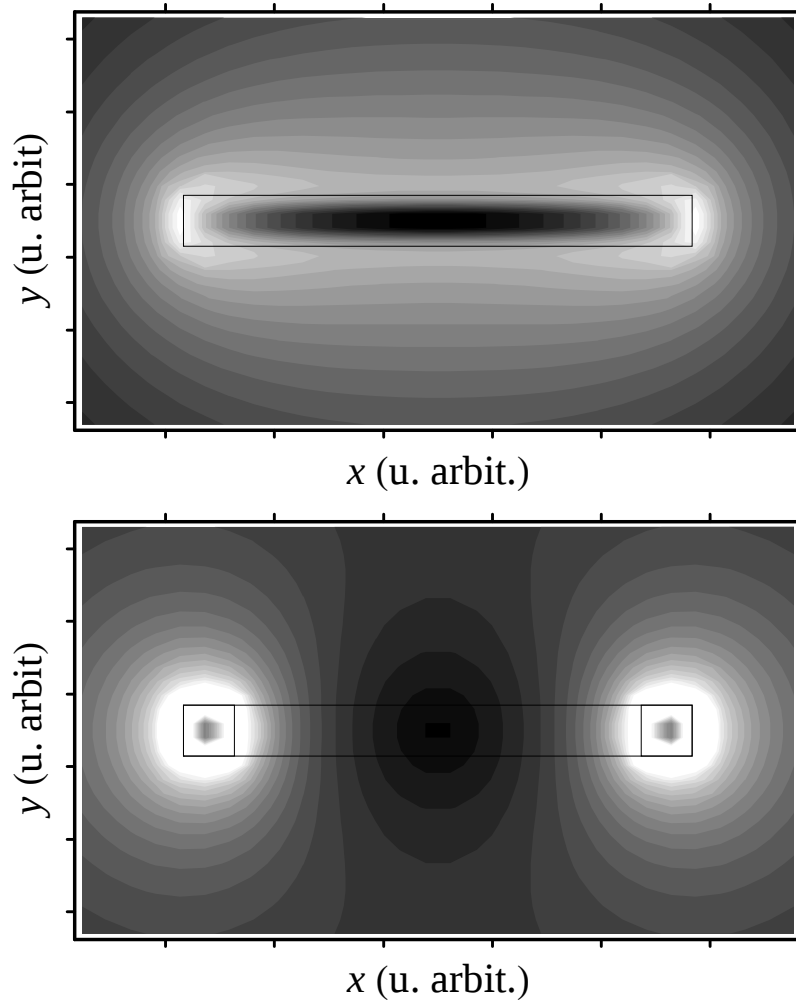


Figura 5.11: Intensidad del campo magnético creado por una corriente que circula por una muestra infinita de sección rectangular. (Blanco: más intenso. Negro: intensidad nula). El perfil de la sección de la muestra son los rectángulos de línea delgada. Arriba, la corriente está uniformemente distribuida en la sección. Abajo, la corriente se concentra sólo en los dos filetes laterales de la muestra, de sección cuadrada. El campo es máximo en los laterales en ambos casos, pero cuando la corriente se concentra, la intensidad es mayor en esos puntos que cuando se reparte.

la de la posición simétrica $(-a/2, 0)$ — queda reducida a

$$H_u(a/2, 0) = \frac{2 \times 10^{-3} I}{a d} \times \left(2 a \arctan \left(\frac{d}{2 a} \right) + \frac{d}{2} \ln \left(\frac{d^2 + 4 a^2}{d^2} \right) \right), \quad (5.8)$$

lo que en el caso límite $a \gg d$ se simplifica a [17]

$$H_u(a/2, 0) = \frac{I}{500 a} \ln \left(\frac{2 a}{d} \right). \quad (5.9)$$

Siguiendo en este caso límite $a \gg d$, la correspondiente expresión para el campo en ese mismo punto cuando la corriente se distribuye sólo por dos filetes *laterales* de longitud de penetración λ ($a \gg \lambda$) resulta

$$H_l(a/2, 0) = \frac{I}{2000 d \lambda} \left(4 \lambda \arctan \left(\frac{d}{2 \lambda} \right) + d \ln \left(1 + \frac{4 \lambda^2}{d^2} \right) \right). \quad (5.10)$$

Para los valores típicos de nuestros micropuentes ($d = 150$ nm, $a = 10$ μ m), el autocampo en el borde con corriente uniforme es $H_u(a/2, 0) \simeq 1000 I$, mientras que si suponemos que la corriente se concentra en una longitud de penetración $\lambda = d$ por cada lado, el autocampo es $H_l(a/2, 0) \simeq 11000 I$, más de diez veces más intenso (el cálculo preciso, sin la aproximación $a \gg d$, da exactamente un factor diez de diferencia).

Volvamos ahora a los resultados de la figura 5.9, y fijémonos en una curva $J^*(H)$ típica, por ejemplo la que a campos aplicados bajos comienza teniendo valores $J^* = 4 \times 10^6$ A/cm². A esta densidad de corriente *aparente* aplicada (que corresponde a una corriente real de $I = 60$ mA), el autocampo de corriente uniforme es $\mu_0 H_u \sim 6 \times 10^{-3}$ T, mientras que el de corriente distribuida en los laterales con $\lambda = d$ es $\mu_0 H_l \sim 7 \times 10^{-2}$ T. Entre ambos valores se sitúa el campo $\mu_0 H \sim 1 \times 10^{-2}$ T en que la corriente de salto $J^*(H)$ comienza a sentir la influencia del campo aplicado externamente. Parece así confirmarse nuestra intuición primera: el campo externo no hace notar sus efectos

sobre J^* hasta que supera en intensidad al autocampo generado por la corriente inyectada; mientras sea de menor valor, será el autocampo el que prevalezca. Esto mismo parece apreciarse en el comportamiento de $J_c^{pin}(H)$, aunque la resolución experimental del campo aplicado no permita medirlo con tanto detalle: como J_c^{pin} es, a campos bajos, unas tres veces menor que J^* , el autocampo que se genera es también tres veces menos (suponiendo que la distribución de corriente fuese la misma en ambos regímenes), de modo que el punto en que el campo externo supera al autocampo se sitúa en torno a $\mu_0 H \sim 3 \times 10^{-3}$ T, lo que para nuestra ventana experimental equivale a campo aplicado nulo.

Una vez hechas estas consideraciones, volvamos al análisis de los parámetros críticos. En la figura 5.12 vemos los valores de E^* y, de nuevo, J^* correspondientes a la muestra A, a varias temperaturas, en función del campo aplicado. Como hemos visto, los datos que están más afectados de incertidumbre, debido al calentamiento, son los de E^* : se muestran para una de sus curvas las barras de error, crecientes para campos mayores. En la figura 5.13 tomamos dos de estas curvas y las ajustamos al modelo Bezuglyj-Shklovskij (BS) [18, 78], que establece los valores de E^* y de J^* como

$$E^* = E_0 \frac{(1-t)(3t+1)}{2\sqrt{2}t^{3/4}(3t-1)^{1/2}}, \quad (5.11)$$

$$J^* = J_0 \frac{2\sqrt{2}t^{3/4}(3t-1)^{1/2}}{3t+1}, \quad (5.12)$$

donde

$$t = \frac{1+b+\sqrt{b^2+8b+4}}{3(1+2b)}$$

y

$$b = B/B_T.$$

$B = \mu_0 H$ es el campo magnético aplicado, y B_T un parámetro del modelo BS vinculado al tiempo de relajación energética de los

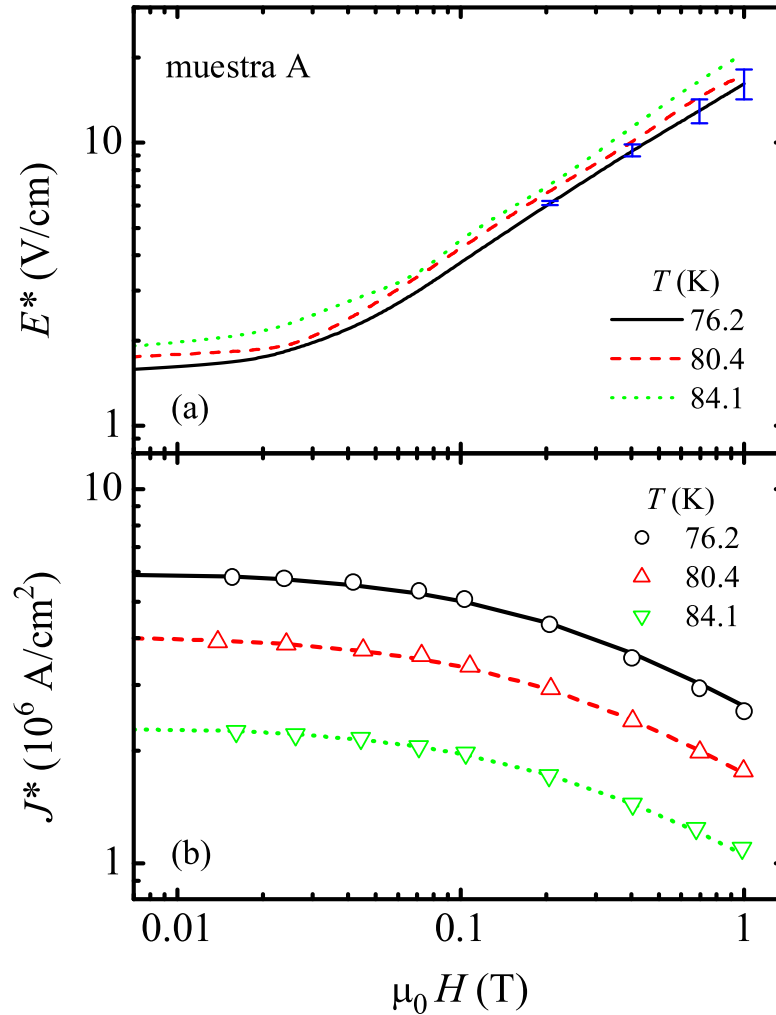


Figura 5.12: Campo E^* y corriente J^* de salto en función del campo aplicado de la muestra A, para varias temperaturas. Se indica la incertidumbre del campo E^* , que se vuelve notable a campos altos, cuando la disipación en el momento del salto es mayor. En (a) las líneas son guías para la vista que unen los puntos experimentales: son prácticamente *paralelas*, diferenciadas sólo por un factor multiplicativo. En (b), las líneas son ajustes a la ecuación 5.12, teniendo en cuenta el autocampo según se explica en el texto. E^* varía un orden de magnitud mientras que J^* apenas lo hace un factor dos.

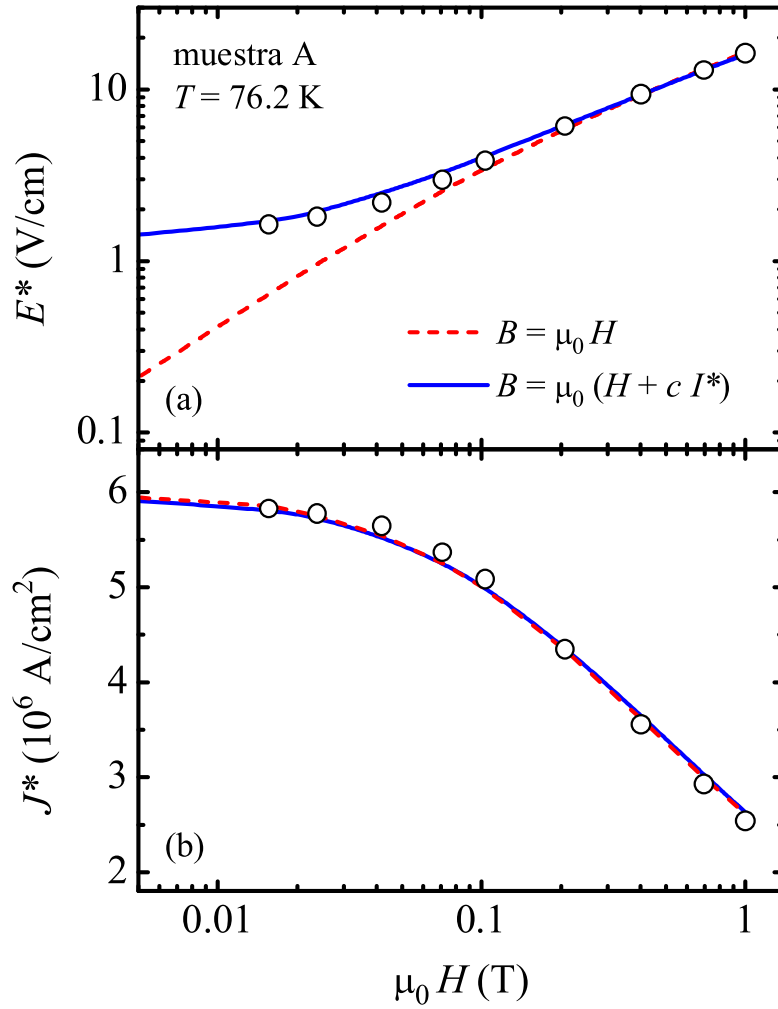


Figura 5.13: Campo E^* y corriente J^* de salto en función del campo aplicado de la muestra A, para $T = 76.2$ K. El ajuste de las ecuaciones 5.11 y 5.12 en función del campo aplicado (línea discontinua) es válido para J^* pero no para E^* . Sin embargo, el modelo ajusta bien ambas curvas si consideramos que el campo total es el externo aplicado más el autocampo de la corriente inyectada, dado por un término $c I^*$.

portadores τ_ϵ —una combinación de los tiempos de dispersión electrón-electrón y electrón-fonón, $\tau_\epsilon = (\tau_{ee}^{-1} + \tau_{ef}^{-1})^{-1}$ [78]—, a la resistividad en el estado normal ρ_n y a la resistencia de transferencia térmica entre filme y entorno h :

$$B_T = 0.374 \frac{e_0 h \rho_n \tau_\epsilon}{k_B d} \quad (5.13)$$

En esta última ecuación, k_B es la constante de Boltzmann, e_0 la carga del electrón, y d el espesor del filme.

Los dos ajustes que se muestran en la figura 5.13 emplean distintos valores de B . En el ajuste que se separa de los datos de $E^*(H)$ a campos bajos (líneas de trazo discontinuo), tomamos $B = \mu_0 H$, siendo H el campo magnético aplicado externamente. Como resultado, obtenemos que los mejores parámetros son $J_0 = 6.08 \times 10^6$ A/cm², $E_0 = 13.3$ V/cm, y $B_T = 0.31$ T.

En el ajuste que recoge por completo la tendencia de los datos $E^*(H)$ en todos los rangos de campo aplicado, sin perder por esto la fidelidad a la tendencia de $J^*(H)$ (líneas continuas), incluimos los efectos del autocampo generado por la corriente, haciendo $B = \mu_0 (H + c I^*)$, donde c es un parámetro libre del ajuste. Obtenemos $E_0 = 12.0$ V/cm, $J_0 = 6.48 \times 10^6$ A/cm², $B_T = 0.27$ T, y $c = 3133$ Oe/A. Con este cambio, el parámetro que más varía en términos relativos es B_T , que lo hace un 14 % aproximadamente. En general, sin variar mucho los parámetros físicos implicados, el ajuste mejora considerablemente si tenemos en cuenta los efectos del autocampo generado por la corriente.

Empleando los parámetros característicos de nuestra muestra³, obtenemos de la ecuación 5.13 un valor para el tiempo de relajación energética de las partículas portadoras $\tau_\epsilon \sim 1.2 \times 10^{-12}$ s para esta temperatura $T = 76.2$ K, lo que es del todo compatible con los resultados de otro tipo de experimentos, como de medidas de impedancia superficial en el rango de las microondas [99–101]. Este

³ $\rho_n \sim 75 \mu\Omega \text{ cm}$, $h \sim 1000 \text{ W/cm}^2 \text{ K}$, $d \sim 150 \text{ nm}$

es un valor que se escapa del rango de validez del modelo Larkin-Ovchinnikov, por lo que el empleo de dicho modelo para la extracción de τ_ϵ resulta ineficaz, como se ha visto en trabajos previos, en los que τ_ϵ es algunos órdenes de magnitud menor [7, 15, 79]. Aparentemente el modelo Bezuglyj-Shklovskij, en contraposición, arroja valores más realistas de este parámetro, pero en este punto se requeriría un estudio más sistemático que escapa a las pretensiones actuales del presente trabajo.

La aparente validez del modelo Bezuglyj-Shklovskij se pone en evidencia también en la figura 5.12, donde los puntos experimentales de $J^*(H)$ están ajustados, para todas las temperaturas mostradas, con la ecuación 5.12 incluyendo el autocampo⁴. La figura 5.14 recoge estas mismas tendencias de $J^*(H)$ y $E^*(H)$ para varias muestras y diferentes temperaturas. Estos efectos del autocampo podrían ser, por tanto, la causa de que los modelos que explican la corriente de salto se desvíen de los datos experimentales a campos magnéticos aplicados bajos; de ser así, se podrían descartar otros mecanismos más complejos que se pueden encontrar en la bibliografía [9].

Por otra parte, el valor obtenido para el parámetro $c = 3133$ Oe/A, que da $H_{sf} = c I$, es intermedio a los que calculábamos para el autocampo con corriente uniformemente distribuida en la sección ($c \simeq 1000$ Oe/A, ec. 5.9) y con corriente concentrada en los laterales de la muestra $\lambda = d$ ($c \simeq 11000$ Oe/A, ec. 5.10). Según esta última ecuación, al valor c obtenido de nuestros ajustes le corresponde una longitud de penetración de la corriente en el interior de la muestra

⁴El parámetro c es el mismo en todas las curvas, y los parámetros que varían para las otras temperaturas son $J_0 = 4.28 \times 10^6$ A/cm², $B_T = 0.27$ T (para $T = 80.4$ K) y $J_0 = 2.39 \times 10^6$ A/cm², $B_T = 0.33$ T (para $T = 84.1$ K). Estos ajustes requieren de bastante trabajo para lograr acuerdos simultáneos de las expresiones de J^* y E^* , y sólo el mostrado previamente para $T = 76.2$ K se hizo con rigor. Estos otros, para temperaturas mayores, se han hecho sólo aproximadamente, para ver si se conservaba un acuerdo general, y la tendencia observada es que la bondad del ajuste se pierde parcialmente para los valores de E^* conforme aumenta la temperatura.

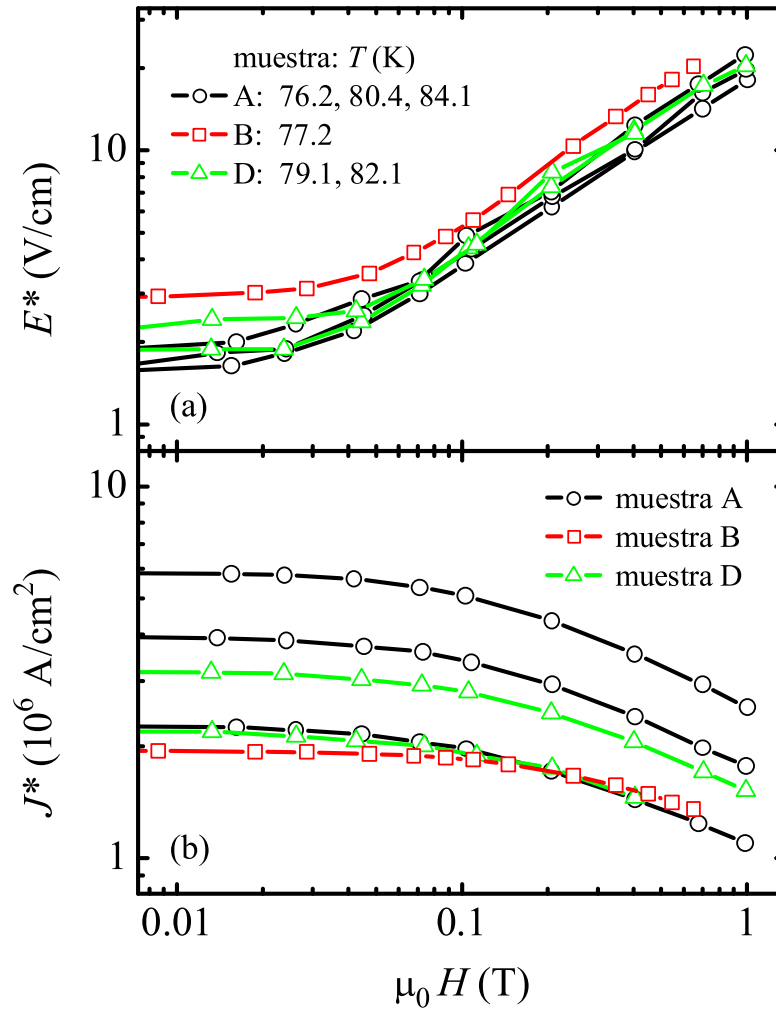


Figura 5.14: Campo E^* y corriente J^* de salto en función del campo aplicado, para varias muestras y temperaturas. Al aumentar la temperatura, E^* crece levemente y J^* disminuye. La dispersión en valores de E^* es la mitad que la de J^* , pero E^* varía un orden de magnitud mientras que J^* apenas un factor dos. Las líneas que unen los puntos son sólo guías para la vista.

$\lambda \simeq 8 \ d = 0.12 \ a = 1.2 \times 10^{-6} \text{ m}$, de manera que la densidad de corriente *real* sería más de cuatro veces superior a la aparente (esta última obtenida de considerar que la corriente inyectada se distribuye uniformemente por toda la sección $a \times d$). Esto no es más que una estimación muy cruda, pues la ecuación 5.10 da el valor del campo justo en la superficie, y lo que en realidad necesitaríamos calcular es una especie de valor efectivo del campo en toda la región por la que pasa la corriente. De hacerlo así, encontraríamos que la densidad de corriente para un campo efectivo $H_{sf} = c \ I$ es incluso mayor, con campos más intensos en la superficie, y con λ más pequeña. Es importante señalar aquí que esta posibilidad acercaría notablemente los valores de J^* a los predichos teóricamente para la corriente de desapareamiento J_d [10, 11, 30], por lo que habría que considerar con más detalle la posibilidad de que la transición abrupta al estado normal en J^* se produjese por ruptura de pares de Cooper, demasiado acelerados como para que su existencia siga compensando desde un punto de vista energético. Esta posibilidad de que la corriente circule en realidad concentrada en los laterales de la muestra se ha confirmado, al menos en parte, de manera experimental, y hay algunos modelos que intentan explicar este proceso [90–93]. Estas consideraciones se han hecho aquí de manera breve, para apuntar su posible relevancia en estos mecanismos y en películas delgadas. Un estudio más detallado se lleva a cabo en la tesis doctoral de M. T. González [14].

Para terminar este apartado del estudio de las dependencias de los parámetros críticos con el campo aplicado, sometemos nuestros datos a un escalamiento propuesto para dicha dependencia en algunas publicaciones. En 1990, Xu, Shi y Fox [103] propusieron un modelo generalizado para la dependencia de la corriente crítica $J_c(T, H)$, que unificaba todos los modelos previos: el de Bean [104], el de Anderson [105, 106], y otros posteriores. Este modelo generalizado separa las dependencias respecto de T y de H , y tiene la forma

$$J_c(H, T) = J_c(T) J_c(H) = \frac{J_c(T)}{(1 + H/H_0(T))^n}. \quad (5.14)$$

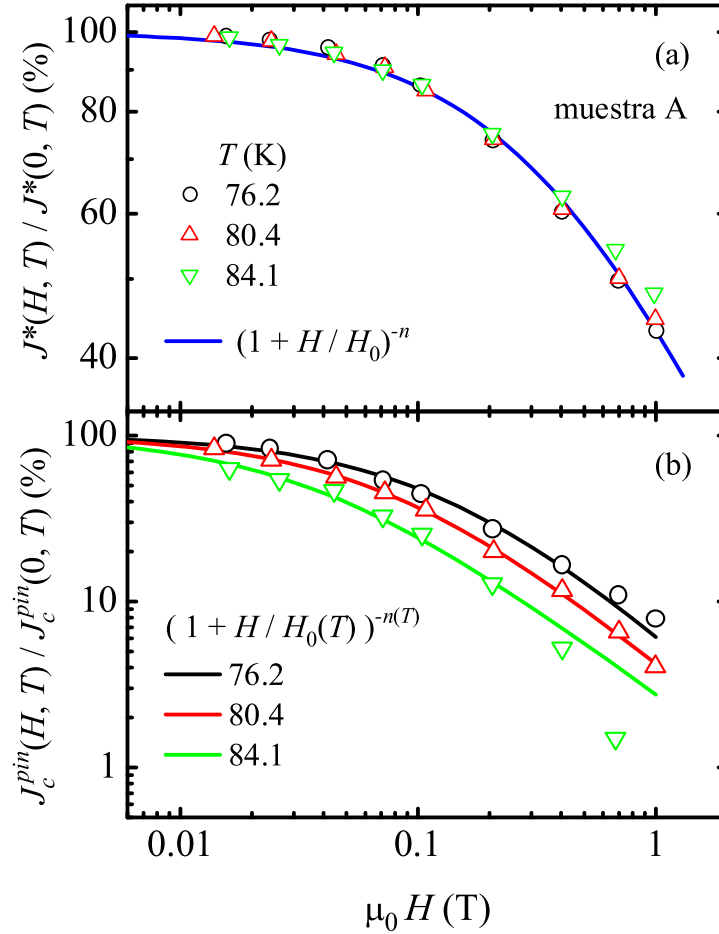


Figura 5.15: Normalización, al correspondiente valor con campo aplicado nulo, de las corrientes J^* y J_c^{pin} en función del campo y para varias temperaturas. La dependencia de J^* coincide para todas las temperaturas, y se ajusta con la ecuación 5.14 con $H_0(T) = 0.36$, $n = 0.63$. Por el contrario, J_c^{pin} no escala tan bien, y necesita valores de H_0 y n diferentes para cada temperatura (0.13 y 1.29 en 76.2 K; 0.077 y 1.20 en 80.4 K; 0.036 y 1.07 en 84.1 K), y ni siquiera de esa forma el ajuste es bueno. Este comportamiento se repite en las otras muestras estudiadas.

En algunos trabajos se empleó esta misma dependencia, con el parámetro $H_0(T)$ constante, para ajustar el comportamiento también de J^* [15, 18]. Como ya hemos visto en la sección 5.3.2, la variación de $J_c(T)$ con la temperatura es la misma que la de $J^*(T)$, dependiendo de la temperatura reducida con un exponente $3/2$ (ec. 5.5, p. 131). Veamos si las dependencias respecto de H son también similares.

En la figura 5.15 vemos el resultado de dividir J^* y J_c^{pin} entre los valores a campo aplicado nulo que corresponden a cada temperatura, de modo que el resultado es la dependencia respecto de H según la ecuación 5.14. Las curvas de J^* coinciden notablemente en una única dependencia, que se describe con la funcionalidad propuesta y con H_0 constante. Por el contrario, $J_c^{pin}(H)$ no se ajusta a esa misma función, ni siquiera haciendo H_0 y n dependientes de la temperatura, y las curvas no coinciden en una misma dependencia. Normalizar J_c en vez de J_c^{pin} no varía estos resultados, J_c y J_c^{pin} normalizadas tienen valores muy similares.

Como hemos visto, las variaciones del valor de J^* con H y T presentan notables similitudes con las de J_c (o J_c^{pin}) y J_d , aunque también se pueden describir aparentemente bien con modelos específicos que contemplan mecanismos completamente diferentes de los que originan J_c y J_d . No queda claro, por tanto, a qué mecanismos atribuir la transición abrupta al estado normal en J^* , y se hace necesario más trabajo en esta dirección.

5.3.4. Dependencia respecto de la duración de la medida

En la figura 5.16 vemos los resultados de un experimento realizado aplicando corrientes constantes, de valores muy parecidos entre sí, y cercanas a la corriente de salto. Medimos con la DAQ la evolución temporal del voltaje a corriente constante. En todas las curvas se observa una variación de la señal, relativamente suave, en los primeros instantes de la medida, atribuible como hemos visto a una elevación

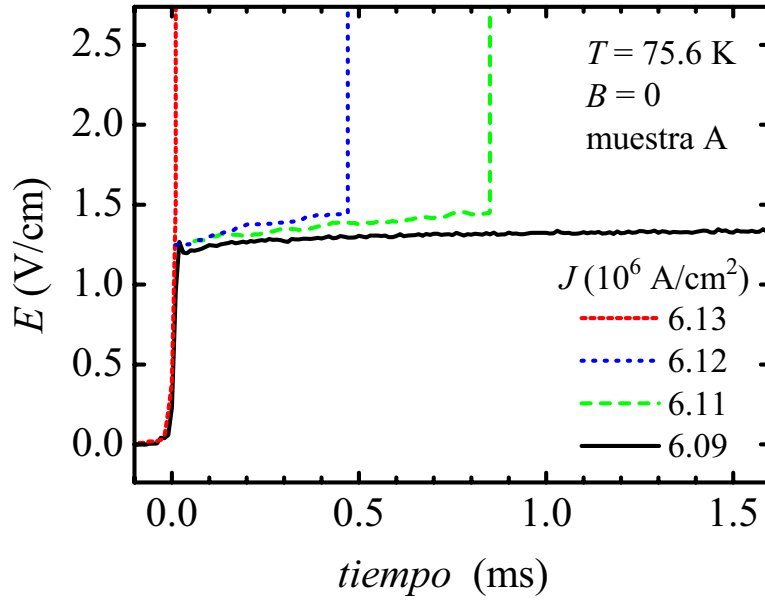


Figura 5.16: Experimento realizado aplicando corrientes constantes, de valores muy parecidos entre sí, cercanas a la corriente de salto. Se mide la evolución temporal del voltaje. La corriente de 6.09 A/cm² lleva a un voltaje aparentemente estable en tiempos mayores de 1 ms, pero la de 6.13 (un 0.6% mayor) causa una avalancha tan pronto se aplica (dentro de la resolución temporal de la medida). Los valores intermedios de corriente conllevan una transición en momentos diferentes, más pronto cuanto más alta es J .

de la temperatura de la muestra generada por la disipación. Pero además, pasado un cierto tiempo, estas corrientes cercanas a J^* hacen transitar abruptamente la muestra al estado normal. La corriente de 6.09 A/cm² lleva a un voltaje aparentemente estable en tiempos mayores de 1 ms, pero la de 6.13 (un 0.6% mayor) causa una avalancha tan pronto se aplica (dentro de la resolución temporal de la medida). Los valores intermedios de corriente conllevan una transición en momentos diferentes, más pronto cuanto más alta es J . Esto se traduce en una aparente dependencia del valor de J^* respecto del tiempo que dure la medida: un experimento que no mida la evolución temporal del voltaje con esta resolución, sino simplemente un valor promedio V durante un pulso de corriente de duración t , verá que una

misma corriente J será crítica o no dependiendo de dicha duración t . Algunos trabajos previamente publicados informaban, sin embargo, de que no se apreciaban diferencias en el valor de J^* en función de t [7, 16]. Veremos en capítulos posteriores (sec. 7.1.1) que esto puede ser debido a que en todo momento sus experimentos se encuadraban en un rango temporal excesivamente largo. Por el contrario otros trabajos, que empleaban tiempos mucho más cortos, sí aprecian diferencias en la medida dependiendo de la duración del pulso [107], corroborando la observación de la figura 5.16.

5.4. Variación de la potencia disipada antes del salto

En las figuras 5.17 y 5.18 vemos la variación que se produce en el valor de la potencia disipada justo antes del salto $W^* = E^* \times J^*$, al variar la temperatura inicial del baño y el campo magnético aplicado, respectivamente. Aunque el estudio sistemático de la dependencia respecto de temperatura no es uno de los propósitos de este trabajo, en todas las muestras en que hemos medido curvas E - J a diferentes temperaturas (muestras A, D y E) hemos observado esta tendencia, de que la potencia W^* disminuya conforme nos acercamos a T_c . Esta misma tendencia se encuentra en otras muestras de la bibliografía [11, 18], aunque excepcionalmente se puede encontrar alguna cuyo comportamiento sea justo el opuesto, siendo $W^*(T)$ mayor a temperaturas más elevadas [10, 20].

La tendencia de la potencia $W^*(H)$ a aumentar con el campo externo es, por el contrario, universal hasta el momento, tanto en nuestras muestras como en otras cuyos datos se han publicado [8, 18, 19]. Es conocido que aplicar campo magnético tiene el efecto de disminuir la temperatura crítica T_c , así que si aumentamos el campo lo que hacemos es aproximar la muestra a la transición, de manera parecida a si aumentásemos directamente la temperatura. El que la

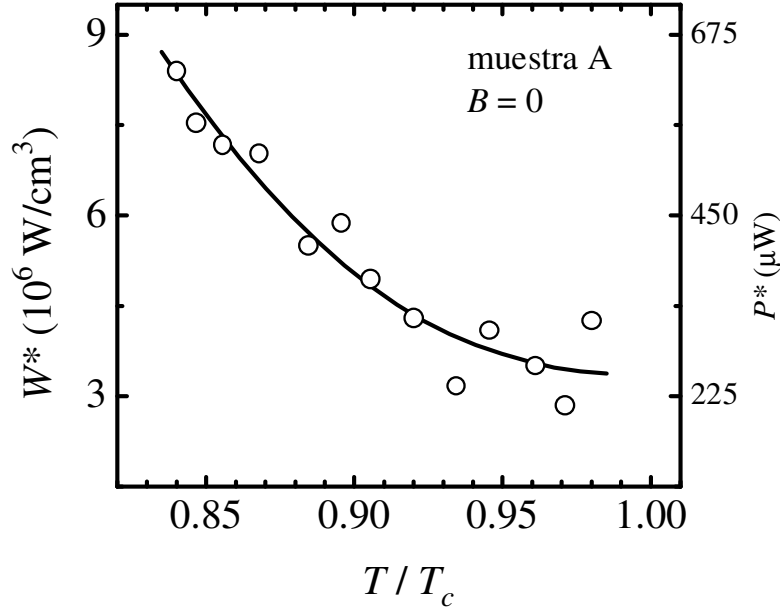


Figura 5.17: Variación de la potencia disipada justo antes del salto W^* con la temperatura de baño. La línea es una guía para la vista que resalta la tendencia descendente.

potencia disipada antes del salto sea mayor cuanto más nos acercamos a T_c parecería indicar que el mecanismo implicado en la transición al estado normal nada tiene que ver con efectos térmicos. En principio, si la causa del salto fuese que el calor eleva la temperatura de la muestra hasta por encima de T_c , se podría esperar que la potencia necesaria para generar la transición disminuyese con el campo aplicado o, en todo caso, fuese independiente de él [8], y desde luego que no aumente con la temperatura.

Más adelante (sec. 7.1.2) veremos, sin embargo, que este razonamiento es incorrecto cuando hacemos un detallado análisis de la disipación del calor desde la muestra al entorno. Concluiremos que no sólo el valor de W^* es suficiente para establecer si un estado dado es crítico o no, y que hay que implicar otros factores.

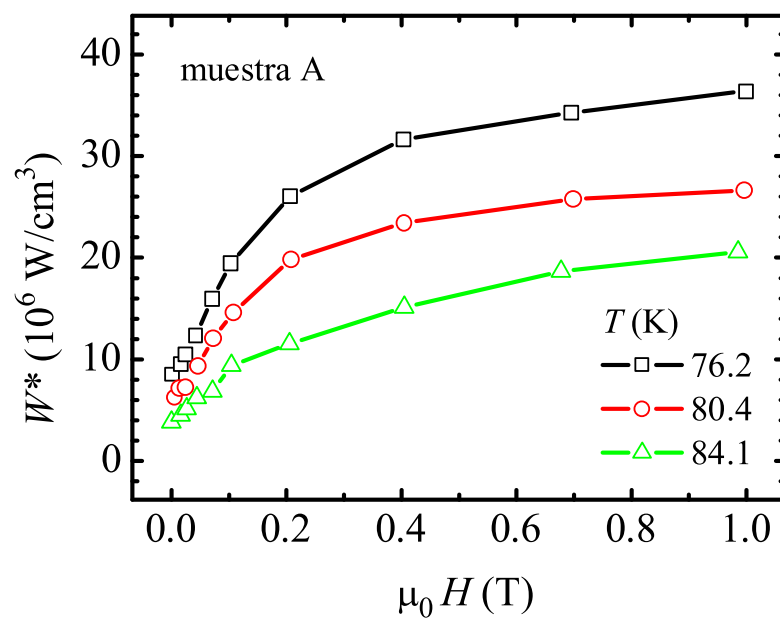


Figura 5.18: Variación de la potencia disipada justo antes del salto W^* con el campo magnético externo aplicado.

Capítulo 6

Modelo de calentamiento en avalancha

6.1. Introducción

En este capítulo proponemos un modelo sencillo de calentamiento en avalancha que puede explicar la transición abrupta de un filme superconductor al estado normal inducida por una corriente eléctrica. Recordemos que a la densidad de corriente que induce la transición la denominamos J^* y, como hemos visto, en los filmes que hemos estudiado depende apreciablemente de la temperatura T —en general, de la temperatura reducida T/T_c — y de la amplitud del campo magnético aplicado H . La pretensión de nuestro modelo es no sólo justificar la existencia de J^* , sino también su dependencia respecto de T y H , y dar cuenta, en general, de los resultados observados cerca del salto.

Nuestro modelo se basa en que por encima de la corriente crítica J_c , definida como es habitual como aquella a partir de la cual hay disipación, dicha disipación es fuertemente dependiente de la temperatura. Esta dependencia bien conocida puede causar, en función de las condiciones de refrigeración del filme, un notable

aumento de la temperatura que puede llegar a inducir el salto al estado normal. Subrayemos ya aquí que, como veremos en este capítulo, la efectividad de este proceso depende crucialmente de las condiciones de refrigeración, es decir, del balance energético entre la generación de calor en el filme y su evacuación al entorno. Este tipo de *calentamiento en cascada* se suele dar por supuesto para explicar $J^*(T, H)$ en superconductores masivos, sin entrar en mayores consideraciones [74, 76], quizá incluso precipitadamente. Se pueden encontrar en la bibliografía análisis térmicos de este tipo de muestras en los que se considera detalladamente el calentamiento como causa de la transición [75]. Sin embargo, la posibilidad de que el calentamiento sea quien genere la transición también en películas delgadas ha sido sucesivamente descartada, por una incorrecta estimación del balance energético: se estimaba que la evacuación del calor era demasiado buena como para que éste tuviera algo que ver. Mostraremos aquí que una estimación más realista del reparto de energía en las películas delgadas que hemos estudiado permite explicar la existencia de J^* , y su dependencia respecto de T y H , invocando sólo un mecanismo puramente térmico (extrínseco). Naturalmente nuestra propuesta no excluye que en la transición al estado normal inducida por una corriente *super crítica* estén también involucrados mecanismos intrínsecos, como los mencionados en el capítulo 5 (desapareamiento de pares de Cooper, cambio de régimen del movimiento de vórtices. . .). Sin embargo, incluso en el caso de que dichos mecanismos intrínsecos estén presentes, nuestros resultados sugieren que el *calentamiento en cascada* debe de desempeñar un papel importante tanto en los valores de J^* medidos como en su dependencia respecto de T y H .

6.2. Aspectos básicos del modelo

Los dos ingredientes esenciales del modelo son: i) Por un lado, tener en cuenta que la potencia disipada es altamente dependiente de la propia temperatura del micropuente. ii) Considerar de manera

adecuada el intercambio térmico entre el filme y su entorno, a través del sustrato.

La combinación de ambos elementos nos permitirá apreciar que la disipación puede, en determinadas circunstancias, aumentar abruptamente y generarse así una avalancha térmica. Explicamos cada uno de estos aspectos en un subapartado independiente.

6.2.1. Variación de la disipación con la temperatura

Para ilustrar la bien conocida dependencia de la disipación respecto de la temperatura podemos utilizar algunas de las curvas E - J obtenidas en uno de nuestros filmes (muestra A), representadas en la figura 6.1. Estas curvas corresponden a campo magnético aplicado nulo. Como ejemplo, para una densidad de corriente $J = 4.75 \cdot 10^6$ A/cm², que es superior a J_c en todas las isothermas mostradas, la disipación por unidad de volumen $W = E \times J$ a cada temperatura es equivalente a las áreas de los rectángulos mostrados. En cada rectángulo se inscribe la potencia que se disipa en su correspondiente isoterma. Esta figura pone pues en evidencia el aspecto fundamental que se pretende enfatizar aquí: la potencia disipada aumenta considerablemente cuando, a corriente constante, aumenta la temperatura del filme. El incremento de la potencia disipada no es lineal con el de la temperatura, sino que crece de manera exponencial. Para destacar esta dependencia, en la figura 6.2 representamos el campo eléctrico E en función de la temperatura para distintos valores de J , con datos extraídos de las curvas E - J . Como a corriente constante la potencia disipada $W = E \times J$ es proporcional a E , la variación de la potencia con la temperatura se muestra implícitamente en esa figura. La representación es logarítmica para apreciar lo fuertemente que varía E —y por lo tanto W — con pequeños cambios de temperatura.

Se pone así de manifiesto lo relevante que es considerar con

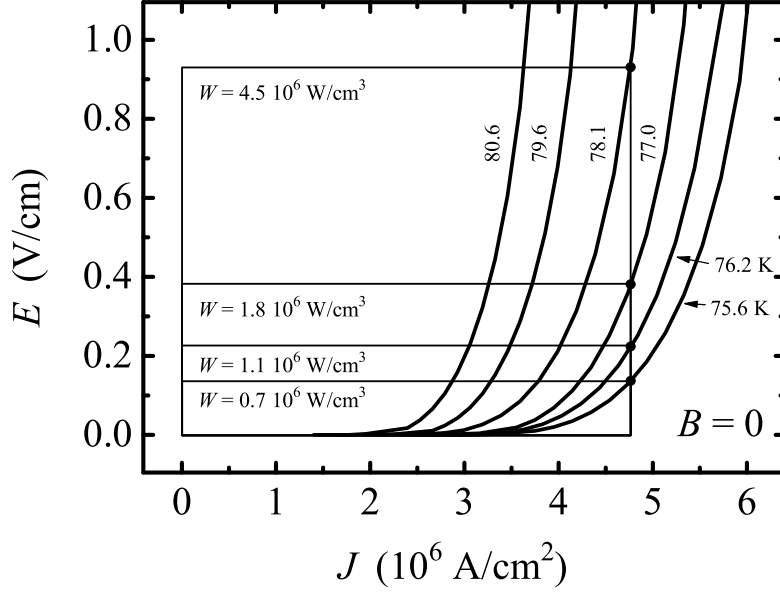


Figura 6.1: Ejemplos de curvas E – J para distintas temperaturas en uno de los filmes de Y-123 estudiados en este trabajo. El área de los rectángulos es la potencia disipada por unidad de volumen. Estos ejemplos ilustran cómo un relativamente pequeño aumento de la temperatura, a corriente constante, aumenta considerablemente la disipación en el filme.

atención cualquier posible calentamiento del filme, por pequeño que sea. El calor generado aumenta de manera tan notable con pequeños incrementos de temperatura que si no se evacua eficientemente puede, como veremos, producirse una avalancha térmica.

El calor total que se genera en la muestra por unidad de tiempo es $P = W v_f = E J v_f$, donde v_f es el volumen del filme. Un punto relevante en los cálculos que aquí se mostrarán es considerar que esta potencia varía, a corriente J constante, debido a la variación del campo E con la temperatura, como se acaba de mostrar con el ejemplo de la figura 6.2. Esto es lo que en este contexto denominaremos *realimentación*: cuando la temperatura de la muestra aumenta, aunque sea levemente, la potencia P también se ve incrementada, y en algunos casos no tan levemente; esto motiva un nuevo incremento

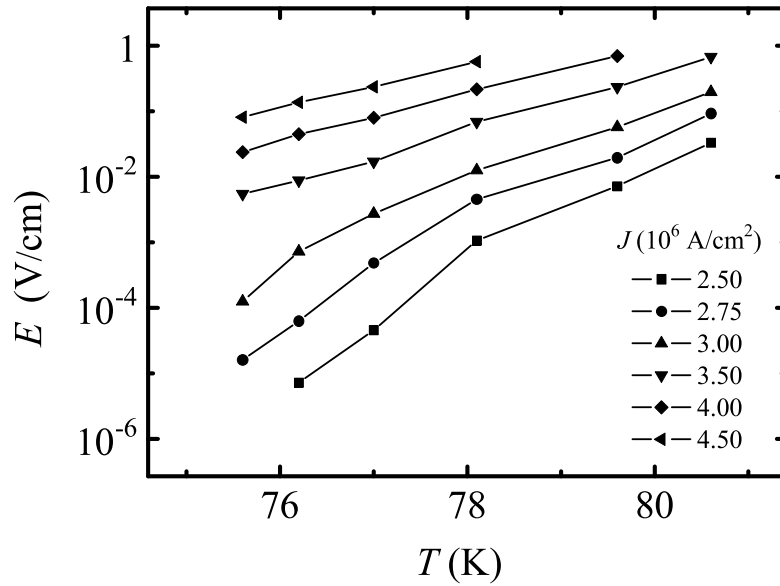


Figura 6.2: Valor del campo E en función de la temperatura, a distintas densidades de corriente J constantes, para la muestra A.

de temperatura, que vuelve a causar un aumento de disipación, y así sucesivamente. No hacer estas consideraciones implica subestimar el calor generado.

Algunas publicaciones han tenido en cuenta este mecanismo de realimentación (en muestras masivas [75] y en capas delgadas [70, 94]), pero no basta sólo con esto para hacer una correcta descripción de la evolución térmica de estas muestras. Hay que considerar de manera adecuada también la capacidad de evacuación de calor desde el micropuente al entorno. En el siguiente subapartado mostramos cómo lo hace nuestro modelo, e indicamos qué aspectos no se tuvieron en cuenta en los trabajos citados.

6.2.2. Intercambio térmico de la muestra

De estar el filme completamente aislado del entorno (caso adiabático), la potencia típica generada cerca del salto (en torno

a 10^7 W/cm^3) tardaría $1 \mu\text{s}$ en aumentar 10 K la temperatura, y pasados 0.1 ms esta llegaría hasta unos 1000 K. Evidentemente esto no ocurre (supondría la destrucción instantánea de la muestra), porque la película evacua calor al entorno con mucha eficiencia.

La aproximación habitual al problema del calentamiento consiste en resolver el balance energético del sistema [94]. Mientras se pueda evacuar todo el calor que se genera, el sistema tenderá a estabilizarse. Cuando la generación de calor P supere la evacuación al entorno $\dot{Q}$, se producirá un progresivo calentamiento de la muestra. La cuestión está en calcular correctamente estos términos.

Es habitual encontrar en la bibliografía ciertas simplificaciones que llevan a resultados erróneos, por hacer una estimación a la baja del primer término P , y excesiva del segundo término $\dot{Q}$. Ya hemos visto en el apartado 6.2.1 que si no tenemos en cuenta la *realimentación* en P podemos estar subestimando el calor generado.

En lo relativo a la evacuación $\dot{Q}$, lo normal es suponer un término de transferencia entre dos medios a través de una frontera, del tipo

$$\dot{Q} = \gamma (\Delta T)^n = h A (\Delta T)^n \quad (6.1)$$

donde ΔT es la diferencia de temperatura entre la muestra y su entorno, h es el coeficiente de transferencia de calor de la frontera, A el área de contacto entre muestra y entorno, y n es un exponente del orden de 1.

Esta generalidad dará cuenta realmente del calor evacuado si definimos correctamente ΔT y h , es decir, si establecemos de manera oportuna cuál es el entorno al que se va el calor desde la muestra. Esta forma de expresar la evacuación ha dado buenos resultados en el análisis térmico de muestras masivas dentro de un medio líquido [75], cuando se consideraba que el entorno al que se evacua el calor de la muestra es el baño circundante con temperatura constante, con h también constante. El caso de películas delgadas es diferente: como ya vimos en la parte experimental (ver p. 78), el calor se transmite

mejor al sustrato que al gas o al líquido circundante, así que es habitual considerar que el entorno del filme es exclusivamente su sustrato. El problema ahora surge cuando se hacen simplificaciones del tipo $\Delta T = T_f - T_b$, bastante frecuentes [69, 70, 78, 94], que suponen que el entorno de la muestra, es decir, el propio sustrato, está a temperatura constante —en este caso termalizado con el baño externo a temperatura T_b —, mientras que la muestra se encuentra a una temperatura superior T_f . En este esquema, h es el coeficiente de transferencia de calor de la frontera entre filme y sustrato, y se suele considerar constante. Estas simplificaciones sobreestiman la evacuación real de calor desde la muestra al entorno. En realidad el calor se transmite a través del sustrato a velocidad finita, generando en su seno una distribución no uniforme de temperatura que en general requiere de complejos cálculos numéricos para su exacta determinación. De esta manera, la parte del sustrato en contacto directo con el filme ya no está a temperatura T_b , sino a otra mayor que esta, por lo que la eficiencia de la evacuación de calor se ve mermada. No tener en cuenta esta distribución no uniforme de temperatura en el sustrato supone sobreestimar la capacidad de evacuación de calor de la muestra, y conduce a conclusiones erróneas. En nuestro modelo vamos a tenerlo en cuenta, de manera sencilla, calculando la temperatura a la que se encuentra la capa de sustrato adyacente al filme¹.

¹Una aproximación alternativa a una correcta descripción del sistema sería, si se quiere definir $\Delta T = T_f - T_b$ en la ecuación 6.1, hacer que el coeficiente h sea dependiente de la temperatura T_f : de este modo el entorno de la muestra sería el baño a temperatura constante T_b , y todo el sustrato haría de *frontera* entre ambos medios, con un coeficiente efectivo h que dependería de la distribución de temperatura en su seno. En todo caso, siguiendo esta línea no se puede mantener h constante e igual al coeficiente de transferencia entre filme y sustrato si se quiere describir correctamente el sistema. Este planteamiento alternativo con un h efectivo variable es equivalente al modelo que propondremos aquí, y se podría extraer de él con algunos cálculos.

6.2.2.a. Modelización de la geometría

Vamos a hacer una modelización muy elemental de esta distribución no uniforme de temperatura. En el modelo que proponemos ya no tendremos un sistema compuesto de dos fases (una muestra inmersa en un entorno). Consideraremos por el contrario un único sistema continuo, la muestra más el substrato, en cuyo seno hay una distribución no uniforme de temperatura que evoluciona en el tiempo, con generación variable de calor en uno de sus extremos, el que ocupa la muestra. Desde este punto de vista el término de evacuación de calor $\dot{Q}$ ya no se expresa fácilmente con una función de transferencia a través de una frontera entre dos medios a temperaturas constantes, del tipo de la Ec. (6.1). Al no tener una expresión de $\dot{Q}$ no podremos compararla con P y establecer un criterio de estabilidad, pero veremos que podemos hacerlo de otra forma.

Para modelizar apropiadamente la muestra con el substrato recordemos cómo es su geometría. En la figura 6.3 representamos un corte transversal del micropuente superconductor depositado sobre el substrato cristalino. Las dimensiones no están a escala (el micropuente tiene en realidad un espesor d mucho más delgado en proporción a su ancho a): en la figura se muestra solamente un esquema conceptual.

Recordemos que el coeficiente de transferencia de calor h entre la muestra y el substrato es muy superior al que presentan la muestra o el substrato con la atmósfera circundante, ya sea ésta líquida o gaseosa. Esto se entiende si recordamos que el método de crecimiento de la película hace que ésta sea una continuación de la estructura cristalina del substrato. Los valores que se extraen de la bibliografía son de $1000 \text{ W/cm}^2 \text{ K}$ para filme-substrato [47], y de $1 \text{ W/cm}^2 \text{ K}$ para filme-entorno cuando este último es nitrógeno líquido [48–50], o incluso menos si es gas. (Consideraremos que el del substrato-entorno es también igual a éste último valor). Podemos por lo tanto despreciar la evacuación del calor desde la muestra a la atmósfera, considerando que a tiempos cortos todo el calor se transmite al substrato.

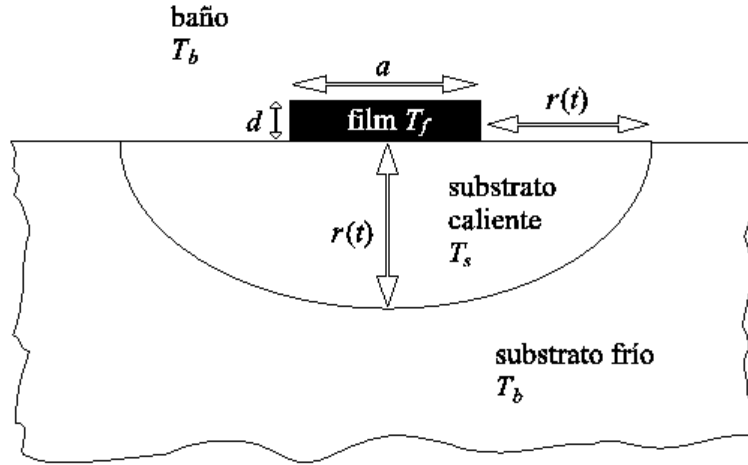


Figura 6.3: Corte transversal del filme y el sustrato (esquema). Se indica el volumen de sustrato que se ha calentado pasado un tiempo t desde que comenzó la generación de calor en la muestra. El resto del sustrato no ha tenido tiempo de sufrir ningún calentamiento.

También podemos despreciar la evacuación de calor a la atmósfera desde el sustrato, debido a que el coeficiente de transferencia de calor del sustrato-entorno es igualmente muy pequeño. Recuérdese que el sustrato, un monocristal, tiene una gran capacidad de conducción (κ) de calor. Este encontrará por lo tanto menos resistencia para circular por el sustrato que para salir a la atmósfera. Por supuesto, si el tiempo de la medida fuese muy largo, el sustrato se calentaría notablemente y entraría en juego la evacuación a la atmósfera, pero en una primera estimación podemos obviar esta posibilidad.

Considerando que la longitud del micropuente es mayor que el ancho o el espesor, el problema se puede en principio reducir a dos dimensiones, las mostradas en la figura 6.3. El sistema es simétrico por traslación a lo largo del eje que determina el puente². La difusividad

²Esta simplificación pierde validez para describir nuestro sistema si el micropuente *no es* mucho más largo que ancho (si $a \sim l$); esta posibilidad requeriría un cálculo más complejo que el que aquí mostramos, en tres dimensiones. En nuestro caso, la relación típica de nuestros puentes es sólo $l/a = 5$, con lo que quizá estamos muy al límite de la validez de la resolución en 2D. Pero como

térmica en el seno del sustrato, $D = \kappa/c_p$, lleva a que pasado un tiempo t el calor haya penetrado en éste una distancia [59, 108]

$$r(t) = 2\sqrt{Dt}, \quad (6.2)$$

representada también en la figura 6.3. El valor de la difusividad para el SrTiO_3 es $D = 0.18 \text{ cm}^2/\text{s}$ [59, 109], por lo que el calor alcanzará la pared inferior de nuestro sustrato, separada 1 mm del micropuente, en unos 14 ms. Para medidas de duración menor, el modelo que proponemos tiene plena validez, e incluso a tiempos más largos si el sustrato no se calienta mucho.

Consideraremos que el volumen del sistema que está dentro de ese radio (variable con el tiempo) se ha calentado en mayor o menor medida hasta una temperatura promedio T_s , y que el resto permanece a la temperatura inicial del baño T_b . De esta manera simplificamos la distribución no uniforme de temperatura en el sustrato dividiéndolo en sólo dos partes: una termalizada con el baño externo a T_b , y otra a temperatura $T_s > T_b$, más cerca de la muestra.

El calor que se genera en la muestra (asumamos que uniformemente, por simplificar) la calienta sólo a ella cuando $t \rightarrow 0$, pero luego se va repartiendo por el resto del sustrato conforme pasa el tiempo, según la ecuación 6.2. Una buena estimación del volumen v_s que se ha calentado con el paso del tiempo es, por tanto (largo $\times$ ancho $\times$ alto)

$$v_s(t) = l \times (2r(t) + a) \times (r(t) + d) \quad (6.3)$$

donde l , a y d son la longitud, el ancho y espesor de micropuente, respectivamente. Esta ecuación del volumen total calentado tiende al volumen de la muestra $v_f = l \times a \times d$ a tiempos cortos.

Tal y como lo hemos definido, el volumen $v_s(t)$ tiene geometría prismática, que se podría dividir entre $4/\pi \sim 1.27$ para hacer una

primera aproximación es razonable y sencilla, y veremos que los resultados del modelo son muy acordes con el experimento. De todos modos apuntaremos más adelante la necesidad de hacer cálculos más refinados, por éste y otros motivos.

aproximación a una forma cilíndrica, que es el caso límite ideal. Emplearemos este factor posteriormente para obtener resultados algo más realistas con los cálculos de nuestro modelo. No es correcto en el límite de t tendiendo a cero, en que el volumen v_s coincide con el del micropuente v_f , que es prismático, pero la corrección es apropiada a tiempos largos, cuando $t \rightarrow \infty$. Cuando hagamos cálculos tendremos en cuenta este factor de manera adecuada, viendo qué tiempos consideraremos como muy largos, dentro de los rangos de validez de este modelo.

6.2.2.b. Aumento de temperatura

En cualquier momento dado, el aumento *promedio* de temperatura de este volumen caliente v_s (de film más sustrato, pero que llamo de sustrato por simplificar) está determinado por el calor total generado hasta ese momento, $Q(t)$, que es la integral en el tiempo de la potencia disipada $P(t)$:

$$Q(t) = \int_0^t P(\tau) d\tau, \quad (6.4)$$

$$\Delta T_s(t) = T_s - T_b = \frac{Q(t)}{c_p v_s(t)}. \quad (6.5)$$

donde c_p es la capacidad calorífica por unidad de volumen del sustrato, y que consideramos constante con la temperatura. Como la c_p del SrTiO_3 es prácticamente coincidente con la del Y-123, resulta factible unificar micropuente y sustrato como un volumen único, a efectos de esta ecuación. Tomamos $c_p = 1 \text{ J/K cm}^3$ [59, 110].

Veamos qué ocurre en el caso concreto de que la potencia disipada *fuese constante*. La dependencia de $\Delta T_s(t)$ en este caso se representa en la figura 6.4. Observamos que, a tiempos largos, cuando el volumen del filme se hace despreciable comparado con el del sustrato caliente, el incremento de temperatura alcanza un régimen casi estacionario. El calor disipado $Q(t) = P t$ sería lineal con el tiempo, pero el volumen caliente cilíndrico también tiene un límite lineal en t a

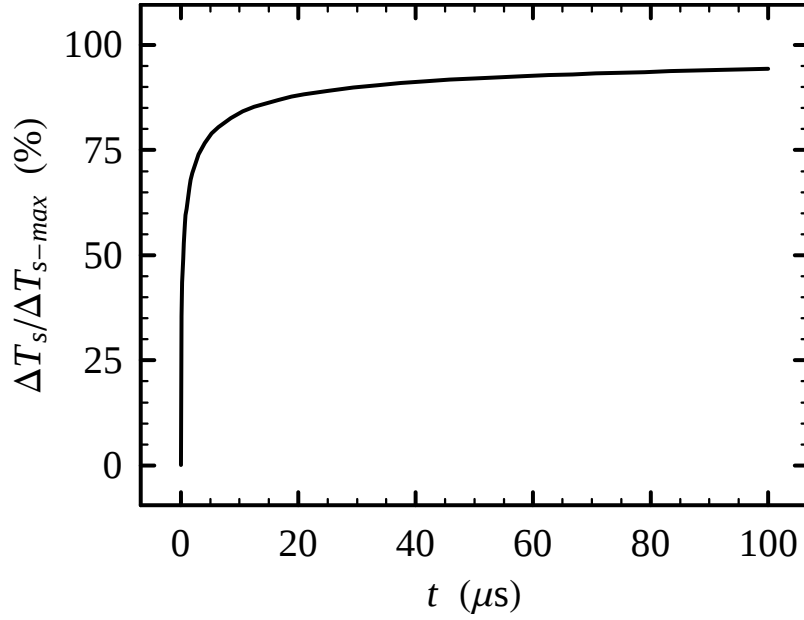


Figura 6.4: Aumento de la temperatura del sustrato caliente ΔT_s en función del tiempo, normalizado, suponiendo potencia disipada constante (ecuación 6.7).

tiempos largos, de modo que el cociente tiende a ser constante: el aumento de temperatura máximo, a $t \rightarrow \infty$, es

$$\Delta T_{s-max} = \frac{P}{8 l D}. \quad (6.6)$$

De este modo, la ecuación que se representa en la figura 6.4 es

$$\frac{\Delta T_s(t)}{\Delta T_{s-max}} = \frac{8 l D t}{c_p v_s(t)}. \quad (6.7)$$

Por dar algunos valores típicos, tomemos la isoterma más baja de la figura 5.2 (p. 119). En esa muestra y a esa temperatura, el salto ocurre con J^* rondando los 6×10^6 A/cm². La correspondiente potencia disipada es $W = E J = 7.5 \times 10^6$ W/cm³, $P = W v_f = 5.6 \times 10^{-4}$ W. Si aplicamos un pulso de esa corriente durante $t = 1$ ms, el volumen de sustrato implicado es $v_s(1 \text{ ms}) = 7.3 \times 10^{-6}$ cm³, de manera que $\Delta T_s = P t / (c_p v_s) \simeq 8 \times 10^{-2}$ K, prácticamente coincidente con el

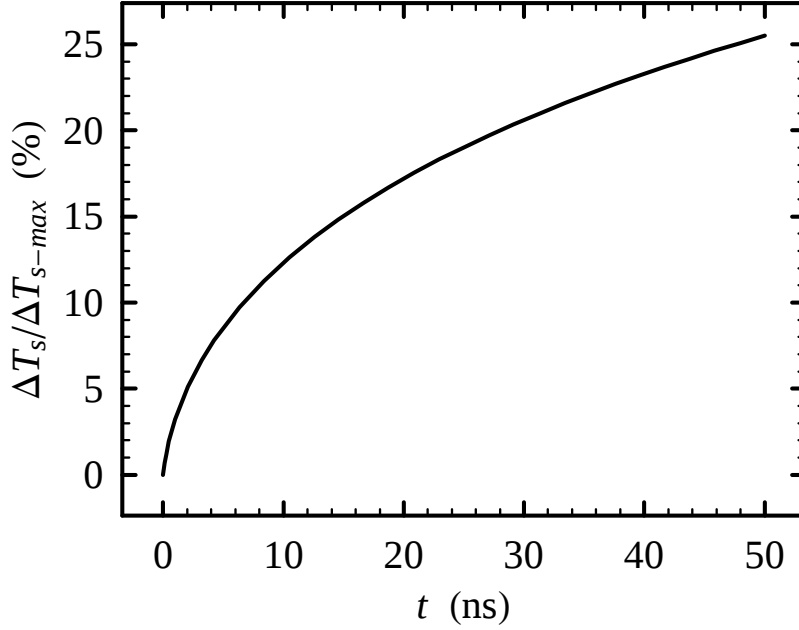


Figura 6.5: Aumento de la temperatura del sustrato caliente ΔT_s en función del tiempo, normalizado, suponiendo potencia disipada constante. (Detalle de la figura 6.4).

valor de $\Delta T_{s-\max}$ que se extrae de la ecuación 6.6. Es un pequeño aumento de temperatura, en apariencia despreciable. Uno podría pensar que con tan poco incremento de temperatura tan cerca del salto el calentamiento no puede ser la causa de la transición. Este ΔT_s no es suficiente para llevar al sistema por encima de T_c . Pero si recordamos que la potencia disipada P no se mantiene en realidad constante, sino que su variación depende fuertemente del incremento de temperatura, deberíamos considerarla en nuestros cálculos.

El 95 % del aumento máximo $\Delta T_{s-\max}$ se alcanza, con independencia del valor concreto, hacia los $100 \mu s$. Este es el tiempo característico de calentamiento τ_i de nuestro sistema. Es mucho mayor que el tiempo bolométrico de enfriamiento

$$\tau_B = \frac{c_p l a d}{h l a} = \frac{c_p d}{h} \simeq 15 \text{ ns} \quad (6.8)$$

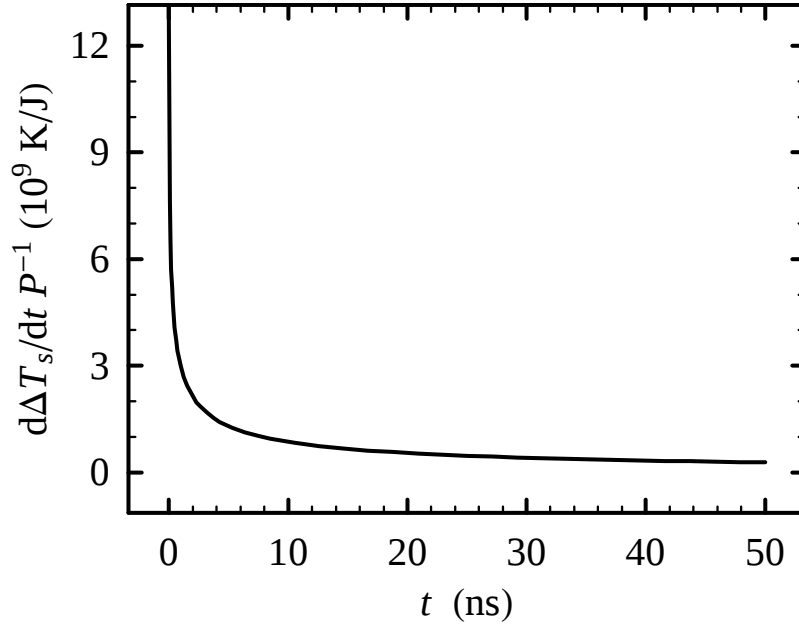


Figura 6.6: Derivada del aumento de la temperatura del sustrato caliente $d\Delta T_s/dt$ en función del tiempo, dividida por P^{-1} , suponiendo potencia disipada P constante.

porque se refiere a los efectos de inercia del sustrato, y no a la resistencia térmica de frontera que determina τ_B . En cualquier caso es un tiempo muy breve, apenas diez veces mayor que la resolución temporal de nuestro sistema de adquisición de datos.

En la figura 6.5 representamos una visión ampliada de la gráfica 6.4, para tiempos más breves. Vemos que para restringir el aumento de temperatura a sólo un 10 % del máximo habría que aplicar pulsos de unos 10 ns. La derivada de este aumento de temperatura, $d\Delta T_s/dt$ (figura 6.6) refleja lo abruptamente que ΔT_s crece en los primeros instantes, y cómo lo hace más suavemente pasado el tiempo.

En una primera aproximación, muy simplista pero que más tarde refinaremos, podemos hacer que el aumento de temperatura del micropuente ΔT_f sea igual al incremento promedio ΔT_s de la ecuación

6.5. De este modo, la temperatura del micropuente sería

$$T_f(t) = T_b + \Delta T_f(t) = T_b + \Delta T_s(t). \quad (6.9)$$

A este modelo geométrico tan elemental, que pretende dar cuenta de la distribución de temperatura dentro del conjunto de micropuente más sustrato, se le pueden añadir algunas correcciones muy razonables que lo aproximen algo más al sistema real. Lo veremos en secciones posteriores. Pero por el momento ya podemos hacer algunos cálculos con lo que hasta aquí hemos explicado, y ver en qué medida afecta el tener en cuenta la realimentación.

6.2.3. Generación de calor en avalancha en el filme

El modelo geométrico que acabamos de exponer en la sección 6.2.2.a no es original nuestro. Se puede encontrar por ejemplo aplicado en la referencia [59] y en posteriores publicaciones. Lo que en este trabajo hacemos de original es combinar esta geometría con la realimentación de la potencia al variar la temperatura. Juntando los dos elementos —la variación de la potencia disipada con la temperatura, y la distribución de temperatura en el entorno de la muestra—, calculamos la evolución de la temperatura del micropuente a lo largo de una medida.

En la figura 6.7 mostramos los resultados de una simulación de un experimento típico, empleando la ecuación 6.9 y previas, y teniendo en cuenta en la ecuación 6.4 que la potencia disipada aumenta al aumentar la temperatura — P varía con T_f como explicamos en la sección 6.2.1—. El experimento consiste en que, a una temperatura inicial, determinada por el baño en que está inmersa la muestra, aplicamos a nuestro micropuente un pulso breve de corriente J constante ³ en el instante $t = 0$. Vemos que la temperatura del

³Se podría simular igualmente la aplicación de rampas en que varíe la corriente,

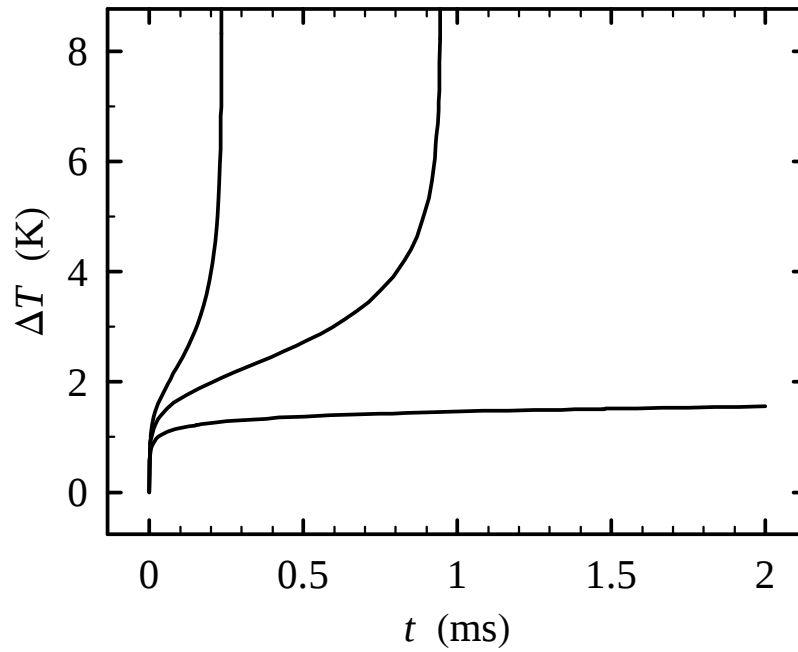


Figura 6.7: Resultados de una simulación con realimentación, a $T_b = 76.2$ K y $B = 0$, aplicando tres corrientes de valores diferentes pero cercanos entre sí (7.70 , 7.83 y 7.90×10^6 A/cm²). Se representa el incremento de temperatura del micropuente $\Delta T_f = T_f - T_b$, calculado según el modelo simple de las ecuaciones 6.9 y previas. La corriente más baja genera un estado casi estacionario tras el incremento inicial de temperatura, pero las otras dos causan avalanchas térmicas (más pronto cuanto mayor es la corriente) que elevan la temperatura de la muestra por encima de T_c , al estado normal.

micropuente aumenta con el paso del tiempo, causando así un aumento del campo eléctrico y de la señal de voltaje que se mide. Esta variación del campo conlleva una variación de la potencia disipada, lo que a su vez acelera el aumento de temperatura. Experimentalmente no podemos medir la temperatura del micropuente, pero a corriente constante vemos su variación a través de la señal de voltaje, como en la figura 5.16 de la página 150. Vemos que los resultados experimentales de aquella figura y de las simulaciones que ahora se presentan muestran tendencias semejantes: *toda* corriente aplicada causa un aumento de temperatura de la muestra, pero se distinguen dos regímenes esencialmente distintos. Hay un rango de corrientes con las que, pasado un tiempo inicial de crecimiento rápido, se obtiene una aparente estabilización de la temperatura a tiempos largos; por el contrario, hay otras corrientes que producen calentamientos en cascada, elevando la temperatura de la muestra, abruptamente, por encima de la temperatura crítica y haciéndola transitar así al estado normal. El cambio de régimen estacionario a crítico ocurre en un rango estrecho de corrientes: corrientes estables y críticas difieren experimentalmente de menos del 1 %, mientras que nuestro modelo sencillo da un valor que ronda el 2 %.

En la figura 6.8 comparamos una simulación con realimentación en la potencia —variando P con T_f en la ecuación 6.4 convenientemente—, con su correspondiente resultado a potencia constante, sin introducir realimentación —haciendo P constante en la ecuación 6.4, e igual al valor inicial en $t = 0$ —. Representamos la curva con corriente más baja de la figura 6.7, y la que le corresponde haciendo P constante, tal y como hicimos en la figura 6.4. Los parámetros son iguales en ambos casos. Vemos con esta comparación que al introducir realimentación, incluso en los casos en que se tiende prácticamente a una temperatura estable, se alcanzan temperaturas más elevadas que cuando la potencia se mantiene (artificialmente)

pero el caso de pulsos con corrientes constantes resulta más clarificador, por ser más simple, de los procesos térmicos que tienen lugar durante la medida.

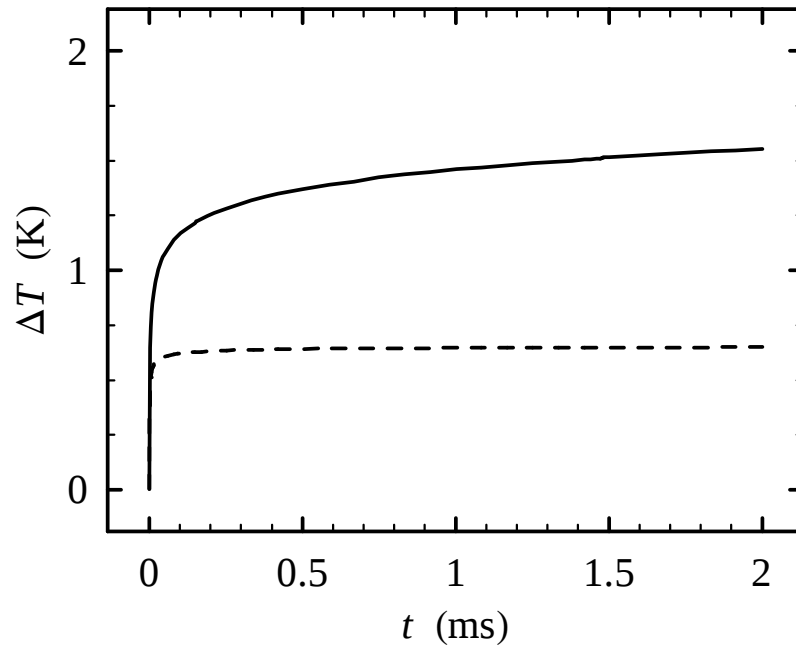


Figura 6.8: Comparación de una simulación con realimentación (línea continua) con otra en la que la potencia permanece constante (línea a trazos). Se representa el aumento de temperatura $\Delta T = \Delta T_f = \Delta T_s$ (ecuaciones 6.5 y 6.9). La temperatura inicial y la corriente aplicada son las mismas en ambos casos, pero en el de realimentación se tiene en cuenta que la potencia P aumenta cuando aumenta la temperatura. El que estabiliza antes y a temperatura menor es el de potencia constante, con resultados análogos a los mostrados en la figura 6.4.

constante. Pero el resultado más importante no es este, sino el de que al introducir realimentación se consiguen, en ciertas condiciones, avalanchas térmicas que no aparecían en el caso de P constante (fig. 6.7). Para tener esta posibilidad es necesario que la potencia aumente con el paso del tiempo: la realimentación es fundamental, y como vemos puede tener efectos notables.

Dependiendo de la temperatura inicial y de la corriente aplicada, los resultados de las simulaciones se dividen, como acabamos de ver en la figura 6.7, en dos categorías: por un lado están los que, tras un aumento inicial, rápido, de temperatura (en un tiempo característico de unos $100\ \mu\text{s}$, como el del caso a potencia constante de la figura 6.4) predicen una temperatura (y por lo tanto una señal de voltaje) *prácticamente* estable a tiempos largos. Por otro lado están los que conllevan una avalancha abrupta que lleva a la muestra por encima de su temperatura crítica T_c , causando la transición al estado normal. Esta transición ocurre en tiempos muy breves, también de unos $100\ \mu\text{s}$, tras un cambio brusco en la tendencia del aumento de temperatura.

Los resultados de estas simulaciones que hemos mostrado — calculando la temperatura del filme con la ecuación 6.9 y empleando los parámetros del muestra A—, dicen que, a $T_b = 76.2\ \text{K}$, la corriente de $7.70 \times 10^6\ \text{A/cm}^2$ causa un estado casi estacionario, y que sólo si elevamos la corriente hasta unos $7.80 \times 10^6\ \text{A/cm}^2$ tendremos una transición al estado normal dentro del tiempo que dura la medida. Según estos resultados, el valor de J^* ronda por tanto los $7.80 \times 10^6\ \text{A/cm}^2$. En comparación con el resultado experimental de $6 \times 10^6\ \text{A/cm}^2$, tenemos una predicción teórica que se equivoca por exceso en un 30 %, lo que no está nada mal dada la sencillez del modelo que empleamos para describir la complejidad del sistema real. Los valores de J^* calculados análogamente para otras temperaturas iniciales se muestran en la figura 6.9. El exceso de la predicción en un 30 % se mantiene para todas las temperaturas. En las siguientes secciones emplearemos alguna correcciones muy razonables a la ecuación 6.9 que nos permitirán acercar más las predicciones a los

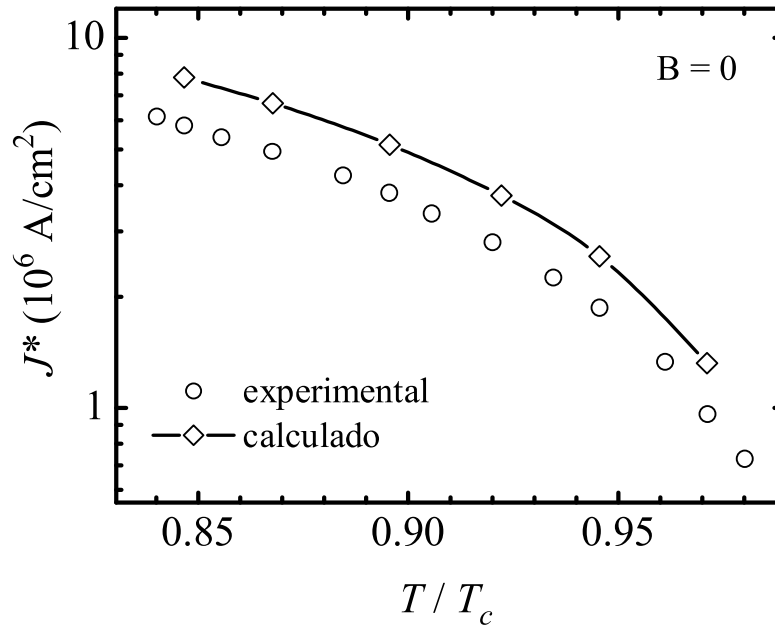


Figura 6.9: Comparación con el experimento de los valores de J^* calculados con la ecuación 6.9 y previas, introduciendo realimentación en la potencia en la ecuación 6.4. La línea que une los puntos calculados es sólo una guía visual. El modelo, debido a su simplicidad, predice valores de J^* que exceden en un 30% los reales. Introduciremos correcciones al modelo sencillo para mejorar las predicciones, pero lo relevante ya se encuentra aquí: existen corrientes que hacen transitar a la muestra hasta el estado normal sólo con mecanismos térmicos, y la dependencia de J^* con la temperatura es idéntica a la experimental.

resultados experimentales. Pero lo esencial ya se recoge en esto que hasta aquí hemos expuesto: cuando se tienen en cuenta tanto la realimentación en la potencia disipada (lo que hace aumentar notablemente el calor generado) como la distribución de temperaturas no uniforme en el entorno de la muestra (lo que disminuye la capacidad de evacuación del calor) se pueden generar avalanchas térmicas que elevan la temperatura de la muestra por encima de T_c muy rápidamente, causando así transiciones abruptas al estado normal.

Los cálculos los hemos realizado con un programa escrito en *Mathematica* que mostramos con detalle en el apéndice A. En resumen, lo que el programa hace es dividir la duración de la medida en pequeños intervalos de tiempo, de manera que en cada momento se calcula la temperatura del micropuente T_f con las ecuaciones 6.9 y previas. A una corriente J aplicada, la temperatura calculada T_f determina un campo eléctrico E (que introducimos en el programa empleando una función que ajusta a nuestros datos experimentales: explicaremos esto con detalle en la sección 6.3), lo que nos proporciona una señal de voltaje que podemos comparar con la experimental. Pero además nos sirve para calcular la potencia disipada $P = E J v_f$, lo que nos permite, en el siguiente intervalo de tiempo, calcular de nuevo la temperatura del micropuente convenientemente: en cada intervalo, la potencia P que conlleva una cierta temperatura de la muestra está a su vez determinada por la temperatura T_f del intervalo previo. De este modo introducimos la realimentación.

Destaquemos aquí otro resultado importante, que ya apreciábamos en los experimentos de la figura 5.16 y que ahora hemos reproducido con nuestro modelo teórico: el tiempo característico de estabilización de la temperatura τ_i , en los casos a $J < J^*$ donde no se produce avalancha, es de unos $100 \mu s$. Recordemos, como ya dijimos en la sección 6.2.2.b (p. 167) que este tiempo característico es mayor que el tiempo bolométrico τ_B de enfriamiento porque tiene en cuenta sobre todo la inercia térmica del substrato, cosa que τ_B no hace. Si este τ_i es el tiempo característico de inercia térmica de nuestro

sistema, es comprensible que cualquier medida que se realice en escalas temporales mucho mayores no muestre, por debajo de J^* , una dependencia respecto de duración de la medida. Si por ejemplo medimos experimentalmente curvas $E-J$ cerca de la transición al estado normal (pero manteniéndonos siempre por debajo de J^*), en sentidos ascendente y descendente de la corriente, con pulsos para cada valor de la corriente de, digamos, decenas de milisegundos, no es de esperar que apreciemos efectos de histéresis: la duración de la medida de cada pulso es órdenes de magnitud mayor que el tiempo de calentamiento o de enfriamiento. Pero que no veamos efectos de histéresis no significa, como hemos visto aquí, que no haya calentamiento implicado: lo que ocurre es que no medimos, en este ejemplo de experimento, con la resolución temporal suficiente como para apreciarla.

Pues bien: diversas publicaciones, donde se mostraban experimentos en que se empleaban pulsos de decenas de milisegundos [10] o incluso de segundos [15], descartaban la implicación de fenómenos de calentamiento relevantes debido precisamente a la ausencia de histéresis en sus medidas. Con lo que hasta aquí hemos mostrado desmontamos este argumento: si en esos experimentos no se apreciaban efectos de histéresis era debido a la poca resolución temporal de la medida, y no necesariamente a que los efectos térmicos fuesen despreciables. Como corroboración experimental de lo que acabamos de explicar, resultados que empleaban mayor resolución temporal empezaban a apreciar dependencia del experimento respecto de la duración de la medida sólo cuando sus pulsos se reducían por debajo del milisegundo, hasta 100 o 50 μs [107].

6.3. Detalles del cálculo y mejoras al modelo

En esta sección explicamos cómo introducimos la disipación en función de la temperatura dentro de nuestras simulaciones, y proponemos un par de mejoras muy razonables al modelo sencillo de la ecuación 6.9, que acercarán más todavía los resultados teóricos a los experimentales.

6.3.1. Disipación en función de la temperatura

En los cálculos para simular la evolución temporal del sistema necesitamos conocer cuál es concretamente el campo E que se tiene cuando varía la temperatura, para introducir con ello la realimentación. Esta variación de E con T_f a una corriente J dada la podríamos obtener como interpolación de nuestros datos experimentales, pero es más práctico buscar una única función $E(J, T_f)$ que englobe toda esa información. Esta función la obtenemos de los ajustes a los datos experimentales que vimos en el capítulo 5, empleando los modelos habituales que describen las curvas E – J . Para campo aplicado nulo, usamos la dependencia de la ecuación 5.1 (p. 120), mientras que para campo aplicado usamos la ecuación 5.4. De esta manera obtenemos una única función para cada caso que nos da el valor de $E(J, T_f)$, y que empleamos en nuestros cálculos para introducir realimentación, variando el valor de la potencia al variar la temperatura de la muestra. Para ver los detalles de estos cálculos remitimos al apéndice A.

6.3.2. Mejoras al modelo sencillo

En el apartado 6.2.3 hemos visto cómo el sencillo modelo térmico de las ecuaciones 6.9 y previas reproduce la existencia de una corriente

crítica que genera una avalancha, elevando así la temperatura de la muestra de manera abrupta y haciéndola transitar al estado normal. Dada la sencillez del modelo propuesto, la predicción teórica de J^* difería del resultado experimental en aproximadamente un 30 % (fig. 6.9). Con la intención de reducir esta diferencia introducimos aquí, y para todos los cálculos consecuentes, un par de mejoras al modelo sencillo que modifican los resultados exclusivamente de manera cuantitativa, sin alterar las ideas básicas. Como veremos, estas mejoras son muy razonables, y se aplican con la intención de hacer una descripción más realista del sistema. Están basadas en las correcciones que ya se encontraban en la referencia [59], pero aquí se han adaptado para tener en cuenta las dependencias temporales.

Distribución no uniforme de temperatura. Lo que nos interesa en última instancia es la temperatura del micropuente, no la del sustrato. Si queremos introducir realimentación en el modelo y calcular una nueva potencia disipada teniendo en cuenta la variación de temperatura a lo largo del tiempo de la medida, es la temperatura del filme T_f la que es relevante. En una primera aproximación, la más simple, hemos considerado que $T_f = T_s$ (ec. 6.9), lo que implica que la temperatura en el volumen caliente es uniforme e igual al promedio que calculábamos con la ecuación 6.5. Para conseguir resultados más realistas, sin embargo, podemos tener en cuenta que en el seno del volumen v_s al que ha llegado el calor en un tiempo t hay una distribución no uniforme de temperatura, con $T \rightarrow T_f$ cerca de la muestra y $T \rightarrow T_b$ en el extremo opuesto. Para lo que nos interesa es suficiente conocer cuál es la temperatura en el extremo cercano al filme, y no tanto cómo es en detalle la distribución de temperatura dentro de v_s . El aumento de temperatura en ese punto será mayor que el promedio ΔT_s y, en general, lo podemos tomar como un factor α mayor que ΔT_s :

$$\Delta T_f(t) = \alpha \Delta T_s(t), \quad (6.10)$$

de manera que la temperatura de filme queda

$$T_f(t) = T_b + \Delta T_f(t) = T_b + \alpha \Delta T_s(t). \quad (6.11)$$

En el caso más simple que consideramos anteriormente, haciendo la temperatura del filme igual al promedio T_s , α tomaba el valor 1.

Este factor α se puede hacer más complejo, con la intención de aproximarnos más al sistema real. Hacer α mayor que 1 implica corregir, en lo que a la temperatura del film se refiere, la simplificación que supone dividir el substrato caliente sólo en dos regiones de temperaturas uniformes: una termalizada con el baño a T_b y la otra a una temperatura T_s algo mayor. La región del substrato pegada al film tiene en realidad una temperatura más elevada que *la media* T_s de todo el volumen caliente, y este factor α daría cuenta de esto.

Para tener en cuenta el valor de α sin profundizar en la solución completa de la ecuación de conducción del calor, que sería bastante compleja, podemos hacer unas estimaciones de su comportamiento en casos límite que nos permitan hacer cálculos. A tiempos cortos, cuando $t \rightarrow 0$, es decir, cuando el $v_s(t)$ coincide con el volumen del micropuente v_f , o es de su orden de magnitud, tiene mucho sentido hacer la temperatura del film igual a la del volumen total caliente: son casi coincidentes. En este caso límite se puede hacer $\alpha = 1$.

Por el contrario, cuanto más pasa el tiempo menos es válida la aproximación $\alpha = 1$, ya que la geometría tiende a la de un semicilindro calentado por su eje, con distribución no uniforme de temperatura. El micropuente, en el eje, calienta a todo el cilindro, y es en el propio filme donde se alcanza la máxima temperatura de la distribución. En el caso ideal, cuando $t \rightarrow \infty$, α toma el valor $4/\sqrt{\pi} \simeq 2.26$ [59].

Podemos además incluir en este factor aquel que corrige la forma del volumen caliente, tendiendo a hacerla cilíndrica a tiempos largos (ver sec. 6.2.2.a, p. 165). De este modo, el valor límite de α con $t \rightarrow \infty$ será en realidad $4/\sqrt{\pi} \times 4/\pi \simeq 2.26 \times 1.27 = 2.87$, pero seguirá valiendo 1 en tiempos cercanos al cero.

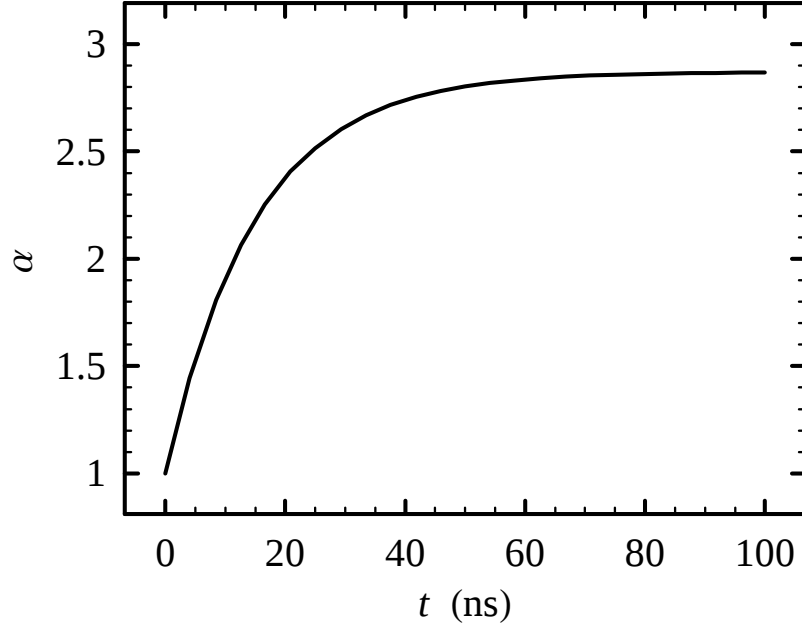


Figura 6.10: Función $\alpha(t)$ que se emplea para corregir la distribución de temperatura en el sustrato, dada por la ecuación 6.12.

Tomaremos en nuestros cálculos un factor α dependiente del tiempo que tenga los límites que hemos señalado. De forma sencilla usamos como aproximación al valor real de α una función que tienda suavemente a 2.87, representada en la figura 6.10, de la forma

$$\alpha(t) = 1 + 1.87 (1 - e^{-t/t_c}) \quad (6.12)$$

donde t_c es un tiempo característico que estimamos comparando el volumen caliente de sustrato $v_s(t)$ con el del filme v_f . Como primera aproximación, tomamos el tiempo t en que $v_s(t)$ se hace grande comparado con v_f , digamos diez veces mayor. En nuestro caso, usando los parámetros propios de nuestro sistema y empleando la ecuación 6.3, ese tiempo es $t_c \simeq 15$ ns. Más adelante haremos estimaciones de qué pasaría si el sustrato tuviese una conductividad térmica quince veces mayor (como si empleásemos MgO en vez de SrTiO₃[7, 109]); en este otro caso $t_c \simeq 0.25$ ns.

Frontera entre filme y sustrato. Nótese que, a pesar del anterior factor corrector de la geometría, seguimos estimando por defecto la temperatura del film: al poner al film en un continuo con el sustrato y sin más consideraciones, hacemos que el film y la capa de sustrato inmediatamente pegada a él estén a la misma temperatura; es decir, que el coeficiente de transferencia de calor entre ambos sea infinito. En esta imagen, el film y el sustrato son un continuo de características térmicas iguales. En realidad el film está a una temperatura algo mayor que la capa de sustrato a que está adherido; en un caso estacionario esta diferencia sería de $\Delta T = P/(l a h)$, donde P es la potencia estacionaria, el producto $l a$ es el área de contacto, y h es el coeficiente de transferencia de calor entre sustrato y film. Como no estamos en el estacionario este límite es inexacto: P varía con el tiempo y la temperatura, y la resolución del problema se complica.

Veremos que obviar esta cuestión, como ya hemos mencionado, no afecta cualitativamente a los principales resultados, pero, para acercar más las predicciones del modelo al experimento, en los resultados finales que mostraremos se incluye un término que da cuenta de este incremento de temperatura extra, mejorando cuantitativamente las predicciones. Juntando las dos correcciones que hemos mencionado, la temperatura del micropuente resulta

$$T_f(t) = T_b + \Delta T_f(t) = T_b + \alpha(t) \Delta T_s(t) + \beta(t) \frac{P}{l a h}. \quad (6.13)$$

Para la función $\beta(t)$ emplearemos una dependencia temporal análoga a la que hemos expuesto para $\alpha(t)$ en la ecuación 6.12, de modo que también $\beta(t)$ transite suavemente de un límite al otro, pero teniendo en cuenta que los límites son ahora $\beta = 0$ para $t \rightarrow 0$ y $\beta = 1$ para $t \rightarrow \infty$. También haremos, como primera aproximación, el parámetro t_c diez veces menor que en el caso de α : la resistencia a la transferencia de calor entre medios se pone de manifiesto desde los primeros momentos de la evolución de la medida, no hay que esperar a que el calor llegue a grandes volúmenes de sustrato. Teniendo en

cuenta estos límites, haremos que

$$\beta(t) = 1 - e^{-t/10/t_c}. \quad (6.14)$$

En el siguiente capítulo compararemos las simulaciones, teniendo en cuenta estos dos términos correctores, con los resultados experimentales, y veremos que las similitudes son notables, apoyando la validez de dichas correcciones.

Capítulo 7

Predicciones del modelo de calentamiento en avalancha

En este capítulo veremos las principales predicciones que se extraen del modelo de calentamiento en avalancha que hemos propuesto, y las compararemos con los datos experimentales. También sugeriremos una condición de avalancha que explica por qué el sistema, bajo ciertas condiciones, alcanza estados aparentemente estacionarios, mientras que en otras condiciones se produce una avalancha térmica que lleva a la muestra al estado normal. Esta condición de avalancha nos permitirá interpretar algunos resultados experimentales dentro del contexto del calentamiento.

7.1. Predicciones del modelo y comparación con los experimentos

7.1.1. Variación del valor de J^* en función de la duración de la medida

En la figura 5.16 de la página 150 veíamos como la avalancha se alcanzaba en distintos momentos a partir del inicio de la medida dependiendo del valor concreto de la corriente que aplicásemos. De este modo, el valor experimental de J^* dependía del tiempo que durase la medida. Algunos valores de corriente aplicada daban una aparente estabilización, sin causar avalancha. Por el contrario otros valores, a partir de una cierta corriente, conducían siempre a una avalancha, aunque en tiempos más breves cuanto mayor fuese el valor de J .

Esto mismo lo predicen nuestras simulaciones, como ya hemos mencionado. Con las correcciones explicadas en el apartado previo, en la figura 7.1 vemos la evolución en el tiempo del incremento de temperatura ΔT_f del micropuente al aplicar distintas corrientes de valores cercanos entre sí ($6.70, 6.73, 6.74$ y 6.84×10^6 A/cm²), partiendo de una temperatura inicial de 75.6 K, igual a la del experimento de la figura 5.16 con el que hacemos la comparación. Entre la primera, que lleva a una temperatura aparentemente estable dentro de los tiempos de la medida, y la última, que produce una avalancha inmediata, hay un 2 % de diferencia. Pero entre la primera y la segunda de las corrientes aplicadas, que ya dan resultados distintos dentro del tiempo que dura la medida, hay sólo un 0.5 % de diferencia. Esto da cuenta, al menos cualitativamente, de los resultados de la tesis de S. R. Currás [11] publicados en la referencia [10], en los que una cierta corriente aplicada generaban un estado estacionario prolongable varios minutos, pero aumentar la corriente en un 0.2 % hacía transitar la muestra al estado normal. Entonces se utilizó este resultado experimental para descartar que el calentamiento fuese exclusivamente el causante de la transición al estado normal: muy

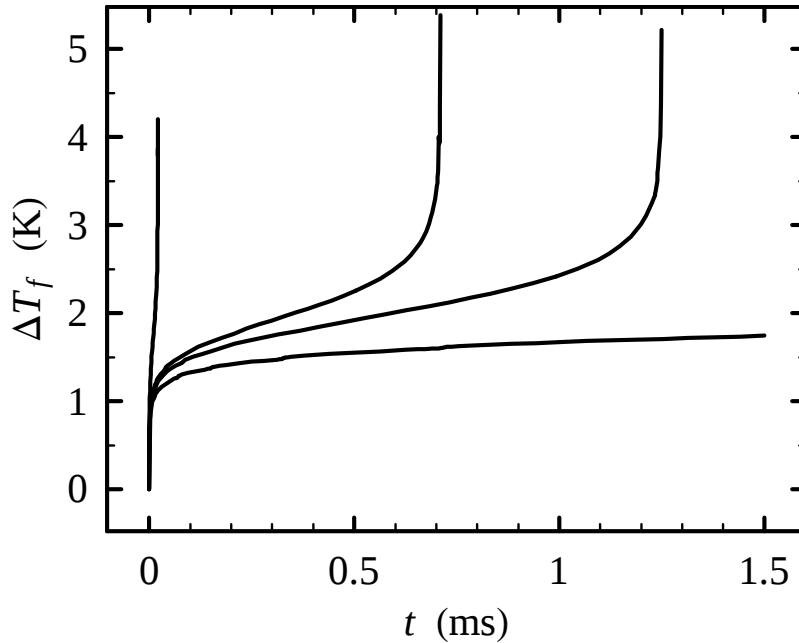


Figura 7.1: Simulación de la evolución temporal de la temperatura de un micropuente, aplicando distintas corrientes de valores próximos entre sí ($6.70, 6.73, 6.74$ y 6.84×10^6 A/cm²), a $B = 0$. Entre la primera y la última hay un 2 % de diferencia, pero conllevan resultados muy diferentes. La temperatura inicial es $T_b = 75.6$ K.

pequeñas diferencias de la potencia disipada conllevaban estados notablemente diferentes, así que parecía más probable que el motivo fuese algún mecanismo intrínseco. Ahora vemos, sin embargo, que la realimentación en la potencia disipada justifica estas diferencias a pesar de hacer el experimento con potencias iniciales notablemente parecidas. No podemos, por tanto, descartar que el calentamiento esté directamente involucrado en la ruptura de la superconductividad de la muestra.

De estas simulaciones obtenemos también la evolución del campo eléctrico $E(J, T_f)$, que se representa en la figura 7.2 juntamente con los resultados experimentales ya mostrados en la figura 5.16, y que se repiten aquí para facilitar la comparación. Los saltos de la simulación no son tan abruptos como los experimentales, pero el comportamiento

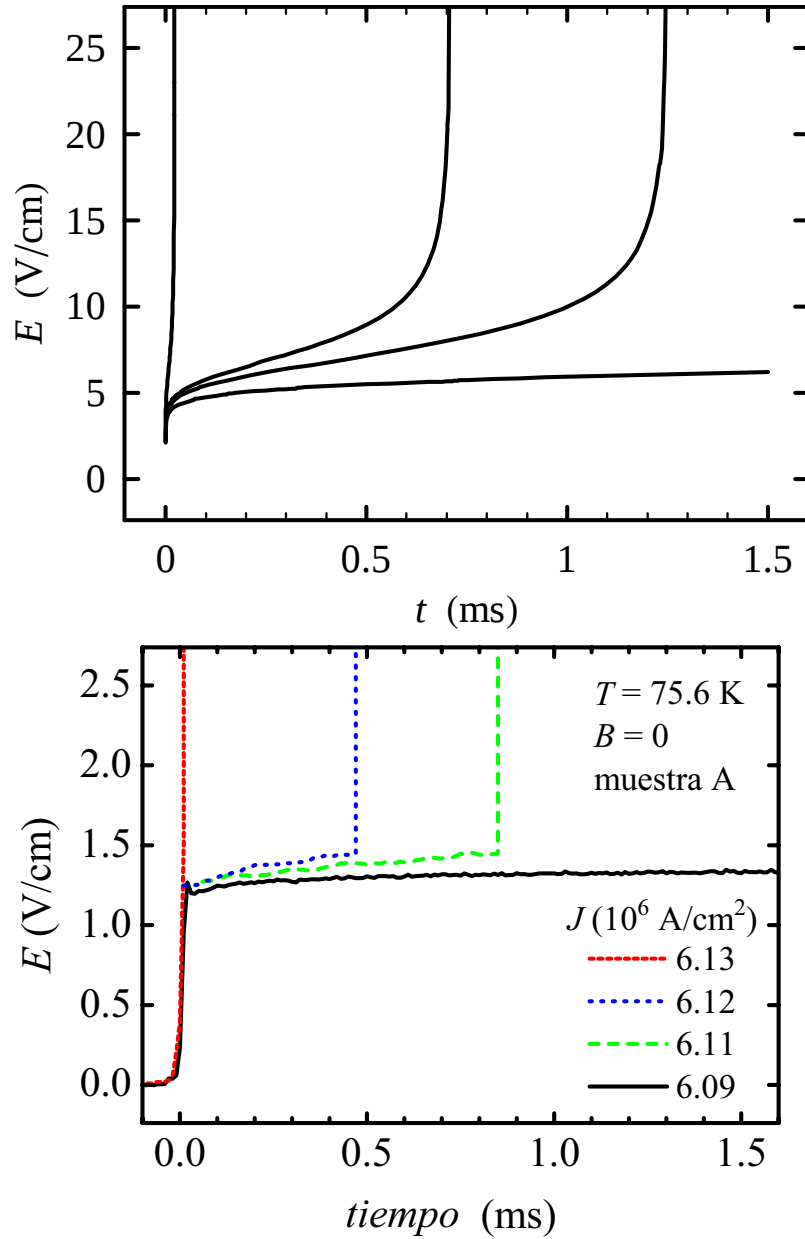


Figura 7.2: Arriba, evolución temporal del campo E en un micropunto a distintas corrientes constantes (6.70 , 6.73 , 6.74 y 6.84×10^6 A/cm 2), correspondiente a la simulación de la figura 7.1. Abajo, por comparación, los resultados experimentales ya mostrados previamente en la figura 5.16 (p.150), con 6.09 , 6.11 , 6.12 y 6.13×10^6 A/cm 2 . $T_b = 75.6$ K, $B = 0$. Las transiciones del modelo no son tan abruptas, ni a las mismas corrientes que las experimentales, pero el comportamiento es semejante.

con la duración de la medida es análogo. (Que los saltos no ocurran exactamente en el mismo instante no es significativo: se han elegido estos valores de corriente para la simulación porque muestran tendencias semejantes, pero no se ha buscado que la transición sea *exactamente* en el mismo instante temporal). Probablemente el modelo es demasiado pobre para dar cuenta de cambios tan rápidos en tan poco tiempo, pero lo interesante es destacar que incluso en la sencillez del modelo se predice una avalancha que lleva a la muestra al estado normal.

Los resultados para la temperatura inicial de 75.6 K no difieren significativamente de los de 76.2 K, pero mostramos también estos últimos (figura 7.3) porque más adelante los necesitaremos para compararlos con las simulaciones obtenidas al aplicar campo magnético, y con otros datos experimentales. Las corrientes que ahora, al incrementar un poco la temperatura inicial, producen la avalancha a tiempos iguales son algo menores ($6.38, 6.41, 6.42$ y 6.52×10^6 A/cm²), como cabía esperar. Para esta misma simulación, las evoluciones de la resistividad $\rho = E/J$ y de la potencia disipada $W = E \times J$ se muestran en la figura 7.4.

Resaltemos aquí el efecto que ha tenido el introducir las correcciones al modelo sugeridas en el apartado 6.3.2. De las simulaciones de la figura 6.7 se extraía un valor teórico de J^* de 7.8×10^6 A/cm², que excedía el experimental en un 30 %. Con las correcciones, vemos ahora en la figura 7.3 que el valor predicho desciende hasta rondar los 6.4×10^6 A/cm², lo que supone una discrepancia de sólo el 7 % respecto al valor experimental de 6.0×10^6 A/cm². En todo caso la mejora es solamente cuantitativa: los principales resultados ya aparecían cualitativamente en el modelo sin correcciones.

En la figura 7.3 vemos cómo el sobrecalentamiento ΔT_f evoluciona de manera relativamente lenta hasta aproximadamente $\Delta T_f = 2.5$ K, y cómo a partir de ese momento se acelera el incremento de temperatura de modo que casi al instante se produce una transición. Estos 2.5 K de

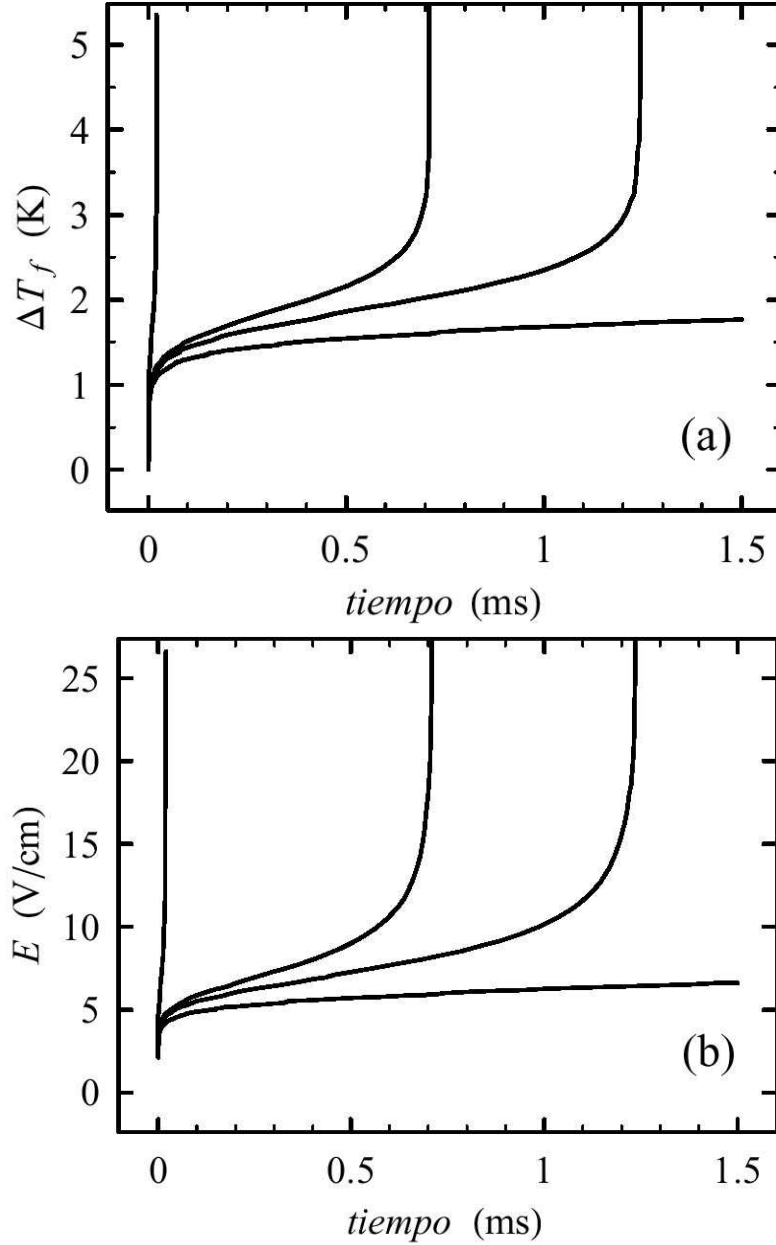


Figura 7.3: Simulación de la evolución temporal de la temperatura (a) y del campo eléctrico (b), aplicando distintas corrientes de valores próximos entre sí ($6.38, 6.41, 6.42$ y 6.52×10^6 A/cm²), a $B = 0$. Entre la primera y la última hay un 2% de diferencia, pero conllevan resultados muy diferentes. La diferencia con la simulación de las figuras 7.1 y 7.2 es que la temperatura inicial es ahora de $T_b = 76.2$ K. Los resultados son parecidos, pero necesitaremos estos para posteriores comparaciones.

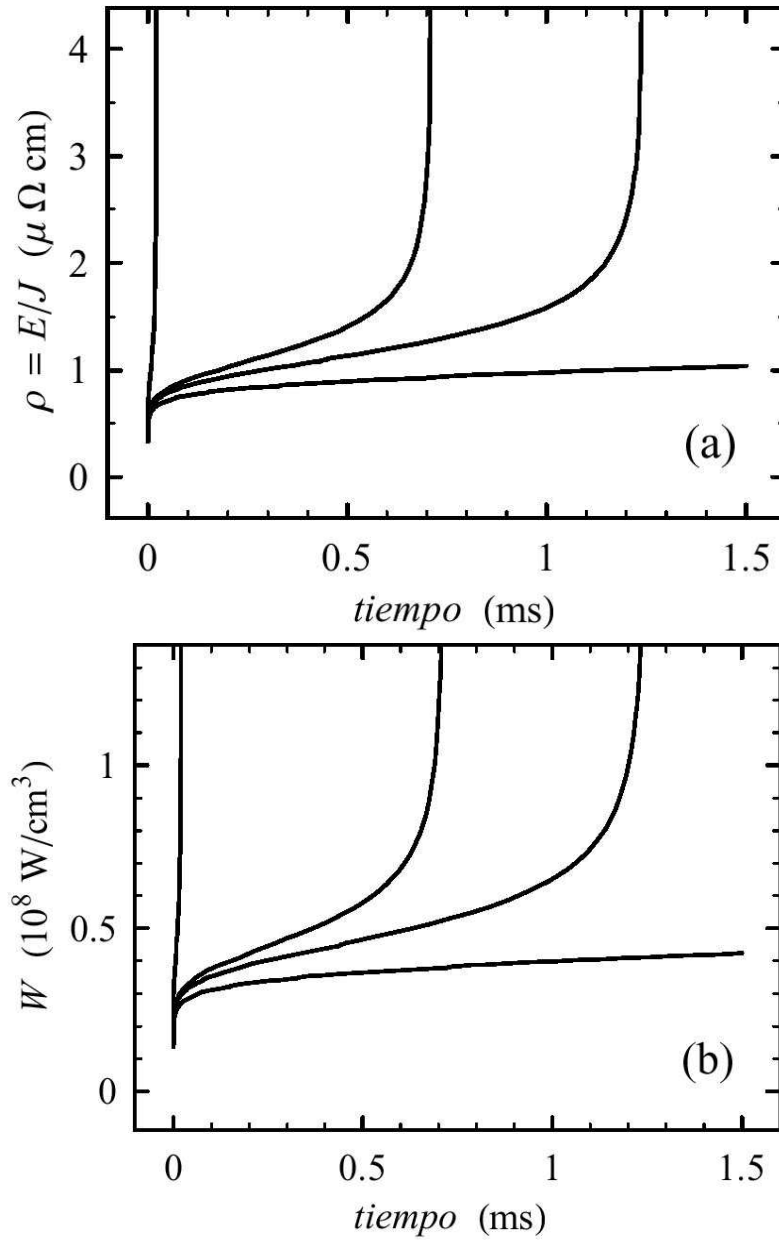


Figura 7.4: Evolución temporal de la resistividad ρ del micropunto (a) y de la potencia disipada W (b) a distintas corrientes constantes, correspondientes a la simulación de la figura 7.3. $T_b = 76.2 \text{ K}$, $B = 0$.

sobrecalentamiento antes de la transición seguramente no son tantos en el experimento real: ya hemos dicho que el salto que se predice aquí no es tan abrupto como el que se mide, y es casi seguro que en la realidad la temperatura de la muestra no aumenta tanto antes de transitar. Pero estos valores aquí predichos para campo magnético aplicado nulo nos serán de utilidad cuando los comparemos con los obtenidos al aplicar campo, para interpretar la tendencia de los experimentos. El incremento máximo de temperatura estacionario es de unos 1.8 K

También estaremos interesados en comparar el valor de la potencia disipada en torno al salto. Nótese, en la figura 7.4.b, que el mayor valor estable que se obtiene de la potencia ronda los 4×10^7 W/cm³. Valores mayores siempre conllevan una avalancha, y no podrían ser medidos experimentalmente como puntos estacionarios.

Mostramos también los resultados de las simulaciones para otra temperatura inicial notablemente mayor, de $T_b = 82.0$ K, ahora con más corrientes diferentes aplicadas, en el rango de 3.47 – 3.55×10^6 A/cm². Centramos nuestro interés en las evoluciones de la temperatura y de la potencia disipada, que se muestran en la figura 7.5. Ahora la avalancha se alcanza con menor sobrecalentamiento que en la simulación a 76.2 K (figura 7.3), de sólo unos 1.6 K: al elevar la temperatura inicial (la del baño) necesitamos menos sobrecalentamiento de la muestra para entrar en régimen crítico. Las correspondientes curvas de potencia disipada disminuyen su valor estacionario previo al salto, comparadas con las obtenidas a menor temperatura inicial. El límite estable ronda ahora los 2.5×10^7 W/cm³, un 40 % menos.

En las figuras 7.6 y 7.7 se muestran resultados análogos a estos, a temperatura inicial $T_b = 76.2$ K, pero para campo aplicado $\mu_0 H = 1$ T. Se obtienen empleando para las simulaciones la función 5.4 para describir las curvas experimentales. Las corrientes a las que se produce la avalancha son ahora menores: los valores empleados en los resultados que se muestran son $2.68, 2.70, 2.71$ y 2.80×10^6 A/cm². El incremento

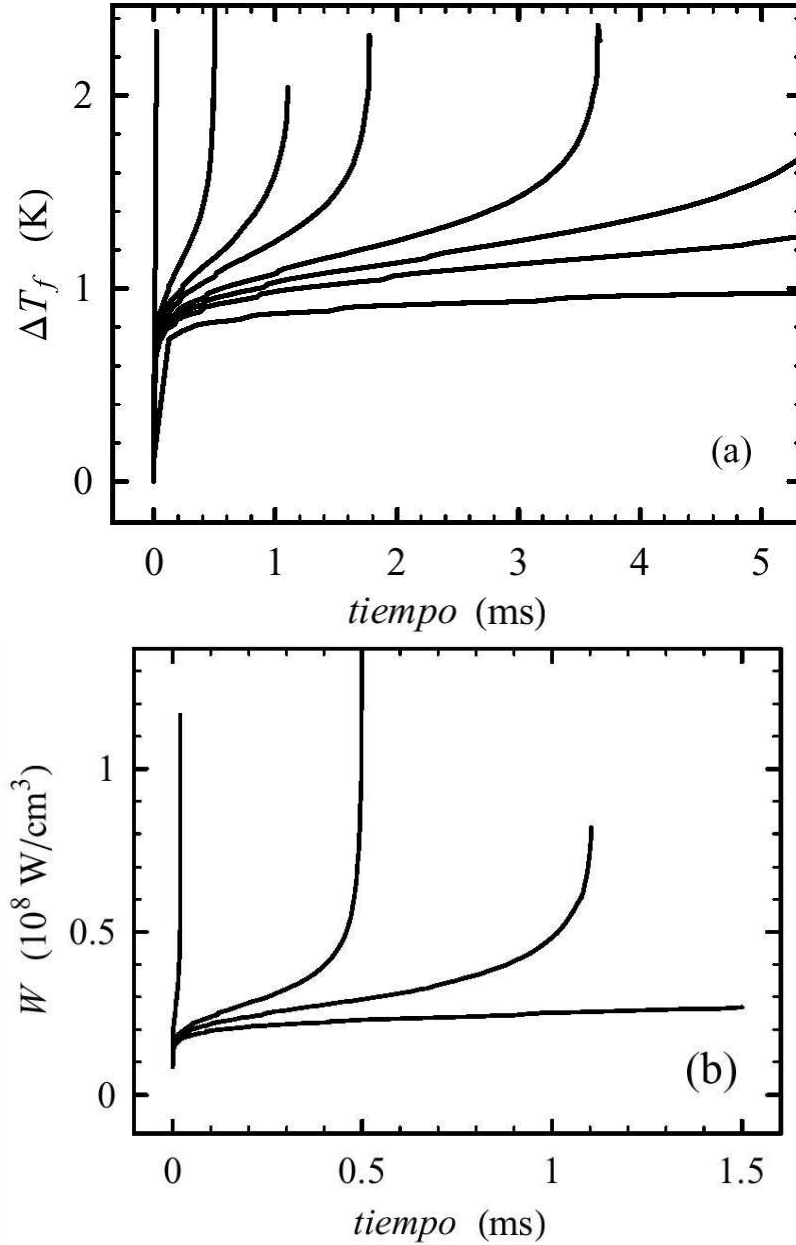


Figura 7.5: Arriba, simulación de la evolución temporal de la temperatura, aplicando distintas corrientes en el rango de $3.47\text{--}3.55 \times 10^6$ A/cm², a $B = 0$. La temperatura inicial es de $T_b = 82.0$ K. Abajo, evolución temporal de la potencia disipada $W = E \times J$ a algunas de esas mismas corrientes. La figura (a) abarca un rango temporal más amplio que el resto de las figuras mostradas, para apreciar las tendencias a tiempos mayores.

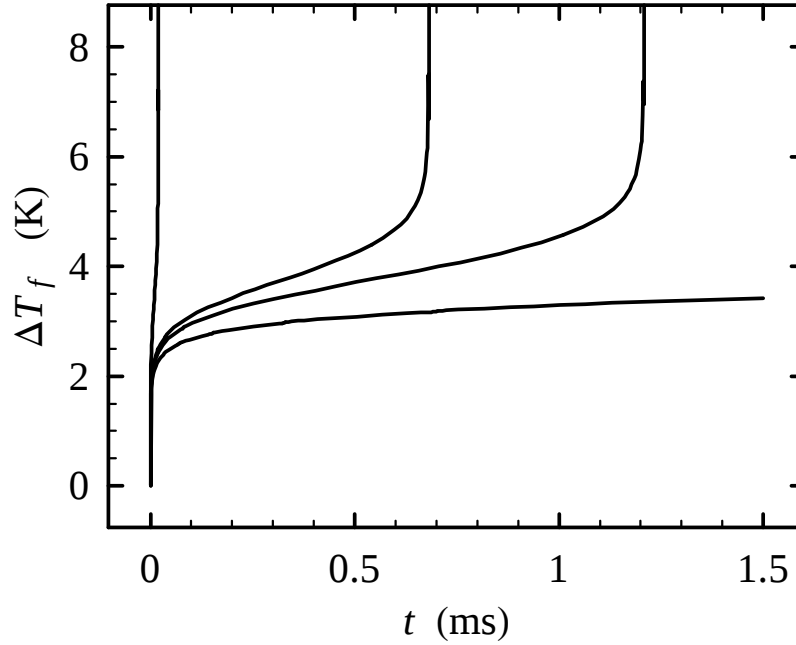


Figura 7.6: Simulación de la evolución temporal de la temperatura, aplicando distintas corrientes de valores próximos entre sí ($2.68, 2.70, 2.71$ y 2.80×10^6 A/cm²). La diferencia con la simulación de la figura 7.3-a es que el campo aplicado es ahora $\mu_0 H = 1$ T.

de temperatura en el momento en que se produce la avalancha es de unos 5 K, el doble que en el caso sin campo magnético a la misma temperatura. El incremento máximo de temperatura estacionario es de unos 3.5 K. También aumenta la potencia estacionaria más alta que se puede alcanzar, situándose en torno a los 8×10^7 W/cm³. Analizamos estos resultados en el siguiente apartado.

En la figura 7.8 se recoge la correlación entre corriente aplicada y tiempo t que dicha corriente tarda en causar una avalancha. Esta información se ha extraído de la simulación de la figura 7.5.a. Como ya hemos visto, una cierta corriente aplicada J puede inducir, o no, una avalancha térmica dependiendo de cuánto tiempo la mantengamos. Equivalentemente, nuestra predicción nos dice que el valor experimental de la corriente de salto J^* dependerá de la duración

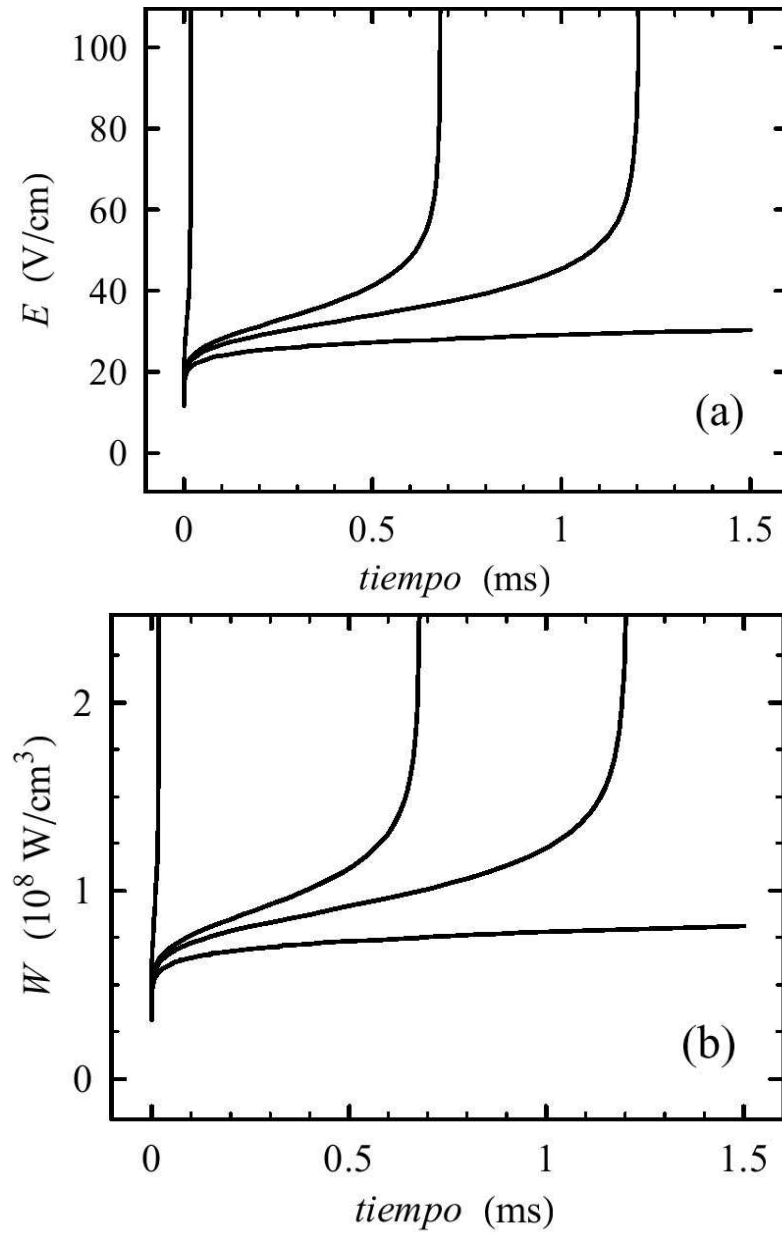


Figura 7.7: Evolución temporal del campo E (a) y de la potencia disipada (b) a distintas corrientes, correspondiente a la simulación de la figura 7.6. $T_b = 76.2$ K, $\mu_0 H = 1$ T.

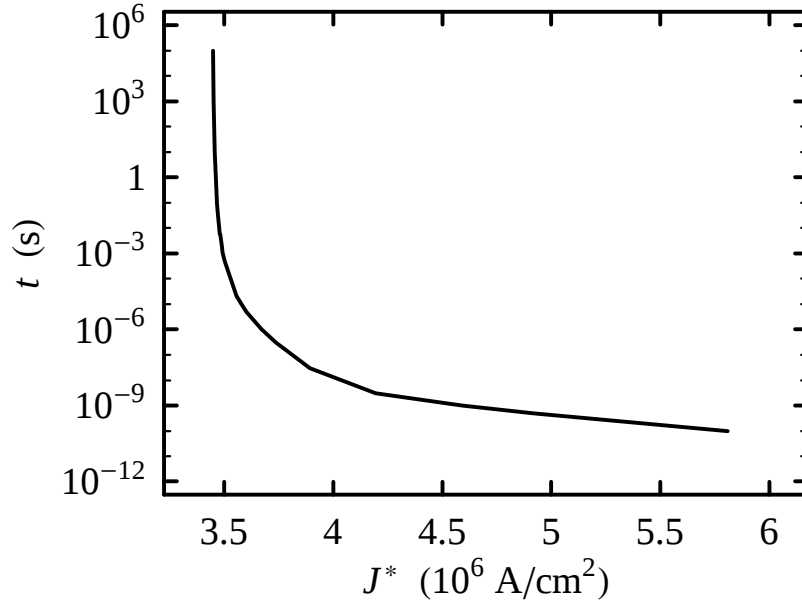


Figura 7.8: Correlación entre el valor de J^* y el tiempo t de duración de la medida, a una temperatura inicial $T_b = 82.0 \text{ K}$, obtenida de la simulación de la figura 7.5-a: se representa el tiempo t que una corriente J tarda en inducir una avalancha, contado desde que se aplica el pulso de corriente.

del pulso de medida, pudiendo alcanzarse valores más altos si se mide en pulsos más breves.

La primera conclusión que podemos sacar de esta representación es que conforme aumenta la duración de la medida t , la corriente J^* que medimos tiende a un valor mínimo, en este caso unos $3.45 \times 10^6 \text{ A/cm}^2$. Corrientes menores darán resultados casi estacionarios, sin llegar a causar nunca una transición al estado normal, por mucho tiempo que se mantenga aplicada la corriente. En realidad estos cálculos, como sabemos, suponen que el substrato es infinito, y que por mucho que pase el tiempo el calor no sale de él. La realidad es más compleja, y habría quizá que tener en cuenta, para estos t tan largos, correcciones relativas al entorno del substrato (portamuestras y atmósfera circundante). Pero como primera aproximación esto resulta suficiente, y en cualquier caso coincide con los resultados

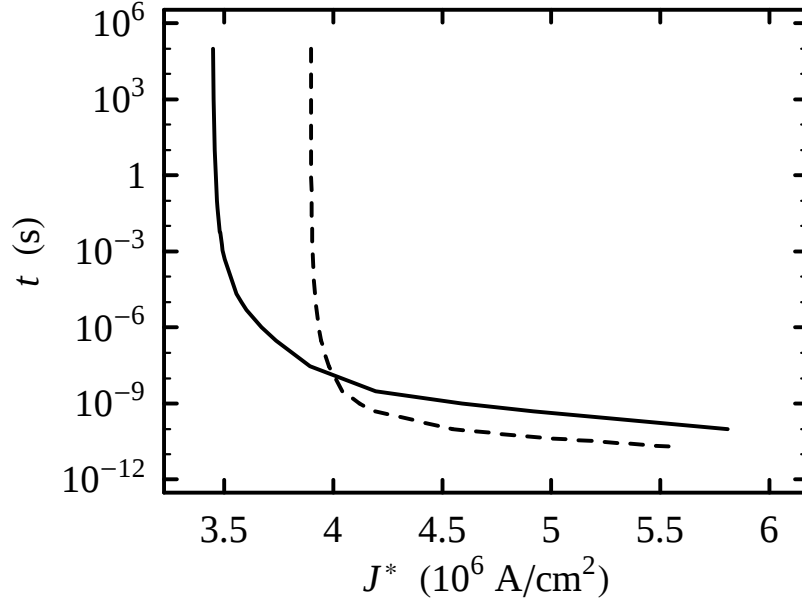


Figura 7.9: Comparación de los resultados de la figura 7.8 (en trazo continuo) con los obtenidos de simulaciones equivalentes considerando que el sustrato tiene una conductividad eléctrica 15 veces mayor (en trazo discontinuo; se pretende simular así el empleo de sustratos de MgO en vez de SrTiO₃). Se representa el tiempo t que una corriente J tarda en generar una avalancha, contado desde que se aplica el pulso de corriente.

experimentales en el sentido de que se puede aplicar una corriente $J \lesssim J^*$ y permanecer mucho tiempo en ella sin causar un salto, como ya hemos mencionado [10, 11].

Destaquemos de esta figura que el tiempo t en el que el valor de J^* comienza a ser independiente de la duración del pulso coincide con el tiempo en que el volumen caliente de sustrato se hace grande comparado con el volumen de filme. Recordemos que v_s es unas diez veces mayor que v_f hacia los 15 ns (ver la ecuación 6.12 y su explicación en la página 180).

En la figura 7.9 se comparan los resultados anteriores con los que análogamente se obtienen suponiendo que la conductividad térmica del sustrato es quince veces mayor, y dejando igual los demás parámetros. De esta manera pretendemos simular qué sucede cuando

se emplean sustratos cristalinos de MgO en vez de SrTiO₃, como se ha hecho en algunos experimentos de otros grupos [7, 16]. Las películas delgadas que se crecen sobre estos sustratos de MgO suelen tener una temperatura crítica más baja que las crecidas sobre SrTiO₃, debido a una menor compatibilidad entre las constantes de red sustrato-filme, así que no variar ningún parámetro más que la conductividad térmica es probablemente una descripción optimista, pero nos sirve en primera aproximación para contrastar los resultados.

A pesar de las diferencias, en ambos casos la tendencia que muestra J^* con tiempos de medida largos lleva a concluir que una vez que los pulsos aplicados superan una cierta duración (del orden de decenas de microsegundo de duración en el SrTiO₃, y de nanosegundos en este supuesto MgO ideal), todos los experimentos son prácticamente equivalentes a efectos de establecer la corriente crítica, dentro de un mismo tipo de sustrato. Esto es coincidente con resultados experimentales en los que habiéndose empleados pulsos muy largos (de decenas de milisegundos) no se apreciaban diferencias entre multiplicar o dividir su duración por factores del orden de 100 [7, 16]. En otros experimentos en que se mide, sin embargo, con mejor resolución temporal, se aprecian notables diferencias en los resultados cuando el tiempo de medida se reduce al orden de los microsegundos [107].

El valor mínimo de J^* , como era de esperar, aumenta al mejorar la conductividad térmica del sustrato, pero poco más de un 10 %. En estos cálculos, por simplicidad, no hemos cambiado el coeficiente de transferencia de calor entre película y sustrato al calcular con SrTiO₃ o con MgO: en todo caso ambos valores son del mismo orden de magnitud [7].

Nótese también que, cuando el tiempo del pulso es tan breve que el sustrato apenas interviene en el fenómeno, las J^* obtenidas en cada caso tienden a valores muy semejantes. Recordemos que al simular el comportamiento del MgO el volumen de sustrato caliente se hace grande comparado con el del filme bastante antes que con el SrTiO₃: v_s es diez veces mayor que v_f a los 0.25 ns. Esto también se refleja en

esta figura 7.9, en la que el valor de J^* comienza a variar mucho con t a tiempos menores para el MgO que para el SrTiO₃. Es la relación entre volumen de filme y volumen de sustrato que interviene en el fenómeno lo que establece estos tiempos característicos.

Otra conclusión interesante es que, efectivamente, el valor experimental de la corriente de salto J^* puede aumentar si medimos suficientemente rápido, aunque para ver apreciables variaciones de J^* hay que reducir mucho la duración del pulso t . En el caso del SrTiO₃, para aumentar el valor mínimo de la corriente de salto en un 10% (llevarla hasta 3.8×10^6 A/cm²) hay que bajar t hasta menos de 100 ns. Según este modelo, sólo a partir de ese momento comienzan a verse diferencias más notables con la variación del pulso.

La tendencia indica que cuando $t \rightarrow 0$ no se produce avalancha térmica para ninguna corriente aplicada, de manera que se podría ver una transición al estado normal causada, de existir, por otros fenómenos distintos de los térmicos. Si hubiese un fenómeno intrínseco a una corriente J_i^* mayor que las J^* mínimas a se que tiende en la figura 7.9, dicho fenómeno estaría entremezclado con el calentamiento y no se discriminaría midiendo con pulsos de larga duración. El fenómeno intrínseco se vería alterado, adelantado a corriente más bajas debido al calentamiento, hasta que redujésemos tanto el tiempo de medida t que la J^* determinada por el calentamiento superase ese valor J_i^* . A partir de ese momento veríamos siempre un valor constante de corriente de salto J_i^* con independencia de sucesivas reducciones de la duración del pulso, pues el fenómeno intrínseco sería dominante. En este tipo de medidas que aquí simulamos, sólo podríamos empezar a discriminar *nítidamente* ambos efectos (el del calentamiento y el posible intrínseco que hubiese) cuando redujésemos la duración de la medida a menos de 1 ns, momento en el que el valor de J^* comienza a variar apreciablemente.

Pero esta dificultad para discriminar los efectos extrínsecos de calentamiento de los posibles intrínsecos que estén presentes (como los mencionados en el capítulo 5) no quiere decir que sea imposible

Cuadro 7.1: Valores de la potencia estacionaria W^* y la derivada dW/dT para los valores estables previos al salto de las simulaciones de las figuras 7.3 -7.7, así como de otros campos intermedios. La potencia estable previa al salto decrece con la temperatura inicial, pero aumenta con el campo.

B	$T = T_b + \Delta T_f$	J	W^*	dW/dT
T	K	10^6 A/cm ²	10^7 W/cm ³	10^7 W/cm ³ K
0	76.2 + 1.8	6.38	4.32	3.34
0	82.0 + 1.0	3.49	2.43	2.66
0.1	76.2 + 2.8	5.80	6.52	2.21
0.4	76.2 + 3.2	3.80	7.35	2.16
0.7	76.2 + 3.4	3.18	7.66	1.99
1.0	76.2 + 3.5	2.68	8.35	1.40

separarlos en alguna medida. El calentamiento puede afectar a la determinación precisa de una posible J_i^* , pero medidas detalladas de la evolución temporal del salto podrían permitir detectar el efecto intrínseco, aunque estuviese precipitado por el calentamiento de la muestra. Esta podría ser una explicación para la discrepancia entre las simulaciones y los resultados experimentales, puesta de manifiesto de la figura 7.2: el experimento muestra una transición mucho más abrupta de la que somos capaces de reproducir con nuestras simulaciones. Quizá se deba a la simplicidad de nuestro modelo, pero sin hacer cálculos más precisos no podemos descartar que haya un fenómeno intrínseco más rápido que el calentamiento (como un desapareamiento de los pares de Cooper, por ejemplo), y que se anticipa a su valor esperado debido al incremento de temperatura en avalancha de la muestra. Una interesante vía de continuación del presente trabajo sería hacer estos cálculos de calentamiento con mayor detalle, mejorando el realismo del modelo.

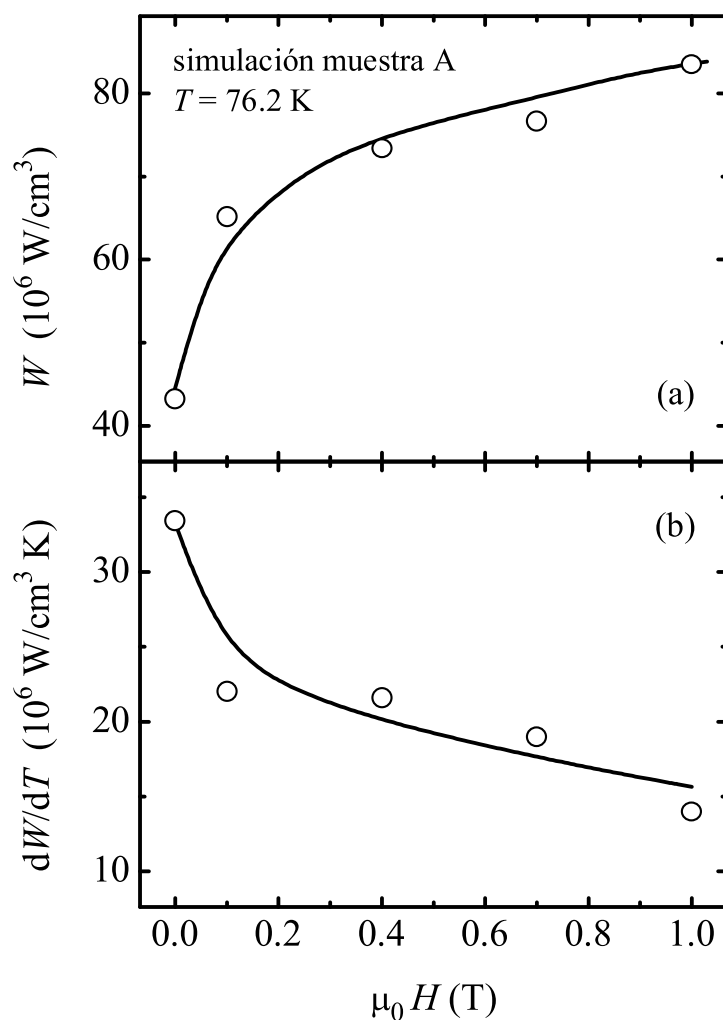


Figura 7.10: Resultados de simulaciones para la muestra A a $T = 76.2 \text{ K}$, en función del campo magnético aplicado. En (a), potencia disipada por unidad de volumen justo antes del salto W^* —la potencia W a la temperatura estacionaria más alta posible—. El modelo predice la misma tendencia de W^* creciente con H que los experimentos (compárese con la fig. 5.18). En (b), la derivada de la potencia respecto de la temperatura dW/dT , en ese mismo punto previo al salto. Mientras que W^* aumenta con el campo aplicado, su derivada, sin embargo, decrece. (Las líneas son guías para los ojos).

7.1.2. Variación de la potencia disipada previa al salto W^* con la temperatura y el campo

Haciendo simulaciones como las del apartado anterior podemos conocer en todo momento cuál es la temperatura de la muestra, a corriente y campo magnético aplicados contantes. Con esta temperatura así calculada —que debido al calentamiento es, en general, mayor que la inicial del baño—, y haciendo uso de la ecuación 5.1 que da el valor del campo E (y consecuentemente la potencia $W = E \times J$ a corriente constante) obtenemos, para cualquier instante de tiempo, los valores precisos de W y su derivada dW/dT . En la tabla 7.1 se muestran los valores de W^* , y de la derivada dW/dT , que se alcanzan en los resultados estacionarios de las figuras 7.4.b, 7.5.b y 7.7.b (los más altos que no producen avalancha en el tiempo de la medida). En esta tabla se incluyen también otros valores, calculados de la misma manera, para más campos magnéticos aplicados de valores intermedios. Para esta muestra, aumentar la temperatura inicial (en el caso calculado, desde 76.2 hasta 82.0 K) implica disminuir el valor de la potencia disipada antes del salto. Es la misma tendencia que mostraban los experimentos (ver fig. 5.17, p. 152). Pero la tendencia es la contraria si aumentamos el campo magnético aplicado.

En la figura 7.10 representamos gráficamente los valores de W y dW/dT en función del campo magnético aplicado que se incluyen en dicha tabla, calculados según nuestro modelo de calentamiento. Compárese con los resultados experimentales correspondientes, mostrados previamente en la figura 5.18 (p. 153). Aunque los cálculos teóricos dan valores algo mayores para la potencia estacionaria disipada antes del salto, el orden de magnitud es el mismo que en el experimento. Y lo que es más importante: predecimos la misma tendencia de aumento de la potencia con el campo aplicado que se observa experimentalmente, tanto en los datos que hemos mostrado en el capítulo 4 como en los que se encuentran en algunas publicaciones [8, 18, 19]. Pero mientras que la potencia disipada justo antes del

salto W^* *crece*, el valor de la derivada de la potencia respecto de la temperatura dW/dT en ese instante *decrece* con el campo aplicado.

Ya hemos apuntado que el que W^* aumente con H se empleó como argumento para descartar que los efectos térmicos fuesen los causantes directos de la transición al estado normal. Si éstos eran la causa, resultaba paradójico que al aumentar el campo se necesitase más potencia disipada W para hacer transitar a la muestra. (Como T_c disminuye al aumentar H , un aumento de campo aplicado equivale, a una temperatura constante dada, a aproximar más la muestra a su temperatura de transición, por lo que en principio haría falta menos calor para hacerla transitar). Veremos en la sección 7.2 que este razonamiento no es correcto en el contexto del modelo térmico que proponemos: no es sólo el valor de W lo que causa una avalancha, también su derivada con la temperatura está implicada en que el sistema sea crítico o estable. Los resultados de las simulaciones aquí mostrados confirman que un modelo térmico puede explicar los resultados experimentales.

7.1.3. Curvas características E – J afectadas de calentamiento

De simulaciones como las mostradas, por ejemplo, en la figura 7.3, podemos reproducir una curva E – J , haciendo cálculos para una misma temperatura inicial y aplicando distintas corrientes. Tras un tiempo t tendremos un campo $E(J, t)$ derivado de nuestros cálculos, que podemos comparar con el resultado experimental de hacer una medida con un pulso de duración t . En general, el valor del campo E será también dependiente de la temperatura inicial y del campo magnético aplicado. Simular de este modo una curva E – J equivale a dar una información recopilada de muchas simulaciones independientes como las mostradas en la figura 7.3, una para cada punto.

En la figura 7.11 se muestran los resultados para una temperatura

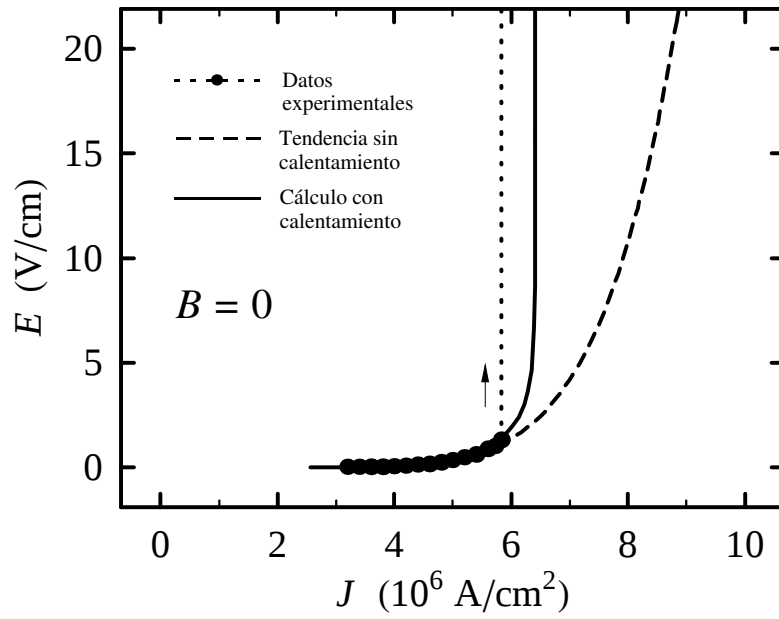


Figura 7.11: Comparación de la curva E – J que predicen las simulaciones con pulsos de 1 ms (trazo continuo) con los datos experimentales correspondientes (círculos negros, unidos por línea de puntos). $T_b = 76.2$ K, $B = 0$. Se muestra también la tendencia de los datos con menos disipación (línea a trazos discontinuos), dada por el modelo de la ecuación 5.1 y que es la base de nuestros cálculos. La predicción del modelo se aleja de esta tendencia y establece una J^* , una *singularidad* en la que la muestra transita al estado normal, en $J = 6.4 \times 10^6$ A/cm², valor que difiere de la corriente de salto experimental en apenas un 7%. La tendencia de trazo discontinuo no tiene una singularidad, y crece continuamente.

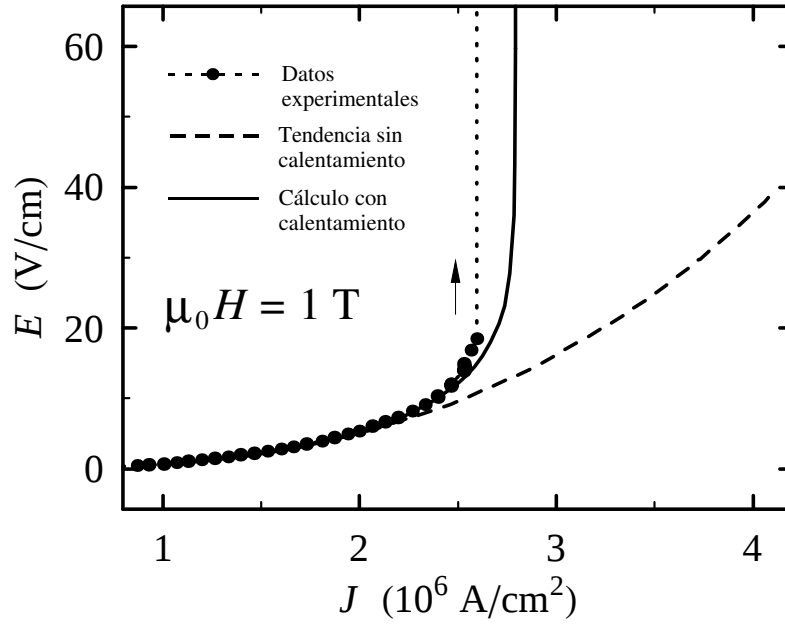


Figura 7.12: Comparación de la curva E – J que predice las simulaciones con pulsos de 1 ms (trazo continuo) con los datos experimentales correspondientes (círculos negros, unidos por línea de puntos: la flecha indica el salto al estado normal), con campo magnético aplicado. $T_b = 76.2 \text{ K}$, $\mu_0 H = 1 \text{ T}$. La línea a trazos discontinuos es la tendencia de los datos con menos disipación, dada por el modelo de la ecuación 5.4. La predicción del modelo se aleja de esta tendencia y establece una J^* , una *singularidad* en la que la muestra transita al estado normal, en $J = 2.8 \times 10^6 \text{ A/cm}^2$, valor que difiere de la corriente de salto experimental en menos de un 8%.

inicial $T_b = 76.2$ K, y a campo magnético nulo, empleando pulsos de 1 ms. Se puede ver cómo la simulación predice un distanciamiento de la tendencia que muestran los datos en la región de baja disipación y, lo que es más importante, la existencia de una *singularidad*: una corriente máxima que se puede aplicar sin que la muestra transite al estado normal. La singularidad no está implícita en la tendencia de trazo discontinuo (ec. 5.1, p. 120) que es la base de los cálculos: esta crece continuamente. Como ya hemos venido observando en resultados previos, esta separación de la simulación respecto de la tendencia previa no es tan abrupta como en el experimento (el salto de los datos experimentales se muestra en la línea de puntos), pero nuestro modelo, a pesar de su sencillez, predice el valor de J^* con un error de menos del 7 %.

El buen acuerdo entre modelo y experimento es todavía más llamativo en la figura 7.12, donde se muestran resultados análogos para el experimento con campo magnético aplicado $\mu_0 H = 1$ T. Se aprecia no sólo la predicción de una corriente de salto (con un error de menos del 8 %), sino también mucho mejor la desviación que los datos experimentales muestran respecto de la tendencia que tienen en el rango de menos disipación. Con nuestro modelo térmico justificamos esta desviación exclusivamente por el incremento de temperatura de la muestra en esta región de alta disipación¹. Este es un resultado importante, pues reafirma la validez del modelo propuesto, sugiriendo que la singularidad en J^* no se introduce forzosamente, de manera artificial: surge como consecuencia inevitable del calentamiento, el mismo calentamiento que tan bien explica los resultados experimentales antes del salto. En el siguiente apartado mostraremos otro resultado que va en esta misma línea, dando fuerza

¹Este incremento de temperatura lo estimábamos en la figura 7.6, quizá un poco al alza, en unos 3.5 K cerca de la transición (máxima temperatura estacionaria). Pero no nos interesa tanto la exactitud de este valor, como su comparación con el del caso sin campo magnético de la figura 7.3: la relación es de dos a uno. Con campo aplicado se produce un incremento de temperatura, antes de la transición por avalancha, mayor que sin campo aplicado.

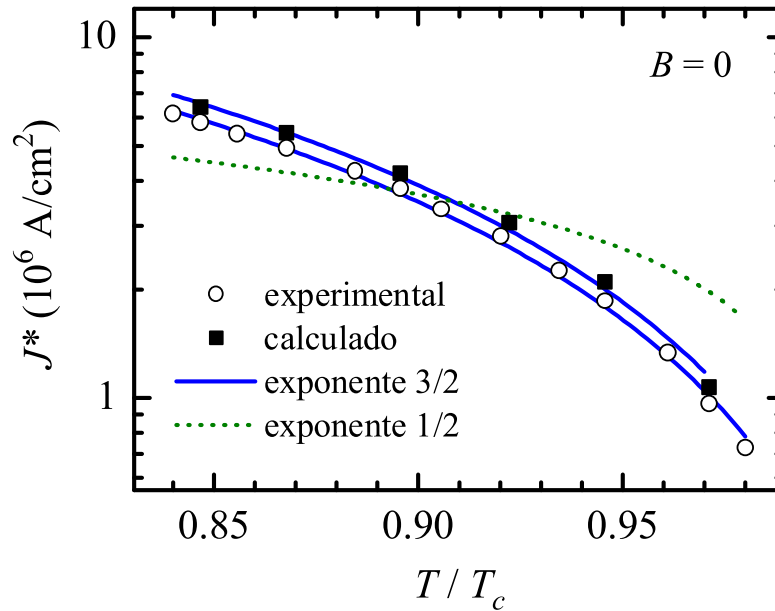


Figura 7.13: Variación con la temperatura de la corriente de salto J^* . En círculos blancos, los resultados experimentales ya mostrados en el capítulo 4. En cuadrados negros, los calculados según nuestro modelo de calentamiento en avalancha. La coincidencia en valores absolutos es notable. Pero lo que es más importante: se reproduce la misma tendencia con la temperatura, cosa que hasta el momento ningún modelo térmico había logrado. Las líneas de trazo continuo son ajustes a los datos empleando una función con exponente $3/2$ en temperaturas reducidas (ec. 5.5, p. 131), mientras que la línea de puntos es el mejor ajuste con exponente $1/2$ (ec. 5.6).

a la validez de nuestro modelo térmico.

7.1.4. Variación de la corriente de salto J^* con la temperatura

En la figura 7.13 se muestra la dependencia de la corriente de salto J^* respecto de la temperatura, comparándose los resultados experimentales (círculos blancos) con las predicciones teóricas de nuestro modelo de calentamiento en avalancha (cuadrados negros). Lo más relevante no es tanto la proximidad entre los valores reales y

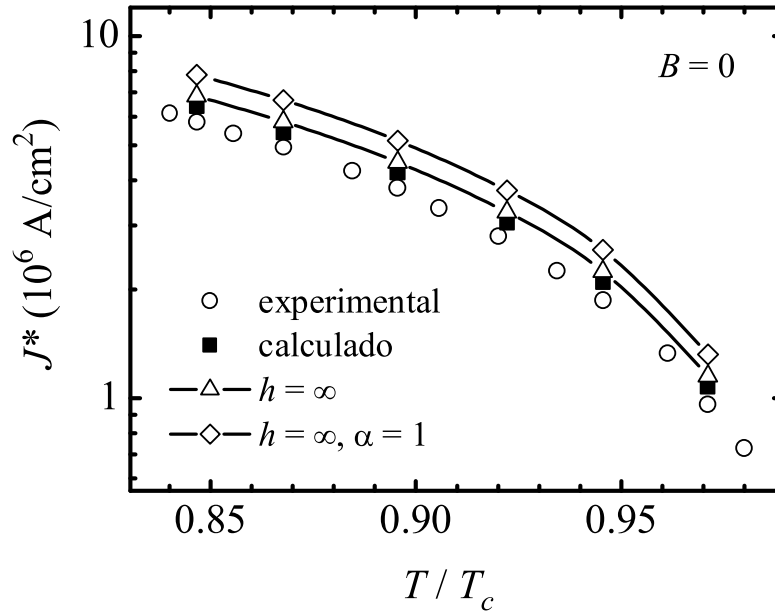


Figura 7.14: Variación con la temperatura de la corriente de salto J^* . En círculos blancos, y en cuadrados negros, los mismos puntos de la figura 7.13. Por compararlos con estos, se incluyen los resultados de emplear el modelo térmico con sucesivamente menos correcciones: en triángulos, los obtenidos con la ecuación 6.11 (p. 179); en rombos, los de la ecuación 6.9 (p. 169) ya mostrados previamente en la figura 6.9. Las líneas que unen los puntos son sólo guías visuales.

los predichos, como que estos últimos tengan la misma dependencia funcional con un exponente $3/2$ en temperaturas reducidas (ver sec. 5.3.2, y ec. 5.5). En la figura 7.14 se muestran las predicciones con sucesivamente menos correcciones, y se aprecia que todas ellas muestran igual tendencia: las correcciones simplemente afinan el valor absoluto del resultado. Esta dependencia la muestran incluso los resultados que se obtienen del modelo más sencillo, carente de correcciones, empleando la ecuación 6.9, como queda reflejado en esta figura (rombos) y como ya habíamos visto previamente en la figura 6.9.

Si este resultado es importante es porque, hasta ahora, los modelos que se habían propuesto para describir el comportamiento térmico de

este tipo de muestras [69, 94] no eran capaces de describir la tendencia experimental y universal de J^* con la temperatura ($J^*(\varepsilon) \propto \varepsilon^{3/2}$, siendo $\varepsilon \simeq 1 - T/T_c$). Por este motivo, frecuentemente se descartó el calentamiento como causa directa de la transición en este régimen de altas densidades de corriente, incluso en trabajos previos de nuestro laboratorio [10, 11, 15]. Aquí hemos puesto de manifiesto que nuestro modelo térmico sí puede explicar esta dependencia respecto de la temperatura.

7.1.5. Correlación entre potencia disipada y aumento de temperatura

Para finalizar este apartado vamos a hacer una última comparación con los datos experimentales que es más bien una verificación de la coherencia del modelo: queremos comprobar si nuestra descripción térmica del sistema es correcta, y que no estamos introduciendo un sobrecalentamiento artificioso y generando con ello una avalancha térmica irreal.

Ya hemos visto que conocer la temperatura real del micropuente es difícil experimentalmente, al menos en el estado superconductor. Pero en la figura 4.16 de la página 115 mostrábamos los resultados de un experimento en que correlacionábamos la potencia disipada $W = E \times J$ con el incremento de temperatura ΔT de la muestra, en la región normal por encima de T_c . Recordemos que este experimento se hacía necesariamente a $T > T_c$ debido a la imposibilidad de medir directamente la temperatura de la muestra. En esta región en que la muestra está en estado normal podíamos atribuir cualquier diferencia del voltaje experimental, según aplicásemos una corriente que provoque disipación elevada u otra en que la disipación sea despreciable, exclusivamente a efectos térmicos, pues en principio no hay fenómenos intrínsecos que dependan notablemente de la corriente aplicada. De este modo estimábamos el aumento de temperatura ΔT . Esta correlación de ΔT con la potencia disipada W , a pesar de

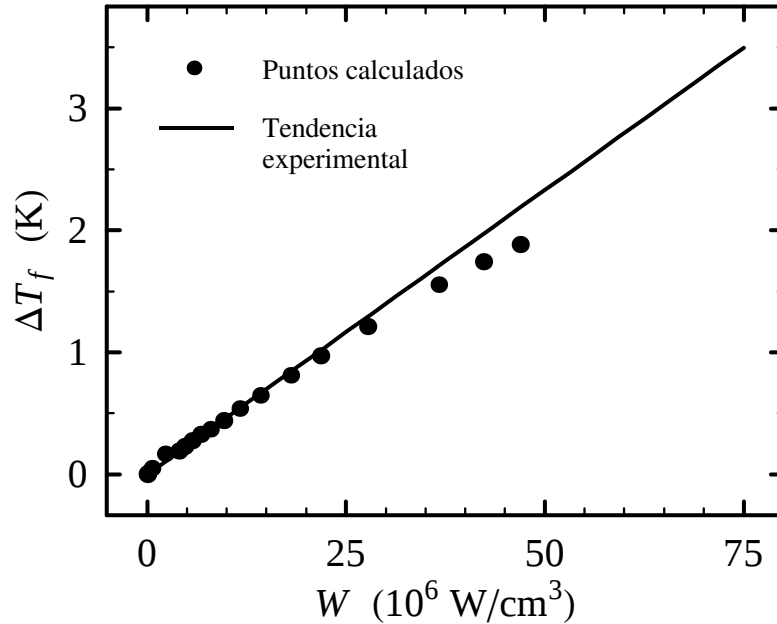


Figura 7.15: Correlación entre potencia disipada y aumento de temperatura de la muestra, según las predicciones de nuestro modelo térmico (círculos negros) para pulsos de 1 ms. Compárese con los resultados experimentales de la figura 4.16 (p. 115). La tendencia que mostraban esos datos se muestra aquí también con una línea recta.

haberse medido por encima de T_c , es en principio extrapolable a la región superconductora, de la que sólo distamos unos pocos grados: aunque la superconductividad modifique algo los parámetros térmicos del filme, los parámetros del sustrato, que son los más relevantes, no se alteran por ello. Asípodremos comprobar la fiabilidad de nuestro modelo, viendo qué correlación teórica entre ΔT y W se extrae de él, y comparándola con la experimental.

En la figura 7.15 vemos, en círculos negros, las predicciones que el modelo propuesto aquí —calculando la temperatura del filme con la ecuación 6.13, e introduciendo realimentación en la ecuación 6.5 mediante la función 5.1— hace para dicha correlación. Son resultados para pulsos de 1 ms, a $T_b = 76.2 \text{ K}$, aplicando corrientes entre 2.5 y $6.4 \times 10^6 \text{ A/cm}^2$. Para facilitar la comparación con los resultados

experimentales mostramos la misma línea recta que se incluía en aquella figura, de ecuación $\Delta T = 0.047W$ (con la potencia W en MW/cm^3), y que recoge la tendencia de los datos.

Los resultados son notablemente similares, aunque la tendencia de que se extrae de los cálculos parece indicar que podemos estar subestimando teóricamente el calentamiento a corrientes altas. Esto coincidiría con que nuestras predicciones, basadas en un modelo muy sencillo, no dan exactamente los valores esperados de J^* , ni producen transiciones tan abruptas como las experimentales. Pero tampoco hay que tener demasiado en cuenta estos puntos tan cercanos al salto. Como ya explicamos al hacer este experimento, este tipo de representación sólo tiene algo de sentido cuando el voltaje (y por tanto la potencia, y la temperatura) está determinado sin ambigüedad. No es el caso de los puntos más cercanos al salto, ya que ahí la temperatura presenta tendencias de crecimiento que no permiten establecer un valor concreto de ΔT . Esta ambigüedad se traslada exponencialmente a $E(J, T)$, y por él a W , de manera que no es extraño que los puntos de la gráfica con potencias más altas sean menos de fiar.

Nótese una vez más que no es sólo la potencia lo que causa una avalancha térmica: en el experimento realizado en el estado normal podíamos llegar a aplicar potencias de más de $75 \times 10^6 \text{ W}/\text{cm}^3$ sin que esto supusiese un aumento de temperatura de más de 4 K, y en todo caso obteniendo estados casi estacionarios. Sin embargo, cuando esta muestra se encuentra en estado superconductor, se produce una avalancha al llegar a esa misma potencia (el último círculo negro que se muestra en la figura 7.15 es muy próximo a J^*). No es que la temperatura haya aumentando en los instantes previos hasta cerca de T_c (lo que supondría un aumento ΔT de más de 10 K), sino que en ese punto la variación de la potencia disipada con la temperatura se hace tan notable que se tiene una fuerte realimentación positiva en lapsos de tiempo breves. Esto lo entenderemos mejor cuando estudiemos, en el apartado 7.2, la condición de avalancha que se extrae de nuestro modelo térmico.

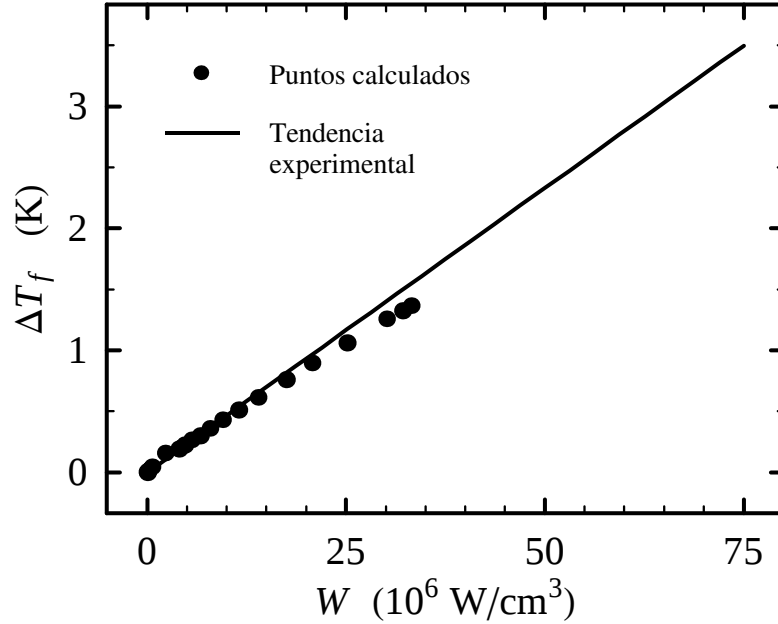


Figura 7.16: Correlación entre potencia disipada y aumento de temperatura de la muestra, según las predicciones de nuestro modelo térmico (círculos negros). La diferencia con la figura 7.15 es que ahora empleamos pulsos de duración diez veces menor, de $100 \mu\text{s}$.

Por comparación, en la figura 7.16 mostramos nuevamente unos resultados simulados para las mismas corrientes que antes, pero acortando la duración del pulso en un factor diez. La tendencia es la misma aunque, por supuesto, los puntos se sitúen en coordenadas diferentes (hay menos disipación, y menor aumento de temperatura).

Se concluye de estos resultados que el modelo térmico que proponemos no debe de estar generando una transición en J^* de manera artificial, por una sobreestimación del calentamiento real. Al contrario, el modelo da buena cuenta de los resultados experimentales que acotan este calentamiento.

7.2. Condición de avalancha térmica

Analizaremos ahora qué condiciones hacen que la evolución de la temperatura tome un camino u otro, el de la estabilidad o el de la avalancha.

Ya hemos mencionado que dentro de este modelo térmico que proponemos no hay estrictamente una evacuación desde la muestra a un medio externo: lo que estamos calculando es una distribución no uniforme de temperatura en un medio continuo, siendo este la suma del micropuente más el sustrato. Desde este punto de vista no es fácil hacer consideraciones fijándonos en las inestabilidades que se producen cuando el calor generado P es mayor que el evacuado $\dot{Q}$, porque *en este modelo* no hay dos medios que intercambien calor. Hacer estas consideraciones entraña notables dificultades. Pero se pueden hacer otras igualmente interesantes.

Tomemos, para simplificar, la temperatura del micropuente que mostrábamos en la ecuación 6.11:

$$T_f(t) = T_b + \Delta T_f(t) = T_b + \alpha \Delta T_s(t).$$

Supongamos además que α es independiente del tiempo, para no complicar demasiado los resultados. La temperatura del baño T_b también es una constante. La derivada de la temperatura del micropuente resulta por tanto

$$\frac{dT_f(t)}{dt} = \frac{\alpha}{c_p v_s(t)} \left(P(t) - \frac{v_s'(t)}{v_s(t)} Q(t) \right). \quad (7.1)$$

Recuérdese que

$$Q(t) = \int_0^t P(\tau) d\tau.$$

La condición estricta de estabilidad es $dT_f/dt = 0$. En realidad esta condición no se cumple nunca en nuestro modelo (ni en el experimento), salvo como caso límite tendiendo a tiempos muy largos.

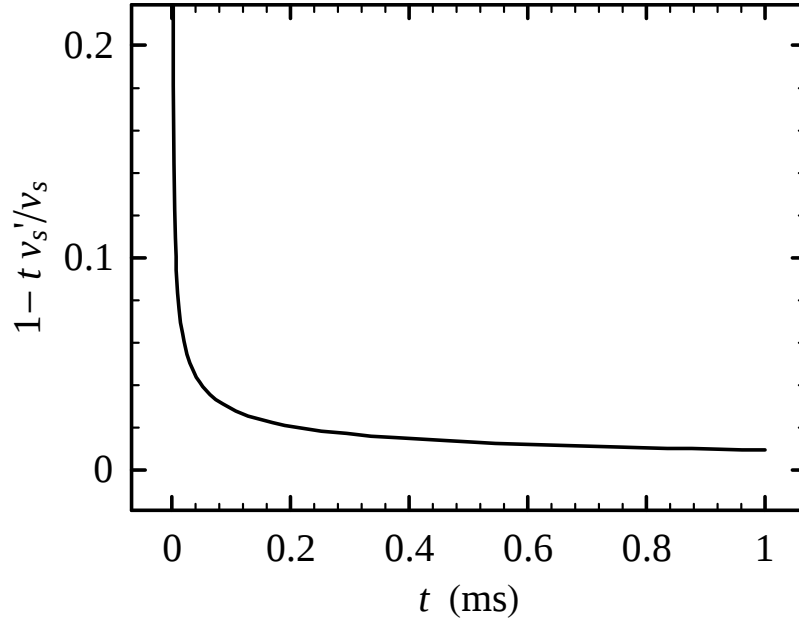


Figura 7.17: Término entre paréntesis de la ecuación 7.2. Como no se anula ni siquiera a potencia constante, la derivada dT_f/dt nunca es cero, por lo que estrictamente no existe estabilidad.

Podemos verlo incluso en el límite de potencia constante, en cuyo caso esta derivada tendría la forma siguiente:

$$\left[\frac{dT_f(t)}{dt} \right]_{P=cte} = \frac{\alpha}{c_p v_s(t)} P \left(1 - \frac{v'_s(t)}{v_s(t)} t \right). \quad (7.2)$$

El término dentro del paréntesis en el lado derecho no se anula nunca, salvo en el límite $t \rightarrow \infty$. Puede verse su representación en la figura 7.17. Esta misma dependencia temporal se mostró ya en la figura 6.6 (p. 168). Si la derivada de la temperatura no se anula a potencia constante, menos aún si la potencia crece con el tiempo.

Expresado esto en términos habituales de disipación y evacuación desde la perspectiva del filme, tenemos que siempre P es mayor que $\dot{Q}$, por lo que la temperatura siempre aumenta. La diferencia entre una medida sin avalancha y otra con avalancha no está por tanto determinada porque la temperatura se estabilice o no. Lo relevante

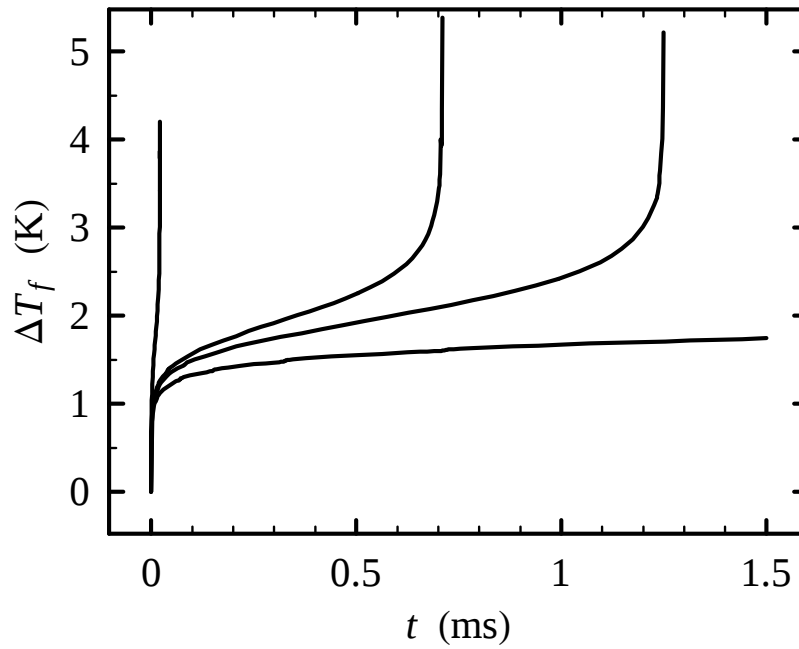


Figura 7.18: Ilustración de los dos posibles tipos de evoluciones temporales de la temperatura: estabilidad o avalancha. Es la misma simulación ya mostrada en la figura 7.1 (p. 185), que incluimos de nuevo aquí por comodidad. Se aplican distintas corrientes de valores próximos entre sí (6.70 , 6.73 , 6.74 y 6.84×10^6 A/cm²), a $B = 0$ y $T_b = 75.6$ K. Entre la primera y la última hay un 2 % de diferencia, pero conllevan resultados muy diferentes. En la evolución que conduce a la avalancha, llega un momento en que la derivada de ΔT en el tiempo (la recta tangente a la curva) crece, mientras que en el caso estable dicha derivada es *siempre* cada vez menor.

es en realidad la tendencia con que crece la temperatura. En la figura 7.18 mostramos un resultado típico, ya conocido: la temperatura siempre crece un poco, pero puede tender a una *aparente* estabilización cuando crece lentamente, o desbocarse y crecer abruptamente. Se puede apreciar que la avalancha se distingue de la estabilidad por la forma en que varía la temperatura en el tiempo. En la evolución que conduce a la avalancha, llega un momento en que la derivada de ΔT en el tiempo —la recta tangente a la curva en cuestión— crece, mientras que en el caso estable la derivada $d\Delta T/dt$ es *siempre* cada vez menor.

Formalmente hablando, en el caso que desemboca en avalancha, la derivada segunda en el tiempo de la temperatura del micropuente se hace positiva. Esto nos lleva a establecer una condición de avalancha con la siguiente expresión:

$$\frac{d^2 T_f}{dt^2} > 0. \quad (7.3)$$

Desarrollando esta derivada segunda a partir de la ecuación 7.1, tendremos avalancha si

$$\frac{d^2 T_f}{dt^2} = \frac{\alpha}{c_p v_s(t)} \left(\frac{dP(t)}{dt} - 2 P(t) f_1(t) + Q(t) f_2(t) \right) > 0. \quad (7.4)$$

Las funciones $f_1(t)$ y $f_2(t)$ son dependientes del tiempo y de los parámetros de la muestra y el substrato, pero independientes de sus temperaturas y de la potencia disipada. Son siempre positivas, y consisten en combinaciones de la función $v_s(t)$ y sus derivadas primera y segunda. Sus expresiones concretas, aunque no son demasiado relevantes para los razonamientos que siguen, se muestran a continuación:

$$f_1(t) = \frac{v_s'(t)}{v_s(t)}, \quad (7.5)$$

$$f_2(t) = 2 \frac{v_s'(t)^2}{v_s(t)^2} - \frac{v_s''(t)}{v_s(t)}, \quad (7.6)$$

donde $v_s(t)$ es el que se mostró en la ecuación 6.3,

$$v_s(t) = l (d + 2 \sqrt{D t}) (a + 4 \sqrt{D t}),$$

y

$$v_s'(t) = \frac{D l (a + 2d + 8 \sqrt{D t})}{\sqrt{D t}}, \quad (7.7)$$

$$v_s''(t) = -\frac{D^2 l (a + 2d)}{2 (D t)^{3/2}}. \quad (7.8)$$

Los límites de f_1 y de f_2 son ∞ para $t \rightarrow 0$ y 0 para $t \rightarrow \infty$. A tiempos cortos f_2 es mayor que f_1 , pero decrece más rápidamente, de modo que a tiempos largos esta relación se invierte.

Siguiendo con nuestro ejemplo elemental de potencia constante, tenemos que si $dP/dt = 0$ la condición de avalancha queda reducida a

$$t f_2(t) - 2 f_1(t) > 0, \quad (7.9)$$

que nunca se satisface pues es siempre negativo. En la figura 7.19 se representa el término de la izquierda de la desigualdad, en escala logarítmica para apreciar mejor su dependencia. En este caso, como ya venimos viendo por diversos resultados, la temperatura, aunque siempre aumenta, lo hace cada vez más lentamente tendiendo a una estabilización a tiempos largos, y no se produce avalancha térmica.

En realidad, el sumando que incluye a la función $f_2(t)$ en la ecuación 7.4 es prácticamente irrelevante en los rangos que manejamos: a tiempos muy cortos, Q (la integral de P en el tiempo) es pequeño, y a tiempos largos es la propia función $f_2(t)$ la que se vuelve despreciable. Eliminando pues ese sumando, y prescindiendo de términos que no influyen en el signo, la condición de avalancha queda

$$\frac{dP(t)}{dt} - 2 P(t) f_1(t) > 0. \quad (7.10)$$

Se puede ver así que no sólo el valor concreto de la potencia P en un momento dado determina una avalancha: para causar este fenómeno es

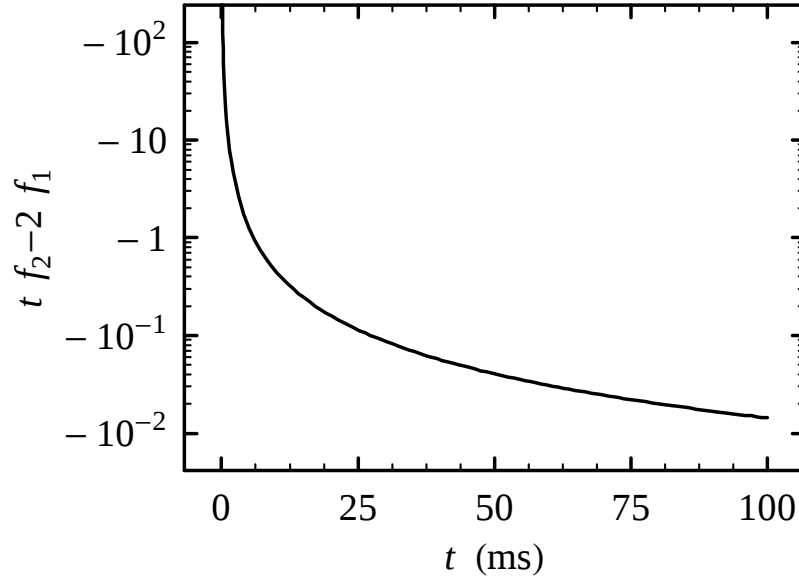


Figura 7.19: Término que determina la condición de avalancha a potencia P constante, según la ecuación 7.9. Como siempre es negativo, la condición de avalancha nunca se satisface.

también relevante su derivada dP/dt . Para simplificar imaginemos que aplicamos un pulso cuadrado de corriente J constante, de manera que la variación de P se deba exclusivamente a cómo varíe la temperatura T_f de la muestra. De este modo, $P(t) = P(T_f(t))$, y la expresión se convierte en

$$\frac{dP(T_f)}{dT_f} \frac{dT_f}{dt} - 2 P(T_f) f_1(t) > 0. \quad (7.11)$$

A este último resultado es al que prestaremos más atención, viendo qué conclusiones se pueden extraer de la condición que impone.

En la ecuación 7.11 se pone de manifiesto lo crucial que resulta no sólo el valor de P para tener una avalancha, sino también el valor de su derivada con la temperatura. Entre otras cosas, como ya hemos venido observando, si P fuese constante nunca se cumpliría la desigualdad 7.11 y no habría avalancha (dP/dT_f valdría cero y la expresión sería siempre negativa). Es necesario que la potencia varíe. Esta condición explica ciertas paradojas aparentes que se

observan en los experimentos: si, por ejemplo por la aplicación de un campo magnético, modificamos la forma de la curva $E-J$, podemos llegar a una situación en que para iguales valores de P tuviésemos otros menores de dP/dT_f . En ese caso podrían no observarse avalanchas con potencias disipadas P que antes, con campo nulo, eran suficientes para inducir la transición. Si no se hacen las consideraciones que aquí hemos mostrado dentro de nuestro modelo térmico, esta observación experimental suele llevar a que se descarte el calentamiento como causa del salto [8, 10, 11] sin que sea necesariamente correcto.

Incluyendo en la última expresión 7.11 la derivada de la temperatura calculada en la ecuación 7.1, y haciendo para simplificar $Q \rightarrow 0$ (condición de pulsos breves), tenemos la condición de avalancha expresada como

$$\frac{dP(T_f)}{dT_f} \frac{\alpha}{c_p v_s(t)} P(T_f) - 2 P(T_f) f_1(t) > 0. \quad (7.12)$$

Emplearemos esta expresión para estimar qué valores de los parámetros que caracterizan nuestro sistema conducen irremediabilmente a una avalancha. De momento podemos interpretar la información que aporta esta ecuación: dada una funcionalidad de $P(T_f)$ —que en general dependerá también del valor concreto de J y B aplicados, no sólo de la temperatura—, si pasado un tiempo t desde que empezamos a disipar calor se consigue llevar la muestra hasta una temperatura T_f de manera que el signo de la expresión sea positivo, tendremos inevitablemente una avalancha pocos instantes después, salvo que paremos la medida y eliminemos la corriente. Si el signo es negativo, sin embargo, nada nos garantiza que momentos más tarde no pueda cambiar a positivo y desembocar también en una avalancha. La ecuación nos dice por tanto si un estado concreto es *suficiente* para generar una avalancha, pero no dice nada de que un estado estable vaya *necesariamente* a mantenerse siempre así. En cualquier caso podemos hacer el estudio de esta expresión a tiempos muy largos, con $t \rightarrow \infty$, de manera que cubramos los rangos de tiempo típicos experimentales,

y obtener de este modo un mapa de las regiones críticas: si para unos parámetros dados la condición 7.12 no se cumple dentro de los rangos de tiempo del experimento, se tiene que el sistema no conduce a una avalancha.

En cualquier caso insistimos en el resultado más relevante que nos dan estas ecuaciones de condición de avalancha: *no sólo el valor de la potencia disipada* determina que un cierto estado conduzca a una avalancha, *también la derivada de la potencia* dP/dT está implicada. Puede haber estados que, a igualdad de potencia disipada, tengan la derivada diferente, de modo que unos sean estables y otros críticos.

La ecuación 7.12, como las anteriores de este apartado, están expresadas para una J y un B constantes dados, y por eso incluyen sólo dependencias respecto de T_f . Pero en función del valor de J , T_f y B concretos tendremos curvas E - J diferentes, y de ahí distintos valores de P y de su derivada, y por lo tanto también distintos signos para la expresión 7.12 que nos da el criterio de avalancha. De esta manera, dicha ecuación divide el espacio de estados tetradimensional J - T_f - B - t en regiones de dos tipos, una en la que la expresión tiene signo negativo (estados casi estacionarios) y otra en la que tiene signo positivo (estados críticos que causan avalancha).

Veamos en primer lugar qué ocurre a $\mu_0 H = 0$. Limitando así el espacio de estados a tres dimensiones (J - T_f - t), vemos en la figura 7.20 una representación de la frontera entre la región crítica —que cumple la condición de la ecuación 7.12— y la estable, que no la cumple —pues el signo es negativo—. Por encima de esta frontera tenemos la región inestable: ahí siempre se producirá una avalancha térmica que hace transitar la muestra al estado normal. Por debajo de la frontera siempre se alcanzan estados casi estacionarios, que tienden a una estabilización de la temperatura.

Veamos algunos cortes significativos de este espacio de estados. Para $T_f = 78$ K, por ejemplo, tenemos el diagrama de estados t - J (tiempo del pulso-densidad de corriente aplicada) que se muestra en la figura 7.21. La región de sombreado oscuro indica un signo negativo

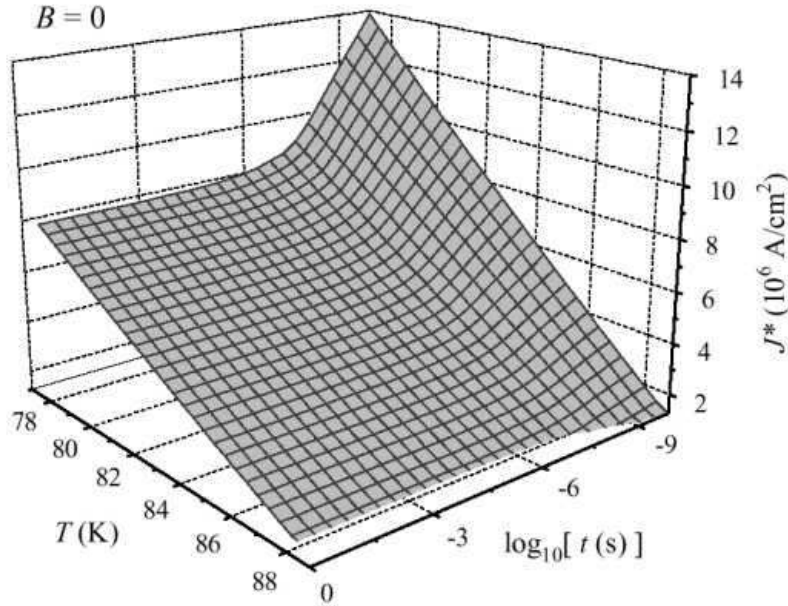


Figura 7.20: Frontera entre las regiones de estabilidad e inestabilidad determinadas por la ecuación 7.12, para campo aplicado nulo. Esta frontera corresponde a los valores de J^* . Por debajo, el sistema es estable y alcanza temperaturas casi estacionarias. Por encima, se cumple el criterio de la ecuación 7.12 y el sistema es inestable, obteniéndose avalanchas térmicas que llevan la muestra al estado normal.

de la ecuación 7.12 (lo que implica que no se genera una avalancha dentro del tiempo t), y la de color blanco un signo positivo (lo que implica un estado crítico que conduce inevitablemente a la avalancha). En el eje vertical se representa el logaritmo decimal del tiempo, para apreciar qué ocurre en distintos órdenes de magnitud. La frontera entre ambas regiones se puede interpretar como las coordenadas de J^* en función de t , para $T_f = 78$ K y $\mu_0 H = 0$. La tendencia de aumento de J^* conforme decrece la duración del pulso es logarítmica en la región de pulsos cortos: hay que dividir la duración del pulso por mil para conseguir un aumento de J^* del 50 %.

Nótese la similitud de esta dependencia con los resultados de la figura 7.8 (p. 194), aunque aquella fuese para una temperatura algo mayor. Recuérdese que se había obtenido de manera completamente

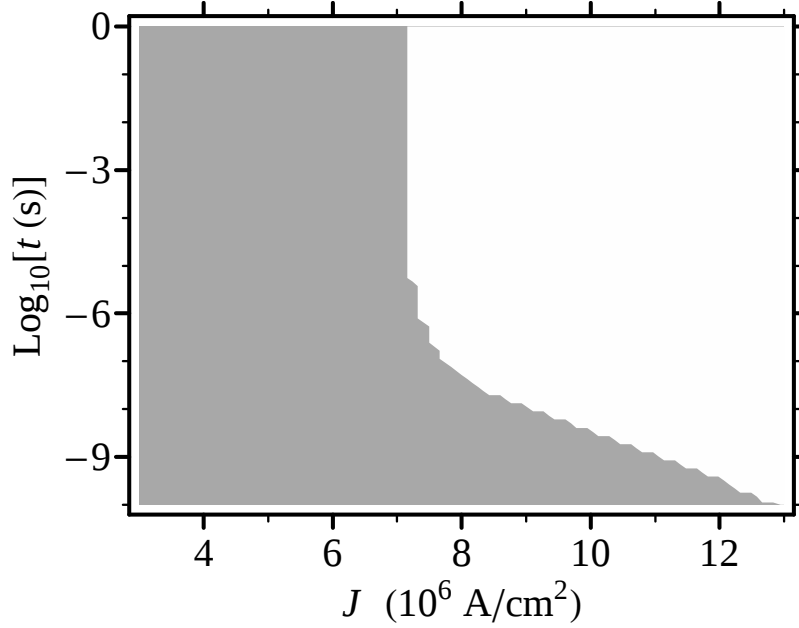


Figura 7.21: Diagrama de estados t - J para $T_f = 78$ K y $B = 0$, establecido por la condición de avalancha de la ecuación 7.12. La región gris representa estados estables (signos negativos de la ecuación), y la blanca estados críticos que conllevan una avalancha térmica (signos positivos).

diferente, simulando la evolución temporal de los experimentos con cálculos más complejos. Ahora, a pesar de las simplificaciones que hemos incorporado para llegar a la ecuación 7.12 (de manera destacada, la aproximación de pulsos cortos para hacer $Q \rightarrow 0$, que en principio fallaría para t grande), los resultados coinciden notablemente, en lo que a la forma de la dependencia respecto de t se refiere, aunque estos últimos tengan menos precisión. Las reflexiones que se hicieron allí acerca de la dependencia de J^* respecto de la duración de la medida son aplicables igualmente para estos nuevos resultados.

En la figura 7.22 mostramos un diagrama de estados a t constante, estudiando el espacio de estados en función de la densidad de corriente y la temperatura. Los resultados mostrados son para $t = 0.1$ ms, pero en realidad prácticamente son idénticos para cualquier $t > 10 \mu s$. Sólo si disminuimos t por debajo de este umbral comenzamos a apreciar

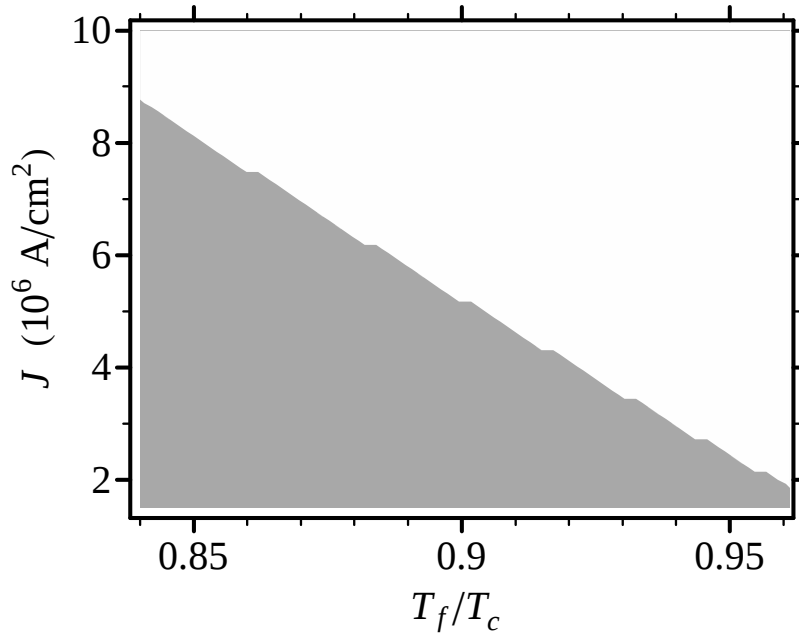


Figura 7.22: Diagrama de estados J - T_f/T_c para $t = 0.1$ ms y $B = 0$, establecido por la condición de avalancha de la ecuación 7.12. La región gris representa estados estables (signos negativos de la ecuación), y la blanca estados críticos que conllevan una avalancha térmica (signos positivos). Dividir t por un factor diez o multiplicarlo por cualquier factor no varía los resultados, así que este diagrama de estados es válido para cualquier $t > 10 \mu\text{s}$.

diferencias, siendo esto acorde con los resultados de la figura 7.21. Por ejemplo, en la figura 7.23 se muestra el diagrama análogo para $t = 1$ ns, que ya es notablemente diferente al anterior: la región de estabilidad (en oscuro) aumenta, dando para las mismas temperaturas una región mayor de estabilidad.

La frontera entre la región de estabilidad (oscura) y la región crítica (en blanco) de la figura 7.22 nos da de nuevo los valores de J^* , en este caso para tiempos de medida que en general sean más largos de $10 \mu\text{s}$. Esta frontera se muestra como una línea continua en la figura 7.24, en la representación logarítmica habitual. La línea inferior de esa figura, en trazo discontinuo, es la que ajusta a los cálculos con nuestro modelo en apartados previos, con duración de

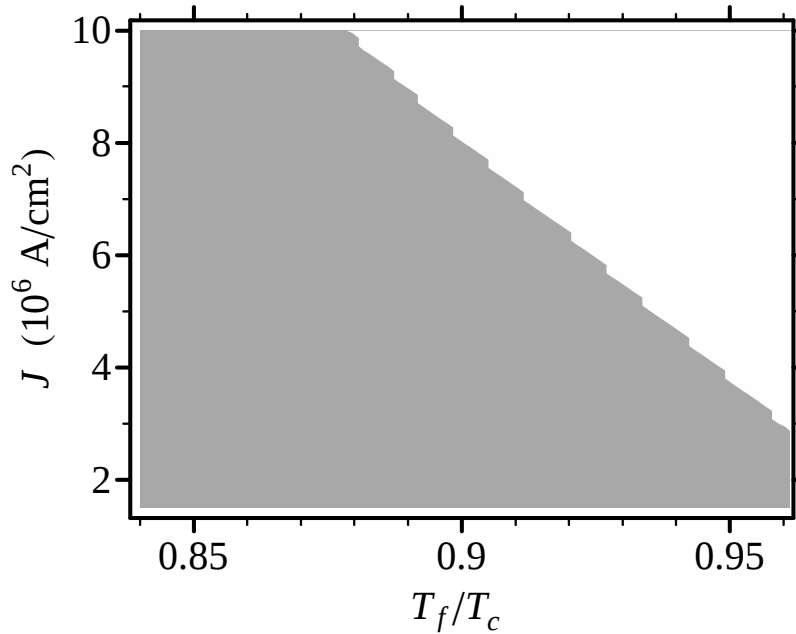


Figura 7.23: Diagrama de estados J - T_f/T_c para $t = 1$ ns y $B = 0$, establecido por la condición de avalancha de la ecuación 7.12. La región gris representa estados estables, y la blanca estados críticos que conllevan una avalancha térmica.

pulso de 1 ms (los rectángulos negros en la figura 7.13 de la página 205). La similitud entre las dos curvas es notable. Vemos que los resultados calculados empleando el criterio de avalancha también reproducen la misma tendencia en temperatura reducida que se ve en los experimentos, y que ya reprodujimos con nuestros cálculos detallados. Podría pensarse que las diferencias en valores absolutos de ambas curvas se deben a las simplificaciones que hemos ido adoptando para llegar a nuestra condición de avalancha, pero en realidad lo que ocurre es que representan cosas distintas:

La curva de trazo discontinuo está calculada empleando realimentación y temperatura variable partiendo de una temperatura inicial T_b , la del baño. En esta representación, T_f es en realidad, para esta curva, la temperatura inicial de la muestra T_b , no la que tiene en el momento de la avalancha. Esto se debe a que es una simulación de

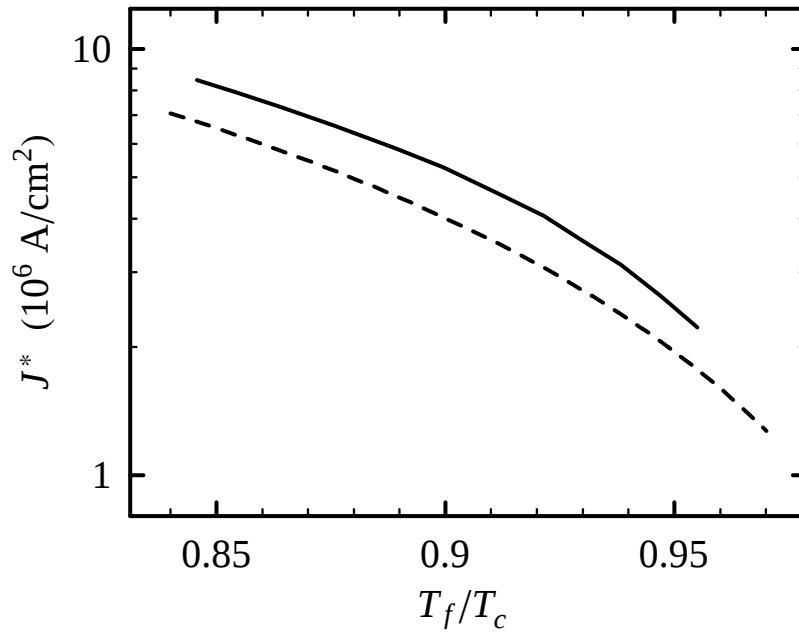


Figura 7.24: Dependencia de la corriente de salto respecto de la temperatura, para $B = 0$. Comparación de los resultados extraídos de la condición de avalancha con los cálculos más detallados de apartados previos. La línea continua es la frontera que separa la región de estabilidad de la crítica en la figura 7.22. La línea de trazos discontinuos es la que ajusta los mismos datos que se representaron como rectángulos negros en la figura 7.13 (p. 205). Destacamos la similitud de ambas curvas en sus dependencias funcionales respecto de la temperatura. No se piense que las diferencias provienen de simplificaciones de los cálculos: en realidad ambas curvas representan cosas ligeramente distintas. Ver texto para detalles.

los experimentos: como en estos no se puede medir la temperatura real de la muestra, las representaciones frente a la temperatura emplean inevitablemente la temperatura inicial, la del baño.

La otra curva, en trazo continuo, representa sin embargo los valores de J^* en función de la temperatura *real* de la muestra en el instante t que hemos considerado en el cálculo del diagrama de estados. Esta curva da los valores mínimos de corriente aplicada que hacen que la muestra vaya inevitablemente hacia una avalancha térmica, siempre que la muestra alcance la temperatura T_f en algún instante $t > 10 \mu s$. Con corrientes que estén por encima de esa curva siempre se produce una avalancha. Si están por debajo, el sistema se mantiene estable, en un estado casi estacionario.

Por lo tanto, podemos interpretar las diferencias entre estas dos curvas, calculadas con dos métodos distintos, como desplazamientos horizontales, en temperaturas, de una respecto de la otra. La curva de trazo discontinuo tiene que desplazarse hacia temperaturas más altas para coincidir con la de trazo continuo, pero este desplazamiento es distinto en cada punto. Por ejemplo, en $T_f = 76.2 \text{ K}$ ($T_f/T_c = 0.85$) hay que correrla $+2.7 \text{ K}$ para hacerla coincidir con la otra ($\Delta T_f/T_c = 0.03$). En $T_f = 82.0 \text{ K}$ ($T_f/T_c = 0.91$), basta con correrla $+1.8 \text{ K}$, es decir, $\Delta T_f/T_c = 0.02$.

Estos desplazamientos en temperaturas, según lo antedicho, pueden interpretarse de este modo: la medida que parte inicialmente de una temperatura de 76.2 K , y que se realiza aplicando justamente el valor J^* que da la curva de trazo discontinuo para esta temperatura, lleva a la muestra a una temperatura 2.7 K más elevada dentro del tiempo que dura la medida, e induce instantes después una avalancha. Si partimos de una temperatura de 82.0 K y aplicamos el correspondiente valor de J^* , el calentamiento será de 1.8 K en el momento en que se satisface la condición de avalancha, y se tendrá igualmente una cascada térmica.

Nótese que estos valores de sobrecalentamiento antes del salto son aproximadamente los mismos que encontrábamos en las curvas de la

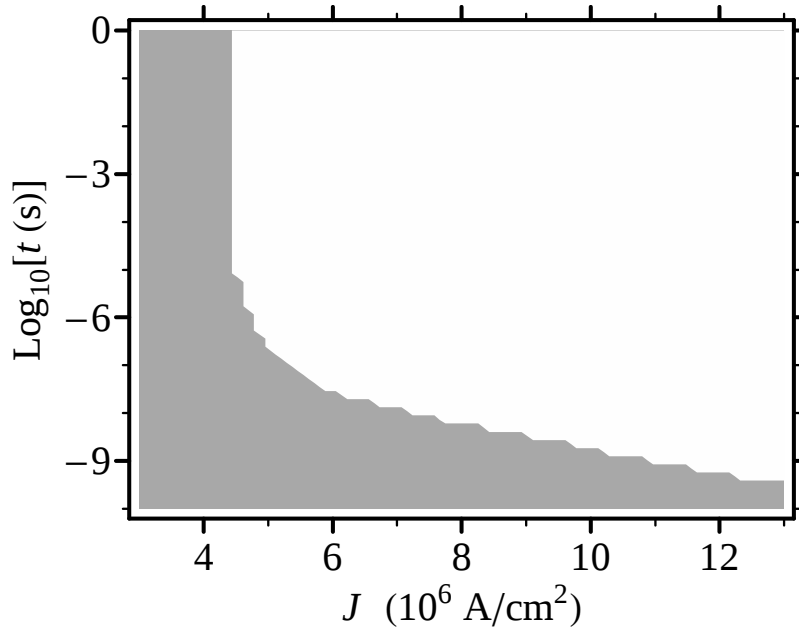


Figura 7.25: Diagrama de estados t - J para $T_f = 78 \text{ K}$ y $\mu_0 H = 1 \text{ T}$, establecido por la condición de avalancha de la ecuación 7.12.

evolución de la temperatura en el tiempo calculadas en las figuras 7.3 y 7.5 (páginas 188 y 191), para temperaturas iniciales de 76.2 y 82.0 K, aplicando distintas corrientes. En aquel caso veíamos que había un aumento de temperatura de unos 2.5 K en un caso, y de 1.6 K en el otro, antes de que la tendencia de aumento de temperatura se desbocase en cascada. Esta coincidencia constituye un éxito notable de nuestra condición de avalancha de la ecuación 7.12, derivada de criterios de estabilización de la temperatura.

Para terminar, y como última corroboración de la validez de nuestro modelo y de la condición de avalancha que de él se deriva, veamos qué ocurre al aplicar campo magnético. Subir el campo magnético a $\mu_0 H = 1 \text{ T}$ implica, como hemos visto, variar la forma de las curvas E - J , y por lo tanto el valor de P y de su derivada a demás parámetros iguales. Introduciendo en nuestros cálculos las nuevas curvas E - J (ecuación 5.4) tenemos un nuevo diagrama de

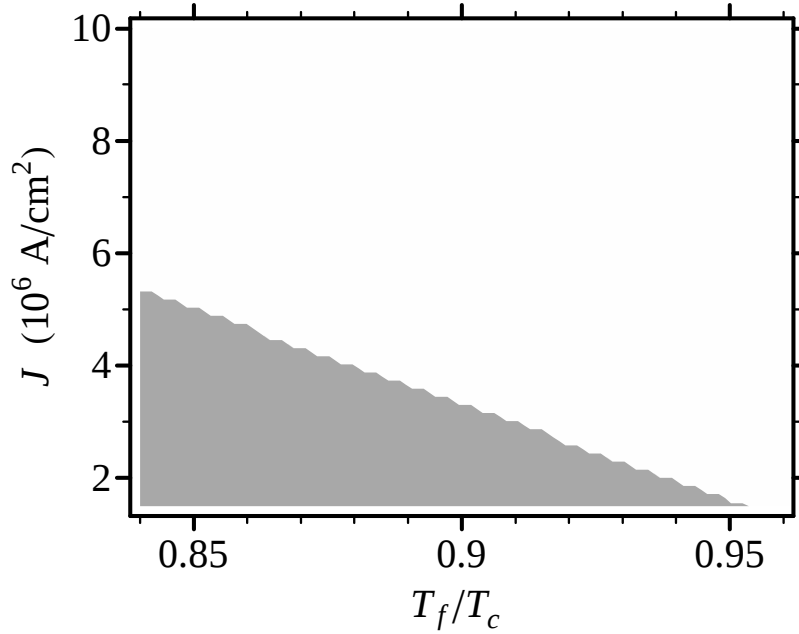


Figura 7.26: Diagrama de estados J - T_f/T_c para $t = 0.1$ ms y $\mu_0 H = 1$ T, establecido por la condición de avalancha de la ecuación 7.12. La región gris representa estados estables, y la blanca estados críticos que conllevan una avalancha térmica.

estados en el espacio J - t , a temperatura constante de 78 K, que mostramos en la figura 7.25. Compárese con la figura 7.21: la región de estabilidad disminuye, y el valor de J^* (determinado por la frontera entre regiones) se hace menor para experimentos en igualdad de condiciones. El correspondiente diagrama J - T_f/T_c , mostrado en la figura 7.26, también ve aumentada su región crítica.

Igual que para el caso $B = 0$, comparamos en la figura 7.27 la curva de J^* en función de la temperatura que se extrae de la frontera entre ambas regiones, con la que proviene del experimento. En este caso la curva inferior, de trazo discontinuo, no es una simulación, sino la experimental, para ahorrarnos los cálculos. Mostramos asímäs destacadamente no sólo las distintas conclusiones del modelo, sino también su similitud con el experimento. En todo caso recordemos que la simulación detallada de $J^*(T_f)$ de apartados previos coincide

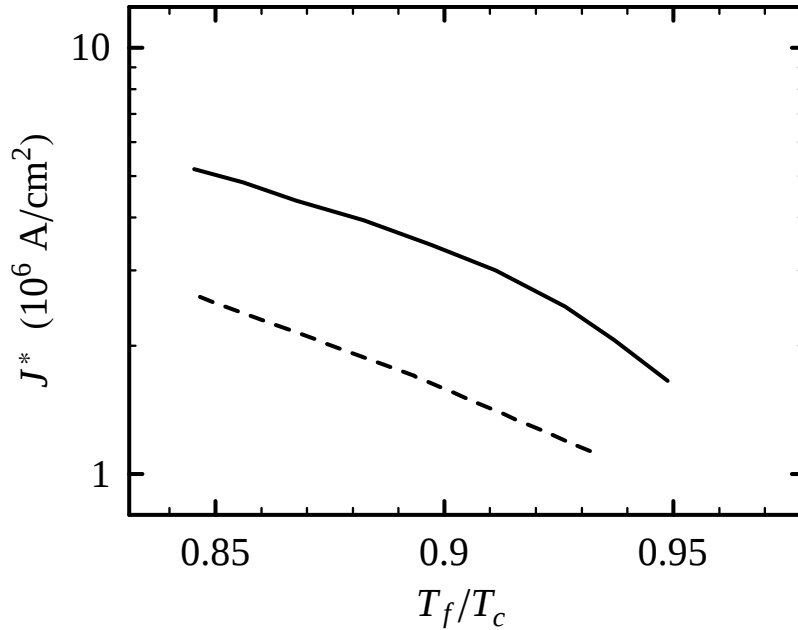


Figura 7.27: Variación de la corriente de salto con la temperatura, para $\mu_0 H = 1 \text{ T}$. Comparación de los resultados extraídos de la condición de avalancha con los datos experimentales. La línea continua es la frontera que separa la región de estabilidad de la crítica en la figura 7.26. La línea de trazos discontinuos es la que ajusta a los datos experimentales. Ver texto para detalles.

notablemente bien con el experimento. Lo que se quiere poner de manifiesto aquí es que ahora ambas curvas están desplazadas horizontalmente una de la otra mucho más que antes, con campo aplicado nulo. Concretamente en 76.2 K, por comparar con los resultados previos, el desplazamiento necesario para hacerlas coincidir es de +6.7 K (un $\Delta T_f/T_c$ de unos 0.07), de nuevo un resultado comparable al que obteníamos como sobrecalentamiento antes de la avalancha en la evolución de la temperatura para $\mu_0 H = 1 \text{ T}$, en la figura 7.6 (página 192). Ya mencionábamos entonces que estos sobrecalentamientos que se deducen de nuestro modelo sencillo no son, probablemente, tan elevados en la realidad: lo que nos interesa resaltar no son tanto sus valores absolutos, como la tendencia de variación que muestran con el campo aplicado y la temperatura

inicial. Concretamente, en estos cálculos, como en aquellos, vemos que las avalanchas con campo magnético aplicado se producen tras un mayor sobrecalentamiento, y con una potencia disipada mayor, que en el caso sin campo aplicado a la misma temperatura. Recordemos una vez más, aun a riesgo de ser demasiado insistentes, que este comportamiento llevó a pensar que la transición no podía estar directamente relacionada con fenómenos térmicos, pues de ser así se esperaba que la potencia disipada necesaria para causar una transición disminuyese al aumentar H o, en el mejor de los casos, que fuese independiente de él [8, 10]. Sin embargo todo lo que hemos venido calculado hasta ahora, basado exclusivamente en calentamientos de las muestras, predice exactamente esa misma tendencia, entre otros contundentes resultados que apoyan la validez del modelo. No podemos, por lo tanto, descartar que la causa real de la transición esté vinculada a mecanismos térmicos. Al contrario: parece más bien que dichos mecanismos están íntimamente relacionados con la transición y, si no son ellos exclusivamente los que la inducen, al menos sí que están entremezclados con otros posibles intrínsecos.

Capítulo 8

Resumen y conclusiones de la parte I

A continuación hacemos un resumen de los principales resultados de esta primera parte de la memoria, dedicada al estudio de la transición al estado normal en el régimen de altas densidades de corriente. Recogemos también las principales conclusiones que se extraen de dichos resultados, así como los nuevos interrogantes planteados y las posibles líneas de continuación de estos trabajos.

8.1. Resumen

8.1.1. Del experimento

Empleando un banco de pulverización catódica, se crecieron numerosas películas de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ de espesor alrededor de 150 nm sobre sustratos cristalinos de SrTiO_3 de 1 cm² de superficie. Sobre estas películas se grabaron, mediante fotolitografiado, micropuentes de dimensiones típicas $l = 50 \mu\text{m}$ y $a = 10 \mu\text{m}$. Este tipo de muestras presentan, frente a otros posibles, dos ventajas fundamentales: su pequeña sección permite aplicar elevadas densidades de corriente con

corrientes absolutas bajas, y presentan una muy buena evacuación del calor, debido a la elevada relación superficie/volumen que tienen, y a que están en muy buen contacto térmico con el sustrato cristalino, mucho más masivo.

Las películas y los micropuentes resultantes se caracterizaron mediante difracción de rayos-x (XRD), perfilometría, microscopía de fuerza atómica (AFM), y medidas de resistividad en función de la temperatura y el campo magnético. Las muestras de mejor calidad —con temperatura crítica T_c más alta, menor resistividad en el estado normal a $T > T_c$ y con transición resistiva más estrecha— se reservaron para las medidas más precisas de curvas características y de parámetros críticos, mientras que las de peor calidad se emplearon para experimentos más agresivos y potencialmente destructivos, de caracterización térmica a tiempos largos o a muy altas disipaciones. Se aplicaron contactos eléctricos mediante microsoldadura por ultrasonidos, logrando resistencias de contacto despreciables frente a las resistencias características de las muestras en estudio.

Con estos micropuentes se realizaron medidas de curvas características $E-J$ (curvas $V-I$ escaladas a las dimensiones geométricas de las muestras), en función de la temperatura —entre aproximadamente la temperatura del nitrógeno líquido y T_c — y del campo magnético aplicado perpendicular a las capas —desde campo aplicado nulo hasta 1 T—. Se empleó una configuración estándar de cuatro hilos en línea, una fuente de corriente programable de precisión, y un nanovoltímetro (en el régimen de baja disipación, donde los efectos térmicos son despreciables). Para las medidas $V-I$ hasta la corriente de salto I^* se utilizó una tarjeta de adquisición (DAQ) que permitía hacer medidas rápidas (en el rango del milisegundo, con resolución de $10\ \mu\text{s}$) y minimizar los efectos térmicos. Las curvas características medidas son comparables a las de los mejores filmes de Y-123 óptimamente dopado que se encuentran en la bibliografía. Las muestras se alojaban en un criostato refrigerado con flujo de vapor de nitrógeno líquido, cuya temperatura se regulaba electrónicamente.

También se hicieron medidas de caracterización térmica de las muestras, de las que podemos concluir que, al menos en tiempo breves, el intercambio térmico del micropuente ocurre principalmente con el sustrato, estableciéndose una inercia térmica del sistema con tiempos característicos que rondan las décimas de milisegundo.

8.1.2. Del análisis

De las diferentes curvas E - J se extrajeron los valores de los parámetros que las caracterizan: la corriente J_c en que se alcanza un cierto umbral de disipación dentro de estado mixto —típicamente $10 \mu\text{V}/\text{cm}$ —, la corriente J_c^{pin} en que los vórtices superan un cierto umbral de velocidad $v = E/B$ —alrededor de 10^{-3} m/s —, y la corriente J^* de transición al estado normal. Otros parámetros que se estudiaron son el voltaje E^* a que ocurre la transición en J^* , y la potencia disipada $W^* = E^* \times J^*$ en ese mismo punto.

Estos parámetros se analizaron en función de la temperatura inicial de la muestra (la temperatura antes de inyectar corriente; entre aproximadamente la temperatura del nitrógeno líquido y T_c), y en función del campo magnético aplicado perpendicular a los filmes (con valores $\mu_0 H$ entre 0 y 1 T). La variación con la temperatura, tanto de J_c como de J^* , es la habitual en estas muestras: ambas densidades de corriente presentan una relación funcional con la temperatura reducida $\varepsilon \simeq (1 - T/T_c)$ con un exponente $3/2$. Estos resultados sugieren que quizá J^* se origine por mecanismos similares a los de J_c —disipación por movimiento de vórtices— o a los de la corriente de desapareamiento J_d —en la que los pares de Cooper se destruyen por ser demasiado energéticos—.

La relación de J^* con el campo magnético se describe notablemente bien con un modelo propuesto inicialmente para J_c , que tiene la forma $(1 - H/H_0)^{-n}$. Por el contrario, ni J_c ni J_c^{pin} siguen de manera tan notable esta dependencia con H , aunque se aproximan bastante. Tanto la corriente de salto J^* como el voltaje E^* parecen ajustarse bastante

bien al modelo Bezuglyj-Shklovskij (BS) [78], que es una extensión del modelo Larkin-Ovchinnikov (LO) [77] con correcciones térmicas (el modelo LO no proporciona buenos resultados para este tipo de muestras [7, 15, 79]). Ambos modelos atribuyen la transición en J^* a un cambio drástico de la dinámica de los vórtices magnéticos en el estado mixto, debido al valor finito del tiempo de relajación energética de los portadores τ_ϵ . El valor que, de unos análisis preliminares con el modelo BS, hemos extraído para una de nuestras muestras, coincide de manera notable con los valores de τ_ϵ obtenidos de otros experimentos ($\tau_\epsilon \sim 1.2 \times 10^{-12}$ s en $T = 76.2$ K), aunque se hacen necesarios más estudios en esta línea para ser concluyentes.

Para poder aplicar el modelo BS al régimen de campos bajos que hemos estudiado hemos tenido que tener en cuenta el autocampo generado por las elevadas corrientes que se inyectan en la muestra. El autocampo de la corriente se superpone al campo aplicado externamente, de modo que este último hace notar sus efectos sólo cuando supera el valor de aquel. Estos efectos del autocampo podrían ser la causa de que los modelos que explican la corriente de salto se desvíen de los datos experimentales a campos magnéticos aplicados bajos; de ser así, se podrían descartar otros mecanismos más complejos que se pueden encontrar en la bibliografía [9]. De estos análisis parece concluirse que la corriente inyectada en el micropuente puede estar distribuyéndose de manera no uniforme, concentrada en los laterales de la muestra, de modo que la densidad de corriente real sería superior a la aparente (calculando ésta con distribución de corriente uniforme). Esta posibilidad acercaría de manera considerable los valores de J^* a los predichos teóricamente para J_d , la corriente de desapareamiento de los pares de Cooper [10, 11, 30], por lo que la causa de la transición al estado normal podría tener que ver con este mecanismo.

El valor de la corriente J^* depende, por debajo del rango de varios milisegundos, del tiempo que dure la medida, de modo que ciertos valores de la corriente aplicada no causan transición si se aplican durante poco tiempo, pero acaban induciéndola si se mantienen

más tiempo. Los experimentos en donde se realizan medidas en rangos temporales suficientemente cortos, por debajo de los tiempos térmicos característicos de décimas de milisegundo, aprecian notables diferencias dependiendo de la duración de los pulsos de corriente [107]. Pulsos mucho más largos que estos son, por el contrario, en todo momento equivalentes a corrientes continuas [7, 10, 15, 16].

En nuestras muestras, la potencia disipada antes del salto W^* disminuye al aumentar la temperatura inicial del baño, cuanto más cerca de T_c esté. Esta tendencia se observa también en las muestras de la bibliografía [11, 18], aunque con algunas excepciones [10, 20]. Como contraposición, W^* aumenta, siempre, de manera notable al aplicar campos magnéticos externos cada vez mayores. Este comportamiento lo presentan todas las muestras de las que tenemos referencias [8, 18, 19], sin excepción, y en ocasiones se ha empleado como argumento para descartar el origen térmico de la transición en J^* [8].

8.1.3. Del modelo de calentamiento en avalancha

Los trabajos recientes en los que se descartaba el calentamiento como causa principal de la transición abrupta al estado normal lo hacían basándose en argumentos que aquí se han refutado. La variación experimental de J^* con la temperatura [10, 15], por ejemplo, se predice con el modelo sencillo de calentamiento que hemos propuesto en el capítulo 6. Con la condición de avalancha que de él se deriva, y que hemos deducido en el capítulo 7, también se explica la aparente paradoja de que la potencia disipada en el instante previo al salto P^* sea más grande cuanto mayor es el campo magnético aplicado —lo que podría quizás extenderse a las muestras en las que la potencia también aumenta con la temperatura del baño—. Lo relevante para producir una transición debida a una avalancha térmica, como se ha puesto de manifiesto, no es sólo el valor concreto de la potencia disipada, sino también cómo varía éste con la temperatura.

La formalización de esta idea, a corriente y campo aplicado constantes, involucra no sólo al valor de $P(T)$, sino también al de su derivada con la temperatura dP/dT .

La ausencia de histéresis en las curvas características $E-J$ [10, 15], o la invariancia de los experimentos con la longitud del pulso de corriente [7, 16] que ven algunos autores se justifica porque los tiempos característicos del sistema son muy breves, rondando las décimas de milisegundo. Cualquier experimento que trabaje con pulsos de corriente de longitud mayor será comparable a uno que use corriente continua. Confirmando esta idea, ciertos autores han visto experimentalmente que la transición se suaviza, y deja de ser abrupta, (con la consiguiente aparición de efectos de histéresis) cuando se emplean pulsos de decenas de microsegundos, aun en muestras depositadas sobre substratos mejores conductores del calor [107].

El modelo propuesto aquí, basado en supuestos muy razonables, predice con notable bondad los principales los resultados experimentales observados en nuestras muestras. Sucesivos refinamientos mejorarían seguramente la calidad de las predicciones, sobre todo en lo que se refiere a lo abrupto de las transiciones, pero podría llegar a perderse intuición sobre lo que sucede si el modelo se complica. En todo caso se hace necesaria una resolución numérica del problema basada en elementos finitos, para ratificar con más contundencia lo que aquí se ha mostrado.

De cualquier manera, nuestros resultados experimentales y los correspondientes análisis sugieren que el calentamiento es un efecto de gran importancia en el tipo de filmes que hemos estudiado en nuestros experimentos. De haber cualquier otro posible fenómeno intrínseco como causante o acelerador de la transición, sería muy difícil en estas condiciones acceder experimentalmente a él, discriminándolo *nítidamente* de los efectos térmicos. Se observaría más bien una anticipación del fenómeno intrínseco respecto de sus valores esperados, causada por el rápido incremento de temperatura de la muestra en la avalancha: ambos efectos, el intrínseco y el extrínseco del

calentamiento estarían entremezclados. Esta podría ser la explicación de que las predicciones de nuestro modelo térmico, que no tiene en cuenta ningún mecanismo intrínseco, den transiciones más suaves que las experimentales. Se hace necesaria una resolución más detallada del balance energético del sistema para ver si el calentamiento, exclusivamente, podría dar cuenta de todo el fenómeno de la transición en J^* , o si por el contrario transiciones tan abruptas requieren necesariamente un mecanismo intrínseco, más rápido que el calentamiento, para producirse.

8.2. Conclusiones

Las principales conclusiones de esta primera parte, extraídas de lo que se acaba de resumir, son:

1. El intercambio térmico de estos micropuentes de $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ ocurre principalmente con el sustrato, siendo despreciable, en tiempos breves, la interacción con la atmósfera circundante. Esta interacción del filme con el sustrato establece una inercia térmica del sistema con tiempos característicos de décimas de milisegundo, mayores que los tiempos bolométricos de enfriamiento.
2. El modelo Bezuglyj-Shklovskij (BS) explica aparentemente bien la dependencia de los parámetros críticos E^* y J^* en la región de campos bajos estudiada, proporcionando un tiempo de relajación energética de los portadores que coincide con el de otros experimentos. Esto parece indicar que la transición al estado normal se produce, siguiendo el modelo BS, por una avalancha en la dinámica de los vórtices magnéticos.
3. Por otra parte, la variación de la corriente de salto J^* presenta las mismas dependencias funcionales de la temperatura y el campo magnético que la corriente crítica J_c , lo que sugiere que ambos

fenómenos —la aparición de disipación en el estado mixto, y la transición abrupta al estado normal— podrían tener su causa en mecanismos físicos análogos: alteraciones en la dinámica de los vórtices.

4. Sin embargo, para poder aplicar el modelo BS en la región de campos bajos estudiada hemos tenido que tener en cuenta el autocampo generado por las altas corrientes inyectadas. Este análisis sugiere que la densidad de corriente real podría ser mayor que la aparente, si la corriente se distribuyese de manera no uniforme, concentrándose en los laterales de la muestra. De ser así, los valores reales de J^* podrían coincidir con los de desapareamiento de los pares de Cooper, siendo este desapareamiento la causa de la transición al estado normal.
5. A mayores, el modelo térmico que hemos propuesto para describir al sistema de micropuente más substrato, considerando la realimentación en la disipación, predice notablemente bien los principales resultados experimentales, incluso de manera cuantitativa. De esto podemos concluir que, aunque pueda existir otro fenómeno más intrínseco relacionado con la transición abrupta —no excluido por los resultados del modelo sencillo—, los efectos térmicos tienen en estos experimentos más relevancia de la que hasta ahora se había considerado.

8.3. Líneas de continuación

Las conclusiones que acabamos de relacionar no dan respuesta a todos los interrogantes relacionados con la causa de la transición abrupta al estado normal en J^* ; antes al contrario, plantean a su vez otros nuevos. Mencionamos los más destacados, así como las posibles líneas de investigación para intentar resolverlos:

1. La posibilidad de que la transición abrupta en J^* se deba

a ruptura de pares de Cooper —por estar la corriente muy concentrada en los laterales de la muestra, y alcanzarse así la corriente de desapareamiento J_d —, podría estudiarse repitiendo estos experimentos con micropuentes de diferentes anchuras o espesores, del orden de los aquíempleados y aún menores, y viendo de qué manera dependen los valores de I^* y J^* de estos parámetros geométricos.

2. El estudio experimental detallado de la transición abrupta en J^* requiere de dispositivos todavía más rápidos de los aquíempleados. Por un lado, para seguir el voltaje a lo largo de la transición se hace necesario un sistema de medida más rápido aún que la tarjeta adquisidora, que aumente la resolución temporal por encima de los $10 \mu s$. Por otro, es imprescindible mayor flexibilidad y rapidez en la aplicación de la corriente. Por ejemplo, se necesitan valores estables de corriente en tiempos muy breves, muy por debajo de los tiempos característicos térmicos del sistema (décimas de milisegundo), para poder estudiar con precisión los regímenes temporales en que los efectos térmicos todavía afectan poco.
3. Desde un punto de vista teórico, sería conveniente mejorar el modelo térmico tan sencillo que aquí se ha propuesto, para tener en cuenta de manera realista los grandes cambios de disipación que se producen en tiempos tan breves en torno a la transición en J^* . Un análisis detallado mediante simulación por elementos finitos, por ejemplo, podría ayudar a discriminar mejor si la transición abrupta que se mide a altas densidades de corriente puede explicarse exclusivamente por mecanismos térmicos, y por lo tanto extrínsecos, o si por el contrario la velocidad del fenómeno requiere para su explicación mecanismos electrónicos más intrínsecos.

Parte II

**Paraconductividad: tiempos
de relajación y altas
temperaturas reducidas**

Capítulo 9

Introducción a la parte II

9.1. Definición de paraconductividad

Además de su relativamente elevada temperatura crítica T_c , una característica de gran importancia que poseen los superconductores de altas temperaturas (HTSC) es la pequeñez, en todas las direcciones, de la denominada longitud de correlación o de coherencia superconductora $\xi(T)$. Esta longitud de coherencia es aproximadamente la dimensión espacial de los pares de Cooper, y por tanto la distancia entre los dos electrones apareados que los conforman. En términos de la función de onda cuántica superconductora $\Psi(r)$, $\xi(T)$ es la longitud característica a la cual $\Psi(r)$ puede variar apreciablemente sin necesidad de pagar un elevado precio en energía ($\xi(T)$ es la dimensión mínima del paquete de onda).

Aplicando el principio de incertidumbre de Heisenberg, podemos ver cualitativamente que en torno a la transición superconductora ξ y T_c están interconectadas entre sí [31, cap. 1.3]:

$$\xi \Delta p \geq \hbar, \quad (9.1)$$

siendo $\Delta p \simeq k_B T_c/v_F$ el momento de los portadores, v_F su velocidad de Fermi, y k_B la constante de Boltzmann. Vemos pues que,

crudamente,

$$\xi \simeq \hbar v_f / (k_B T_c). \quad (9.2)$$

Esta relación, naturalmente muy aproximada [31], nos indica que, dado que no es de esperar que v_F difiera mucho en los HTSC de los valores que toma en los superconductores convencionales con baja T_c , es previsible que ξ sea mucho más pequeña en los HTSC que en los superconductores metálicos convencionales.

Una consecuencia importante de que simultáneamente T_c sea alta y $\xi(T)$ sea pequeña en los HTSC es que las fluctuaciones termodinámicas son, cerca de T_c , muy apreciables en estos materiales: por un lado la energía de agitación térmica $k_B T_c$ —siempre disponible *gratuitamente*— es elevada, y por otro lado la energía necesaria para crear y destruir pares de Cooper es pequeña. Esta última energía es, de modo aproximado, la necesaria para crear un par de Cooper multiplicada por el número de pares que se encuentran en el volumen coherente¹. Pero ese número de pares será proporcional al volumen coherente, es decir, a $\xi(T)^D$, siendo $D = 3, 2, 1$ la dimensionalidad de la muestra. Dado que en los HTSC $\xi(T)$ es pequeña, sea cual sea la dimensionalidad el volumen coherente será pequeño; pero además estos materiales son laminares, y en general $3 \geq D \geq 2$, lo que contribuye a hacer que el volumen coherente sea todavía menor. Todo esto conduce a que la creación y destrucción de pares de Cooper por fluctuaciones térmicas sea un fenómeno relevante y de gran interés en los HTSC.

Una de las magnitudes más adecuadas, tanto desde el punto de vista de la facilidad y precisión de su medida como de su sensibilidad a estos efectos, para observar experimentalmente las fluctuaciones térmicas, es la resistividad eléctrica $\rho(T)$: la creación de pares de Cooper por fluctuaciones térmicas hace disminuir apreciablemente $\rho(T)$, incluso para temperaturas varios grados por encima de T_c . De hecho la posible importancia de estos efectos en los HTSC fue

¹Esta multiplicación se debe a que la coherencia superconductora no permite crear o destruir un solo par de Cooper, lo que sería equivalente a variar $\Psi(r)$ a escalas espaciales menores que ξ .

mencionada ya por Bednorz y Müller en su publicación pionera [1]. La magnitud convencional que recoge estos efectos es la denominada *paraconductividad*, el exceso de conductividad eléctrica debido a fluctuaciones, que se define como

$$\Delta\sigma(T) = \frac{1}{\rho(T)} - \frac{1}{\rho_{bg}(T)}. \quad (9.3)$$

En esta expresión $\rho(T)$ es la resistencia experimental a cada temperatura, mientras que $\rho_{bg}(T)$ es la denominada resistividad de fondo (*background*), la resistividad que habría alrededor de T_c si no hubiese transición superconductora.

9.2. Medida experimental

9.2.1. Determinación y errores

Las medidas de la paraconductividad que se muestran en esta segunda parte se realizaron con el mismo montaje experimental descrito en el capítulo 3, salvo por los aparatos empleado para la determinación del voltaje en los puentes superconductores. En este caso, para medir con buena resolución la resistividad en el estado normal, se empleó un amplificador lock-in EG&G (Princeton Applied Research) 5302, con filtro pasa-banda en 37.4 Hz. La corriente se inyectó con la propia fuente de voltaje interna del lock-in — funcionando a esta misma frecuencia— y una resistencia tampón en serie con la muestra.

En la determinación experimental de la paraconductividad $\Delta\sigma$ existe una incertidumbre, que es constante en términos relativos para toda temperatura, y que puede llegar a ser mayor que del 20 %. Esta incertidumbre constante se debe a la dificultad de establecer con precisión las dimensiones de las muestras, en películas (ver sec. 2.4, p. 69), pero sobre todo en cristales, debido al tamaño proporcionalmente grande de los contactos. Además, a este error constante en valores

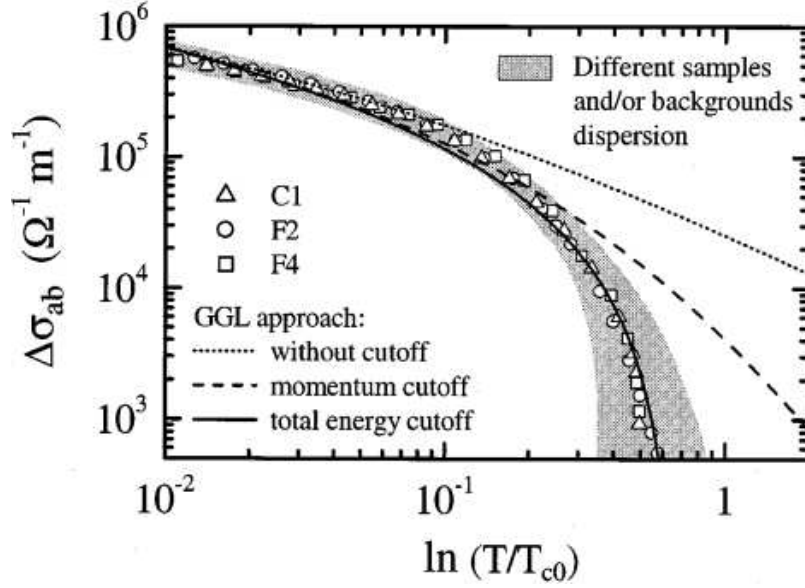


Figura 9.1: Incertidumbre en la determinación de la paraconductividad. Los datos son de la paraconductividad en función de la temperatura reducida, para varias muestras (cristales y capas delgadas). La zona sombreada cubre la región en que se encuadran todos los resultados experimentales, de estas y otras muestras, y con el empleo de diferentes fondos para la resistividad normal. Gráfica extraída de un artículo incluido en el capítulo siguiente (Phys. Rev. B **63**, 144515), en su figura 2.

relativos, se le suma otro que es creciente en temperaturas, debido a la ambigua determinación de la resistividad de fondo $\rho_{bg}(T)$. Para ésta, el único acceso experimental conocido y comúnmente empleado consiste en la extrapolación del comportamiento de $\rho(T)$ desde regiones de altas temperaturas, supuestamente libre de fluctuaciones, hasta las regiones de más baja temperatura. Las ambigüedades inherentes a esta extrapolación en los mejores casos se mantienen por debajo del 10 % sólo para temperaturas reducidas² $\varepsilon \leq 10^{-1}$, y crecen dramáticamente para mayores temperaturas, conforme $\Delta\sigma$ tiende a anularse, pudiendo llegar hasta el 700 % ya en $\varepsilon \sim 5 \cdot 10^{-1}$.

²En la región por encima de la transición $T > T_c$, la temperatura reducida se define con signo opuesto a la que hemos empleado en la primera parte de este trabajo: $\varepsilon \equiv \ln(T/T_c) \simeq T/T_c - 1$.

Cuadro 9.1: Dimensiones típicas de las muestras empleadas en las medidas de paraconductividad. Distancia entre contactos de voltaje l —no es el largo de la muestra—, ancho a y espesor d .

Tipo	l (mm)	a (mm)	d (μm)
cristal	0.5	0.5	70
filme	1	0.1	0.2

Estas ambigüedades experimentales y del análisis se recogen en la figura 9.1: la zona sombreada cubre la región en que se encuadran todos los resultados experimentales, para diversas muestras y con el empleo de distintos fondos. Pero incluso siendo esta dispersión experimental, como mencionamos, tan proporcionalmente amplia, ninguno de los modelos teóricos propuestos antes de la publicación de nuestros trabajos conseguía explicar la tendencia descendente de los resultados experimentales de la región $\varepsilon \geq 10^{-1}$. A pesar de estas enormes incertidumbre, todavía es posible discriminar entre los modelos previos, que no seguían la tendencia experimental, y el nuevo modelo que aquí se propone para explicar esta región de alta temperatura (modelo de *corte en energía total*, que incluye la energía de localización de los pares de Cooper en el volumen coherente.), que se ajusta notablemente a la tendencia de los datos.

9.2.2. Resolución experimental

Hagamos una estimación de cuál es la resolución de la medida (la separación mínima que pueden tener dos valores próximos de la resistividad para que sean distinguibles) en estos experimentos de determinación de paraconductividad. Esta estimación es relevante debido a la manera en que determinamos esta magnitud, como resta de valores de resistividad: es necesario conocer hasta qué límite de proximidad entre valores de fondo y valores de resistividad con fluctuaciones tenemos acceso experimental.

Las dimensiones típicas de las muestras empleadas en estas medidas se muestran en la tabla 9.1. El ruido de fondo típico en la medida es $\delta V_1 \approx 25$ nV, mientras que la resolución del lock-in δV_2 es de una parte en 10^4 del máximo de escala que se emplee en cada momento. Veamos cual de estas dos fuentes de incertidumbre es la que resulta más limitante.

La resistencia de contacto de los hilos de corriente es $R_{cont} \approx 40$ m Ω . Como queremos limitar la disipación por contacto a menos de un cierto límite, digamos de 10^{-8} W, la corriente máxima que podemos aplicar es

$$\begin{aligned} I^2 \cdot R_{cont} &\lesssim 10^{-8} \text{ W}, \\ I^2 &\lesssim \frac{10^{-8} \text{ W}}{40 \times 10^{-3} \Omega} = 2.5 \times 10^{-8} \text{ A}^2, \\ I_{m\acute{a}x} &\approx 5 \times 10^{-4} \text{ A}. \end{aligned}$$

Esto implica una densidad de corriente máxima, en cristales, de

$$J_{m\acute{a}x}^c = \frac{5 \times 10^{-4} \text{ A}}{0.5 \cdot 0.07 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^2} \approx 1.5 \text{ A/cm}^2,$$

y en filmes, de

$$J_{m\acute{a}x}^f = \frac{5 \times 10^{-4} \text{ A}}{0.1 \cdot 0.0002 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^2} = 2500 \text{ A/cm}^2.$$

Suponiendo que el material tiene, a una cierta temperatura, una resistividad $\rho = 100$ $\mu\Omega$ cm, y que aplicamos a las muestras sus correspondientes densidades de corriente máximas, el voltaje que mide el lock-in es, en cristales,

$$V = E \cdot l = J_{m\acute{a}x}^c \cdot \rho \cdot l = 1.5 \text{ A/cm}^2 \times 10^{-4} \Omega \text{ cm} \cdot 5 \times 10^{-2} \text{ cm} = 7.5 \mu\text{V},$$

mientras que en los filmes es

$$V = 2500 \text{ A/cm}^2 \cdot 10^{-4} \Omega \text{ cm} \cdot 1 \times 10^{-1} \text{ cm} = 25 \text{ mV}.$$

El ruido de fondo δV_1 afecta a la medida de estos voltajes de la siguiente manera:

En el cristal,

$$\frac{\delta\rho_1}{\rho} = \frac{\delta V_1}{V} = \frac{2.5 \times 10^{-8} \text{ V}}{7.5 \times 10^{-6} \text{ V}} = 3.3 \times 10^{-3},$$

$$\delta\rho_1 = \rho \cdot \frac{\delta V_1}{V} = \frac{\delta V_1}{J_{\text{máx}} \cdot l} = \rho \cdot 3.3 \times 10^{-3} = 0.33 \mu\Omega \text{ cm}.$$

En el filme,

$$\frac{\delta\rho_1}{\rho} = \frac{\delta V_1}{V} = \frac{2.5 \times 10^{-8} \text{ V}}{25 \times 10^{-3} \text{ V}} = 1.0 \times 10^{-6},$$

$$\delta\rho_1 = \rho \cdot \frac{\delta V_1}{V} = \frac{\delta V_1}{J_{\text{máx}} \cdot l} = \rho \cdot 1.0 \times 10^{-6} = 1.0 \times 10^{-4} \mu\Omega \text{ cm}.$$

Como lo que resuelve el lock-in es una parte en diez mil (10^{-4}) del máximo de escala, tenemos que:

En el cristal, los $7.5 \mu\text{V}$ que se obtienen se medirían en la escala de $V_{\text{máx}} = 10 \mu\text{V}$, lo que implica una resolución de

$$\delta V_2 = V_{\text{máx}} \cdot 10^{-4} = 10^{-9} \text{ V},$$

que se traduce en

$$\frac{\delta\rho_2}{\rho} = \frac{\delta V_2}{V} = \frac{10^{-9} \text{ V}}{7.5 \times 10^{-6} \text{ V}} = 1.3 \times 10^{-4},$$

$$\delta\rho_2 = 1.3 \times 10^{-4} \cdot \rho = 0.013 \mu\Omega \text{ cm}.$$

Este resultado es menor que el de su correspondiente ruido de fondo $\delta\rho_1$, así que tanta resolución del lock-in no sirve para gran cosa, y el factor limitante es dicho ruido. La resolución final de la medida es, en este caso, $\delta\rho_1^{\text{crist}} = 0.33 \mu\Omega \text{ cm}$.

En el filme, de manera análoga, los 25 mV de señal que se obtienen se medirían en la escala de $V_{\text{máx}} = 50 \text{ mV}$, lo que implica una resolución del lock-in de

$$\delta V_2 = V_{\text{máx}} \cdot 10^{-4} = 5 \times 10^{-6} \text{ V}.$$

Esto lleva a

$$\frac{\delta\rho_2}{\rho} = \frac{\delta V_2}{V} = \frac{5 \times 10^{-6} \text{ V}}{25 \times 10^{-3} \text{ V}} = 2.0 \times 10^{-4},$$

$$\delta\rho_2^{film} = 2.0 \times 10^{-4} \cdot \rho = 0.02 \mu\Omega \text{ cm}.$$

El lock-in no es capaz de apreciar, en esta escala, los voltajes de ruidos de fondo, así que el factor limitante para la medición de la resistividad viene determinado por la propia instrumentación. De este modo, y salvo mejoras experimentales, la resolución de la medida es $\delta\rho_2^{film} = 0.02 \mu\Omega \text{ cm}$, mejor en todo caso que la que se obtiene para los cristales.

Como hemos visto, la resolución de la medida viene determinada en principio por el ruido de fondo en la medida del voltaje, que se presupone constante y pequeño. Variando las dimensiones de la muestra y la corriente aplicada se puede hacer que este ruido se haga despreciable frente a la señal medida, y así la resolución estará determinada por la que establezcan los dispositivos de medida. En los cristales típicos que empleamos el factor limitante es el ruido de fondo, y la buena resolución que proporciona el lock-in se desperdicia parcialmente. En las películas delgadas, por el contrario, se obtienen señales muy altas con relativamente poca corriente, lo que lleva a aprovechar por completo la resolución que brinda el lock-in, siendo ésta el factor limitante. Los valores de la paraconductividad que se determinen a temperaturas muy altas, de manera que la diferencia entre la resistividad de fondo y la experimental con fluctuaciones sea menor o del orden de la resolución de la medida, carecen de fiabilidad.

En el caso de los filmes, si pudiésemos aplicar un voltaje de compensación constante para contrarrestar la señal experimental — cosa que pueden hacer dispositivos como los lock-ins, sin variar el voltaje en la muestra, sino sólo internamente en su lectura— podríamos medir en escalas de $V_{m\acute{a}x}$ menores, reduciendo con ello $\delta V_2 = V_{m\acute{a}x} \cdot 10^{-4}$. Haríamos el voltaje de compensación muy cercano en valor absoluto a la señal de voltaje experimental para una temperatura dada (en 100 K, $V_{offset} = 25 \text{ mV}$) pero de signo

contrario, para que se contrarresten, de modo que mediríamos las diferencias, ya muy pequeñas, con respecto a este voltaje al variar la temperatura. Lograríamos de esta manera acercarnos a la resolución mínima determinada por el ruido de fondo, $\delta\rho_{1,f} = 1 \times 10^{-4} \mu\Omega \text{ cm}$. La dificultad experimental está, por supuesto, en que este voltaje de compensación tendría que ser estable por lo menos hasta la cifra $\delta V_2 = 5 \times 10^{-6} \text{ V}$.

Se debe señalar aquí, como apunte complementario, que el ruido $\delta V_1 = 25 \text{ nV}$ es el que se observa sólo cuando la resistividad se anula tras la transición superconductora, y podemos medir en la escala mínima del lock-in. En el estado normal, sin embargo, se manifiestan dispersiones de los puntos experimentales del orden de la propia resolución del lock-in: es “la última cifra que oscila”, lo que implica un ruido de fondo real comparable a la resolución de escala δV_2 . Además, esto sucede sólo cuando la temperatura es aproximadamente estable. Cuando la temperatura varía y se realizan medidas en deriva térmica (ya sea natural o controlada), se aprecian dispersiones de los puntos experimentales respecto de la tendencia que son algo mayores que las que generaría simplemente esta *oscilación* de la última cifra del aparato. Así, por ejemplo, en la región donde uno de los filmes³ tiene resistividad $\rho = 100 \mu\Omega \text{ cm}$ (en $T = 142 \text{ K}$) las desviaciones son cercanas a cuatro partes en 10^4 , cuatro veces la resolución del lock-in. Esto apunta en la dirección de que, para conseguir llegar a resoluciones tan bajas como la que generaría exclusivamente el ruido de fondo δV_1 , se necesitaría, además del antedicho voltaje de compensación altamente estable, una excelente estabilización en temperatura (o una deriva *infinitamente* lenta) que evitase esta fuente de error añadida.

³Muestra LYS50(1).

Capítulo 10

Resultados y conclusiones de la parte II (separatas de los artículos publicados)

A modo de resumen, se incluyen en las páginas siguientes las publicaciones relacionadas con la paraconductividad en las que el autor de esta memoria participó a lo largo del periodo de doctorado.

En las dos primeras publicaciones se estudia el tiempo de relajación de los pares de Cooper fluctuantes. En las tres siguientes se estudia el comportamiento de la paraconductividad a *altas* temperaturas reducidas, con $\varepsilon \equiv \ln(T/T_c) \gtrsim 0.1$. El principal resultado de este último estudio es la sugerencia de que a altas temperaturas reducidas las fluctuaciones superconductoras están dominadas por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que limita el *encogimiento* de la función de onda superconductora cuando T aumenta por encima de T_c .

Las aportaciones del autor de esta memoria a dichos estudios sobre la paraconductividad consistieron principalmente en las medidas de la resistividad en función de la temperatura, la extracción de la paraconductividad a partir de esas medidas, y el análisis de los diversos errores experimentales y de las incertidumbres asociadas con

las estimaciones del fondo (*background*) y de la temperatura crítica T_c .

Nota para esta versión en arXiv

Por motivos de copyright no se han incluido en esta versión de la tesis, especial para arXiv.org, las mencionadas publicaciones. Éstas se encuentran relacionadas en la página 334. Se conserva a continuación la numeración de páginas original de esta tesis, por lo que se saltan los números que correspondían a las páginas omitidas.

Apéndice

Apéndice A

Herramientas de edición y cálculo

A.1. Herramientas de edición

Para la elaboración del documento original se emplearon las siguientes herramientas informáticas.

Maquetación: PDF $\text{\TeX}$ 3.14159-1.10a (de la distribución MiK $\text{\TeX}$ 2.2) junto con WinEdt 1.414 (Aleksander Simonic), y Acrobat 4.0 (Adobe). Cálculos, análisis de datos, y representación gráfica: Origin 7.0 (OriginLab) y Mathematica 4.1 (Wolfram Research). Tratamiento de imagen digital: Photoshop 5.5 (Adobe) e IrfanView 3.61 (Irfan Skiljan). Diseño de gráficos vectoriales: CorelDraw 8 (Corel). Gestión de bibliografía en Bib $\text{\TeX}$: BibDB 2.2 (Eyal Doron). Extractos en versión HTML: T $\text{\TeX}$ H 2.2 (Ian Hutchinson).

Este documento se escribió en L $\text{\TeX}$ A $\text{\TeX}$ 2 ϵ , empleando los paquetes graphicx, hyperref, amsmath, amssymb, afterpage, float, fancyheadings, calc, pifont, enumerate, array, makeidx, babel, natbib, hypernat, e inputenc.

Se empleó Acrobat 4.0 (Adobe) para insertar, en el documento

final, las publicaciones de la segunda parte y los ficheros Mathematica de este apéndice, a partir de sus versiones en PDF (*Portable Document Format*). Para escribir estos últimos en PDF, se imprimieron desde Mathematica a un archivo, empleando el controlador de impresora Adobe Distiller 4.2.4.

Para la versión de arXiv se emplearon imágenes EPS de tamaño pequeño, lo que obligó en algunos casos a prescindir del color y de altas resoluciones.

A.2. Cálculos con *Mathematica*

Se incluyen a continuación dos ficheros del entorno de cálculo *Mathematica* (Wolfram Research), en su versión 4.1. En el primero de ellos se explica cómo se realizaron los cálculos de los capítulos 6 y 7. Se muestra el programa de cálculo iterativo para la determinación con realimentación de la temperatura del micropuente, que resuelve la ecuación 6.13, o las ecuaciones 6.11 y 6.9 si se desean menos correcciones al modelo. Se muestran también las funciones complementarias necesarias para este programa, y algunos ejemplos de uso elementales.

En el otro fichero que se incluye, se detalla cómo se le dio formato a las figuras que, hechas con *Mathematica*, se incorporaron al presente documento.

Cálculo de evoluciones térmicas

■ Programa de cálculo

Los cálculos que se han mostrado en los capítulos relativos al modelo de calentamiento en avalancha se realizaron, básicamente, con el siguiente programa escrito en *Mathematica*. Resuelve iterativamente la evolución de temperatura en el micropuente con el paso del tiempo. En él se introducen la temperatura inicial $T0$, la corriente constante que se aplica JJ , el tiempo $tmax$ hasta el que se quiere calcular la evolución temporal, en número máximo de puntos np que se iterarán, el incremento de temperatura máximo DTm que será el umbral de salto entre una iteración y la siguiente (a efectos de regular automáticamente el intervalo de tiempo dt en cada iteración), el valor característico $tcor$ que regula el comportamiento de $\alpha(t)$, y un parámetro *MeteDTI* que vale 0 ó 1.

```
MideTt[T0_, JJ_, tmax_, np_, DTm_, tcor_, MeteDTI_] :=
(
  sTf = T0; sTs = T0; lDT = 0; lTf = T0; sJ = JJ; n = 0;
  sQ = 0; dt = 0.000005; tt = 0; sIdP = 0; dt = 10.^-12;
  vectort = {0}; vectdt = {0}; vecT = {T0};
  sLP = P[sJ, sTf]; DP = {{0, 0}};

  Do[

    (* volumen caliente de substrato *)
    sV = vs[tt];

    (* potencia disipada *)
    sP = P[sJ, sTf];

    (* en principio, aumenta el paso temporal *)
    dt = dt * 2;

    (* preliminar: aumento de T *)
    sQtemp = sQ + sP * dt;
    sDTs = sQtemp / (1. sV);

    (* si el aumento de T es grande,
       reduce el paso temporal: *)
```

```

While[sDTs - lDT > DTm ,
  {dt = dt / 2; sQtemp = sQ + sP * dt; sDTs = sQtemp / (1. sV) ;}];

(* aumento de T en la frontera film-substrato*)
DTl = (1 - Exp[-tt l0 / tcor]) sP / (l a h) /. Parámet;

(* aumento de T en este paso: *)
sQ = sQtemp;
sDTf = MeteDTl * DTl + (1 + facDP * .2) alpha[tt, tcor] sDTs;

(* temperatura del filme *)
sTf = T0 + sDTf;
sTs = T0 + sDTs;
tt = tt + dt;

(* fin de programa si transita *)
If[sTf ∈ Reals, , Break[]];
If[P[JJ, sTf] ∈ Reals, , Break[]];

(* guarda datos de este paso *)
vectort = Append[vectort, tt];
vectdt = Append[vectdt, dt];
vecT = Append[vecT, sTf];
DP = Append[DP, {sDP, sDDP}];

(* fin de programa si completamos lo requerido *)
If[tt > tmax, Break[]];

(* fin de programa si T se dispara mucho *)
If[dt < 1. 10^-12, Break[]];

lTf = sTf;
lDT = sDTs;
n = n + 1;
,
{ii, np}];

(* el resultado es una interpolación *)
Interpolation[Transpose[{vectort, vecT}]]
)

```

Se puede ver dentro del código un número llamado DT1 que sólo se emplea cuando se le da al parámetro *MeteDT1* el valor 1. Esto tiene en cuenta la transferencia de calor entre el film y el sustrato, introduciendo los efectos de la resistencia de transferencia.

■ Funciones y parámetros previos

El programa anterior emplea unas funciones que dan la potencia disipada $P(J,T)$, el volumen de sustrato caliente, y el factor corrector de la geometría. Se detallan a continuación.

Los parámetros descriptivos de la muestra y el sustrato, en unidades A, V, Ω , cm, s.

```
Parámet = {cp → 1., h → 1000., d → 150. 10-7,  
D → 0.18, a → 10. 10-4, l → 50. 10-4};
```

Para la potencia disipada, se emplea una función que da el campo eléctrico en función de la corriente y la temperatura. Aquí, como ejemplo, mostramos las funciones que se emplearon para las simulaciones con campo magnético $\mu_0 H = 1$ T.

```
EfaB1[J_, T_] := (J / (J0 Log[Tc / T] ^ f)) ^ m  
Coefs1 = {m → 2.85, J0 → 8.0 106, Tc → 89.76, f → 1.08};  
Ef[J_, T_] := EfaB1[J, T] /. Coefs1
```

La siguiente función es la que se emplea dentro del programa principal. Hay que redefinirla convenientemente, por medio de las anteriores, para describir el comportamiento de unas curvas E - J concretas (por ejemplo si variamos el campo magnético, o simulamos otra muestra):

```
P[J_, T_] := J Ef[J, T] l a d /. Parámet;
```

Para el volumen de sustrato caliente en función del tiempo se emplea:

```
r[t_] := 2  $\sqrt{D t}$   
vs[t_] := l (2 r[t] + a) (r[t] + d) /. Parámet;
```

Para corregir la distribución no uniforme de temperatura:

```
alpha[t_, tc_] := (1 + 1.87 (1 - Exp[-t / tc])) ;
```

■ Uso del programa

Para determinar con comodidad el valor de la corriente de avalancha que corresponde a unas circunstancias dadas, se emplea la siguiente función, que acota un valor de corriente entre los límites crítico y casi estacionario. Se le suministran J_i y J_s , unas cotas inferior y superior para la corriente de avalancha, y se regula el comportamiento de las mejoras sucesivas al modelo con los parámetros t_{cor} y $MeteDT1$. Se busca con esta función la corriente más baja a la que se tiene una avalancha, entendiendo ésta por una evolución de temperatura que se desboca antes de llegar a un tiempo *pulso* (el tiempo característico de la medida experimental).

```
buscaJx[T0_, Ji_, Js_, tcor_,
  MeteDT1_, precisión_, pulso_] := (
  Jinf = Ji; Jsup = Js; lJJ = Jinf; JJ = (Jsup + Jinf) / 2;
  While[Abs[JJ - lJJ] > precisión 10^6,
    MideTt[T0, JJ, pulso, 5000, .005, tcor, MeteDT1];
    If[tt ≥ pulso && vecT[[Length[vecT]]] ∈ Reals &&
      vecT[[Length[vecT]]] < 100, Jinf = JJ; Jx = Jinf;
      Print[JJ, " < Jx"], Jsup = JJ; Print[JJ, " > Jx"]];
    lJJ = JJ; JJ = (Jsup + Jinf) / 2; ];
  MideTt[T0, Jx, pulso,
    5000, .005, tcor, MeteDT1]; pinta; Jx)
```

Para representar fácilmente los resultados del cálculo, se emplea la siguiente función. Muestra el resultado de la evolución temporal de temperatura, y los sucesivos intervalos dt que se han empleado durante el cálculo.

```

pinta := ( Off[Graphics::"gptn"];
  gT = ListPlot[Transpose[{vectort, vecT}],
    PlotJoined → True, DisplayFunction → Identity,
    PlotRange → All, AxesLabel -> {"t", "T"}];
  gdt = ListPlot[Transpose[{vectort, vectdt}],
    PlotJoined → False, DisplayFunction → Identity,
    PlotStyle → {PointSize[0.01]},
    PlotRange → All, AxesLabel -> {"t", "dt"}];
  Show[GraphicsArray[{gT, gdt}], ImageSize → 600];
  On[Graphics::"gptn"];
  Print["T= ", vecT[[Length[vecT]]], " t= ", tt]; )

```

El intervalo máximo de incremento de temperaturas, el parámetro DTm de los cálculos, se establece tras haber hecho varias pruebas en 0.005 K. En un caso típico de ejecución, dividir este parámetro entre 5 llevó a una variación de la J^* calculada de un 0.11%, pero incrementó el tiempo de cálculo en un factor 3.5. Dividirlo entre 50, haciéndolo igual a 0.0001 K, varió la J^* en sólo un 0.13%, y el tiempo de cálculo se multiplicó por 40. Por el contrario, multiplicar este parámetro por 2, aunque acelera los cálculos también en un factor 2, hace variar los resultados en un 0.41%, lo que no compensa demasiado teniendo en cuenta los tiempos implicados. (Entre llaves, se da el tiempo de cálculo, y el valor de la corriente de avalancha calculado).

```

Timing[buscaJx[82, 3. 10^6,
  6.5 10^6, .25 10^-9, 1, 0.0001, 1. 10^-3]]

{7.85 Second, 3.90619 × 10^6}

Timing[buscaJxDt[82, 3. 10^6, 6.5 10^6,
  .25 10^-9, 1, 0.0001, 1. 10^-3, 0.001]]

{27.63 Second, 3.91057 × 10^6}

Timing[buscaJxDt[82, 3. 10^6, 6.5 10^6,
  .25 10^-9, 1, 0.0001, 1. 10^-3, 0.0001]]

{316.15 Second, 3.91132 × 10^6}

Timing[buscaJxDt[82, 3. 10^6, 5.5 10^6,
  .25 10^-9, 1, 0.0001, 1. 10^-3, 0.01]]

{3.85 Second, 3.89005 × 10^6}

```

Simplificando los parámetros del cálculo, para emplear siempre unos que funcionan aceptablemente, tenemos tres funciones que usan los tres típicos casos del modelo (sin correcciones, con corrección de distribución no uniforme de temperatura, y con resistencia de frontera film-sustrato):

```
SolT[JJ_, T0_] := MideTt[T0, JJ, 0.001, 5000, .005, 15 10^3, 0]

SolTal[JJ_, T0_] :=
  MideTt[T0, JJ, 0.001, 5000, .005, 15 10^-9, 0]

SolTaldt[JJ_, T0_] :=
  MideTt[T0, JJ, 0.001, 5000, .005, 15 10^-9, 1]
```

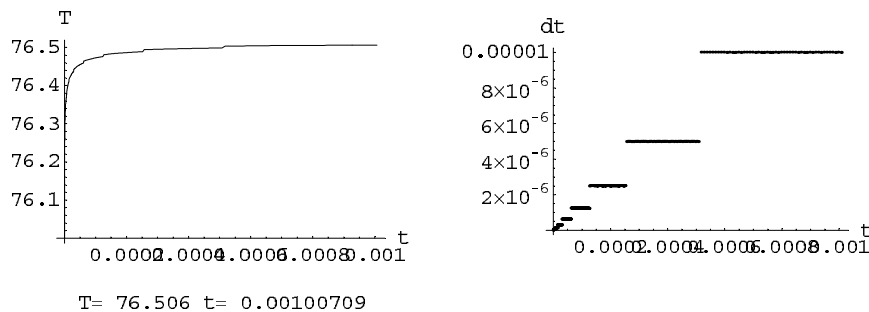
■ Ejemplo de uso

Evolución de la temperatura del film en función del tiempo, para $B = 0$, con temperatura inicial $T_0 = 76$ K y a corriente aplicada del orden de la J^* experimental ($7.3 \cdot 10^6$ A/cm²). Este es el resultado para la aproximación más simple, con $\alpha = 1$ y $h = \infty$. A esta corriente y temperatura inicial, se llega a una estabilización de la temperatura: no hay avalancha.

```
Timing[t760j650 = SolT[7.3 10^6, 76]]

{2.69 Second, InterpolatingFunction[{{0., 0.00100709}}], <>]}
```

pinta

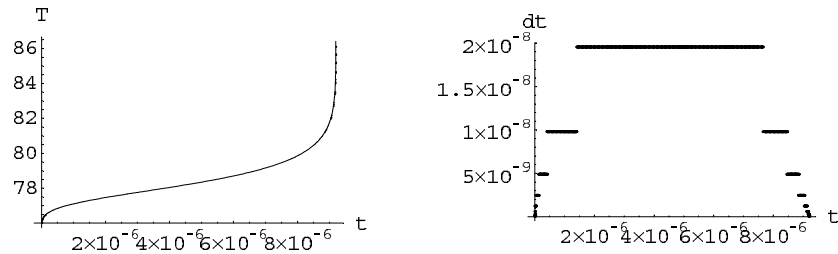


Si lo comparamos con una versión mejorada del modelo (poniendo $\alpha = \alpha(t)$) pero a igualdad de los demás parámetros, obtenemos una avalancha en tiempos muy breves:


```
Timing[t760j650b = SolTal[7.3 10^6, 76]]
```

```
{7.03 Second, InterpolatingFunction[{{0., 9.19538×10-6}}, <>]}
```

```
pinta
```



```
T= 86.4124 t= 9.19538×10-6
```

Basándose en estas funciones, se pueden construir curvas E - J completas (ahora usando el modelo con las correcciones):

```
vj = {.4, .5, .6, .7, .8, 0.85, 0.865, 0.88, 0.895, 0.91,  
      0.925, 0.94, 0.955, 0.97, 0.98, 0.99, .997, .999, 1.};
```

```
ve76B =
```

```
Map[(Ef[#, SolTaldt[#, 76.2][0.001]]) &, vj 6.4133 10^6];
```

```
ve78B = Map[(Ef[#, SolTaldt[#, 78.1][0.001]]) &,  
            vj 5.427 10^6];
```

```
ve80B = Map[(Ef[#, SolTaldt[#, 80.6][0.001]]) &,  
            vj 4.175 10^6];
```

```
ve85B = Map[(Ef[#, SolTaldt[#, 85.1][0.001]]) &,  
            vj 2.030 10^6];
```

Para representarlas gráficamente:

```

plejB = ListPlot[Transpose[
  {Append[vj #, #], Append[ve76B, 2 ve76B[[19]]]}] &[
  6.4133 ], PlotStyle -> {Thickness[0.0065]},
  PlotJoined -> True, DisplayFunction -> Identity];
p2ejB = ListPlot[Transpose[{Append[vj #, #],
  Append[ve78B, 2 ve78B[[19]]]}] &[5.427 ],
  PlotStyle -> {Thickness[0.0065]}, PlotJoined -> True,
  DisplayFunction -> Identity];
p3ejB = ListPlot[Transpose[{Append[vj #, #],
  Append[ve80B, 2 ve80B[[19]]]}] &[4.175 ],
  PlotStyle -> {Thickness[0.0065]}, PlotJoined -> True,
  DisplayFunction -> Identity];
p4ejB = ListPlot[Transpose[{Append[vj #, #],
  Append[ve85B, 2 ve85B[[19]]]}] &[2.030 ],
  PlotStyle -> {Thickness[0.0065]}, PlotJoined -> True,
  DisplayFunction -> Identity];

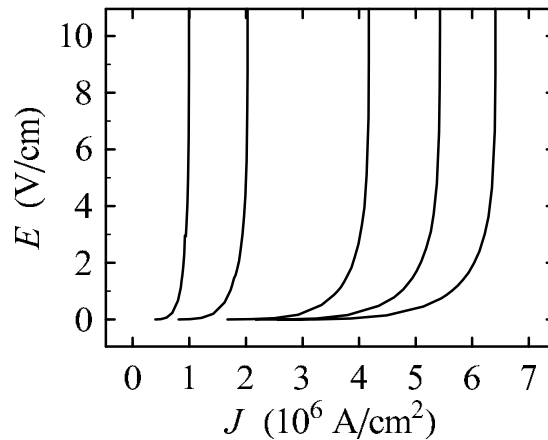
```

El resultado final, juntando todas esas curvas:

```

lJ = "J (106 A/cm2)"; lE = "E (V/cm)";
Show[plejB, p2ejB, p3ejB, p4ejB, p5ejB,
  DisplayFunction -> $DisplayFunction, Frame -> True,
  Evaluate[formatoshow[lJ, lE, 351, 0.0065]],
  Evaluate[fticks[0, 7., 1, 0, 0, 10, 2, 1, 0.02, 0.0065]],
  Evaluate[margen[0, 7, 0, 10, 0.02, 3]]];

```



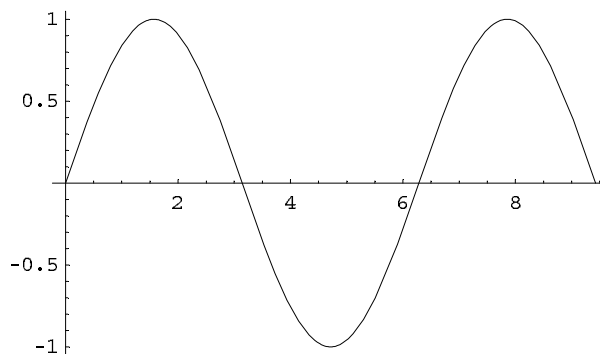
Formatos gráficos

En contraste con su potencia de cálculo y su facilidad de uso, *Mathematica* tiene ciertas carencias para dar formato a los resultados gráficos. A las figuras que se han incluido en este documento se les dio su forma final empleando una serie de funciones definidas a propósito, y que se incluyen aquí para futuras referencias. Las gráficas se imprimieron con un driver PostScript a un archivo, y se convirtieron posteriormente a formato PDF con Adobe Distiller.

■ Uso de las funciones de formato

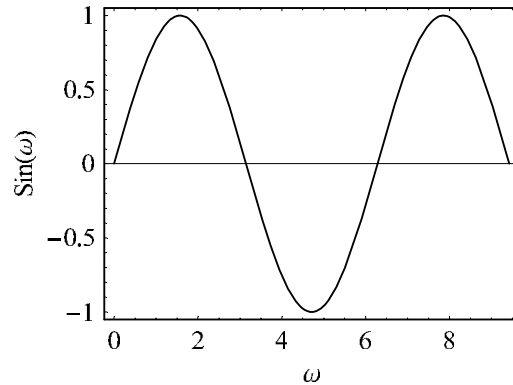
Gráfica estándar de *Mathematica*:

```
Plot[Sin[x], {x, 0, 3 Pi}];
```



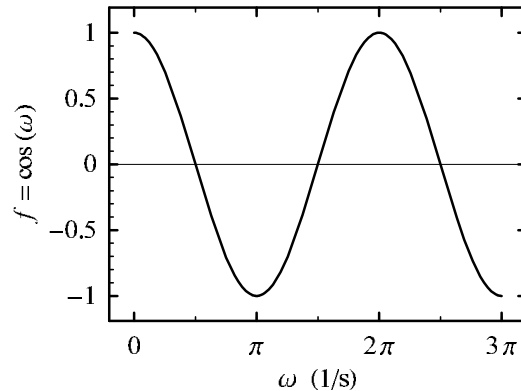
Añadimos *formato* con el marco, líneas y tipos de letra. Se incluyen títulos de los ejes, y especificamos el tamaño de la gráfica (250) y el grosor de las líneas (0.5%). El tamaño de la letra se calcula proporcionalmente al de la gráfica. A veces se ajusta mal el espaciado de los caracteres en las etiquetas: se soluciona variando ligeramente el tamaño de la gráfica. El comando *Plot* no expande sus argumentos, así que hay que forzarlo con el comando *Evaluate*. Las figuras previas de este documento se hicieron a tamaño 350, con grosor de línea 0.0065 (0.65%).

```
Plot[Sin[x], {x, 0, 3 Pi},
  Evaluate[formato[" $\omega$ ", "Sin( $\omega$ )", 250, 0.005]]];
```

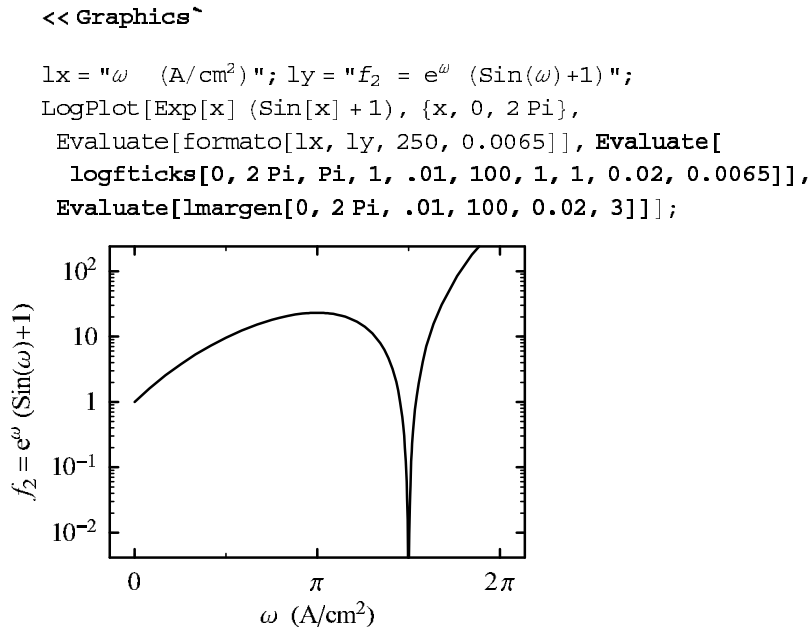


Ahora, con la función *fticks*, añadimos etiquetas personalizadas, además de modificar el largo y ancho de las marcas de los ejes para hacerlas más visibles. Se usa también la función *margen* para dar holgura al gráfico respecto de las marcas de los ejes: se introduce en ésta el rango de representación $x1, x2, y1, y2$, la longitud de las marcas (2%), y el factor de distancia entre marcas y dibujo (3 veces la longitud de un *tick*). Para etiquetar los ejes con formatos complejos (cursivas, subíndices...) a veces es necesario definir las etiquetas en cadenas de caracteres aparte.

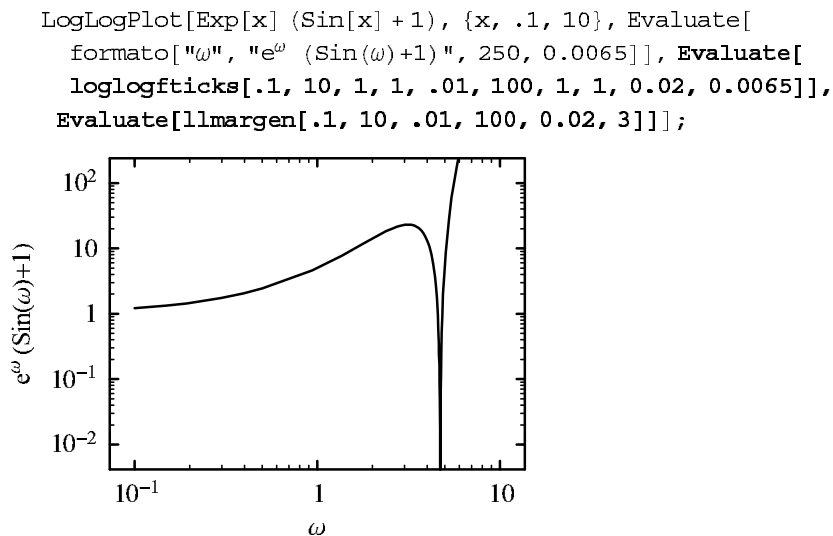
```
lx = " $\omega$  (1/s)"; ly = " $f = \cos(\omega)$ ";
Plot[Cos[x], {x, 0, 3 Pi},
  Evaluate[formato[lx, ly, 250, 0.0065]],
  Evaluate[fticks[0, 3 Pi, Pi, 1, -1, 1, .5, 4, 0.02, 0.0065]],
  Evaluate[margen[0, 3 Pi, -1, 1, .02, 3]]];
```



Si el eje y es logarítmico, hay que emplear *logfticks*, y *lmargen*.

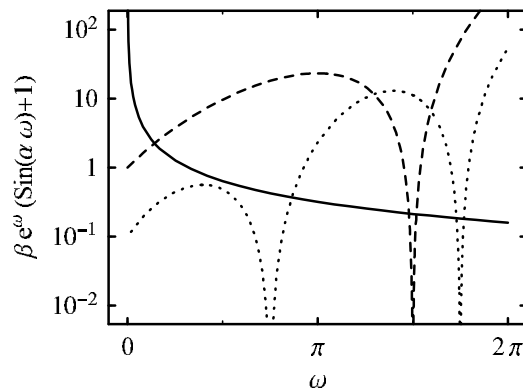


Si los dos ejes son logarítmicos, hay que emplear *loglogfticks*, y *llmargen*.



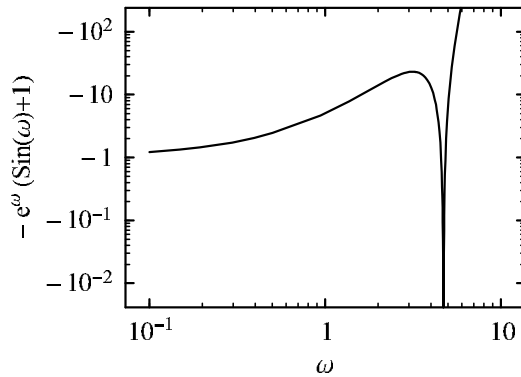
Cuando se juntan varias gráficas con el comando *Show*, hay que emplear *formatoshow*, y si hay ejes logarítmicos también *logfticksshow*. En ese caso hay que especificar el grosor de la línea en cada uno de los *plots* individuales (en general igual al grosor de la línea del marco) y usar *lmargen* también en cada uno, con los mismos parámetros:

```
Show[LogPlot[1/x, {x, 0, 2 Pi},
  lmargen[0, 2 Pi, .01, 100, .015, 3], DisplayFunction→
  Identity, PlotStyle→{Thickness[0.0065]}],
LogPlot[Exp[x] (Sin[x] + 1), {x, 0, 2 Pi}, lmargen[0,
  2 Pi, .01, 100, .015, 3], DisplayFunction→ Identity,
  PlotStyle→{Thickness[0.0065], dash}],
LogPlot[.1 Exp[x] (Sin[2 x] + 1), {x, 0, 2 Pi},
  lmargen[0, 2 Pi, .01, 100, .015, 3], DisplayFunction→
  Identity, PlotStyle→{Thickness[0.0065], dot}],
DisplayFunction→ $DisplayFunction, Evaluate[
  formatoshow["ω", "β eω (Sin(α ω)+1)", 250, 0.0065]],
Evaluate[logfticksshow[0, 2 Pi, Pi, 1,
  .0001, 100, 1, 9, 0.015, 0.0065]]];
```



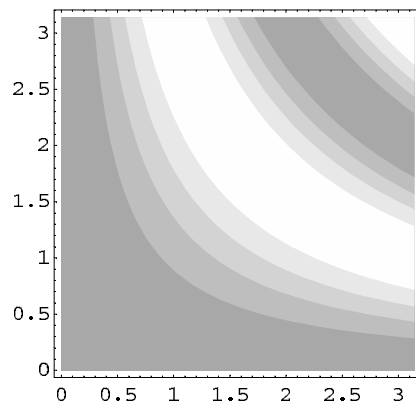
En representaciones logarítmicas, se pueden incluir funciones negativas cambiando de signo la función y especificando un valor negativo como límite superior del eje:

```
LogLogPlot[{-Exp[x] (Sin[x] + 1)}, {x, .1, 10}, Evaluate[
  formato[" $\omega$ ", "- e $^{\omega}$  (Sin( $\omega$ )+1)", 250, 0.0065]], Evaluate[
  loglogfticks[.1, 10, 1, 1, .01, -100, 1, 1, 0.02, 0.0065]],
  Evaluate[lmargin[.1, 10, .01, 100, 0.02, 3]]];
```

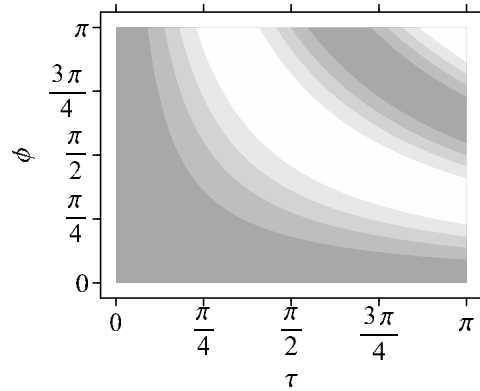


En *ContourPlots* hay que usar *formatoshow* y *margen3D*. Las marcas de eje se pueden poner hacia afuera cambiando el signo de su longitud. Siempre se pueden agrupar varias de estas funciones dentro de un único *Evaluate*, si van consecutivas.

```
cp = ContourPlot[Sin[x*y/2] * Sin[x*y/2], {x, 0, Pi},
  {y, 0, Pi}, ColorFunction -> (GrayLevel[#/3 + .66] &),
  ContourLines -> False, Contours -> 4, PlotPoints -> 30];
```



```
Show[cp, Evaluate[formatoshow["τ", "φ", 250, .005],
  fticks[0, Pi, Pi/4, 0, 0, Pi, Pi/4, 0, -.02, 0.005],
  margen3D[0, Pi, 0, Pi, 0.02, 2, Automatic]]];
```



■ Definición de las funciones de formato

Funciones que se emplean para los formatos mostrados previamente:

Formato de líneas:

```
dash = Dashing[{0.02, 0.02}];
dashdot = Dashing[{0.003, 0.02, 0.02, 0.02}];
lin = Dashing[{1}];
dot = Dashing[{0.003, 0.02}];
```

Para calcular la posición de las marcas de ejes, *t1* pone marcas y etiquetas a los ejes principales, mientras que *t2* sólo pone marcas, sin etiquetas, para los ejes secundarios.

```
t1[n_, x_, d_, m_, l_, t_] :=
Join[Table[{i, If[FractionalPart[i] == 0, IntegerPart[i], i],
  {(1 + Abs[l]) / 2, -(1 - Abs[l]) / 2}, {Thickness[t]}}, {i, n,
x, d}], Table[{i, "", {(1 + Abs[l]) / 4, -(1 - Abs[l]) / 4},
{Thickness[2. t / 3]}}, {i, n, x, d / (m + 1)}]]
```



```

tl2[n_, x_, d_, m_, l_, t_] :=
  Join[Table[{i, "", {(1 + Abs[l]) / 2, -(1 - Abs[l]) / 2},
    {Thickness[t]}}], {i, n, x, d}],
  Table[{i, "", {(1 + Abs[l]) / 4, -(1 - Abs[l]) / 4},
    {Thickness[2. t / 3]}}], {i, n, x, d / (m + 1)}]]

```

Lo mismo, pero para ejes logarítmicos:

```

ltl[n_, x_, d_, m_, l_, t_] :=
  Join[Table[{n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9])),
    If[Sign[x] == -1, "-", ""] NumberForm[
      n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9])) // N,
      ExponentFunction -> (# &), NumberFormat ->
        (If[#1 == "1.", Switch[#3, "0", 1, "1", 10, _, (10^#3)],
          (SequenceForm[#1, "x", 10^#3]) &)],
    {(1 + Abs[l]) / 2, -(1 - Abs[l]) / 2}, {Thickness[t]}}],
  {i, 1, Log[10, Abs[x] / n] * 10, 9 d}],
  Table[{n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9])), "",
    {(1 + Abs[l]) / 4, -(1 - Abs[l]) / 4}, {Thickness[2. t / 3]}}],
  {i, 1, Log[10, Abs[x] / n] * 9 + 1, m}]]

ltl2[n_, x_, d_, m_, l_, t_] :=
  Join[Table[{n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9])), "",
    {(1 + Abs[l]) / 2, -(1 - Abs[l]) / 2}, {Thickness[t]}}],
  {i, 1, Log[10, Abs[x] / n] * 10, 9 d}],
  Table[{n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9])), "",
    {(1 + Abs[l]) / 4, -(1 - Abs[l]) / 4}, {Thickness[2. t / 3]}}],
  {i, 1, Log[10, Abs[x] / n] * 9 + 1, m}]]

```

El comando *Show* precisa una forma diferente de calcular las coordenadas de las marcas, en representación logarítmica:

```

ltls[n_, x_, d_, m_, l_, t_] := Join[
  Table[{Log[10, n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9]))],
    If[Sign[x] == -1, "-", ""] NumberForm[
      n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9))] // N,
      ExponentFunction -> (# &), NumberFormat ->
        (If[#1 == "1.", Switch[#3, "0", 1, "1", 10, _, (10^#3)],
          (SequenceForm[#1, "x", 10^#3]) &)],
      {(1 + Abs[l]) / 2, -(1 - Abs[l]) / 2}, {Thickness[t]}},
    {i, 1, Log[10, Abs[x] / n] * 10, 9 d}],
  Table[{Log[10, n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9]))],
    "", {(1 + Abs[l]) / 4, -(1 - Abs[l]) / 4}, {Thickness[2. t / 3]}},
    {i, 1, Log[10, Abs[x] / n] * 10 - 1, m}]]

ltls2[n_, x_, d_, m_, l_, t_] := Join[
  Table[{Log[10, n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9]))],
    "", {(1 + Abs[l]) / 2, -(1 - Abs[l]) / 2}, {Thickness[t]}},
    {i, 1, Log[10, Abs[x] / n] * 10, 9 d}], Table[
  {Log[10, n (Mod[i - 1, 9] + 1) * (10^(Floor[(i - 1) / 9]))], "",
    {(1 + Abs[l]) / 4, -(1 - Abs[l]) / 4}, {Thickness[2. t / 3]}},
    {i, 1, Log[10, Abs[x] / n] * 10 - 1, m}]]

```

Estas funciones se emplean para introducir las marcas previamente calculadas en los gráficos con comodidad:

```

fticks[xn_, xx_, xd_, xm_, yn_, yx_, yd_, ym_, l_, t_] :=
  {FrameTicks -> {tl[xn, xx, xd, xm, l, t], tl[yn, yx, yd, ym, l,
    t], tl2[xn, xx, xd, xm, l, t], tl2[yn, yx, yd, ym, l, t]}}

logfticks[xn_, xx_, xd_, xm_, yn_, yx_, yd_, ym_, l_, t_] :=
  {FrameTicks -> {tl[xn, xx, xd, xm, l, t], ltl[yn, yx, yd, ym, l,
    t], tl2[xn, xx, xd, xm, l, t], ltl2[yn, yx, yd, ym, l, t]}}

logfticksshow[xn_, xx_, xd_, xm_, yn_, yx_, yd_, ym_, l_, t_] :=
  {FrameTicks -> {tl[xn, xx, xd, xm, l, t], ltls[yn, yx, yd, ym, l,
    t], tl2[xn, xx, xd, xm, l, t], ltls2[yn, yx, yd, ym, l, t]}}

loglogfticks[xn_, xx_, xd_, xm_, yn_, yx_, yd_, ym_, l_, t_] :=
  {FrameTicks -> {ltl[xn, xx, xd, xm, l, t], ltl[yn, yx, yd, ym, l,
    t], ltl2[xn, xx, xd, xm, l, t], ltl2[yn, yx, yd, ym, l, t]}}

```

Las funciones para separar los ejes de la figura:

```

margen[x1_, x2_, y1_, y2_, t1_, fac_] :=
{PlotRange -> {{x1 - (fac + 10^-6) (x2 - x1) t1 / (1 - fac 2 t1),
  x2 + fac (x2 - x1) t1 / (1 - fac 2 t1)},
  {y1 - (fac + 10^-6) (y2 - y1) t1 / .75 / (1 - fac 2 t1 / .75),
  y2 + fac (y2 - y1) t1 / .75 / (1 - fac 2 t1 / .75)}}}

margen3D[x1_, x2_, y1_, y2_, t1_, fac_, D3_] :=
{PlotRange -> {{x1 - (fac + 10^-6) (x2 - x1) t1 / (1 - fac 2 t1),
  x2 + fac (x2 - x1) t1 / (1 - fac 2 t1)},
  {y1 - (fac + 10^-6) (y2 - y1) t1 / .75 / (1 - fac 2 t1 / .75),
  y2 + fac (y2 - y1) t1 / .75 / (1 - fac 2 t1 / .75)}, D3}}

lmargen[x1_, x2_, y1_, y2_, t1_, fac_] := {PlotRange ->
  {{x1 -  $\frac{(fac + \frac{1}{10^6}) (x2 - x1) t1}{1 - fac 2 t1}$ , x2 +  $\frac{fac (x2 - x1) t1}{1 - fac 2 t1}$ }, {10^
     $\left( \text{Log}[10, y1] - \frac{(fac + \frac{1}{10^6}) (\text{Log}[10, y2] - \text{Log}[10, y1]) t1}{0.75^{\left(1 - \frac{fac 2 t1}{0.75}\right)}} \right)$ ,
    10^  $\left( \text{Log}[10, y2] + \frac{fac (\text{Log}[10, y2] - \text{Log}[10, y1]) t1}{0.75^{\left(1 - \frac{fac 2 t1}{0.75}\right)}} \right)$  }}}

llmargen[x1_, x2_, y1_, y2_, t1_, fac_] :=
{PlotRange -> {{10^  $\left( \text{Log}[10, x1] - \frac{(fac + \frac{1}{10^6}) (\text{Log}[10, x2] - \text{Log}[10, x1]) t1}{(1 - fac 2 t1)} \right)$ , 10^
     $\left( \text{Log}[10, x2] + \frac{fac (\text{Log}[10, x2] - \text{Log}[10, x1]) t1}{(1 - fac 2 t1)} \right)$  }, {10^
     $\left( \text{Log}[10, y1] - \frac{(fac + \frac{1}{10^6}) (\text{Log}[10, y2] - \text{Log}[10, y1]) t1}{0.75^{\left(1 - \frac{fac 2 t1}{0.75}\right)}} \right)$ ,
    10^  $\left( \text{Log}[10, y2] + \frac{fac (\text{Log}[10, y2] - \text{Log}[10, y1]) t1}{0.75^{\left(1 - \frac{fac 2 t1}{0.75}\right)}} \right)$  }}}

```

Y finalmente las funciones que se emplean para dar formato:

```

formato[labX_, labY_, s_, t_] :=
{Frame -> True, AspectRatio -> .75,
PlotStyle -> {Thickness[t]}, FrameStyle -> {Thickness[t]},
FrameLabel -> {StyleForm[labX, FontSize -> s / 21.],
StyleForm[labY, FontSize -> s / 21.]],
TextStyle -> {FontFamily -> "Times New Roman",
FontSize -> s / 21.}, ImageSize -> s}

formatoshow[labX_, labY_, s_, t_] :=
{DisplayFunction -> $DisplayFunction, Frame -> True,
AspectRatio -> .75, FrameStyle -> {Thickness[t]},
FrameLabel -> {StyleForm[labX, FontSize -> s / 21.],
StyleForm[labY, FontSize -> s / 21.]],
TextStyle -> {FontFamily -> "Times New Roman",
FontSize -> s / 21.}, ImageSize -> s}

formatocont[labX_, labY_, s_, t_] :=
{Frame -> True, FrameStyle -> {Thickness[t]},
FrameLabel -> {StyleForm[labX, FontSize -> s / 21.],
StyleForm[labY, FontSize -> s / 21.]],
TextStyle -> {FontFamily -> "Times New Roman",
FontSize -> s / 21.}, ImageSize -> s}

```

Bibliografía

- [1] J. G. Bednorz y K. A. Müller. Z. Phys. B **64**, 189 (1986).
- [2] D. M. Ginsberg (ed.). *Physical Properties of High Temperature Superconductors* (World Scientific, Singapur, 1989).
- [3] A. V. Narlikar (ed.). *Studies of High Temperature Superconductors (Advances in Research and Applications)*, tomos 13, 22, 31, 32 (Nova Science, New York, 1994, 1997, 2000).
- [4] C. P. Poole, Jr., H. A. Farach y R. J. Creswick. *Superconductivity* (Academic Press, San Diego, 1995).
- [5] W. Klein, R. P. Huebener, S. Gauss y J. Parisi. J. Low Temp. Phys. **61**, 413 (1985).
- [6] M. N. Kunchur. Phys. Rev. Lett. **89**, 137005 (2002). cond-mat/0208256.
- [7] S. G. Doettinger, R. P. Huebener, R. Gerdemann, A. Kühle, S. Anders, T. G. Träuble y J. C. Villégier. Phys. Rev. Lett. **73**, 1691 (1994).
- [8] Z. L. Xiao, P. Voss-de Haan, G. Jakob, T. Kluge, P. Haibach, H. Adrian y E. Y. Andrei. Phys. Rev. B **59**, 1481 (1999).
- [9] J. Chiaverini, J. N. Eckstein, I. Bozovic, S. Doniach y A. Kapitulnik. *Nonlinear I-V, high flux-flow velocity instability and evidence for quantum fluctuations in BSCCO superconducting films* (2000). cond-mat/0007479.

-
- [10] S. R. Currás, P. Wagner, M. Ruibal, J. Viña, M. R. Osorio, M. T. González, J. A. Veira, J. Maza y F. Vidal. Supercond. Sci. Technol. **14**, 748 (2001).
- [11] S. Rodríguez Currás. *Contribución al estudio de la interrelación entre la densidad de corriente crítica y la resistividad normal en muestras granulares y películas delgadas de $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$* . Tesis Doctoral, Universidade de Santiago de Compostela (2000).
- [12] M. González, S. Vidal, J. Viña, M. R. Osorio, J. Maza y F. Vidal. Physica C **372-376**, 1852 (2002).
- [13] M. T. González, J. Viña, S. R. Currás, J. Maza y F. Vidal. *Normal-superconducting transition induced by high current densities in $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ melt-textured samples and thin films: Similarities and differences* (2002). En trámites de publicación. cond-mat/0305020.
- [14] M. T. González. *On the electrical transport properties of $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ superconductors textured by top seeded melt growth*. Tesis Doctoral, Universidade de Santiago de Compostela (2003).
- [15] Z. L. Xiao y P. Ziemann. Phys. Rev. B **53**, 15265 (1996).
- [16] S. G. Doettinger, R. P. Huebener y A. Kühle. Physica C **251**, 285 (1995).
- [17] F. Lefloch, C. Hoffmann y O. Demolliens. Physica C **319**, 258 (1999). cond-mat/9903060.
- [18] Z. L. Xiao, P. V. de Haan, G. Jakob y H. Adrian. Phys. Rev. B **57**, R736 (1998).
- [19] M. Pauly, R. Ballou, G. Fillion y J.-C. Villégier. Physica B **284-288**, 721 (2000).

-
- [20] F.-M. Kamm, A. Plettl y P. Ziemann. *Physica B* **284-288**, 561 (2000).
- [21] H. K. Onnes. *Leiden Commun.* **120b, 122b, 124c** (1911).
- [22] F. London y H. London. *Proc. Roy. Soc. (London)* **A155**, 71 (1935).
- [23] W. Meissner y R. Ochsenfeld. *Naturwissenschaften* **21**, 787 (1933).
- [24] V. L. Ginzburg y L. D. Landau. *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **20**, 1064 (1950).
- [25] J. Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer. *Phys. Rev.* **108**, 1175 (1957).
- [26] L. N. Cooper. *Phys. Rev* **104**, 1189 (1956).
- [27] A. A. Abrikosov. *Sov. Phys. JETP* **5**, 1174 (1957).
- [28] A. C. Rose-Innes y E. H. Rhoderick. *Introduction to Superconductivity* (Pergamon Press, Oxford, 1978), 2^a ed.
- [29] G. Blatter, M. V. Feigel'man, V. B. Geshkenbein, A. I. Larkin y V. M. Vinokur. *Rev. Mod. Phys.* **66**, 1125 (1994).
- [30] M. N. Kunchur y D. K. Christen. *Phys. Rev. Lett.* **70**, 998 (1993).
- [31] M. Tinkham. *Introduction to Superconductivity* (McGraw-Hill, New York, 1996), 2^a ed.
- [32] A. V. Samoilov, M. Konczykowski, N.-C. Yeh, S. Berry y C. C. Tsuei. *Phys. Rev. Lett.* **75**, 4118 (1995).
- [33] B. J. Ruck, J. C. Abele, H. J. Trodahl, S. A. Brown y P. Lynam. *Phys. Rev. Lett.* **78**, 3378 (1997).

-
- [34] H. C. Montgomery. J. Appl. Phys. **42**, 2971 (1971).
- [35] J. R. Salgueiro Piñeiro. *Escritura láser directa en la fabricación de máscaras para óptica integrada*. Tesina de Graduación, Área de Óptica, Dpto. de Física Aplicada. Universidade de Santiago de Compostela. (1996).
- [36] W. M. Moreau. *Semiconductor Lithography. Principles, Practices and Materials*. (Plenum Press, New York, 1989), 2^a ed.
- [37] S. Rodríguez Currás. *Crecimiento de películas delgadas de $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ por pulverización catódica y su caracterización estructural*. Tesina de Graduación, Facultade de Física, Universidade de Santiago de Compostela. (1995).
- [38] D. Bhatt, S. N. Basu, A. C. Westerheim y A. C. Anderson. Physica C **222**, 283 (1994).
- [39] A. Catana, J. G. Bednorz, C. Gerber, J. Mannhardt y D. G. Schlom. Appl. Phys. Lett. **63**, 553 (1993).
- [40] J. P. Loquet, Y. Jaccard, C. Gerber y E. Mächler. Appl. Phys. Lett. **63**, 10 (1993).
- [41] D. H. Kim, D. J. Miller, J. C. Smith, R. A. Holbold, J. H. Kang y J. Talvacchio. Phys. Rev. B **44**, 7607 (1992).
- [42] B. Wuyts, Z. X. Gao, S. Libbrecht, M. Maenhoudt, E. Osquiguil y Y. Bruynseraede. Physica C **203**, 235 (1992).
- [43] J. R. Gavaler, J. Talvacchio, T. T. Braggins, M. G. Forrester y J. Gregg. J. Appl. Phys. **70**, 4383 (1991).
- [44] H.-U. Habermeier, G. Beddies, B. Leibold, G. Lu y G. Wagner. Physica C **180**, 17 (1991).
- [45] X. Y. Li, N. J. Wu, K. X. abd J. S. Liu, H. Lin, T. Q. Huang y A. Ignatiev. Physica C **248**, 281 (1995).

-
- [46] S. R. Currás, J. Viña, M. Ruibal, M. T. González, M. R. Osorio, J. Maza, J. A. Veira y F. Vidal. *Physica C* **372-376**, 1095 (2002).
- [47] M. Nahum, S. Verghese, P. L. Richards y K. Char. *Appl. Phys. Lett.* **59**, 2034 (1991).
- [48] J. Mosqueira, O. Cabeza, M. François, C. Torrón y F. Vidal. *Supercond. Sci. Technol.* **6**, 584 (1993).
- [49] J. Mosqueira, O. Cabeza, M. François y F. Vidal. En *ICMAS-93 Superconducting Materials* (J. Etourneau, J. B. Torrance and H. Yamauchi, eds.) pp. 285 – 290 (Institute for Industrial Technology Transfer, Gournay-sur-Marne, 1993).
- [50] J. Mosqueira, O. Cabeza, F. Miguélez, M. François y F. Vidal. *Physica C* **235-240**, 2105 (1994).
- [51] National Instruments. *Data Acquisition (DAQ) Fundamentals* (AN007). Application Note 007, <http://www.ni.com>.
- [52] R. Wördenweber, M. O. Abd-El-Hamed, J. Schneider y O. Laborde. *J. Appl. Phys.* **70**, 2230 (1991).
- [53] H. H. Wen, S. L. Li, G. H. Chen y X. S. Ling. *Phys. Rev. B* **64**, 054507 (2001).
- [54] J. D. Hettinger, A. G. Swanso, W. J. Skocpol, J. S. Brooks, J. M. G. P. M. Mankiewich, R. E. Howard, B. L. Straughn y E. G. Burkhardt. *Phys. Rev. Lett.* **62**, 2044 (1989).
- [55] E. Zeldov, N. M. Amer, G. Koren, A. Gupta y M. W. McElfresh. *App. Phys. Lett.* **56**, 680 (1990).
- [56] P. Bernstein, S. Lamarti y J. Bok. *Solid State Comm.* **75**, 587 (1990).
- [57] R. Wördenweber, M. O. Abd-El-Hamed y J. Scheneider. *Physica C* **171**, 1 (1990).

- [58] M. Tinkham. *Physica B* **169**, 66 (1991).
- [59] S. K. Gupta, P. Berdahl, R. E. Russo, G. Briceño y A. Zettl. *Physica C* **206**, 335 (1993).
- [60] J. M. Roberts, B. Brown, B. A. Hermann y J. Tate. *Phys. Rev. B* **49**, 6890 (1994).
- [61] P. J. M. Wöltgens, C. Dekker, R. H. Koch, B. W. Hussey y A. Gupta. *Phys. Rev. B* **52**, 4536 (1995).
- [62] A. Kiliç, K. Kiliç, S. Senoussi y K. Demir. *Physica C* **294**, 203 (1998).
- [63] M. Prester. *Supercond. Sci. Technol.* **11**, 333 (1998).
- [64] Z. H. Wang, H. Zhang y X. W. Cao. *Physica C* **337**, 62 (2000).
- [65] I. L. Landau y H. R. Ott. *Physica C* **331**, 1 (2000).
- [66] I. L. Landau y H. R. Ott. *Phys. Rev. B* **63**, 184516 (2001).
- [67] I. L. Landau y H. R. Ott. *Phys. Rev. B* **65**, 064511 (2002).
- [68] Z. L. Xiao, E. Y. Andrei y P. Ziemann. *Phys. Rev. B* **58**, 11185 (1998).
- [69] W. J. Skocpol, M. R. Beasley y M. Tinkham. *J. Appl. Phys.* **45**, 4054 (1974).
- [70] V. N. Skokov y V. P. Koverda. *Cryogenics* **33**, 1072 (1993).
- [71] F. S. Jelila, J.-P. Maneval, F.-R. Landan, F. Chibane, A. Marie-de Ficquelmont, L. Méchin, J.-C. Villégier, M. Aprili y J. Lesueur. *Phys. Rev. Lett.* **81**, 1933 (1998).
- [72] J.-P. Maneval, F. Boyer, K. Harrabi y F.-R. Ladan. *Journal of Superconductivity* **14**, 347 (2001).

-
- [73] S. Reymond, L. Antognazza, M. Decroux, E. Koller, P. Reinert y Ø. Fischer. Phys. Rev. B **66**, 014522 (2002).
- [74] C. Yang, O. Miura, D. Ito, M. Morita y Tokunaga. IEEE Trans. Appl. Supercond. **9**, 1339 (1999).
- [75] S. Elschner, J. Bock, G. Brommer y L. Cowey. Appl. Supercond. **167**, 1029 (1999).
- [76] R. Tournier, E. Beaugnon, O. Belmont, X. Chaud, D. Bourgault, D. Isfort, L. Porcar y P. Tixador. Supercond. Sci. Technol. **13**, 886 (2000).
- [77] A. I. Larkin y Y. N. Ovchinnikov. Sov. Phys. JETP **41**, 960 (1976).
- [78] A. I. Bezuglyj y V. A. Shklovskij. Physica C **202**, 234 (1992).
- [79] S. G. Doettinger, S. Kittelberger, R. P. Huebener y C. C. Tsuei. Phys. Rev. B **56**, 14157 (1997).
- [80] O. Pla y F. Nori. Phys. Rev. Lett. **67**, 919 (1991).
- [81] Z. L. Xiao y P. Ziemann. Physica C **282-287**, 2363 (1997).
- [82] K. E. Bassler y M. Paczuski. Phys. Rev. Lett. **81**, 3761 (1998).
- [83] E. Altshuler, T. H. Johansen, Y. Paltiel, P. Jing, K. E. Bassler, O. Ramos, G. F. Reiter, E. Zeldov y C. W. Chu. *Vortex avalanches and self organized criticality in superconducting niobium* (2002). cond-mat/0208266 v2.
- [84] R. Kleiner, F. Steinmeyer, G. Kunkel y P. Müller. Phys. Rev. Lett. **68**, 2394 (1992).
- [85] R. Kleiner y P. Müller. Phys. Rev. B **49**, 1327 (1994).
- [86] R. Kleiner, P. Müller, H. Kohlstedt, N. F. Pedersen y S. Sakai. Phys. Rev. B **50**, 3942 (1994).

-
- [87] K. Tanabe, Y. Hidaka, S. Karimoto y M. Suzuki. Phys. Rev. B **53**, 9348 (1996).
 - [88] A. E. Koshelev y V. M. Vinokur. Phys. Rev. Lett. **73**, 3580 (1994).
 - [89] G. Sabouret, C. Williams y R. Sobolewski. Phys. Rev. B **66**, 132501 (2002).
 - [90] D. T. Fuchs, E. Zeldov, T. Tamegi, S. Ooi, M. Rappaport y H. Shtrikman. Phys. Rev. Lett. **80**, 4971 (1998).
 - [91] D. T. Fuchs, R. A. Doyle, E. Zeldov, S. F. W. R. Rycroft, T. Tamegai, S. Ooi, M. L. Rappaport y Y. Myasoedov. Phys. Rev. Lett. **81**, 3944 (1998).
 - [92] Y. H. Zhang, H. Luo, X. F. Wu y S. Y. Ding. Supercond. Sci. Technol. **14**, 346 (2001).
 - [93] Y. Liu, H. Luo, T. Y. X. Leng, X. F. Wu, J. W. Lin, Z. H. Wang, H. M. Luo y S. Y. Ding. Supercond. Sci. Technol. **15**, 373 (2002).
 - [94] A. V. Gurevich y R. G. Mints. Rev. Mod. Phys. **59**, 941 (1987).
 - [95] A. Kahan. Supercond. Sci. Technol. **6**, 476 (1993).
 - [96] X. Xu, J. Fang, X. Cao, K. Li, W. Yao y Z. Qi. Solid State Comm. **92**, 501 (1994).
 - [97] X. W. Cao, Z. H. Wang, J. Fang, X. J. Xu y K. B. Li. J. Appl. Phys. **81**, 7392 (1997).
 - [98] E. Duran. *Magnétostatique* (Masson et Cie, Paris, 1968).
 - [99] M. I. Flik, Z. M. Zhang, K. E. Goodson, M. P. Siegal y J. M. Phillips. Phys. Rev. B **46**, 5606 (1992).

-
- [100] D. A. Bonn, R. Liang, T. M. Riseman, D. J. Baar, D. C. Morgan, K. Zhang, P. Dosanjh, T. L. Duty, A. MacFarlane, G. D. Morris, J. H. Brewer, W. N. Hardy, C. Kallin y A. J. Berlinsky. Phys. Rev. B **47**, 11314 (1993).
- [101] F. Gao, J. W. Kruse, C. E. Platt, M. Feng y M. V. Klein. Appl. Phys. Lett. **63**, 2274 (1993).
- [102] J. Chiaverini, J. N. Eckstein, I. Bozovic, S. Doniach y A. Kapitulnik. *Nonlinear I-V, high flux-flow velocity instability and evidence for quantum fluctuations in BSCCO superconducting films* (2000). cond-mat/0007479.
- [103] M. Xu, D. Shi y R. F. Fox. Phys. Rev. B **42**, 10773 (1990).
- [104] C. P. Bean. Phys. Rev. Lett. **8**, 250 (1962).
- [105] P. W. Anderson. Phys. Rev. Lett. **9**, 309 (1962).
- [106] P. W. Anderson y Y. B. Kim. Rev. Mod. Phys. **36**, 39 (1964).
- [107] G. Jakob, P. Voss-de Haan, M. Wagner, Z. Xiao y H. Adrian. Physica B **284-288**, 897 (2000).
- [108] A. J. Chapman. *Heat Transfer* (Macmillan, New York, 1984), 4^a ed.
- [109] C. D. Marshall, A. Tokmakoff, I. M. Fishman, C. B. Eom, J. M. Phillips y M. D. Fayer. J. Appl. Phys. **73**, 850 (1993).
- [110] En Y. S. Touloukian (ed.), *Thermophysical Properties of Matter*, tomos 2, 5 (IFI/Plenum, New York, 1970).

Índice de tablas

2.1. Parámetros del crecimiento por pulverización catódica de las películas empleadas en este trabajo	49
2.2. Relación de las muestras empleadas en los experimentos	50
2.3. Parámetros más convenientes para las microsoldaduras.	74
7.1. Valores de la potencia estacionaria W^* y la derivada dW/dT para los valores estables previos al salto de algunas simulaciones.	198
9.1. Dimensiones típicas de las muestras empleadas en las medidas de paraconductividad.	245

Índice de figuras

1. Schematic diagram of a typical E - J curve for a $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ superconductor at $T < T_c$	16
1.1. Representación esquemática de una curva E - J típica de un cuprato superconductor a $T < T_c$	39
2.1. Banco de pulverización (<i>sputtering</i>) Plassys MP400 modificado.	47
2.2. Esquema del difractómetro de rayos-x empleado para la caracterización estructural.	51
2.3. Curva de basculamiento (<i>rocking curve</i>) para el pico (005) del Y-123.	53
2.4. Difractograma θ - 2θ	55
2.5. Esquema de la máscara para el fotolitografiado de los micropuentes.	57
2.6. Insoladora ultravioleta que empleamos para el fotolitografiado.	58
2.7. Imágenes por vídeo digital de un micropuente.	61
2.8. Resultados típicos de las medidas de perfilometría en un micropuente.	62
2.9. Microscopio de fuerza atómica (AFM) de nuestro laboratorio	63
2.10. Detalle de la unidad de medida del AFM.	64
2.11. Dos imágenes de AFM de un mismo micropuente, antes y después de una limpieza por ultrasonidos.	66
2.12. Dos imágenes de AFM de sendos micropuentes.	67

2.13. Fotografía de un filme sobre el portamuestras de cobre intermedio.	70
2.14. Microsoldador KS 4523 para la aplicación de contactos eléctricos sobre los micropuentes.	71
2.15. Detalle de una patilla del portamuestras de cobre intermedio, con los hilos de contactos eléctricos.	72
2.16. Detalle de las microsoldaduras de hilos de aluminio dopados con silicio.	73
3.1. Fotografía de los principales elementos experimentales . . .	79
3.2. Fotografías de las paredes del criostato Oxford.	80
3.3. Fotografías de las paredes y tubos del criostato.	81
3.4. Corte longitudinal esquemático del criostato.	82
3.5. Esquema del bastón portamuestras.	83
3.6. Esquema del circuito eléctrico de medida a cuatro hilos. . .	86
4.1. Resistividad en función de T para las muestras A y B. . .	94
4.2. Resistividad en función de T para las muestras D y G. . .	95
4.3. Ejemplo de derivada de la resistividad en función de la temperatura.	96
4.4. Curvas características $E-J$ para la muestra A, a distintas temperaturas por debajo de T_c , a campo magnético aplicado nulo.	99
4.5. Curvas $E-J$ para la muestra A, a distintas temperaturas por debajo de T_c , a $B = 0$: detalle de las isothermas cercanas a T_c	100
4.6. Curvas $E-J$ para la muestra A, a distintas temperaturas por debajo de T_c , a $B = 0$: representación logarítmica. . .	101
4.7. Curvas características $E-J$ para la muestra A, a distintos campos magnéticos aplicados, a $T = 76.2$ K.	102
4.8. Curvas características $E-J$ para la muestra A, a distintos campos magnéticos aplicados, a $T = 84.1$ K.	103
4.9. Experimento típico para la determinación de curvas $E-J$ en el régimen de alta disipación.	105

4.10. Experimento típico para la determinación de curvas $E-J$ en el régimen de alta disipación: detalle.	106
4.11. Gráfica característica $V-I$ experimental: detalle.	107
4.12. Rampas de corriente escalonadas de distinta duración. . .	109
4.13. Comparación de los valores de J^* determinados con rampas de corriente de distinta resolución.	110
4.14. Medida de voltaje a corriente constante para una muestra a temperatura mayor que T_c	113
4.15. Curva $\rho_{ab}(T)$ desplazada en temperatura debido al calentamiento de la muestra.	114
4.16. Correlación entre la potencia disipada y el incremento de temperatura de la muestra.	115
4.17. Evoluciones temporales del voltaje causadas por el calentamiento y enfriamiento de la muestra.	116
5.1. Curvas de E frente a $J - J_c(H)$ de la muestra A, a distintos campos magnéticos y a $T = 76$ K.	118
5.2. Comparación del modelo propuesto para las curvas $E-J$ con los datos experimentales, con $B = 0$	119
5.3. Comparación del modelo propuesto para las curvas $E-J$ con los datos experimentales, con $\mu_0 H = 1$ T.	120
5.4. Determinación de las corrientes críticas J_c^{pin} y J_c	129
5.5. Comparación de la corriente crítica J_c con J_c^{pin}	130
5.6. Corriente crítica J_c y de salto J^* en función de la temperatura, a campo magnético aplicado nulo.	132
5.7. Corriente de salto J^* en función de la temperatura para dos muestras distintas.	133
5.8. Cociente de la corriente crítica entre la de salto J_c/J^* , a campo aplicado nulo.	134
5.9. Corriente crítica J_c^{pin} y de salto J^* de varias muestras, en función del campo magnético aplicado y para varias temperaturas.	135
5.10. Cociente de la corriente crítica y la de salto J_c^{pin}/J_c en función del campo magnético.	136

5.11. Campo magnético creado por una corriente que circula por una muestra infinita de sección rectangular.	139
5.12. Campo E^* y corriente J^* de salto en función del campo aplicado, para varias muestras y temperaturas.	142
5.13. Campo E^* y corriente J^* de salto en función del campo: ajuste con el modelo BS.	143
5.14. Campo E^* y corriente J^* de salto en función del campo aplicado, para varias muestras y temperaturas.	146
5.15. Normalización de las corrientes J^* y J_c^{pin} en función del campo y para varias temperaturas.	148
5.16. Evolución temporal del voltaje aplicando distintas corrientes cercanas a J^*	150
5.17. Variación de la potencia disipada W^* con la temperatura de baño.	152
5.18. Variación de la potencia disipada W^* con el campo magnético externo aplicado.	153
6.1. Aumento considerable de la potencia disipada con el incremento de la temperatura, a densidad de corriente J constante.	158
6.2. Valor del campo E en función de la temperatura, a distintas densidades de corriente J constantes.	159
6.3. Corte transversal del filme y el sustrato (esquema). . . .	163
6.4. Aumento de la temperatura del sustrato caliente ΔT_s en función del tiempo, a potencia disipada constante.	166
6.5. Detalle de la figura 6.4.	167
6.6. Derivada del aumento de la temperatura del sustrato caliente $d\Delta T_s/dt$ en función del tiempo, a potencia disipada P constante.	168
6.7. Resultados de una simulación con realimentación, calculada según el modelo simple de las ecuaciones 6.9 y previas. .	170
6.8. Comparación de una simulación con realimentación con otra en la que la potencia permanece constante.	172

6.9. Comparación con el experimento de los valores de J^* calculados con el modelo más simple.	174
6.10. Función $\alpha(t)$ que se emplea para corregir la distribución de temperatura en el sustrato.	180
7.1. Simulación de la evolución temporal de la temperatura de un micropuente, a distintas corrientes próximas entre sí. $T_b = 75.6$ K, $B = 0$	185
7.2. Evolución temporal del campo E en un micropuente a distintas corrientes constantes, correspondiente a la simulación de la figura 7.1, y comparación con el experimento. $T_b = 75.6$ K, $B = 0$	186
7.3. Simulación de la evolución temporal de la temperatura y del campo eléctrico, a distintas corrientes próximas entre sí. $T_b = 76.2$ K, $B = 0$	188
7.4. Evolución temporal de la resistividad ρ del micropuente (a) y de la potencia disipada W (b) a distintas corrientes constantes, correspondientes a la simulación de la figura 7.3. $T_b = 76.2$ K, $B = 0$	189
7.5. Simulación de la evolución temporal de la temperatura y de la potencia disipada, a distintas corrientes próximas entre sí. $T_b = 82.0$ K, $B = 0$	191
7.6. Simulación de la evolución temporal de la temperatura, a distintas corrientes próximas entre sí. $T_b = 76.2$ K, $\mu_0 H = 1$ T.	192
7.7. Evolución temporal del campo E (a) y de la potencia disipada (b) a distintas corrientes, correspondiente a la simulación de la figura 7.6. $T_b = 76.2$ K, $\mu_0 H = 1$ T.	193
7.8. Correlación entre el valor de J^* y el tiempo t de duración de la medida.	194
7.9. Comparación de los resultados de la figura 7.8 con los obtenidos de simulaciones equivalentes considerando que el sustrato tiene una conductividad eléctrica 15 veces mayor (como si en vez de SrTiO_3 empleásemos MgO).	195

7.10. Simulaciones para la dependencia de W^* y dW/dT respecto del campo aplicado H	199
7.11. Comparación de la curva $E-J$ que predicen las simulaciones con los datos experimentales. $T_b = 76.2$ K, $B = 0$	202
7.12. Comparación de la curva $E-J$ que predicen las simulaciones con los datos experimentales. $T_b = 76.2$ K, $\mu_0 H = 1$ T.	203
7.13. Variación con la temperatura de la corriente de salto J^* : comparación de las predicciones del modelo con los experimentos.	205
7.14. Variación con la temperatura de la corriente de salto J^* : comparación de las predicciones del modelo con distintas correcciones.	206
7.15. Predicción de la correlación entre potencia disipada y aumento de temperatura de la muestra, según nuestro modelo térmico, para pulsos de 1 ms.	208
7.16. Predicción de la correlación entre potencia disipada y aumento de temperatura de la muestra, según nuestro modelo térmico, para pulsos de 100 μ s.	210
7.17. Término entre paréntesis de la ecuación 7.2, que caracteriza el comportamiento de dT_f/dt a P constante.	212
7.18. Ilustración de las dos posibles evoluciones temporales de la temperatura: estabilidad o avalancha.	213
7.19. Término que determina la condición de avalancha a potencia P constante, según la ecuación 7.9.	216
7.20. Frontera en el espacio $J-T_f-t$ ($B = 0$) entre las regiones de estabilidad e inestabilidad determinadas por la condición de avalancha.	219
7.21. Diagrama de estados estables y críticos $t-J$ para $T_f = 78$ K y $B = 0$	220
7.22. Diagrama de estados $J-T_f/T_c$ para $t > 10$ μ s y $B = 0$	221
7.23. Diagrama de estados $J-T_f/T_c$ para $t = 1$ ns y $B = 0$	222

7.24. Dependencia de la corriente de salto respecto de la temperatura, para $B = 0$: comparación de la condición de avalancha con los cálculos más detallados de apartados previos.	223
7.25. Diagrama de estados estables y críticos t - J para $T_f = 78$ K y $\mu_0 H = 1$ T.	225
7.26. Diagrama de estados J - T_f/T_c para $t = 0.1$ ms y $\mu_0 H = 1$ T.	226
7.27. Dependencia de la corriente de salto respecto de la temperatura, para $\mu_0 H = 1$ T: comparación de la condición de avalancha con los datos experimentales.	227
9.1. Incertidumbre en la determinación de la paraconductividad.	244

Agradecimientos

El autor agradece a los directores de este trabajo, los profesores Félix Vidal y José Antonio Veira, las orientaciones que determinaron el transcurrir de esta investigación, así como los múltiples recursos materiales y humanos puestos a su disposición. En especial, agradece al Dr. Veira el trabajo cotidiano en el laboratorio, en el que tantas cosas ha aprendido en su compañía.

La mayor parte de esta investigación se llevó a cabo en estrecha colaboración con el Dr. Severiano R. Currás y con la Dra. M. Teresa González. Con Seve aprendí a hacer filmes, y de él heredé sus temas de investigación. El trabajo previo de Teresa fue una base fundamental para mis experimentos, y llevar nuestras tesis paralelas resultó muy enriquecedor. De la reflexión conjunta sobre nuestros resultados salió, por ejemplo, la idea del modelo de calentamiento. También contribuyó en las medidas de los filmes Mauricio Ruibal. A ellos, muchas gracias por sus valiosas e indispensables aportaciones. En la parte de las fluctuaciones, el autor colaboró con los doctores Manuel V. Ramallo y Carlos Carballeira, junto con la Dra. Carolina Torrón y el Dr. Jesús Mosqueira. A todos agradezco lo que me aportaron, en el trabajo y en lo personal.

Gracias en general a los miembros del LBTS, y en concreto al profesor Jesús Maza, entre otras cosas por las apreciadas charlas científicas que hemos mantenido, y de las que tantas ideas, buenas y malas, han salido. Manuel R. Osorio, compañero desde hace años, es parte indispensable de estas reuniones. Otros *bolseiros* con los

que comparto fatigas, que ya se han ido o que llegan con renovadas ilusiones, son Silvia Vidal, Lucía Cabo, Gonzalo Ferro y Félix Soto.

El apoyo del múltiple personal técnico que pasa por nuestro departamento ha sido imprescindible en diversos momentos de este trabajo. De manera significativa, y en representación de los restantes, menciono a Juan Ponte, Raúl Santos, Fernando Naya, Laura M. Pouso, Marcos L. Presas, María Jesús Cantelar, Juan Turnes y Beatriz Barral.

Quedo muy agradecido a las personas que, tan generosamente, han hecho una lectura total o parcial de este trabajo, aportando siempre provechosas correcciones, tanto científicas como relativas al estilo o al idioma; entre otras, los profesores José María Viña L., Emilia Rebolledo, Pedro S. Rodríguez H., Luis Viña y Luisa Bausá. El Dr. Calum Byron soportó con estoicismo la lectura de algunos textos ingleses. La Dra. Irene Sendiña contribuyó amablemente a hacer la edición de esta memoria una tarea mucho más fácil.

El agradecimiento más especial, cariñoso y sincero a mis familiares y amigos, entre los que se encuentran varios de los ya mencionados. Han sido fundamentales soportes personales durante todo este largo tiempo como *bolseiro* de investigación, y también durante toda la vida, no tan larga y demasiado fugaz.

Durante estos años de doctorado el autor recibió financiación de la Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento de la Xunta de Galicia, como *bolseiro* de tercer ciclo (conjuntamente con la Dirección Xeral de Universidades) y *bolseiro* predoctoral; también de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología como becario de cooperación asociado a un proyecto (CICYT MAT2001-3053).

Este trabajo, junto con otros del LBTS, recibió diferentes ayudas de investigación e infraestructura de la Unión Europea (SCNET-2), la CICYT (MAT2001-3272 y MAT2001-3053), la Xunta de Galicia (PGIDIT 02PXIC20609PN) y Unión Fenosa (proyectos 0666-98 y 0666-02).

Lista de publicaciones

Los artículos directamente vinculados con diversos aspectos de esta Tesis Doctoral, y publicados o enviados a publicar hasta la fecha, se relacionan a continuación.

De la primera parte de esta memoria:

- *Transition to the normal state of superconducting $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ thin films induced by high current densities.* S. R. Currás, P. Wagner, M. Ruibal, J. Viña, M. R. Osorio, M. T. González, J. A. Veira, J. Maza, F. Vidal. Supercond. Sci. Technol. **14**, 748 (2001).
- *Normal-state resistivity versus critical current in $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ thin films at high current densities.* S.R. Currás, J. Viña, M. Ruibal, M. T. González, M. R. Osorio, J. Maza, J. A. Veira, F. Vidal. Physica C, **372-376** 1095 (2002).
- *Electric field versus current density curves in melt-textured samples of $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ under currents well above the critical current.* M. T. González, S. Vidal, J. Viña, M. R. Osorio, J. Maza, F. Vidal. Physica C, **372-376** 1852 (2002).
- *Normal-superconducting transition induced by high current densities in $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ melt-textured samples and thin films: Similarities and differences.* M. T. González, J. Viña, S. R. Currás, J. Maza, F. Vidal. (2002). En trámites de publicación. cond-mat/0305020.

De la segunda parte de esta memoria:

- *Relaxation time of the Cooper pairs near T_c in cuprate superconductors.* M. V. Ramallo, C. Carballeira, J. Viña, J. A. Veira, T. Mishonov, D. Pavuna and F. Vidal. Europhys. Lett. **48**, 79-85 (1999).
- *Some experimental aspects of the thermal fluctuations around T_c in cuprate superconductors: Application to the “vortex matter”.* F. Vidal, C. Torrón, J. Viña and J. Mosqueira. Physica C, **332**, 166-172 (2000).
- *Paraconductivity at high-reduced-temperatures in $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$.* C. Carballeira, S. R. Currás, J. Viña, M. V. Ramallo, J. A. Veira and F. Vidal. Phys. Rev. B. **63**, 144515 (2001).
- *Universal behaviour of the in-plane paraconductivity of cuprate superconductors in the short-wavelength fluctuation regime.* J. Viña, J. A. Campá, C. Carballeira, S. R. Currás, A. Maignan, M. V. Ramallo, I. Rasines, J. A. Veira, P. Wagner, F. Vidal. Phys. Rev. B, **65** 212509 (2002).
- *On the consequences of the uncertainty principle on the superconducting fluctuations well inside the normal state.* F. Vidal, C. Carballeira, S. R. Currás, J. Mosqueira, M. V. Ramallo, J. A. Veira, J. Viña. Europhys. Lett., **59** 754 (2002).
- *The in-plane paraconductivity in $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ thin film superconductors at high reduced-temperatures: Independence of the normal-state pseudogap.* S. R. Currás, M. T. González, M. V. Ramallo, M. Ruibal, J. A. Veira, J. Viña, P. Wagner, F. Vidal. (2002). En trámites de publicación.

Índice alfabético

- AFM, 65
- autocampo, 36, 42, 77, 121, 137,
140, 141, 144, 145, 232
- avalancha, 43, 124, 125, 150,
158, 173, 184, 192, 209,
214, 233
- baño, 59, 68, 77, 98, 151, 160,
161, 169, 190
- basculamiento, 52, 53
- blanco, 46
- bobinas de Helmholtz, 77
- calentamiento, 44, 49, 86, 89,
93, 104, 108, 111, 122,
123, 125, 128, 133, 155,
156, 158, 160, 167, 176,
184, 197, 204, 207, 209,
217, 233, 235
- campo magnético, 36, 43, 85,
93, 121, 133, 134, 152,
190, 227, 228
- ciclos de red, 87
- circuito, 56, 59, 71, 85, 104, 127
- condición de avalancha, 183,
214, 215, 217, 218, 222,
224, 225, 233
- conductividad eléctrica, 243
- conductividad térmica, 112,
180, 195
- contactos eléctricos, 45, 49, 56,
57, 60, 70, 71, 74, 230,
243, 246
- corriente de desapareamiento,
40, 127, 131, 134, 147,
156, 231, 232, 236
- criostato, 77, 78, 86, 91
- desalineamiento, 52, 54, 63
- desanclaje, 38, 122, 126
- difractómetro, 51, 52
- difractograma, 54
- difusividad térmica, 164
- error, 68, 69, 108, 110, 128, 141,
204, 243
- extrínseco, 44, 123, 156, 197
- flux creep, 120, 126
- fotolitografía, 56
- fotorresina, 57
- free flux flow, 120, 125
- fuerzas de Lorentz, 124
- grabado, 56
- histéresis, 176, 234

- homogéneo, 50
hot-spot, 123, 133
HP-BASIC, 91
- inductivos, 89
inhomogéneo, 49
inhomogeneidades, 49, 50, 96,
97, 113, 123
interdifusión, 70
intrínseco, 40, 44, 124, 156, 185,
197, 198, 207, 228, 234
- microscopio, 65, 68
microsoldador, 71
mosaicidad, 51, 53
- ortorrómbica, 48
oxigenación, 48
- parámetros de red, 46, 196
perfilómetro, 62
phase slip centers, 123
pinning, 38, 122, 126, 131
portamuestras, 52, 70, 78, 84,
194
pulso, 85, 89, 150, 151, 166, 169,
176, 194–197, 201, 210,
216, 219
pulverización catódica, 46, 69
- rampa, 48, 89, 104, 108, 110
realimentación, 65, 158–160,
169, 171, 173, 175, 177,
178, 185, 209, 222, 236,
292
- resistividad, 33, 38, 49, 57, 69,
90, 93, 97, 98, 101, 111,
114, 121, 187, 242–244,
249, 251
rocking curves, 52
- soldadura, 49, 69, 71, 74
sputtering, 46, 68
substrato, 45, 46, 60, 78, 164,
165, 180, 196, 197
- termómetro, 78, 79
termoeléctricos, 87
tetragonal, 48
tiempo bolométrico, 167, 175,
235
tiempo característico, 167, 173,
175, 180
tiempo de dispersión, 124, 126,
144
tiempo de inercia térmica, 112,
167
tiempo de relajación, 125, 141,
144, 232, 235, 251
toma de tierra, 86
- ultrasonidos, 60, 68, 71, 74, 230
umbral, 37, 101, 122, 128, 130,
131, 231
- vórtices, 36, 37, 120–127, 130,
156, 231
viscosidad, 124–126
Visual Basic, 91